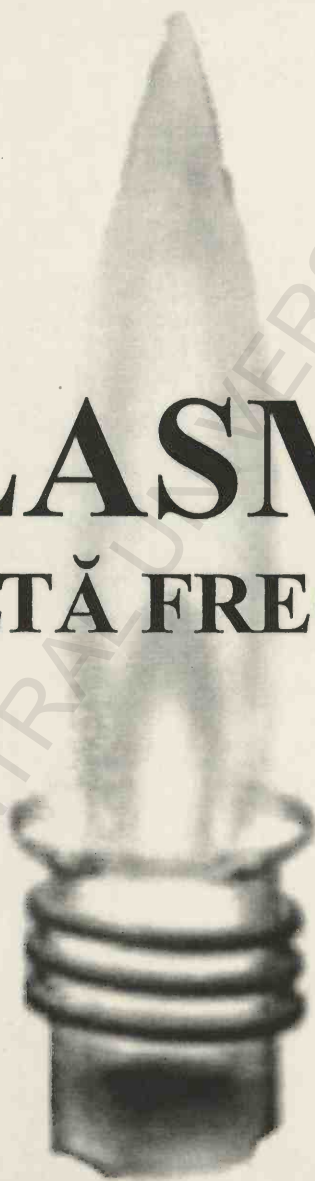


Sorin Dan ANGHEL
SIMON Alpár

PLASMA
DE ÎNALTĂ FRECVENTĂ



CUPRINS

| | |
|--|----|
| Prefață | 7 |
| Capitolul I. | |
| NOȚIUNI FUNDAMENTALE | 9 |
| 1.1 Ce este starea de plasmă ? | 9 |
| 1.2 Constituenții plasmei | 11 |
| 1.3 Parametrii plasmei | 13 |
| 1.3.1 Concentrația. Gradul de ionizare | 14 |
| 1.3.2 Temperatura | 15 |
| 1.3.3 Lungimea Debye | 20 |
| 1.3.4 Lungimea Landau | 23 |
| 1.3.5 Frecvența de plasmă | 25 |
| 1.3.6 Frecvența Larmor. Magnetizarea plasmei | 27 |
| 1.4 Definiția plasmei | 30 |
| Referințe bibliografice | 30 |
| Capitolul II. | |
| PROCESE FUNDAMENTALE ÎN PLASMĂ | 31 |
| 2.1 Tipuri de procese fundamentale | 31 |
| 2.2 Procese elementare de volum | 32 |
| 2.2.1 Ciocniri elastice | 32 |
| 2.2.2 Ciocniri neelastice | 34 |
| 2.2.2.1 Procese de excitare și dezexcitare | 34 |
| 2.2.2.2 Procese de ionizare și recombinație | 38 |
| 2.3 Procese elementare de suprafață | 47 |
| 2.3.1 Mecanismele de emisie electronică | 47 |
| 2.3.2 Emisia atomică | 53 |
| 2.3.3 Ionizarea superficială | 54 |
| Referințe bibliografice | 55 |
| Capitolul III. | |
| GAZE IONIZATE ÎN CÂMPURI ELECTRICE ALTERNATIVE | 56 |
| 3.1 O prezentare a fenomenelor | 56 |
| 3.2 Câmp electric alternativ | 58 |
| 3.3 Câmp electric alternativ și câmp magnetic static | 62 |
| Referințe bibliografice | 66 |
| Capitolul IV. | |
| GENERAREA CÂMPURILOR ELECTRICE ALTERNATIVE | 67 |
| 4.1 Generatoare de radiofrecvență | 67 |

| | |
|--|-----|
| 4.1.1 Principii generale | 67 |
| 4.1.2 Generatoare de plasmă cuplată inductiv | 74 |
| 4.1.3 Generatoare de plasmă cuplată capacitiv | 81 |
| 4.2 Generatoare de microunde | 87 |
| 4.2.1 Generarea microundelor | 88 |
| 4.2.2 Stabilizarea puterii în plasmă | 98 |
| Referințe bibliografice | 101 |
| Capitolul V. | |
| SURSE SPECTRALE CU PLASMĂ DE RADIOFRECVENȚĂ ȘI MICROUND | 103 |
| 5.1 Introducere | 103 |
| 5.2 Mecanisme radiative | 105 |
| 5.3 Introducerea probei în plasmă | 106 |
| 5.4 Surse spectrale cu plasmă de radiofrecvență | 107 |
| 5.4.1 Plasma cuplată inductiv (ICP) | 107 |
| 5.4.2 Plasma cuplată capacitiv (CCP) | 112 |
| 5.4.3 Sursa spectrală tandem | 121 |
| 5.5 Surse spectrale cu plasmă de microunde | 123 |
| 5.5.1 Plasmă indusă în microunde | 123 |
| 5.5.2 Plasmă cuplată capacitiv în microunde | 127 |
| 5.6 Torțe de plasmă | 129 |
| 5.6.1 Torțe pentru plasma de radiofrecvență (RF) | 130 |
| 5.6.1.1 Torțe pentru plasma RF cuplată inductiv | 130 |
| 5.6.1.2 Torțe pentru plasma de RF cuplată capacitiv | 134 |
| 5.6.2 Torțe pentru plasma de microunde | 138 |
| Referințe bibliografice | 140 |
| Capitolul VI. | |
| MODELAREA ÎN FIZICA PLASMEI | 144 |
| 6.1 Conceptul de model | 144 |
| 6.2 Modelarea în fizica plasmei | 146 |
| 6.3 Modelarea electrică a plasmelor de radiofrecvență | 151 |
| 6.3.1 Plasma cuplată capacitiv | 151 |
| 6.3.2 Plasma cuplată inductiv | 156 |
| Referințe bibliografice | 166 |
| Capitolul VII. | |
| TEMPERATURI ȘI DENSITĂȚI DE ELECTRONI | 168 |
| 7.1 Introducere | 168 |
| 7.2 Temperaturi și densități de particule într-o sursă spectrală | 170 |
| 7.3 Echilibrul termodinamic într-o sursă spectrală | 172 |
| 7.4 Intensitatea și profilul unei linii spectrale | 174 |
| 7.5 Metode optico-spectrale de determinare a temperaturilor | 178 |

| | |
|---|-----|
| 7.5.1 Determinarea temperaturii de excitare atomică | 178 |
| 7.5.2 Determinarea temperaturii de ionizare - disociere | 180 |
| 7.5.3 Determinarea temperaturii de excitare moleculară | 183 |
| 7.5.4 Determinarea temperaturii cinetice | 186 |
| 7.6 Determinarea densității de electroni | 189 |
| 7.7 Diagnosticarea plasmelor și inversia Abel | 192 |
| 7.8 Temperaturi și densități de electroni într-o plasmă de argon | 193 |
| Referințe bibliografice | 197 |
| Capitolul VIII. | |
| APLICAȚII ALE PLASMEI DE RADIOFRECVENȚĂ | 198 |
| 8.1 Plasma cuplată capacitiv ca sursă spectrală | 198 |
| 8.1.1 Principii generale | 198 |
| 8.1.2 Instrumentația folosită în evaluarea surselor spectrale cu plasmă | 206 |
| 8.1.3 Analiza probelor lichide | 208 |
| 8.1.4 Analiza probelor solide | 218 |
| 8.1.5 O sinteză a performanțelor surselor spectrale cu plasmă de RF | 225 |
| 8.2 Alte aplicații | 226 |
| 8.2.1 Prelucrarea materialelor cu ajutorul plasmelor termice | 228 |
| 8.2.1.1 Mărirea densității pulberilor cu plasmă termice | 228 |
| 8.2.1.2 Realizarea de straturi subțiri cu plasmă termice | 229 |
| 8.2.1.3 Sintetizarea pulberilor cu plasmă termice | 232 |
| 8.2.2 Modificarea suprafețelor polimerice cu plasmă termice | 233 |
| 8.2.2.1 Prepararea și prelucrarea suprafețelor | 234 |
| 8.2.2.2 Corodarea suprafeței polimerice | 235 |
| 8.2.2.3 Activarea suprafețelor și grefarea cu plasmă | 235 |
| 8.2.2.4 Polimerizarea și depunerea straturilor polimerice | 237 |
| 8.2.3 Surse de lumină | 238 |
| 8.2.3.1 Lămpi fluorescente | 238 |
| 8.2.3.2 Lămpi cu halogenuri | 241 |
| 8.2.4 Panouri de afișare cu plasmă | 242 |
| 8.2.4.1 Principii generale | 242 |
| 8.2.4.2 Caracteristici ale dispozitivelor de afișare cu plasmă | 246 |
| 8.2.4.3 Comportarea electrică a pixelilor | 250 |
| Referințe bibliografice | 254 |

PREFAȚĂ

În urmă cu 20 de ani, după câteva încercări nereușite de abordare a unor teme de cercetare care să poată fi finalizate cu o teză de doctorat într-un domeniu de interferență între fizică și electronică, la sugestia profesorului Ioan Ioviț Popescu venită prin intermediul profesorului Emil Tătaru, am abordat problematica proiectării generatoarelor de radiofrecvență capabile să genereze plasmă la presiune atmosferică. Scopul era acela al punerii în evidență a efectului optogalvanic într-o astfel de descărcare electrică. Dar cum teoria și experimentul nu fac întotdeauna casă bună, experiența acumulată timp de aproape trei ani a fost fructificată în colectivul de cercetare al profesorului Emil Cordoș prin realizarea în 1986 a primei surse spectrale cu plasmă cuplată inductiv din România. Apoi a venit și realizarea în premieră a surselor spectrale cu plasmă cuplată capacitiv la presiune atmosferică, folosite atât pentru probe lichide, cât și pentru probe solide conductoare și neconductoare.

Lucrarea de față încearcă să facă o sinteză a rezultatelor preocupărilor noastre, făcând trimitere și la rezultatele altor colective de cercetare care studiază mecanismele de generare și posibilitățile de utilizare a plasmelor de radiofrecvență și microunde. Ea cuprinde opt capitole, dintre care primele trei reprezintă o parte introductivă, necesară cititorului mai puțin avizat pentru a înțelege următoarele capitole care reprezintă miezul acestei lucrări.

Capitolul al patrulea este dedicat prezentării principiilor de funcționare și proiectare a generatoarelor de înaltă frecvență (radiofrecvență și microunde) capabile să genereze diferite tipuri de plasmă.

Capitolul cinci prezintă sursele spectrale bazate pe descărcări electrice în câmpuri de înaltă și foarte înaltă frecvență. El are un subcapitol destinat torțelor de plasmă, torța reprezentând una dintre cele mai delicate componente ale întregului ansamblu generator de plasmă, pentru că ea este aceea prin intermediul căreia proba care trebuie analizată este introdusă în plasmă.

În capitolul al șaselea sunt prezentate modele electrice pentru plasma cuplată capacitiv și plasma cuplată inductiv. Modelarea, pe lângă aspectul frumuseții teoretice, își are importanța ei din punct de vedere al predicției unor

parametri electrici ai plasmei, parametri care sunt apoi utilizați la proiectarea unor generatoare cu transfer maxim de putere către plasmă.

Capitolul șapte prezintă metode de determinare a temperaturilor și densității de electroni dintr-o plasmă, precum și rezultatele aplicării acestor metode în cazul plasmelor studiate de noi. Acest studiu conduce la explicarea mai bună a proceselor care se petrec la nivel atomic și molecular într-o plasmă.

În capitolul opt sunt prezentate câteva dintre aplicațiile plasmelor de înaltă frecvență. Accentul este pus pe folosirea lor ca surse spectrale, fiind înserate și alte câteva aplicații în tehnologiile moderne.

Aduc pe această cale mulțumirile cuvenite conferențiarului universitar Tiberiu Frențiu cu care am colaborat la obținerea multora dintre rezultatele experimentale, precum și colegului Simon Alpár, coautor al lucrării, a cărui tinerețe și vitalitate m-au stimulat în permanență.

În încheiere, mulțumim referenților pentru lecturarea manuscrisului și pentru sugestiile făcute.

Sorin Dan Anghel

Capitolul I

NOȚIUNI FUNDAMENTALE

1.1 Ce este starea de plasmă ?

Pentru că o definiție a acestei noțiuni nu este tocmai ușor de formulat, vom da la început câteva exemple de stări ale materiei care pot fi considerate plasmă. Și vom începe cu un fenomen natural observat de noi toți, și anume fulgerul. El se formează ca urmare a diferenței uriașe de potențial care ia naștere între nori (de regulă încărcăți cu sarcină electrică negativă) și Pământ (considerat convențional ca având potențial nul). Deoarece aerul nu este un izolator ideal (în condiții normale densitatea de ioni pozitivi și electroni liberi din el este de aproximativ $5 \cdot 10^8 \text{ m}^{-3}$), sub această diferență de potențial electronii dobândesc suficientă energie cinetică pentru ca, ciocnindu-se cu atomii și moleculele neutre, să producă ionizarea acestora, deci să crească densitatea de sarcini electrice libere capabile să asigure o creștere a conductibilității electrice a aerului. Acest proces de multiplicare a sarcinilor electrice libere se dezvoltă în avalanșă, determinând creșterea intensității curentului electric dintre nor și Pământ și favorizând apariția unei descărcări electrice între acești doi "electrozi". Respectând proporțiile, același fenomen fizic se petrece atunci când se atinge pentru o fracțiune de secundă două fire conductoare conectate la bornele unui acumulator auto și se obține ceea ce se numește scânteia electrică. Aceasta nu este decât modelul de laborator al fulgerului. Tot despre o stare de plasmă se vorbește și în cazul unei soluții apoase de NaCl în care are loc separarea ionilor negativi de clor (Cl^-) de ionii pozitivi de sodiu (Na^+), soluția dobândind proprietăți conductoare. Sau, despre ionii cuasistaționari din nodurile unei rețele cristaline a unui metal împreună cu "gazul" electronic din jurul lor se spune că formează tot o stare de plasmă. Iată că, deși este vorba de trei stări de agregare diferite (stările așa-zis clasice, gazoasă, solidă și lichidă) totuși, în exemplele menționate, ele au două proprietăți comune: sunt bune

conductoare de electricitate și, la scară macroscopică, sunt *neutre din punct de vedere electric* (suma algebrică totală a sarcinilor electrice este nulă). Dar, după cum se va vedea în continuare, aceste două proprietăți nu sunt suficiente pentru a caracteriza complet starea de plasmă. De aceea, vom încerca doar în paragrafele următoare să-i dăm o definiție cât mai cuprinzătoare.

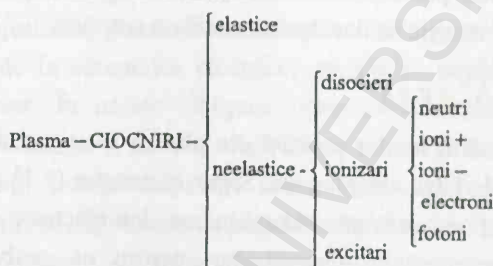
Deoarece starea de plasmă este caracteristică atât corpurilor solide, cât și celor lichide și gazoase, uneori se spune despre aceasta că este a patra stare de agregare a materiei. Dar, în cazul plasmei gazoase mai ales, se poate spune că ea reprezintă o *a patra stare energetică a materiei*, și iată de ce. Să ne imaginăm că unui corp în stare solidă, care se află într-o incintă închisă, i se furnizează suficientă energie pentru a se topi și a trece în stare lichidă, procesul continuând apoi până la vaporizarea completă a lichidului. S-a obținut astfel starea gazoasă folosind pentru fiecare etapă de tranziție o energie de aproximativ 10^{-2} eV/particulă. Dacă se furnizează în continuare energie gazului, atunci, dacă ea este mai mare decât energia de ionizare a acestuia ($1 - 30$ eV/particulă), o mare parte dintre atomii (moleculele) gazului se vor ioniza, gazul trecând în starea de plasmă gazoasă. Din punct de vedere termic acestei energii i se poate asocia o temperatură cuprinsă în domeniul $10^4 - 10^5$ K. Se poate deci observa că energia ce revine unei particule pentru a trece de la starea gazoasă la starea de plasmă este cu aproximativ două ordine de mărime mai mare decât cea necesară tranziției solid-lichid sau lichid-gaz. Deoarece această energie se regăsește sub diferite forme în plasmă, ea poate fi considerată ca o stare de energie mai înaltă a corpului inițial. Dacă s-ar furniza în continuare energie atomilor și ionilor din plasmă, energie care să fie mai mare decât energia de legătură a nucleonilor în nucleu (≈ 8 MeV/nucleon), atunci s-ar obține cea de-a cincea stare energetică a materiei formată numai din electroni și nucleoni, și care ar putea fi denumită gaz nucleonic. Acestei energii i se pot asocia temperaturi de ordinul $10^{12} - 10^{13}$ K, temperaturi imposibil de obținut cu tehnologiile actuale, astfel încât gazul nucleonic rămâne doar o stare ipotetică.

Denumirea de plasmă a fost dată acestei stări a materiei de către fizicianul american Irving Langmuir în anul 1928 și ea derivă de la cuvântul grec *plassein* (a forma, a modela). Ea i-a fost sugerată de faptul că, în studiile sale asupra trecerii curentului prin gaze la presiuni subatmosferice, a observat că, atunci când descărcarea devenea luminiscentă, ea ocupa nu numai spațiul dintre electrozii între

care era aplicat câmpul electric ci se extindea în tot volumul incintei de descărcare, modelându-și forma după forma acesteia.

1.2 Constituenții plasmiei

Dacă presupunem că energia necesară trecerii de la starea gazoasă obișnuită la starea de plasmă este furnizată de către un câmp electric care accelerează electronii liberi, principalul mecanism care va determina tranziția gaz-plasmă este reprezentat de ciocniri. Principalele tipuri de ciocniri și consecințele acestora sunt prezentate în tabloul următor:



Ciocnirile elastice contribuie doar la redistribuirea energiei cinetice între particulele componente ale plasmiei, fără a avea vreo contribuție directă asupra generării plasmiei. În urma acestui proces, distribuția după viteze a particulelor din plasmă va fi descrisă de o funcție de distribuție de tip Maxwell. Ciocnirile neelastice însă, sunt cele care provoacă disocierea moleculelor și "ruperea" lor în atomii constituenți, excitarea acestora din urmă și în final ionizarea lor. Consecințele acestor procese neelastice sunt de fapt chiar componentele plasmiei:

- **componenta neutră** provine din gazul "materie primă", gaz care poate fi monoatomic, poliatomic sau în stare de vapori. Exceptând plasmale de interes termonuclear (plasmale de fuziune), în care componenta neutră poate să apară doar temporar ca urmare a proceselor de recombinare, în toate celelalte plasmale ea este parte integrantă a acestora.

În cazul plasmelor provenite din gaze monoatomice ciocnirile dintre atomi conduc componenta neutră către o stare de echilibru descrisă de legea de distribuție Boltzmann. Dacă componenta neutră se află în stare de echilibru termodinamic cu gazul "materie primă" care înconjoară plasma, atunci întregului ansamblu i se poate atribui o temperatură în sens termodinamic.

Dacă gazul "materie primă" este poliatomic atunci, energia transferată componentei neutre se distribuie între stările interne (electronice, rotaționale și vibraționale) și mișcarea de translație a moleculelor, la echilibru termodinamic obținându-se o distribuție de tip Boltzmann între toate aceste stări.

- *componenta ionică*, care conține atât ionii pozitivi rezultați în urma ciocnirii atomilor sau moleculelor de către electroni, cât și ionii negativi, consecință a proceselor de atașare electronică.

- *componenta electronică*, care este principala răspunzătoare de generarea și menținerea stării de plasmă. În urma ciocnirii neelasice dintre un electron rapid \bar{e} și un atom neutru A , care se desfășoară conform reacției:



se mărește atât numărul ionilor pozitivi din plasmă cât și cel al electronilor, adică al componentelor de bază ale plasmei. Sigur că reacția (1.1) poate avea loc și în sens invers, având ca rezultat recombinarea ion-electron și deci diminuarea componentelor electrice ale plasmei dar, pentru că probabilitatea ca într-o interacție să se întâlnească simultan trei parteneri este mai mică decât probabilitatea să se întâlnească numai doi, rezultatul în timp al celor două procese complementare este creșterea concentrațiilor componentelor electrice.

Electronii din plasmă pot fi rezultatul mai multor procese și fenomene fizice, dintre care cele mai importante sunt emisia termoelectronică, emisia electronică secundară la impactul lor cu atomii și moleculele gazului sau cu suprafețele solide din plasmă (electrozi, pereții incintei) și nu în ultimul rând, electronii existenți în mediul înconjurător ca urmare a acțiunii unor factori ionizanți naturali (radiația cosmică, radioactivitatea Pământului).

Componentele ionică și electronică, fiind purtătoare de sarcină electrică, sunt cele care asigură conductibilitatea electrică a plasmei, posibilitatea ei de a interacționa cu câmpurile electrice și magnetice precum și existența *forțelor de interacțiune de tip coulombian*. În starea de plasmă, suma algebrică a sarcinilor acestor componente este nulă.

- *componenta fonică*, rezultat al emisiei de radiație electromagnetică luminoasă la dezexcitarea spontană sau stimulată a atomilor (moleculelor) excitați(te), al interacțiilor binare (de exemplu radiația de frânare - Bremsstrahlung), a fluctuațiilor câmpului electromagnetic sau ca rezultat al

mişcării ciclotronice. Existența componentei fotonice se manifestă prin existența unui spectru de emisie caracteristic pentru fiecare tip de plasmă suprapus peste emisia continuă a ei. Radiația fonică poate fi folosită cu succes la determinarea anumitor parametri caracteristici ai plasmei (temperaturi, densități electronice și ionice, intensități de câmpuri electrice interne), ea stând la baza metodelor de diagnosticare optico-spectrale.

- *câmpurile electromagnetice*, care pot fi generate chiar de către componentele electronică și ionică datorită deplasării lor permanente, sau pot fi aplicate din exterior pentru generarea și confinarea plasmei (menținerea ei într-un spațiu limitat). Majoritatea plasmelor de laborator sunt generate și întreținute de energia absorbită de la câmpurile electrice, magnetice sau(și) electromagnetice aplicate din exterior. În aceste câmpuri componentele purtătoare de sarcină electrică vor fi accelerate și se vor deplasa pe diverse traiectorii determinând apariția unor curenți interni staționari sau variabili, deci și a unor câmpuri electromagnetice interne. În funcție de natura câmpului dominant, plasmelor pot fi clasificate în trei categorii: *electrice* (dominant este câmpul electric), *magnetice* (dominant este câmpul magnetic) și *electromagnetice* (câmpurile electric și magnetic au efecte comparabile asupra plasmei). În funcție de modul în care are loc transmiterea energiei spre plasmă de la câmpul care o întreține, plasmelor pot fi *rezistive* (sau plasmă de curent continuu), *capacitive* (plasma absoarbe energie de la componenta electrică longitudinală a unui câmp alternativ) și *inductive* (plasma absoarbe energie de la componenta azimutală a unui câmp electric alternativ).

1.3 Parametrii plasmei

O plasmă poate fi caracterizată complet numai dacă se dețin o serie de informații despre proprietățile ei, informații cunoscute sub denumirea de parametrii plasmei. Aceste informații sunt obținute prin diferite metode de măsurare și de calcul, ele fiind cunoscute sub denumire generală de metode de diagnosticare. O parte dintre ele, cele de interes pentru lucrarea de față, vor fi prezentate într-un capitol următor. Pentru simplitate ne vom referi în continuare doar la plasmelor simplu ionizate (de exemplu cele obținute din atomi hidrogenoizi) în care, din condiția de neutralitate, spunem că densitatea de ioni este egală cu densitatea de electroni. Rezultatele pe care le vom obține pot fi aplicate însă și plasmelor multiplu ionizate cu condiția înlocuirii noțiunii de densitate de ioni cu

noțiunea de densitate de sarcină pozitivă și a celei de densitate de electroni cu noțiunea de densitate de sarcină negativă.

1.3.1 Densitatea. Gradul de ionizare

În general prin densitate se înțelege numărul de particule din unitatea de volum. Deoarece în starea de plasmă există trei tipuri de particule, se poate vorbi despre trei densități: densitatea electronilor, n_e , densitatea ionilor, n_i și densitatea particulelor neutre, n_n . Deoarece electronii și ionii se formează prin ionizarea atomilor neutri se poate spune că $n_e \equiv n_i = n_o$, unde n_o poartă denumirea de *densitate a plasmei*. Pentru exemplificare amintim că într-o plasmă de laborator (descărcare luminiscentă) densitatea particulelor purtătoare de sarcină netă (deci a plasmei) este de ordinul 10^{21} m^{-3} , iar densitatea unei plasme dintr-o instalație de fuziune termonucleară este de ordinul 10^{26} m^{-3} .

Gradul de ionizare al plasmei se definește ca fiind raportul dintre densitatea de ioni și suma dintre densitatea de ioni și densitatea de particule neutre:

$$\alpha = \frac{n_i}{n_i + n_n} \quad (1.2)$$

Gradul de ionizare poate constitui un criteriu de clasificare a plasmelor. În funcție de valoarea acestui parametru se disting patru tipuri de plasmă:

a). plasmă în care densitatea componentei neutre este mult mai mare decât densitatea ionică și care se numesc *plasmă slab ionizată* ($\alpha < 10^{-4}$). Un exemplu pentru acest tip de plasmă îl constituie descărcările în gaze.

b). *plasmă mediu ionizată* ($10^{-2} > \alpha > 10^{-4}$), categorie în care pot fi încadrate arcul electric, plasma cuplată inductiv la presiune atmosferică, laserii cu gaz de mare putere.

c). plasmă în care densitatea ionică este mult mai mare decât densitatea componentei neutre și care se numesc *plasmă puternic ionizată* ($10^{-2} < \alpha < 1$), cum ar fi de exemplu fulgerul din atmosferă și modelul lui de laborator, scânteia electrică.

d). plasmă fără componentă neutră ($n_n = 0$, $\alpha = 1$) și care se numesc *plasmă total ionizată*, dintre care cel mai edificator exemplu îl reprezintă plasmă de interes termonuclear din capcanele magnetice.

1.3.2 Temperatura

În general, când este vorba despre temperatură, suntem obișnuiți să ne gândim la temperatura definită în sens termodinamic, adică aceea care poate fi măsurată cu traductoarele de temperatură care se bazează pe efectele fizice determinate de variația acesteia: dilatarea, variația rezistenței electrice, generarea unei tensiuni electromotoare etc. În cazul stării de plasmă însă, se pot defini mai multe temperaturi, temperaturi asociate diferitelor forme sub care energia absorbită se poate regăsi în plasmă. Aceasta pentru că, dată fiind complexitatea stării de plasmă, energia absorbită de ea poate fi folosită pentru sporirea agitației termice, pentru amplificarea mișcării de vibrație și de rotație a moleculelor, pentru disocierea acestora în atomii constituenți, pentru excitarea și ionizarea atomilor și moleculelor.

Într-un sistem de particule, la echilibru termodinamic, distribuția energiei interne între diferitele grade de libertate de translație sau interne, distribuția produselor de disociere și ionizare ca și distribuția spectrală a densității de radiație sunt guvernate de o singură temperatură, T . Acest parametru este denumit *temperatura sistemului*. La o temperatură dată T , aceste distribuții sunt independente de tipul și viteza de desfășurare a proceselor prin care are loc schimbul de energie sau prin care se produc disocierile și ionizările. Distribuția de echilibru depinde de temperatura și proprietățile individuale ale componentelor sistemului și nu depinde de tipul de interacțiuni dintre ele.

La echilibru termodinamic există o anumită repartizare a valorilor medii ale energiei înmagazinate sub diferite forme, guvernată de *legea echipartiției energiei*. Astfel, pentru energia de translație valoarea medie a energiei ce revine unei particule pentru un grad de libertate (respectiv mișcării pe una din direcțiile x , y sau z) este $kT/2$. De asemenea, energia cinetică medie asociată mișcării relative a două particule de-a lungul direcției ce le unește este tot $kT/2$. Această lege de echipartiție se aplică tuturor formelor de energie care au o variație continuă sau cuasicontinuă într-un anumit domeniu de valori.

Deoarece ansamblul *plasmă - sursă de energie - mediu înconjurător* nu poate fi considerat un sistem adiabatic, existând o dinamică continuă a absorbției energiei de la sursă și de transfer a ei către mediul înconjurător, în permanență are loc un transport de căldură, radiație și chiar de masă (vezi cazul plasmă cuplate inductiv sau altor tipuri de plasmă în care gazul "materie primă" se află într-o curgere continuă). În aceste condiții, în cazul plasmă, de cele mai multe ori nu se poate vorbi despre o stare de echilibru termodinamic caracterizată de o singură valoare a temperaturii. Totuși, dacă viteza de desfășurare a acestor procese de transport este mică în comparație cu viteza cu care energia este repartizată local între toate gradele de libertate, se poate accepta și folosi conceptul de *echilibru termodinamic local* (*Local Thermodynamic Equilibrium, LTE*).

Atingerea stării de echilibru termodinamic pentru toate formele de energie depinde de viteza cu care are loc schimbul de energie în interiorul unui grad de libertate sau între diferite grade de libertate. Energia de translație este schimbată mai ușor prin ciocniri între particule cu masă comparabilă, după câteva astfel de procese obținându-se o distribuție de tip Maxwell a vitezelor lor. În general, la presiune atmosferică faaaaaața de ciocnire este de ordinul 10^9 s^{-1} , timpul de relaxare necesar stabilirii unui echilibru Maxwell fiind de ordinul $10^{-8} - 10^{-9} \text{ s}$. În aceleași condiții, pentru stabilirea distribuției de echilibru între gradele de libertate de rotație moleculară este însă necesar un timp ceva mai mare ($10^{-7} - 10^{-8} \text{ s}$), iar pentru echipartiția energiei între gradele de libertate de vibrație este necesar un interval de timp și mai mare, $1 - 10 \mu\text{s}$.

Deoarece energia de vibrație este schimbată mult mai ușor între molecule decât să fie convertită în energie de translație, de regulă, distribuția pe nivelele vibraționale se realizează conform unei distribuții de tip Boltzmann. Prin urmare, datorită schimbului slab al energiei vibraționale în energie de translație, temperatura asociată mișcării de vibrație poate să difere foarte mult de temperatura asociată mișcării de translație care descrie distribuția Maxwell a vitezelor.

În general, când rata de schimb între energiile de același fel este mult mai mică decât rata cu care o formă de energie este convertită în altă formă de energie, apare situația în care fiecărei forme de energie i se poate asocia un parametru T diferit și variabil în timp. În această situație se vorbește despre un echilibru parțial pentru fiecare formă de energie.

Temperatura translațională sau *temperatura cinetică* este asociată energiei cinetice de translație a componentelor plasmei, fiecărei componente purtătoare de masă putându-i-se asocia o astfel de temperatură. Aceasta este temperatura definită în sens termodinamic. În urma proceselor de ciocnire elastică, între particulele cu masă apropiată (de același ordin de mărime) din plasmă are loc o redistribuire a energiei cinetice, astfel încât distribuția particulelor după viteze se va face conform unei legi de distribuție Maxwell:

$$\frac{dn}{n} = \left(\frac{m}{2\pi k T_c} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT_c}} 4\pi v^2 dv \quad (1.3)$$

în care n este numărul de particule cu masa m având viteze cuprinse în domeniul v , $v+dv$, k este constanta lui Boltzmann iar T_c este temperatura cinetică asociată componentei considerate.

Efectul acestei mișcări se manifestă și prin lărgirea liniilor spectrale de emisie atomică, ionică sau din benzile moleculare. Această lărgire poartă numele efectului cu același nume, Doppler, și prin măsurarea ei se pot determina temperaturile cinetice ale speciilor atomice sau ionice. De obicei, între temperatura cinetică și lărgirea Doppler, $\Delta\lambda_D$, există relația:

$$\Delta\lambda_D \sim T^{\frac{1}{2}} \quad (1.4)$$

Temperatura de excitare este temperatura asociată energiei folosite de ansamblul de particule pentru a trece din starea fundamentală în stări excitate. Deoarece producerea fenomenului invers, dezexcitarea, are loc cu emiterea de radiații electromagnetice caracteristice, temperatura de excitare poate fi pusă în legătură directă cu intensitățile liniilor de emisie ale speciilor atomice ionice sau moleculare prezente în plasmă. De obicei, fiecărei specii, să spunem atomice, i se poate atribui o temperatură de excitare. Astfel, de exemplu dacă într-o plasmă de argon se introduc atomi de fier, atunci se poate vorbi despre o temperatură de excitare a argonului și una de excitare a fierului, temperaturi care pot fi calculate din liniile de emisie ale argonului, respectiv ale fierului care se regăsesc în spectrul de emisie al plasmei. Având în vedere faptul că plasmăle gazeoase pot avea ca "materie" primă atât gaze atomice cât și gaze moleculare, se poate vorbi despre temperaturi de excitare atomice și despre temperaturi de excitare moleculare.

Temperatura de excitare atomică (sau ionică) este asociată stărilor excitate ale electronilor în atomii (sau ionii) constituenți ai plasmei. Ea poate fi determinată din raportul populațiilor a două nivele energetice m și n (cu energiile E_m și E_n și având ponderile statistice g_m și g_n), raport exprimat prin legea Boltzmann:

$$\frac{n_m}{n_n} = \frac{g_m}{g_n} e^{\frac{E_n - E_m}{kT_{exc}}} \quad (1.5)$$

și care poate fi pus în relație directă cu intensitățile de emisie corespunzătoare tranzițiilor de pe cele două nivele pe nivelul fundamental.

Temperatura de excitare moleculară este asociată cu cele două tipuri suplimentare de excitare în care se poate afla molecula: excitarea moleculei pe nivele de rotație și respectiv pe nivele de vibrație. De aceea în acest caz se definesc două temperaturi de excitare: *rotațională* și *vibrațională*. Temperatura de excitare rotațională se poate estima din raportul intensităților liniilor spectrale aparținând unei benzi moleculare iar temperatura vibrațională din raportul intensităților a două sau mai multor benzi din spectrul de emisie molecular.

Temperatura de ionizare și disociere este asociată acelei forme de energie care este "folosită" de plasmă pentru disocierea, atomizarea și ionizarea particulelor ei. Ea se poate determina din ecuația lui Saha, ecuație ce exprimă de fapt o relație între concentrațiile particulelor purtătoare de sarcină electrică în exces și concentrația componentei neutre. Pentru a deduce această relație, să considerăm un gaz neutru monocomponentă care, primind energie sub o anumită formă, se ionizează. Gazul rezultat este compus din particule neutre, ioni pozitivi și electroni. Între densitățile acestor componente există relațiile din Fig.1.1.

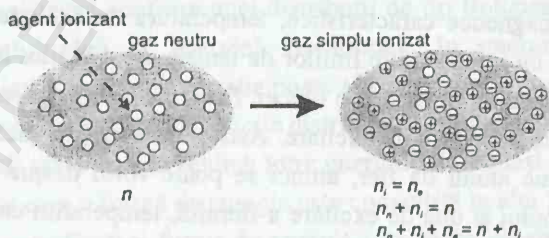


Fig.1.1 – Ionizarea simplă a unui gaz monocomponentă.

Pe lângă procesele de ionizare, în gaz au loc și procese de recombinare, procese care pot fi asimilate unor reacții chimice. Aplicând legea acțiunii maselor

din chimie, lege care spune că *raportul dintre produsul presiunilor parțiale ale produșilor de reacție (în cazul de față ionii pozitivi și electronii) și produsul presiunilor parțiale ale reactanților (în cazul de față doar particulele neutre) este constant*, se poate scrie relația:

$$\frac{p_e p_i}{p_n} = \text{const.} \quad \text{const.} = \left(\frac{2\pi m_e}{h^2} \right)^{3/2} (kT)^{5/2} e^{\frac{eV_i}{kT}} \quad (1.6)$$

în care V_i este potențialul de ionizare al particulelor neutre.

Presiunile parțiale ale componentelor gazului ionizat sunt: $p_e = n_e kT$, $p_i = n_i kT$ și $p_n = n_n kT$ iar presiunea totală p este egală cu suma presiunilor parțiale ($p = (n + n_i)kT$). Împărțind cu p^2 numărătorul și numitorul ecuației (1.6) și ținând seama de expresiile presiunilor și de relațiile dintre densitățile de particule (Fig.1.1), se obține ecuația:

$$\frac{n_i^2}{n^2 - n_i^2} \cdot p = \text{const.} \quad (1.7)$$

Având în vedere că raportul n_i/n reprezintă gradul de ionizare α , ecuația care face legătura dintre acesta și temperatura de ionizare este:

$$\frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} \cdot p = (2\pi m_e)^{3/2} (kT)^{5/2} e^{\frac{eV_i}{kT}} \quad (1.8)$$

Pe baza relației precedente, cunoscând gradul de ionizare al unei plasme se poate determina temperatura de ionizare a ei.

Temperatura de radiație poate fi calculată din punct de vedere formal din formula radiației corpului negru a lui Planck:

$$\rho_\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT_{\text{rad}}}} - 1} \quad (1.9)$$

Produsul $\rho_\lambda d\lambda$ reprezintă energia radiației nepolarizate cu lungimea de undă cuprinsă în intervalul λ , $\lambda + d\lambda$ emise normal pe un element de suprafață unitar, în unitatea de timp și unitatea de unghi solid.

În general, atunci când se vorbește despre temperatura unei plasme, se face referire la temperatura definită în sens termodinamic, adică la temperatura cinetică. Dar, și în acest caz, se poate da o singură valoare temperaturii plasmei doar atunci când temperatura electronică este egală cu temperatura ionică (care este și

temperatura componentei neutre). Această situație se întâlnește în cazul plasmelor astronomice, plasmă cu densități mari și presiuni ridicate. O astfel de plasmă se numește *izotermă* și se spune despre ea că se află în stare de *echilibru termodinamic*. Ea este în echilibru termodinamic și cu mediul înconjurător, energia primită de plasmă fiind egală cu cea radiată de ea iar radiația plasmă coincide cu cea a corpului negru. În cazul plasmelor reci obținute în laborator (plasma coloanei pozitive a unei descărcări luminescente, de exemplu) temperatura electronică este cu aproximativ două ordine de mărime mai mare decât temperatura ionică. Aceste plasmă sunt *neizoterme* și ele nu se mai află în starea de echilibru termodinamic. Există totuși situații în care, deși la scară macroscopică plasma este neizotermă, în interiorul unor volume mici din ea să fie îndeplinită condiția de egalitate a temperaturilor electronică și respectiv ionică. În acest caz se vorbește despre *echilibrul termodinamic local* (LTE).

1.3.3 Lungimea Debye

După cum am arătat, la scară macroscopică plasma este neutră din punct de vedere electric. Dar, datorită mobilității mult mai mari a electronilor față de cea a ionilor (diferență datorată raportului maselor celor două tipuri de particule), din punct de vedere statistic există probabilitatea ca la un moment dat mai mulți electroni dintr-un volum dat să-l părăsească, acesta rămânând cu un exces de sarcină pozitivă. Această sarcină pozitivă va genera un câmp electric care va determina electronii să revină în volumul dat, astfel încât neutralitatea locală a plasmă să fie refăcută. Acest câmp electric care are mereu grijă de neutralitatea plasmă se numește *câmp electric restaurator* și, datorită faptului că pe durate de timp foarte scurte, la scară microscopică sunt posibile abateri de la neutralitate, se vorbește despre *cuasineutralitatea plasmă*.

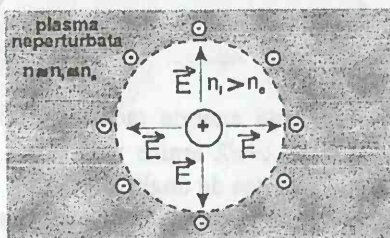


Fig.1.2 - Câmpul electric restaurator.

Pentru a vedea care este expresia câmpului electric restaurator și cât de intens este el, să presupunem că la un moment dat, o parte din electroni au părăsit un volum sferic cu raza r , astfel încât, în volumul respectiv, densitatea n_i de ioni pozitivi este mai mare decât densitatea n_e de electroni (Fig.1.2). Considerând omogenă distribuția sarcinilor în exces atunci, intensitatea câmpului electric generat de excesul de sarcină pozitivă în locurile în care se află electronii (pe suprafața sferei imaginare) va fi:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\frac{4\pi r^3}{3} e \Delta n}{r^2} = \frac{enr \Delta n}{3\epsilon_0 n} \quad (1.10)$$

în care $\Delta n = n_i - n_e$, iar n este densitatea plasmă neperturbată, simplu ionizată. Pentru a putea aprecia cât de mare este intensitatea câmpului electric restaurator, să presupunem o plasmă cu densitatea de 10^{22} m^{-3} , în care s-a creat o abatere relativă de la neutralitate de 0,5 % într-un volum sferic cu raza de 1 mm. Intensitatea câmpului electric care ia naștere este de ordinul 10^8 V/m , valoare care nu înseamnă prea mult dacă nu precizăm și faptul că, sub acțiunea acestui câmp, unui electron îi trebuie doar $6 \cdot 10^{-12}$ secunde pentru a reveni în centrul sferei.

Distanța maximă la care se poate îndepărta un electron de la poziția sa inițială împotriva câmpului electric restaurator este funcție de energia cinetică inițială a lui, deci de temperatura cinetică a electronilor. Această distanță se numește *lungime Debye* și ea reprezintă dimensiunea liniară a domeniului din plasmă în care neutralitatea nu mai este sigură.

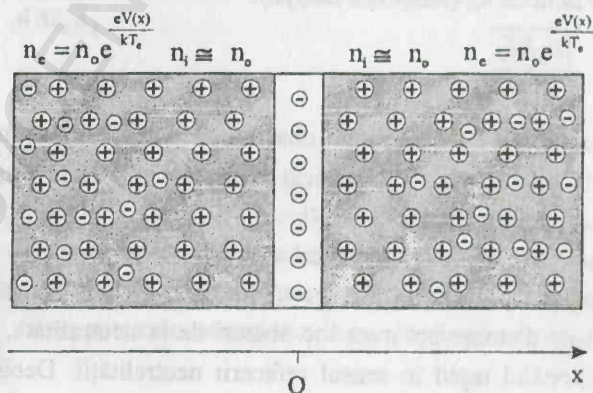


Fig.1.3 - Plasmă perturbată pe direcția Ox.

Pentru a-i stabili expresia, considerăm un strat de plasmă cu densitatea n_o în care se introduce un strat de sarcină negativă, plan și infinit. Stratul de sarcină fiind considerat infinit, efectele introducerii lui în plasmă se vor face simțite doar pe o direcție perpendiculară pe el (direcția Ox , Fig.1.3). Rezultatul acestei perturbații va fi redistribuirea sarcinilor în plasmă. Considerând că energia potențială de interacțiune electrostatică este mult mai mică decât energia termică ($eV \ll kT$) și aplicând statistica Boltzmann, densitatea de electroni va fi dată de relația:

$$n_e(x) = n_o e^{\frac{eV(x)}{kT_e}} \approx n_o \left(1 + \frac{eV(x)}{kT_e} \right) \quad (1.11)$$

Deoarece inerția electronilor este mult mai mică decât cea a ionilor, electronii vor răspunde la perturbație mult mai rapid decât ionii pozitivi, astfel încât se poate considera că $n_i \approx n_o$. Scriind ecuația lui Poisson, $d^2V(x)/dx^2 = -\rho/\epsilon_o$ și folosindu-ne de precizările precedente, obținem:

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{e(n_i - n_e)}{\epsilon_o} \approx \frac{n_o e^2}{\epsilon_o kT_e} \cdot V(x) \quad (1.12)$$

Rezolvarea ecuației de mai sus ne conduce la soluția:

$$V(x) = V_o \cdot e^{-\frac{x}{\sqrt{\frac{\epsilon_o kT_e}{n_o e^2}}}} \quad (1.13)$$

în care V_o este potențialul electric al stratului perturbator în absența plasmei. Se poate observa că radicalul de la exponent are dimensiunile unei lungimi și această mărime o vom nota cu λ_D (lungimea Debye):

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_o kT_e}{n_o e^2}} \quad (1.14)$$

Din expresia (1.13) se poate observa că potențialul stratului perturbator scade mai rapid în prezența plasmei decât în absența ei și că la o distanță $x = \lambda_D$ el este deja de e ori mai mic decât la $x = 0$.

Se poate concluziona că efectul sarcinii perturbatoare se face simțit doar pe distanțe care au ordinul de mărime al lungimii Debye. Aceasta înseamnă că doar pe astfel de distanțe pot avea loc abateri de la neutralitate, câmpul electric restaurator acționând rapid în sensul refacerii neutralității. Deoarece la distanțe

mai mari decât lungimea Debye efectul câmpului electric al sarcinii perturbatoare este neglijabil, lungimea Debye se mai numește și *lungime de ecranare*.

Alte mărimi caracteristice pentru plasmă legate direct de lungimea Debye sunt *volumul Debye*, V_D (volumul unei sfere cu raza egală cu lungimea Debye):

$$V_D = \frac{4\pi}{3} \lambda_D^3 \quad (1.15)$$

și *numărul lui Debye*, N_D (numărul de electroni din sfera Debye):

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \lambda_D^3 n_e \quad (1.16)$$

Deoarece în interiorul volumului Debye pot apare abateri de la neutralitate, *pentru ca un gaz ionizat să satisfacă condiția de neutralitate la scară macroscopică (condiția de plasmă) este necesar ca volumul său să fie mult mai mare decât volumul Debye*.

1.3.4 Lungimea Landau

În cazul stării de plasmă provenite dintr-un mediu gazos se pune aceeași întrebare ca și în cazul gazelor neionizate: *în ce condiții i se poate aplica modelul gazului ideal din termodinamică?* La această întrebare se poate răspunde după introducerea unui nou parametru, *lungimea Landau*, parametru care se definește ca fiind distanța medie dintre purtătorii de sarcină la care energia cinetică a electronilor este egală cu energia potențială de interacțiune dintre ei și ionii pozitivi:

$$\frac{3}{2} kT = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \lambda_L} \quad (1.17)$$

de unde:

$$\lambda_L = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 kT} \quad (1.18)$$

Se știe că, pentru ca un gaz să poată fi considerat ideal, una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinească este ca energia potențială de interacțiune dintre particule să fie mult mai mică decât energia cinetică medie a lor. Dacă se notează cu d distanța medie dintre particule, atunci condiția precedentă se poate scrie:

$$\frac{e^2}{6\pi\epsilon_0\lambda_L} \gg \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 d} \quad (1.19)$$

În final, condiția de idealitate a plasmei poate fi scrisă ca:

$$\lambda_L \ll d \quad (1.20)$$

Lungimea Debye a fost introdusă ca o mărime legată de echilibrul static al plasmei. Dar, în plasmă, pe lângă interacțiunile binare de tip coulombian de rază scurtă (electron - electron, electron - ion și ion - ion) trebuie luate în considerare și interacțiunile unei particule purtătoare de sarcină netă cu toate celelalte particule din volumul plasmei, în acest caz vorbindu-se de *interacțiuni colective* și deci de o *plasmă colectivă*. Pentru ca o plasmă să fie colectivă este necesar ca distanța medie dintre particule să fie mult mai mică decât lungimea de ecranare, ceea ce revine la a afirma că numărul de particule din interiorul sferei Debye trebuie să fie mult mai mare decât unu:

$$N_D \gg 1 \quad (1.21)$$

Având în vedere relațiile (1.20) și (1.21), pentru ca o *plasmă ideală* să fie și *colectivă* este necesară îndeplinirea simultană a condițiilor:

$$\lambda_L \ll d \ll \lambda_D \quad (1.22)$$

1.3.5 Frecvența de plasmă

Pe lângă răspunsul spațial, o plasmă colectivă poate avea și un răspuns temporal la perturbațiile care se produc în ea, răspuns datorat în primul rând particulelor cu mobilitate mai mare, adică electronilor. Ca răspuns la o perturbație aceștia pot oscila în jurul poziției lor de echilibru dând naștere la așa-numitele *oscilații colective* (*oscilații de plasmă*), oscilații care se pot propaga în volumul plasmei calde sub formă de *unde în plasmă*. Frecvența oscilațiilor de plasmă se numește *frecvență de plasmă*, și este unul din parametrii importanți ai acestei stări.

Pentru a exprima cantitativ acest parametru se poate considera un model simplificat unidimensional al unui electron din plasmă asupra căruia, la distanța x față de poziția de echilibru, acționează forța de revenire datorată câmpului electric restaurator dat de relația (1.11):

$$F = -\frac{n_e e^2}{\epsilon_0} x \quad (1.23)$$

Ea este o forță de tip elastic caracterizată de constanta de elasticitate $k_e = n_e e^2 / \epsilon_0$, și frecvența unghiulară de oscilație $\omega_p = (k_e / m_e)^{1/2}$. Această frecvență poate fi asociată și unui grup de electroni care sunt îndepărtați simultan de la poziția de echilibru și ea este cunoscută sub denumirea de *frecvență de plasmă*:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} \quad (1.24)$$

Frecvența de plasmă este un parametru important nu numai din punct de vedere al oscilațiilor libere ale acesteia, ci și din punct de vedere al răspunsului ei la perturbații exterioare, cum ar fi de exemplu comportarea plasmei față de o undă electromagnetică incidentă pe suprafața ei. Comportarea plasmei în această situație este determinată de permitivitatea ei electrică. Pentru a o exprima sub formă analitică, se poate considera o oscilație electrică armonică de forma $E_x = E_{ox} e^{j\omega t}$, incidentă pe suprafața plasmei în direcția Ox . Ecuația de mișcare a unui electron sub acțiunea acestui câmp va fi:

$$m_e \frac{d^2 x}{dt^2} = -e E_x \quad (1.25)$$

Integrând de două ori această ecuație diferențială, se obține expresia deplasării x a electronului, deplasare căreia i se poate asocia un moment dipolar $p = -ex$, dat de expresia:

$$p = -\frac{e^2}{m_e \omega^2} E_x \quad (1.26)$$

Suma tuturor momentelor dipolare din unitatea de volum se definește ca fiind polarizarea plasmei, P :

$$P = -\frac{n_e e^2}{m_e \omega^2} E_x \quad (1.27)$$

Dacă plasma este presupusă izotropă, atunci permitivitatea electrică relativă a ei este:

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon_0 E_x + P}{\varepsilon_0 E_x} \quad (1.28)$$

Înlocuind în relația precedentă expresia polarizării dată de relația (1.27) și ținând seama de expresia frecvenței de plasmă (1.24), se obține pentru permitivitatea relativă a plasmelor o funcție de frecvența oscilației incidente:

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2 \quad (1.29)$$

Reprezentarea grafică a acestei funcții este cea din Fig.1.4.

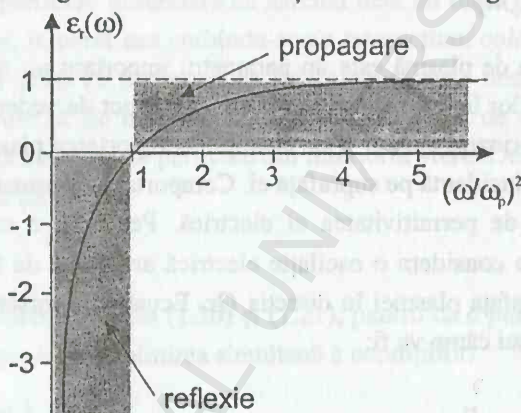


Fig.1.4 - Comportarea plasmelor în funcție de frecvența radiației incidente.

Se poate observa că, în funcție de raportul dintre frecvența radiației incidente și frecvența plasmelor, permitivitatea electrică relativă poate lua atât valori negative cât și valori pozitive. Astfel, dacă frecvența radiației incidente este mai mică decât frecvența de plasmă permitivitatea relativă a plasmelor este negativă, ceea ce în termeni fizici se traduce prin aceea că plasma nu permite trecerea radiației prin ea. Radiația este parțial reflectată, restul fiind absorbită de către plasmă. Perturbația exterioară este dominată de oscilațiile proprii ale plasmelor care acționează în sensul menținerii cuasineutralității deoarece câmpul exterior are tendința de a separa sarcinile electrice. Pentru frecvențe ale radiației incidente mai mari decât frecvența plasmelor aceasta din urmă devine transparentă pentru perturbația care, deși atenuată, va putea traversa plasma. Astfel, se poate afirma că frecvența de plasmă reprezintă frecvența de prag sub care nici o perturbație electrică exterioară nu se va putea propaga prin plasmă.

1.3.6 Frecvența Larmor. Magnetizarea plasmei

În general, pentru confinarea, stabilizarea și încălzirea plasmei se folosesc diferite configurații de câmpuri magnetice. Unul dintre parametrii plasmei legat direct de câmpul magnetic este *frecvența ciclotronică* sau *frecvența Larmor*, consecință a acțiunii forței Lorentz asupra purtătorilor de sarcină electrică aflați în mișcare.

Să presupunem că un electron intră cu viteza \vec{v}_0 într-un câmp magnetic omogen cu inducția \vec{B}_0 , orientat în lungul axei Oz (Fig.1.5).

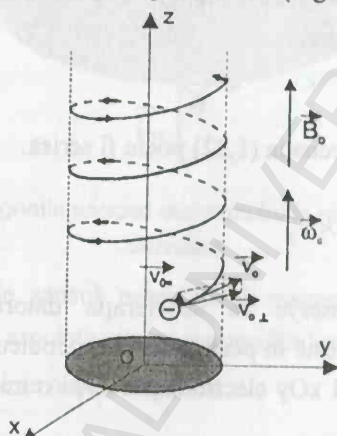


Fig.1.5 – Mișcarea electronului în câmp magnetic constant.

Ecuția de mișcare a electronului este:

$$m_e \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{v} \times \vec{B}_0) \quad (1.29)$$

Viteza electronului poate fi descompusă în două componente, o componentă paralelă cu inducția magnetică, \vec{v}_\parallel și o componentă perpendiculară pe aceasta, \vec{v}_\perp , astfel încât:

$$\vec{v} = \vec{v}_\parallel + \vec{v}_\perp \quad (1.30)$$

Astfel, ecuația (1.29) poate fi proiectată pe cele două direcții obținându-se două ecuații vectoriale:

$$m_e \frac{d\vec{v}_\parallel}{dt} = -e(\vec{v}_\parallel \times \vec{B}_0) \quad (1.31)$$

$$m_e \frac{d\vec{v}_\perp}{dt} = -e(\vec{v}_\perp \times \vec{B}_0) \quad (1.32)$$

Deoarece $\vec{v}_\parallel \times \vec{B}_0 = 0$, din ecuația (1.31) se poate observa că viteza electronului în direcția paralelă cu câmpul magnetic este constantă (acelerația în această direcție este nulă), deci în lungul axei Oz electronul va avea o mișcare rectilinie uniformă cu viteza:

$$\vec{v}_\parallel = \vec{v}_0 \quad (1.33)$$

Pe de altă parte, ecuația (1.32) poate fi scrisă:

$$\frac{d\vec{v}_\perp}{dt} = \vec{a}_c = \frac{e\vec{B}_0}{m_e} \times \vec{v}_\perp \quad (1.34)$$

din care se poate observa că accelerația datorată variației componentei perpendiculare a vitezei este în permanență perpendiculară pe aceasta, adică, într-un plan paralel cu planul xOy electronul va avea o mișcare circulară uniformă cu viteza unghiulară:

$$\vec{\omega}_c = \frac{e\vec{B}_0}{m_e} \quad (1.35)$$

și cu viteza liniară constantă în modul, $v_\perp = v_{0\perp}$. Frecvența corespunzătoare vitezei unghiulare cu care particula încărcată se rotește în câmpul magnetic se numește **frecvență Larmor**. Prin integrarea ecuației (1.34) se obține expresia razei de rotație a traiectoriei:

$$r_c = \frac{mv_{0\perp}}{eB_0} \quad (1.36)$$

Rezultatul compunerii celor două mișcări, rectilinie respectiv circulară, va fi o mișcare de precesie cu avansare în lungul axei Oz. Acestei precesii i se poate asocia un moment magnetic $\vec{\mu}_m$ datorat curentului electric generat de mișcarea electronului, curent a cărui intensitate este dată de expresia:

$$I = \frac{\omega_c}{2\pi} e = \frac{e^2 B_o}{2\pi m_e} \quad (1.37)$$

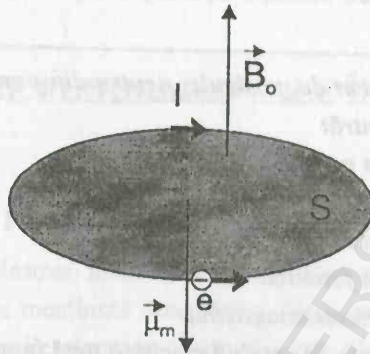


Fig.1.6 - Momentul magnetic asociat electronului în mișcare în câmp magnetic constant.

Ținând seama de sensul momentului magnetic indus (Fig.1.6) și de expresia energiei cinetice asociate vitezei perpendiculare pe câmp, $W_{\perp} = mv_{\perp}^2 / 2$, pentru momentul magnetic se obține expresia:

$$\vec{\mu}_m = -\frac{W_{\perp}}{B_o} \vec{B}_o \quad (1.38)$$

Magnetizarea plasmei se definește ca fiind momentul magnetic al unității de volum:

$$\vec{M} = n_e \vec{\mu}_m = -n_e \frac{W_{\perp}}{B_o} \vec{B}_o \quad (1.39)$$

Deoarece vectorii magnetizare și inducție magnetică sunt antiparaleli se poate afirma că *plasma are proprietăți diamagnetice*.

1.4 Definiția plasmei

După ce am trecut în revistă principalele caracteristici și parametri ai stării de plasmă putem avansa o definiție ei, fără pretenția de a fi cea mai completă:

Plasma este un sistem de particule, neutru din punct de vedere electric, în constituția căruia intră:

- componenta neutră
- componenta electronică
- componenta ionică
- componenta fonică
- câmpurile electromagnetice

particulele purtătoare de sarcină electrică netă interacționând între ele prin forțe de tip coulombian și al cărui volum este mult mai mare decât volumul Debye.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. E. BĂDĂRĂU și I.I. POPESCU, "Gaze ionizate. Descărcări electrice". Ed. Tehn. București 1965.
2. Ch. PECKEL-WIMEL, "Introduction a la spectroscopie des plasmas". Gordon and Breach, Paris - Londres - New-York 1967.
3. G. BRĂTESCU, "Fizica plasmei". Ed. Did. Pedag., București 1970.
4. Gh. BRĂTESCU și E. TOADER, "Metode experimentale în fizica plasmei". Universitatea București, 1973.
5. N.A. KRALL și A.V. TRIVELPIECE, "Principles of Plasma Physics". Mc Graw - Hill Book Comp., Inc. New York - London 1973.
6. I.I. POPESCU, I. IOVA și E. TOADER, "Fizica plasmei și aplicații". Ed. Științ. Encicl., București 1981.
7. I.I. POPESCU și E. TOADER, "Cinetica și dinamica plasmei". Ed. Științ. Encicl., București 1983.
8. L. DĂSCĂLESCU, "An Introduction to Ionized Gases. Theory and Applications". Toyohashi University of Technology, 1993.
9. R.L. BOXMAN, P.J. MARTIN and D.M. SANDERS, "Handbook of Vacuum Arc Science and Technology". Noyes Publications, 1995.
10. Gh. POPA și L. SÎRGIHI, "Bazele fizicii plasmei". Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iași, 2000.

Capitolul II

PROCESE FUNDAMENTALE ÎN PLASMĂ

2.1 Tipuri de procese fundamentale

Constituenții plasmei interacționează permanent atât între ei cât și cu electrozii între care este menținută descărcarea (dacă aceștia se află în incinta de descărcare) și cu câmpurile electrice, magnetice sau electromagnetice exterioare. Principalele procese elementare de interacțiune care se pot manifesta într-o plasmă sunt sintetizate în tabloul următor:

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Procese fundamentale în plasmă | de volum | ciocniri elastice - $\Delta E = 0$ |
| | | ciocniri neelastice $\left\{ \begin{array}{l} \text{directe} - \Delta E > 0 \\ \text{inverse} - \Delta E < 0 \end{array} \right.$ |
| | de suprafață | |
| | interacții cu câmpurile electrice și magnetice prezente în plasmă | |

Cu ΔE s-a notat *variația energiei interne totale* a partenerilor de interacțiune. În cazul ciocnirilor perfect elastice ea este nulă. În cazul ciocnirilor neelastice directe energia internă a cel puțin unuia dintre partenerii de interacțiune crește (de exemplu excitarea unui atom sau molecule în urma ciocnirii cu un electron rapid), iar în cazul ciocnirilor neelastice inverse aceasta se micșorează (este cazul dezexcitării neradiative în urma ciocnirii unui atom aflat în stare excitată cu un electron).

Procesele elastice determină în primul rând proprietățile macroscopice ale gazului ionizat, așa-numitele proprietăți de transport, cum ar fi conductibilitatea electrică și termică sau difuzia și ele pot fi descrise cu mijloacele puse la dispoziție de mecanica clasică. Procesele neelastice pot conduce la crearea sau anihilarea de purtători de sarcină netă (electroni, ioni pozitivi sau negativi), ele fiind principalele

"responsabile" ale mecanismelor de generare și întreținere a plasmei și sunt guvernate de legile mecanicii cuantice.

Interacțiunile dintre constituenții plasmei pot fi cu rază scurtă de acțiune, de obicei *interacțiuni binare*, probabilitatea apariției unui al treilea partener de interacție fiind foarte mică pe distanțe mici și cu rază lungă de acțiune, așa-numitele *interacțiuni colective* în care fiecare constituent al plasmei interacționează cu toți (sau aproape cu toți) ceilalți constituenți. Interacțiunile binare pot fi tratate cu ajutorul teoriei clasice a ciocnirilor folosind conceptele de secțiune eficace de ciocnire, drum liber mediu, frecvență de ciocnire sau timp de interacție. În acest caz comportarea plasmei poate fi descrisă introducând noțiunea de particulă medie și analizându-i comportarea într-un context dat. În cazul interacțiunilor colective, cum ar fi de exemplu cele de tip coulombian, conceptul de ciocnire practic nu mai are sens, plasma este tratată în ansamblul ei ca un fluid conductor cu toate proprietățile care decurg din noțiunea de fluid, la care se adaugă și cele care decurg din conductibilitatea sa electrică.

2.2 Procese elementare de volum

2.2.1 Ciocniri elastice

Este cunoscut faptul că dacă un fascicul de particule cu densitatea N_0 este incident pe un gaz "țintă" cu densitatea n atunci, după traversarea unui strat cu grosimea x , în urma proceselor de ciocnire elastică dintre particulele fasciculului incident și atomii gazului țintă, densitatea fasciculului incident va fi dată de expresia:

$$N(x) = N_0 e^{-\sigma n x} \quad (2.1)$$

în care σ este o mărime caracteristică procesului de interacție numită secțiune eficace de ciocnire. Dacă se notează cu λ drumul liber mediu prin gazul țintă al unei particule incidente, atunci între acesta și secțiunea eficace de ciocnire există relația:

$$\lambda = \frac{1}{\sigma n} \quad (2.2)$$

Ciocnirea electron-particulă neutră este caracterizată de o secțiune eficace de ciocnire egală cu aria suprafeței unui cerc cu raza egală cu suma razelor

electronului și neutrului, considerând că electronul interacționează cu particula neutră numai la contactul lor fizic:

$$\sigma_{en} = \pi (r_e + r_n)^2 \cong \pi r_n^2 \quad (2.3)$$

Aproximația din relația precedentă se poate face datorită razei mult mai mari a particulei neutre în comparație cu raza electronului. Dacă timpul mediu dintre două ciocniri este τ , atunci, ținându-se seama de relațiile (2.2) și (2.3), frecvența de ciocnire electron-particulă neutră va fi dată de expresia:

$$\nu_{en} = \frac{1}{\tau} = \pi n_n^2 \langle v_e \rangle \quad (2.4)$$

în care n_n este densitatea particulelor neutre și $\langle v_e \rangle$ este viteza medie a electronilor. Aceasta din urmă poate fi exprimată în funcție de temperatura cinetică a electronilor, T_e :

$$\langle v_e \rangle = \sqrt{\frac{3kT_e}{m_e}} \quad (2.5)$$

astfel că pentru frecvența de ciocnire electron-neutru se obține expresia finală:

$$\nu_{en} = \pi n_n^2 \sqrt{\frac{3kT_e}{m_e}} \quad (2.6)$$

Pentru a ne forma o imagine mai concretă despre ordinul de mărime al frecvenței de ciocnire dintre electroni și particulele neutre să considerăm o plasmă mediu ionizată la presiune atmosferică și cu temperatura de 2500 K. Admițând că raza și densitatea particulelor neutre sunt de ordinul 10^{-10} m, respectiv 10^{24} m⁻³ și înlocuind aceste valori împreună cu valorile constantelor în relația (2.6), se obține pentru frecvența de ciocnire o valoare de ordinul 10^{10} s⁻¹. În unități de frecvență aceasta înseamnă 10 GHz, valoare importantă din punctul de vedere al plasmelor întreținute în câmpuri electromagnetice de radiofrecvență și microunde, lucru pe care-l vom înțelege mai bine în capitolul următor.

În cazul *ciocnirii electron-ion*, deși raza ionului este aproximativ egală cu raza particulei neutre din care provine, secțiunea eficace de ciocnire este mai mare decât cea din cazul ciocnirii electron – particulă neutră pentru că interacțiunea lor

începe să se manifeste de la o distanță mai mare, prin intermediul forțelor coulombiene. De aceea, în tratarea acestui proces de interacțiune, ionul pozitiv poate fi înlocuit cu o particulă cu raza fictivă egală cu lungimea Landau λ_L , distanță la care energia de agitație termică este egală cu energia potențială de interacțiune electrostatică. Aplicând același raționament ca și în cazul ciocnirii electron-particulă neutră și ținând seama de expresia lungimii Landau (1.14), se obține pentru frecvența de ciocnire electron - ion relația:

$$v_{ei} = \pi \left(\frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 kT_e} \right)^2 n_i \sqrt{\frac{3kT_e}{m_e}} \quad (2.7)$$

în care n_i este densitatea de ioni pozitivi din plasmă. Dacă gradul de ionizare al plasmiei considerate anterior este de 10^{-4} ($n_i \approx 10^{20} \text{ m}^{-3}$) atunci frecvența de ciocnire conform relației precedente este de ordinul 10^9 s^{-1} , adică cu aproximativ un ordin de mărime mai mică decât frecvența de ciocnire electron - neutră.

2.2.2 Ciocniri neelastice

La procesele neelastice de interacțiune care au loc în plasmă participă toate particulele componente ale plasmiei:

- electroni lenți și rapizi: e, \bar{e} ;
- atomi și molecule în stare fundamentală sau în stare excitată: A, A^*, M, M^* . Datorită faptului că moleculele au pe lângă gradele de libertate de translație și grade de libertate de rotație și vibrație, ele pot fi excitate și pe nivele energetice corespunzătoare acestor stări.
- ioni pozitivi sau negativi, simplu sau multiplu ionizați: A^+, A^{++}, A^-, A^{--}
- molecule ionizate: M^+, M^-

2.2.2.1 Procese de excitare și dezexcitare

Pentru înțelegerea mai ușoară a ceea ce înseamnă un proces de excitare sau dezexcitare a unui atom în Fig.2.1 este prezentată o diagramă simplificată a funcției de potențial și a nivelelor energetice dintr-un atom.

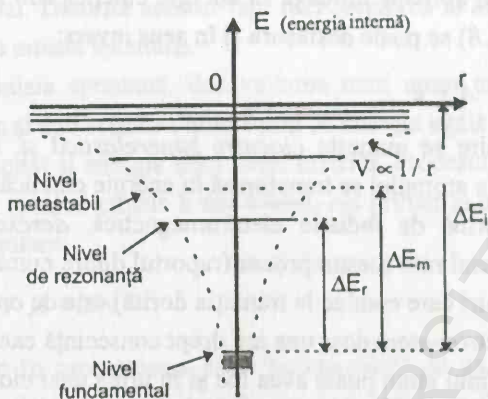
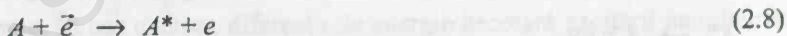


Fig.2.1 - Nivele energetice în atom.

Există trei tipuri de nivele energetice:

- nivelul fundamental*, corespunzător stării energetice celei mai coborâte în care poate exista atomul;
- nivelele excitate* așa-zis normale corespunzătoare unor stări energetice superioare ale atomului, stări în care poate ajunge în urma absorbției de energie din exterior ca urmare a unui proces dat. Atomul poate rămâne într-o astfel de stare un interval de timp de ordinul $10^{-7} - 10^{-8}$ s după care revine în starea fundamentală emițând un foton cu energia egală cu diferența energetică a nivelelor între care are loc tranziția. Acest fenomen se numește *emisie spontană*. Nivelul excitat cel mai apropiat de nivelul fundamental se numește *nivel de rezonanță*;
- nivele metastabile* corespunzătoare unor stări excitate care au un timp de viață mult mai lung decât al nivelelor excitate normale, timp cuprins între 10^{-4} s și câteva secunde.

Excitarea cu electroni are loc conform reacției:



în care o parte energia cinetică a electronului rapid este cedată unui electron din atom, acesta din urmă trecând din starea fundamentală în stare excitată. Datorită faptului că masa electronului este mult mai mică decât masa atomului, electronul

poate ceda atomului aproape întreaga sa energie cinetică sub formă de energie de excitare. Reacția (2.8) se poate desfășura și în sens invers:



Acest tip de ciocnire se numește *ciocnire superelastică* și, datorită faptului că energia de excitare a atomului se transformă în energie cinetică a electronului și nu este emisă sub formă de radiație electromagnetică, *dezexcitarea* se numește *neradiativă*. În general rata acestui proces (raportul dintre numărul total de ciocniri și numărul de ciocniri care conduc la tranziția dorită) este de ordinul 10^{-2} , adică din 100 de ciocniri electron-atom doar una are drept consecință excitarea atomului.

Excitarea unui atom poate avea loc și în urma unei ciocniri *cu o particulă grea* (atom sau ion) conform uneia dintre reacțiile următoare:



Datorită maselor lor mult mai mari decât cea a electronilor, atomii și ionii sunt mai puțin mobili, au viteze mai mici și, în consecință, procesele descrise de reacțiile precedente au loc cu o rată mult mai mică decât procesele de excitare cu electroni.

Fotoexcitarea este procesul prin care un foton având o energie egală cu energia de excitare pe un nivel normal a atomului este absorbit de către acesta, atomul trecând din starea fundamentală în starea excitată. Procesul are loc conform reacției:



Atomul poate exista în această stare aproximativ $10^{-7} - 10^{-8}$ s după care revine în starea fundamentală spontan prin emisia unei cuante luminoase:



Trebuie menționat faptul că prin fotoexcitare nu este posibilă excitarea atomului pe un nivel metastabil. Excitarea din starea fundamentală pe nivele metastabile poate fi realizată prin alte procese, cum ar fi de exemplu bombardarea cu un fasci-

cul de electroni rapizi. Datorită acestui fapt nici revenirea în starea fundamentală nu se poate face prin emisie spontană.

Pe lângă emisia spontană, dezexcitarea unui atom excitat pe un nivel normal se poate face și sub acțiunea unui foton cu energia egală cu diferența dintre energia nivelului excitat și energia unui nivel inferior. Procesul se numește *emisie stimulată*, având ca rezultat emisia a doi fotoni, cel primar și cel rezultat în urma procesului de dezexcitare:

$$A^* + h\nu \rightarrow A + 2h\nu \quad (2.14)$$

În condițiile în care plasma este "bombardată" de un fascicul intens de electroni sau fotoni, datorită faptului că frecvența de ciocnire dintre particule este mare, pot avea loc *procese de excitare cumulative* (în trepte). În aceste procese, dacă un atom deja excitat interacționează cu un foton sau un electron din fasciculul incident, el poate fi excitat pe un nivel superior sau poate fi chiar ionizat.

În câmpuri electromagnetice intense și foarte bine focalizate (îndeosebi radiații laser) este posibilă excitarea atomului chiar dacă energia fotonilor este mai mică decât energia necesară tranziției cu condiția ca diferența energiilor nivelelor energetice între care are loc excitarea să fie un număr întreg de energii fotonice:

$$A + nh\nu \rightarrow A^* \quad (2.15)$$

Procesul se numește *excitare prin absorbție multifotonică*.

În sistemele cu mai multe tipuri de atomi poate avea loc *transferul de excitare*. Presupunând un amestec binar de atomi de tip A și B, dacă de exemplu o parte din atomii de tip A sunt excitați, atunci, în urma interacțiunii lor cu atomi de tip B ei pot trece în starea fundamentală transferând energia eliberată atomilor de tip B care vor trece într-o stare excitată. Dacă energia eliberată de atomii de tip A este mai mare decât energia de excitare a atomilor de tip B atunci diferența celor două energii se va regăsi sub formă de energia cinetică a partenerilor de interacțiune. În caz contrar, diferența de energie necesară excitării atomilor de tip B va fi "împrumutată" de la energiile cinetice ale partenerilor de interacțiune. În cazul particular în care un atom excitat de tip A interacționează cu un atom în starea fundamentală tot de tip A, procesul se numește *transfer rezonant de excitare*. Cu aceste precizări, reacția generală care descrie transferul de excitare poate fi scrisă sub forma:



în care $\Delta E = \Delta E_{excA} - \Delta E_{excB}$.

O aplicație clasică a transferului de excitare este cea a laserilor cu gaz. În Fig.2.2 este exemplificat cazul laserului cu heliu-neon. Atomii de heliu sunt excitați pe nivele metastabile prin "bombardarea" gazului cu un fascicul de electroni rapizi. Deoarece nivelele metastabile ale heliului sunt foarte apropiate de nivelele normale 2s și 3s ale neonului are loc transferul de excitare He - Ne, proces în urma căruia se realizează inversiunea de populație în atomii de Ne, care este una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un mediu pentru a fi activ laser. În urma proceselor de emisie spontană și stimulată atomii de heliu se dezexcită rezultând radiațiile laser prezentate în figură.

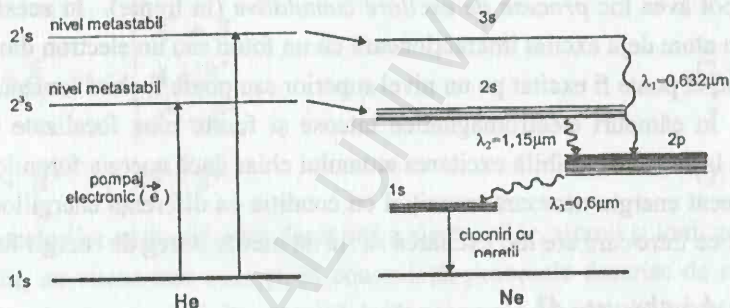
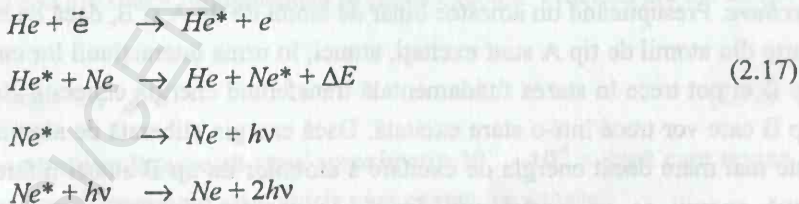


Fig.2.2 - Aplicație a transferului de excitare - laserul cu He-Ne.

Toate aceste procese sunt sintetizate în următorul ansamblu de reacții:



2.2.2.2 Procese de ionizare și recombinare

Dacă un fascicul de electroni intră într-un gaz atunci, pe lângă împrăștierea electronilor datorată ciocnirilor elastice (proces determinat de secțiunea eficace de ciocnire), poate avea loc și ionizarea atomilor (sau moleculelor) gazului.

Ionizarea este procesul prin care un electron de pe o stare legată a unui atom primește energie suficientă pentru a părăsi atomul, trecând în spectrul energetic continuu pe o stare nelegată cu energie pozitivă. Dacă din atom este scos un singur electron atunci ionizarea este simplă iar dacă sunt scoși doi sau mai mulți electroni atunci ionizarea este multiplă. În continuare vom trece în revistă principalele procese care pot conduce la ionizarea unui gaz, cu precizarea că aceste procese sunt "responsabile" de trecerea unui ansamblu de particule din starea normală de gaz în starea de plasmă.

Din totalitatea proceselor de ionizare cel mai important din punctul de vedere al stării de plasmă este *ionizarea cu electroni*. Dacă un electron liber are o energie cinetică mai mare decât energia de ionizare (ΔE_i) a unui atom, atunci este posibilă o reacție de ionizare de tipul:

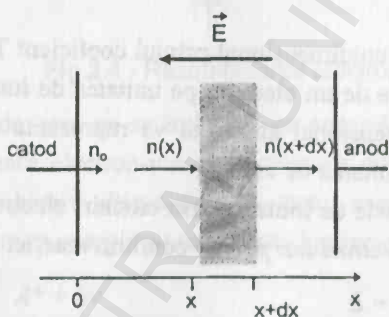


Fig.2.3 - Multiplicarea purtătorilor de sarcină în gazul ionizat.

Dacă electronii sunt accelerați într-un câmp electric (să spunem câmpul electric din spațiul anod catod al unui tub de descărcare în curent continuu - Fig.2.3) atunci o parte din energia cinetică câștigată de un electron de la câmp poate fi cedată unui atom sub formă de energie de ionizare. În urma procesului rezultă un ion pozitiv și doi electroni: electronul primar și electronul rezultat în urma procesului de ionizare. Prin același mecanism cei doi electroni vor produce patru, opt, șaisprezece etc. electroni.

Astfel, se poate declanșa un mecanism de multiplicare în avalanșă a purtătorilor de sarcină (electroni și ioni pozitivi) având ca rezultat final generarea stării de plasmă. Este evident că electronii primari care produc declanșarea

mecanismului trebuie să fie generați într-un mod oarecare. Ei există în orice gaz datorită factorilor ionizanți naturali (radiația cosmică, radioactivitatea Pământului etc) și, dacă nu sunt suficienți, pot fi generați artificial (emisie termoelectronică, emisie fotoelectronică, ionizare într-un câmp intens de radiofrecvență etc.). Presupunând acum că la catod sunt generați n_0 electroni primari în unitatea de volum și că la distanța x de catod densitatea lor este $n(x)$, atunci, în urma proceselor de ionizare, într-un strat de gaz cu grosimea dx se va produce mărirea numărului de electroni din unitatea de volum cu cantitatea $dn(x)$. Această cantitate este proporțională cu numărul de electroni incidenți pe stratul de gaz, cu grosimea acestuia și cu un coeficient de multiplicare α , numit *primul coeficient Townsend*:

$$dn(x) = \alpha n(x) dx \quad (2.19)$$

După integrare rezultă:

$$n(x) = n_0 e^{\alpha x} \quad (2.20)$$

În cazul modelului unidimensional primul coeficient Townsend reprezintă numărul de ionizări produse de un electron pe unitatea de lungime iar dacă se va considera un model tridimensional atunci el va reprezenta numărul de ionizări produse de un electron în unitatea de volum.

Simultan cu procesele de ionizare prin ciocniri electronice pot avea loc și procese de *recombinare electron-ion pozitiv* conform reacției de ciocnire triplă:



Din punctul de vedere al stării de plasmă acesta este un proces nedorit, el determinând tocmai dispariția componentelor de bază ale plasmei (electroni și ioni). Dar, cum probabilitatea ca într-un proces de interacțiune să se întâlnească simultan trei parteneri este mai mică decât probabilitatea să se întâlnească numai doi (cazul reacției directe de ionizare (2.18)), este evident că procesele de ionizare se vor desfășura cu o rată mai mare decât cele de recombinare, deci starea de plasmă se poate realiza.

Există însă procese de recombinare electron-ion care sunt rezultatul unei ciocniri duble. În aceste procese electronul este captat pe unul din nivelele excitate ale atomului conform reacției:



în care ΔE_r este energia eliberată în urma procesului de interacțiune. Analizând diagrama care ilustrează acest proces (Fig.2.4), pentru expresia energiei eliberate rezultă:

$$\Delta E_r = m_e v_e^2 / 2 + \Delta E_i - \Delta E_{exc} \quad (2.23)$$

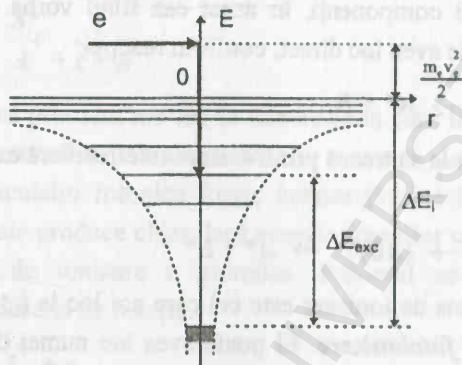


Fig.2.4 - Recombinarea electron-ion.

În funcție de ceea ce se întâmplă cu această energie se pot deosebi trei tipuri de recombinare electron-ion prin ciocnire dublă: *recombinare radiativă*, *efect Auger*, *recombinare disociativă*. În cazul *recombinării radiative* energia rezultată se regăsește ca energie a unei cuante luminoase:



Spectrul radiațiilor emise în urma procesului de recombinare radiativă este unul continuu, limitat la frecvențe mici, radiația cu frecvența limită inferioară fiind emisă atunci când electronul se află în repaus ($m_e v_e^2 / 2 = 0$):

$$\nu_{\min} = \frac{\Delta E_i - \Delta E_{exc}}{h} \quad (2.25)$$

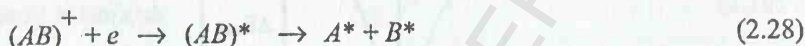
Dacă energia eliberată la capturarea electronului de către atom se regăsește sub formă de energie de excitare a aceluiași atom, atunci acesta devine dublu excitat. Acest proces se numește *efect Auger*. Atomul dublu excitat se poate dezexcita prin emisia unei cuante luminoase sau eliberând un electron și trecând în stare ionizată. Această succesiune de procese poate fi descrisă sintetic de reacțiile:



Dacă recombinarea are loc între un electron și un ion molecular atunci este posibil ca energia eliberată în urma procesului să fie folosită pentru ruperea moleculei în atomii componenți, în acest caz fiind vorba despre *recombinarea disociativă*. Ea poate avea loc direct, conform reacției:



sau mai întâi molecula să treacă printr-o stare intermediară excitată și abia apoi să se disocieze:



Un alt proces de ionizare este cel care are loc la interacțiunea foton-atom și care se numește *fotoionizare*. El poate avea loc numai dacă energia fotonului este cel puțin egală cu energia de ionizare a atomului cu care interacționează ($h\nu \geq \Delta E_i$). Procesul are loc conform reacției:



Eventualul exces de energie, ΔE , al fotonului se va regăsi sub formă de energie cinetică a electronului rezultat. Procesul invers al fotoionizării se numește recombinație radiativă și el a fost prezentat într-un paragraf anterior.

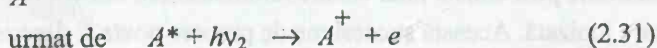
Fotoionizarea poate fi produsă și de cuante luminoase cu energii inferioare energiei de ionizare dacă în prealabil atomul a fost excitat cu electroni sau cu fotoni. Se spune că procesul de ionizare se desfășoară *în trepte*. Cele două procese de ionizare în trepte sunt descrise de ecuațiile:



urmat de



respectiv:



Tot un proces de ionizare în trepte este și cel de *ionizare asociativă* în care doi atomi fotoexcitați interacționează, având ca rezultat ionizarea unuia dintre ei. Reacțiile după care se desfășoară procesul sunt următoarele:



Este evident că procesul are loc în condițiile în care fotonii nu au energie suficientă pentru ionizarea directă a atomilor.

În cazul fasciculelor fotonice foarte intense și bine focalizate (fascicule laser) ionizarea se poate produce chiar dacă energia fotonilor componenți este mai mică decât energia de ionizare a atomilor. Procesul se numește *ionizare multifotonică* și este descris de reacția:



în care n este un număr întreg.

Ionizarea este posibilă și prin ceea ce se numește *transferul de sarcină*. În acest caz interacțiunea are loc între un atom neutru și un ion:



Transferul de sarcină de la atom la ion poate avea loc numai dacă $\Delta E = \Delta E_{IA} - \Delta E_{IB} \geq 0$. Procesul are loc cu o secțiune eficace maximă atunci când $\Delta E = 0$, adică particulele care interacționează sunt identice în stare neutră. În acest caz se vorbește despre un *transfer rezonant de sarcină*. Transferul de sarcină poate fi folosit pentru obținerea unor fascicule puternic monoenergetice de particule neutre. Prin bombardarea unui gaz țintă de atomi de tip B cu un fascicul de ioni rapizi de tip A accelerat într-un câmp electric, are loc reacția de transfer de sarcină:



în urma căreia se obține fasciculul rapid de atomi neutri. Este însă posibil ca un fascicul rapid de atomi neutri să pătrundă într-un gaz ionizat și, în urma transferului de sarcină, să devină parte componentă purtătoare de sarcină a acestuia. Reacția după care are loc procesul este inversa reacției precedente:



Acest proces poate fi o metodă eficientă de încălzire a plasmelor deoarece fasciculul incident, care este neutru și deci nu poate fi influențat de câmpurile din plasmă, poate pătrunde fără dificultate în plasmă unde, după ionizarea prin transfer de sarcină, devine componentă energetică a acesteia.

Un proces de ionizare mai interesant și care este folosit pentru amorsarea mai ușoară a unor descărcări este *ionizarea Penning*. Considerând un amestec binar de gaze, A și B, dintre care atomii gazului de tip A au un nivel metastabil cu energia mai mare decât energia de ionizare a atomilor de tip B, dacă un atom de tip A este excitat pe nivelul metastabil atunci el poate interacționa cu un atom de tip B conform reacției:



Electronii rezultați în urma ionizării atomilor de tip B sunt accelerați în câmpul electric până la energii suficiente pentru producerea de noi ionizări. Un exemplu de folosire a acestui mecanism este amorsarea unei descărcări în neon în care se adugă o cantitate mică de argon, argonul având energia de ionizare mai mică decât a neonului (Fig.2.5).

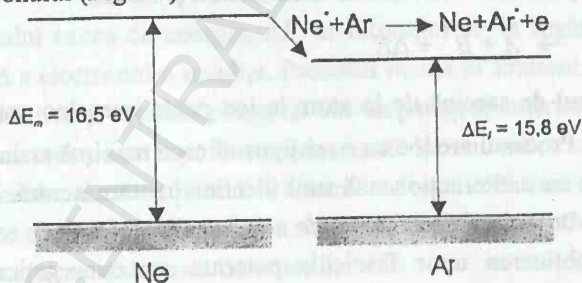


Fig.2.5 - Exemplu de ionizare Penning.

Pe lângă ionii pozitivi, în descărcările care au în componența lor atomi sau molecule cu ultima pătură electronică incompletă este posibilă și *formarea ionilor negativi* prin acceptarea unui electron în această pătură. Această proprietate se numește *afinitate electronică*. Dintre speciile atomice și moleculare care au afinitate electronică pot fi amintite halogenii, oxigenul, carbonul, hidrogenul, oxidul de azot, dioxidul de sulf. Pentru ca o reacție de formare a ionilor negativi să poată avea loc, este necesar ca electronul care va fi acceptat de atomul neutru sau

molecula neutră să fie un electron lent (cu energia de aproximativ 1 eV), pentru ca el să poată rămâne un interval de timp suficient de lung în câmpul electric al atomului sau moleculei. Acest proces are loc cu eliberare de energie și, în funcție de forma sub care se regăsește ea, se poate vorbi de *captură radiativă* și *captură disociativă*. În cazul capturii radiative, în urma reacției:



este generat un foton cu energia

$$h\nu = m_e v_e^2/2 + eV_a \quad (2.39)$$

în care V_a este potențialul de atașare definit conform diagramei energetice din Fig.2.6.

În cazul capturii disociative o moleculă captează un electron devenind un ion molecular. Acesta, având un timp de viață scurt, se va disocia într-un atom neutru și un ion negativ:



Formarea de ioni negativi este posibilă și prin *ciocnirea a două particule grele*:



cu condiția ca afinitatea electronică a atomului B să fie mai mare decât energia de ionizare a atomului A ($eV_{ab} > \Delta E_{ia}$).

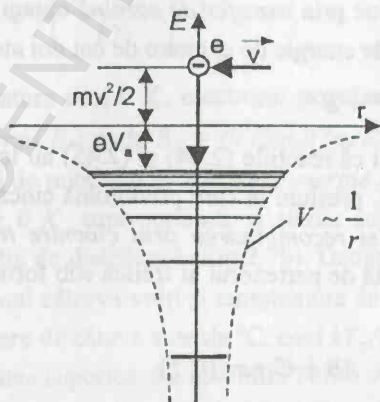


Fig.2.6 - Formarea unui ion negativ prin captură radiativă.

Un proces de formare a ionilor negativi care se petrece mai rar deoarece este necesară prezența simultană a trei parteneri de interacțiune, este *ciocnirea triplă*. În acest caz al treilea partener este un electron care poate fi lent sau rapid:



După cum se poate observa energia eliberată în urma procesului de captură se regăsește fie sub formă de energie cinetică fie sub formă de energie de excitare a partenerului care rămâne în stare atomică.

Intr-un gaz ionizat în care există ioni pozitivi și negativi au loc și *procesele de recombinare ion-ion*. La recombinarea unui ion pozitiv A^+ cu un ion negativ B^- se va elibera o cantitate de energie ΔE_{rec} , numită energie de recombinare, egală cu suma algebrică a energiilor de formare ale celor doi ioni:

$$\Delta E_{rec} = eV_{iA} - eV_{aB} \quad (2.44)$$

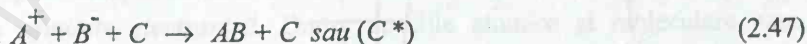
La sfârșitul reacției de recombinare această energie se poate regăsi sub diferite forme, în funcție de tipul reacției. Astfel, în cazul *recombinării radiative* ea se regăsește ca energie a unui foton:



Dacă recombinarea are loc prin *transfer de sarcină* atunci energia de recombinare este preluată sub formă de energie de excitare de cei doi atomi rezultați:



Trebuie menționat faptul că reacțiile (2.44) și (2.45) au loc cu o probabilitate mai mare la presiuni scăzute, presiuni la care predomină ciocnirile binare. La presiuni mai mari este posibilă și *recombinarea prin ciocnire triplă* în care energia de recombinare este preluată de partenerul al treilea sub formă de energie de cinetică sau energie de excitare:



2.3 Procese elementare de suprafață

În descărcările electrice un rol important în ceea ce privește înțelegerea comportării lor îl au procesele care au loc la limita de separare dintre plasmă și suprafețele solide cu care particulele componente ale plasmei vin în contact (electrozii descărcării, pereții incintei de descărcare etc.). Interacțiunea plasmă-solid are ca efecte emisia de electroni și atomi neutri, precum și formarea așanumitelor învelișuri (teci) în vecinătatea electrozilor. Aceste efecte sunt importante la catodii descărcărilor, tipul lor fiind în mare măsură dictat de procesele catodice.

2.3.1 Mecanismele de emisie electronică

O suprafață metalică aflată în contact cu plasma poate emite electroni și, dacă suprafața în discuție este a catodului, atunci acești electroni pot avea un rol esențial în întreținerea descărcării. Pentru a înțelege diversele mecanisme de emisie a electronilor trebuie mai întâi cunoscută natura suprafeței metalului.

Un volum metalic finit poate fi modelat ca o groapă de potențial. Electronii din ea se comportă conform statisticii Fermi-Dirac, având funcția de distribuție după energii dată de:

$$f(E)dE = \frac{\frac{\pi}{2} \left(\frac{8m_e}{h^2} \right)^{3/2} E^{1/2} dE}{\exp\left(\frac{E-E_F}{kT}\right) + 1} \quad (2.48)$$

Când temperatura este 0 K, electronii populează nivelele de energie mai mici decât *nivelul Fermi* E_F , unde $E_F = (h^2/2m_e)(3n_e/8\pi)^{2/3}$. Distanța dintre nivelul Fermi și vârful gropii de potențial este numită *energie de extracție* (notată cu Φ în Fig.2.7a). Pentru $T > 0$ K sunt populate și stările superioare nivelului Fermi în conformitate cu funcția de distribuție (Fig.2.7b). Deoarece potențialul de extracție $V_\phi = \Phi/e$ este de ordinul câtorva volți și temperatura de topire T_m a celor mai multe metale nu este mai mare de câteva sute de °C, deci $kT_m/e < 0.4$ eV, se poate observa că stările din vecinătatea superioară a nivelului Fermi sunt mult mai populate decât stările apropiate de vârful gropii de potențial. Emisia de electroni din metal poate avea loc fie prin escaladarea barierei de potențial, fie prin străpungerea prin efect tunel, atunci când grosimea ei este finită.

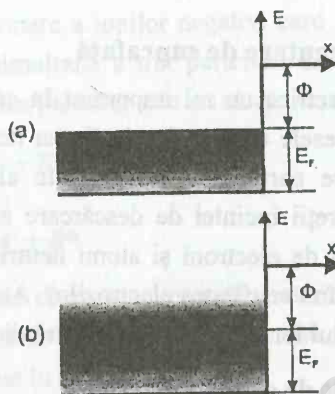


Fig.2.7 - Modelul gazului electronic într-un metal la:

(a) $T = 0 \text{ K}$; (b) $T > 0 \text{ K}$.

În cazul *emisiei fotoelectronice* un foton cu energia hc/λ este trimis pe suprafața metalului. Dacă $(hc/\lambda) > eV_\phi$, există o probabilitate finită ca fotonul să poată transfera energia sa unui electron de pe nivelul Fermi sau de sub el și astfel acesta va putea escalada bariera de potențial.

Dacă temperatura unui metal crește, numărul mic dar finit de electroni cu energia mai mare decât bariera de potențial va crește. Când un astfel de electron se apropie de bariera de potențial, în conformitate cu teoria clasică, el va escalada bariera de potențial devenind un electron emis. Densitatea de curent datorat *emisiei termoelectronice* poate fi calculată transformând funcția de distribuție Fermi-Dirac într-o funcție de distribuție după viteze și calculând numărul total de particule cu energia necesară escaladării barierei, având viteza normală la suprafață. Pentru energii apropiate sau mai mari decât bariera de potențial, distribuția Fermi-Dirac poate fi bine aproximată cu o distribuție Maxwell-Boltzmann, rezultând ecuația Richardson-Dushman:

$$j = AT^2 \exp\left(-\frac{\Phi}{kT}\right) \quad (2.49)$$

unde $A = [4\pi em_e k^2]/h^3 = 1.2 \times 10^6 \text{ A m}^{-2} \text{ K}^{-2}$.

Înălțimea barierei de potențial se micșorează cu $\Delta\Phi$ dacă în apropierea suprafeței metalice există un câmp electric E (Fig.2.8). Aceasta trebuie scăzută din Φ din ecuația Richardson-Dushman, iar efectul se numește *efect Schottky*.

Expresia lui $\Delta\Phi$ poate fi calculată dacă se ține seama de faptul că potențialul electric în vecinătatea suprafeței metalului are două componente; (a) potențialul datorat câmpului propriu-zis:

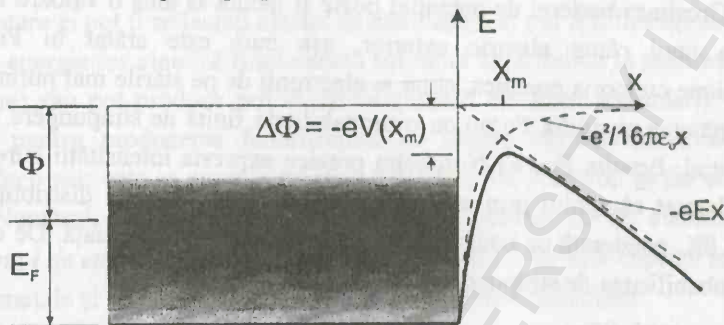


Fig.2.8 - Modificarea barierei de potențial prin efect Schotky.

$$V(x) = -xE(x) \quad (2.50)$$

și (b) potențialul datorat sarcinii imagine induse în metal:

$$V_{im}(x) = -e/16\pi\epsilon_0 x \quad (2.51)$$

Expresia analitică a potențialului total va fi:

$$V(x) = -xE(x) - e/16\pi\epsilon_0 x \quad (2.52)$$

Ea are un maxim pentru

$$x_m = (e/16\pi\epsilon_0 E)^{1/2} \quad (2.53)$$

iar expresia valorii maxime a potențialului va avea forma:

$$V(x_m) = -(eE/4\pi\epsilon_0)^{1/2} \quad (2.54)$$

Astfel, energia de extracție a electronilor din metal se va micșora cu:

$$\Delta\Phi = (e^3 E/4\pi\epsilon_0)^{1/2} \quad (2.55)$$

și nu va mai fi o barieră infinită ci una de grosime finită.

În teoria cuantică se demonstrează că un electron care se apropie de o barieră de potențial cu grosime finită are o probabilitate finită să o străpungă, fie că are o energie mai mare decât bariera de potențial, fie că are o energie mai mică.

Această probabilitate crește cu creșterea energiei dar nu este niciodată egală cu unitatea, astfel că rezultatele teoriei Richardson-Dushman trebuie privite ca un caz particular al teoriei cuantice.

Grosimea barierei de potențial poate fi făcută să aibă o valoare finită prin aplicarea unui câmp electric exterior, așa cum este arătat în Fig.2.8. În conformitate cu teoria cuantică, chiar și electronii de pe stările mai puțin populate din vecinătatea nivelului Fermi au o probabilitate finită de străpungere a barierei de potențial. Ecuația Fowler-Nordheim prezice expresia intensității curentului de emisie datorat câmpului prin integrarea vitezei din funcția de distribuție Fermi-Dirac la 0K, ponderată pe componenta vitezei normală la suprafață. De asemenea, ea dă probabilitatea de străpungere a barierei de potențial:

$$J = CE^2 e^{-D/E} \quad (2.56)$$

unde E este intensitatea câmpului electric,

$$C = \frac{e^3 E_F^{1/2}}{2\pi h (E_F + \Phi) \Phi^{1/2}} \quad (2.57)$$

și

$$D = \frac{8\pi (2m_e)^{1/2} \Phi^{3/2}}{3he} \quad (2.58)$$

Combinând o temperatură ridicată cu un câmp electric intens se produce o combinație a emisiei termoelectronice cu emisia de câmp, emisie care poate avea un rol important în unele descărcări electrice.

La temperatura camerei (300 K) emisia termoelectronică este neglijabilă și, pentru eliberarea unui electron din metal numai sub acțiunea unui câmp electric exterior, ar fi necesar ca intensitatea acestuia să fie de ordinul 10^{10} - 10^{11} V/m. Experimental s-a constatat că emisia electronică la temperatura mediului ambiant, numită și *emisie la rece*, poate avea loc și pentru intensități ale unui câmp exterior de ordinul 10^7 - 10^9 V/m. Acest lucru poate fi explicat numai prin modificarea formei barierei de potențial în prezența câmpului electric exterior și, în consecință, a existenței posibilității ca unui electroni să o străpungă prin efect tunel.

Electronii din solide pot fi eliberați și ca urmare a ciocnirii suprafețelor acestora de către particule componente ale plasmă: electroni, ioni și atomi.

Eliberarea unui electron în urma unui astfel de proces este cunoscut sub denumirea de *emisie electronică secundară*.

La ciocnirea electronilor din plasmă cu suprafețele electrozilor sau incintei de descărcare ei pot fi reflectați elastic de către acestea, pot fi reflectați neelastici (o parte din energia lor cinetică fiind cedată solidului contribuind la mărirea energiei lui interne) sau pot produce noi electroni (numiți electroni secundari). Condiția necesară pentru producerea fenomenului de *emisie electronică secundară la impact electronic* este ca energia cinetică a electronilor incidenți să fie câteva sute de eV. Numărul mediu de electroni secundari generați de un electron primar (*coeficientul de emisie secundară la impact electronic* - γ_e) este cuprins între 0,5 și 2 pentru metale și semiconductori și între 1 și 10 pentru dielectrice.

Dacă suprafața solidului este ciocnită de un ion pozitiv atunci trebuie să se țină seama atât de energia cinetică transportată de acesta cât și de energia potențială datorată interacțiunii lui cu microcâmpurile rețelei cristaline a solidului. În analiza procesului de *emisie secundară la impact ionic* se va avea în vedere și faptul că, pe lângă electronul secundar mai trebuie scos încă un electron din solid, electron care va neutraliza ionul pozitiv, deci:

$$E_{cin} + E_{pot} \geq 2\Phi \quad (2.59)$$

În cazul în care ionii incidenți au energii mai mari decât 10^3 eV predomină emisia cinetică fie prin scoaterea unui electron liber sau legat dintr-un atom superficial, fie prin încălzirea locală a suprafeței solidului. În acest caz coeficientul de emisie secundară este cuprins între 1 și 15 electroni/ion.

Dacă ionii incidenți sunt mai lăni, având energii mai mici decât 10^3 eV, atunci predomină emisia secundară potențială. Un ion cu potențialul de ionizare $V_i > 2V_\phi$, poate transfera energia sa de ionizare unui electron din atom, acesta devenind un electron liber. Procesul se numește *emisie Auger*. *Coeficientul de emisie secundară potențială la impact ionic*, γ_i , este funcție de energia de ionizare. De exemplu, pentru He^+ și He^{++} el este aproximativ 0,2, respectiv 0,8 atât pentru suprafețe de molibden cât și pentru suprafețe de tantal. Emisia secundară potențială poate fi explicată pe baza schemei din Fig.2.9 considerând că ionul, fiind mai lent, are un timp de rezidență în apropierea suprafeței metalului suficient de lung pentru a forma, pentru un scurt interval de timp, un sistem unic cu acesta.

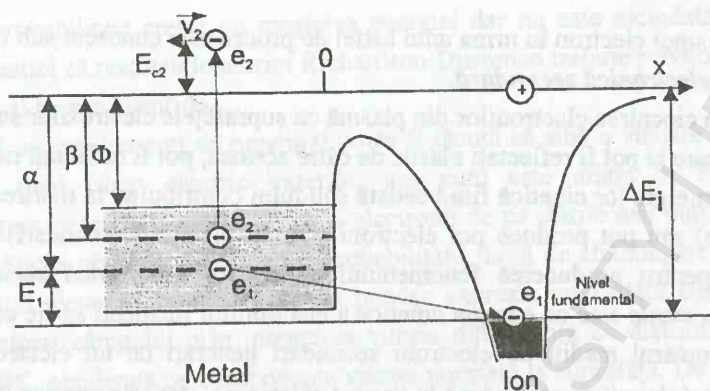


Fig. 2.9 - Emisia electronică secundară potențială.

Prezența ionului determină modificarea formei barierei de potențial în mod asemănător cu ceea ce se întâmplă în cazul efectului Schottky. Un electron e_1 al metalului având energia α , poate străpunge bariera prin efect tunel și să se "așeze" pe nivelul fundamental al ionului, transformându-l în atom neutru. Energia E_1 eliberată în acest proces poate fi preluată de un al doilea electron e_2 al metalului având energia β . Dacă energia E_1 este suficient de mare, atunci el poate părăsi metalul devenind un electron secundar. Această condiție se poate scrie:

$$E_1 = \beta + E_{c2} \quad (2.60)$$

Pe de altă parte:

$$E_1 = \Delta E_{ion} - \alpha \quad (2.61)$$

Din ultimele două relații se poate scrie că:

$$\Delta E_{ion} = E_{c2} + (\alpha + \beta) \quad (2.62)$$

Deoarece atât α cât și β sunt mai mari decât Φ , condiția minimală pe care trebuie să o îndeplinească ionul este obținută din relația (2.62) în care se consideră situația cea mai favorabilă (electronul secundar să fie în repaus):

$$\Delta E_{ion} \geq 2\Phi \quad (2.63)$$

adică, energia de ionizare a atomului din care a provenit ionul pozitiv trebuie să fie cel puțin egală cu dublul energiei de extracție a electronului din metal.

Procesul de emisie electronică secundară poate avea loc și în cazul ciocnirii suprafețelor solide de către atomi neutri. Spre deosebire de emisia secundară la impact ionic, în cazul *emisiei electronice secundare la impact atomic* se are în vedere doar emisia cinetică, atomul nefiind purtător de sarcină în exces. Ca urmare, coeficientul de emisie secundară la impact atomic va fi mult mai mic decât cel la impact ionic. Dacă atomul incident este într-o stare excitată și $V_{exc} > V_{\phi}$, atunci energia de excitare poate fi transferată unui electron din metal care va deveni electron liber. În acest caz emisia se numește rezonantă, coeficientul de emisie secundară la impact atomic fiind funcție de energia de excitare disponibilă.

2.3.2 Emisia atomică

Plasma descărcărilor electrice poate interacționa cu suprafețele solide pe care le acoperă (pereții incintei de descărcare, suprafețele electrozilor) provocând, pe lângă emisia de electroni și emisia de atomi de pe acestea. În multe descărcări acesta poate fi un efect secundar, mai mult sau mai puțin important. Dar în unele descărcări, cum ar fi de exemplu arcul în vid, emisia atomică joacă un rol esențial în existența acestora, atomii emiși putând fi ionizați și astfel să devină mediul conductor dintre electrozi.

Evaporarea și sublimarea sunt procese prin care atomi individuali părăsesc suprafața unui corp solid sau lichid datorită energiei termice. Într-un corp cald atomii au o anumită distribuție statistică a energiilor. Acei atomi de la suprafața corpului care au o energie mai mare decât energia de legătură și au viteza orientată către suprafața lui, vor rupe legătura și vor părăsi corpul. În unele privințe, emisia termică a electronilor este asemănătoare cu evaporarea și lucrul mecanic de extracție poate fi privit ca energia de legătură a electronilor de conducție.

O estimare a ratei procesului de evaporare sau sublimare poate fi făcută folosind modelul simplu al lui Langmuir care consideră corpul condensat în echilibru cu vaporii lui. În starea de echilibru fluxul de atomi evaporați sau sublimați dinspre suprafața corpului este egal cu fluxul atomilor din starea de vapori care se îndreaptă spre suprafață. Dacă atomii de gaz respectă o distribuție statistică de tip Maxwell, fluxul de atomi condensați este dat de:

$$\Gamma = N_a \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} = \frac{P_v}{\sqrt{2\pi m kT}} \quad (2.64)$$

unde P_v este presiunea de echilibru a vaporilor în cauză. Dacă sistemul este în echilibru, atunci Γ poate fi și fluxul de atomi dinspre suprafață. Langmuir susține că, deoarece procesele de emisie atomică sunt influențate în primul rând de temperatura suprafeței și mai puțin de condițiile în care se află gazul, Γ trebuie să reprezinte fluxul de atomi dinspre suprafața corpului indiferent dacă sistemul este în echilibru sau nu. Dacă sistemul este în echilibru atunci fluxul net este zero, existând un flux egal de atomi de gaz care se întorc spre suprafața corpului.

2.3.3 Ionizarea superficială

Pulverizarea catodică este procesul în care o particulă incidentă grea provoacă eliberarea unui atom dintr-un corp condensat (de regulă, solid). Corpul solid poate fi modelat ca o rețea de "sfere grele" atomice, legate între ele printr-un sistem de resorturi care reprezintă forțele interatomice. O particulă incidentă se ciocnește cu una din suprafețele atomice punând în mișcare un sistem cuplat de vibrații atomice care sunt interconectate prin resorturi. Dacă mișcarea inițială a atomului ciocnit este înspre interior el poate ricoșa înspre exterior. Dacă are o viteză suficient de mare, el poate "rupe resorturile" și, dacă energia lui este mai mare decât lucrul mecanic de extracție din metal, el poate părăsi metalul. *Coeficientul de pulverizare*, adică numărul de atomi emiși de către o particulă incidentă, depinde de viteza și masa particulei incidente, de suprafața țintei și de direcția de impact cu suprafața ei și cu planele cristaline de sub aceasta. Coeficientul de pulverizare crește odată cu creșterea masei și vitezei particulei incidente și are o valoare maximă atunci când direcția de impact este paralelă cu direcția de densitate liniară maximă a atomilor din metal, adică cu direcția în care distanța atom-atom este minimă.

La impactul unui atom neutru cu o suprafață metalică el poate pierde sau atașa un electron, vorbindu-se în acest caz de *ionizare superficială pozitivă sau negativă*. Ca și în cazul emisie electronice secundare la impact ionic, atomul lent și metalul pot forma pentru un scurt timp un sistem unic, bariera de potențial micșorându-se și devenind finită.

Dacă energia de ionizare a atomului este mai mică decât energia de extracție a electronilor din metal, atunci există o probabilitate diferită de zero ca un electron din atom să o străpungă și să treacă în metal iar atomul să devină ion pozitiv (Fig. 2.10).

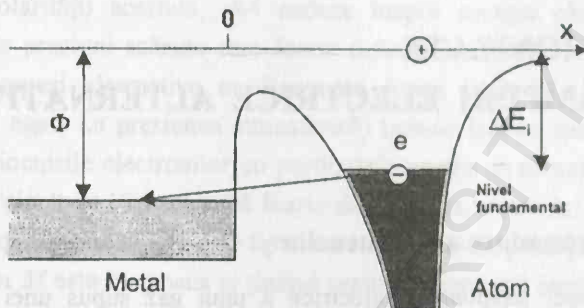


Fig. 2.10 - Ionizarea superficială pozitivă.

Un exemplu de ionizare superficială pozitivă este cel al sistemului wolfram-cesiu. Energia de ionizare a cesiului este de 3,9 eV iar energia de extracție a electronilor din wolfram este de 4,5 eV. Ionizarea superficială negativă se produce după un mecanism asemănător.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. E. BĂDĂRĂU și I.I. POPESCU, "Gaze ionizate. Descărcări electrice". Ed. Tehn. București 1965.
2. G. BRĂTESCU, "Fizica plamei". Ed. Did. Pedag., București 1970.
3. N.A. KRALL și A.V. TRIVELPIECE, "Principles of Plasma Physics". Mc Graw - Hill Book Comp., Inc. New York - London 1973.
4. I.I. POPESCU, I. IOVA și E. TOADER, "Fizica plamei și aplicații". Ed. Științ. Encicl., București 1981.
5. N. GHERBANOVSKI și Gh. PETRESCU, "Descărcarea inelară". Ed.Acad., București 1983.
6. A. MONTASER and D.W.GOLIGHTLY, "Inductively Coupled Plasma in Analytical Atomic Spectrometry". VCH Publishers, New York, Inc. 1987.
7. L. DĂSCĂLESCU, "An Introduction to Ionized Gases. Theory and Applications". Toyohashi University of Technology, 1993.
8. R.L. BOXMAN, P.J. MARTIN and D.M. SANDERS, "Handbook of Vacuum Arc Science and Technology". Noyes Publications, 1995.

Capitolul III

GAZE IONIZATE IN CÂMPURI ELECTRICE ALTERNATIVE

3.1 O prezentare a fenomenelor

Mecanismul străpunerii electrice a unui gaz supus unei diferențe de potențial alternativ este funcție de frecvența câmpului aplicat și de presiunea gazului. Principalele particule răspunzătoare de acest fenomen sunt electronii care, absorbind energie de la câmpul electric alternativ, determină, prin cedarea acesteia în urma ciocnirilor, ionizarea atomilor sau moleculelor neutre și crearea de noi purtători de sarcină.

Procesul absorbției energiei de la un câmp electric alternativ de către o particulă încărcată cu sarcină electrică se deosebește de cel de absorbție de energie de la un câmp continuu tocmai datorită schimbării periodice a polarității acestuia. Să presupunem un electron supus acțiunii unui câmp electric sinusoidal de forma $\vec{E} = \vec{E}_0 \sin(\omega t + \theta)$, în care \vec{E}_0 este amplitudinea câmpului, ω - frecvența unghiulară și θ - faza inițială a oscilației (corespunzătoare momentului în care electronul își începe mișcarea în câmp). Forța exercitată de câmp asupra electronului este:

$$\vec{F} = m_e \vec{a} = e \vec{E}_0 \sin(\omega t + \theta) \quad (3.1)$$

unde a este accelerația electronului, iar m_e și e sunt masa, respectiv sarcina lui. Integrând ecuația (3.1), pentru viteza electronului se obține expresia:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \frac{e \vec{E}_0}{m_e \omega} [\cos \theta - \cos(\omega t + \theta)] \quad (3.2)$$

unde \vec{v}_0 este viteza lui inițială. Se poate observa că între viteza electronului și intensitatea câmpului electric este un defazaj de 90° . Din punct de vedere fizic aceasta înseamnă că electronul este mai întâi accelerat de către câmp, pentru ca, la schimbarea polarității acestuia, să-i cedeze înapoi energia câștigată. Datorită acestui fapt, la presiuni scăzute este foarte dificilă amorsarea și susținerea unei plume în câmpuri alternative cu frecvențe foarte înalte. La presiuni înalte (apropiate sau egale cu presiunea atmosferică) trebuie luat în considerare efectul pe care-l au ciocnirile electronilor cu particulele neutre. Frecvența acestora fiind considerabilă, electronul își schimbă foarte des direcția, viteza lui modificându-se foarte puțin după fiecare ciocnire de tip elastic. Într-adevăr, presupunând că atomul neutru cu masa M este în repaus și ținând seama de raportul maselor partenerilor de interacție, în cazul unei ciocniri unidimensionale viteza atomului după ciocnire va fi:

$$v_n = \frac{2m_e}{m_e + M} v_e \cong 2 \frac{m_e}{M} v_e \quad (3.3)$$

iar raportul dintre energia cinetică finală a atomului neutru și energia cinetică inițială a electronului va fi $4m/M$. Deci o cantitate foarte mică din energia cinetică a electronului va fi transferată atomului și între două ciocniri el poate acumula energie de la câmpul electric. Acest proces continuă până când electronul câștigă suficientă energie de la câmp pentru ca ciocnirea să devină neelastică și să aibă ca efect ionizarea atomului. Amorsarea descărcării are loc prin repetarea proceselor descrise mai sus până când energia absorbită de la câmp este distribuită între electronii mobili și ionii generați de aceștia. Trebuie subliniat faptul că doar o mică parte din această energie este cedată direct de la câmp către ioni, masa considerabilă a acestora împiedicându-i să câștige o cantitate mare de energie cinetică de translație în scurtul interval de timp dintre două schimbări ale polarității câmpului.

Se poate deduce din cele prezentate anterior că există o presiune optimă a gazului (corelată direct cu raportul dintre frecvența câmpului și frecvența de ciocnire) deoarece la presiuni prea scăzute energia transferată de la câmp către electroni este mică, iar la presiuni prea ridicate frecvența de ciocnire este atât de mare încât un electron câștigă insuficientă energie pentru a ioniza un atom.

Astfel, s-a calculat și s-a verificat experimental că, pentru un câmp cu frecvența de 2,45 GHz, presiunea optimă este de 4 torr pentru a amorsa și întreține o plasmă indusă în microunde cu puterea de 25 W. În schimb, pentru a genera același tip de plasmă la presiune atmosferică este necesară o putere de 100 W.

După cum s-a văzut până acum, în procesul de amorsare și întreținere a plasmelor rolul cel mai important îl au electronii, dar tot ei sunt răspunzători și de cele mai multe dintre proprietățile acestora. De aceea considerăm necesară prezentarea comportării lor în câmpuri electrice și magnetice aplicând modelul uniparticulă. Deoarece s-a văzut importanța ciocnirilor, ne vom referi doar la cazurile în care acestea sunt prezente.

3.2 Câmp electric alternativ

Dacă se consideră un electron într-un câmp electric alternativ de forma $\vec{E} = \vec{E}_0 \sin \omega t$, mișcarea având loc în prezența ciocnirilor a căror frecvență este ν_c , atunci, ecuația de mișcare a lui este:

$$m_e \frac{d\vec{v}_e}{dt} = -e\vec{E}_0 e^{j\omega t} - \nu_c m_e \vec{v}_e \quad (3.4)$$

Rezolvarea acestei ecuații conduce la o soluție de forma:

$$\vec{v}_e(t) = \frac{-e\vec{E}}{m_e(\nu_c + j\omega)} \quad (3.5)$$

în care s-a neglijat un termen de forma $\vec{C}e^{-\nu_c t}$, care se anulează rapid în timp în cazul unei frecvențe mari de ciocnire.

Ținând seama de relațiile care definesc mobilitatea electronilor și densitatea de curent electronic:

$$\vec{v}_e = -\mu_e \vec{E} \quad (3.6)$$

$$\vec{j}_e = -n_e e \vec{v}_e = n_e e \mu_e \vec{E} \quad (3.7)$$

$$\vec{j}_e = \sigma_e \vec{E} \quad (3.8)$$

în care n_e este densitatea de electroni, și de relația (3.5), rezultă pentru conductibilitatea electronică, σ_e , o expresie de forma:

$$\sigma_e = \sigma_{er} + j\sigma_{ei} \quad (3.9)$$

în care:

$$\sigma_{er} = \frac{n_e e^2}{m_e} \frac{v_c}{v_c^2 + \omega^2} \quad (3.10)$$

și

$$\sigma_{ei} = -\frac{n_e e^2}{m_e} \frac{\omega}{v_c^2 + \omega^2} \quad (3.11)$$

Această formă a conductibilității gazului îi conferă acestuia o impedanță complexă, compusă dintr-o parte rezistivă și o parte reactivă. Se poate observa că dacă se face raportul celor două conductibilități rezultă o funcție numai de frecvența câmpului și frecvența de ciocnire. Măsurându-se cele două componente ale conductibilității la o frecvență cunoscută a câmpului, se va putea calcula frecvența de ciocnire v_c , deci și secțiunea eficace de ciocnire corespunzătoare acestui proces. Totodată, din punct de vedere electric, gazului ionizat i se poate atribui o admitanță complexă de forma:

$$\bar{Y}_g = \frac{1}{\bar{Z}_g} = \xi \frac{n_e e^2}{m_e} \frac{v_c}{v_c^2 + \omega^2} - j\psi \frac{n_e e^2}{m_e} \frac{\omega}{v_c^2 + \omega^2} \quad (3.12)$$

în care ξ și ψ sunt constante care depind în primul rând de geometria incintei de descărcare.

Partea rezistivă a impedanței este responsabilă de energia absorbită de electroni de la câmpul electric alternativ, puterea absorbită de unitatea de volum de gaz (densitatea de putere) prin intermediul electronilor fiind:

$$p_m = \frac{1}{T} \int_0^T j_{er} E_r dt = \frac{1}{T} \int_0^T \sigma_{er} E_r^2 dt = \frac{n_e e^2 E_o^2}{2m_e} \frac{v_c^2}{v_c^2 + \omega^2} \quad (3.13)$$

Analizând relația (3.13), se pot face două observații interesante:

- în absența ciocnirilor ($v = 0$), energia absorbită de gaz de la câmpul electric alternativ este nulă, de unde rezultă rolul ciocnirilor în acest proces.
- energia absorbită de gaz de la câmpul electric alternativ este maximă atunci când $\omega = v$.

Pe de altă parte, comparând densitatea de putere absorbită de la câmpul alternativ cu cea absorbită de la un câmp continuu ($\omega = 0$):

$$p_{\omega} = j_e E_{\omega} = \frac{n_e e^2}{m_e \nu_c} E_{\omega}^2 \quad (3.14)$$

se poate introduce noțiunea de *câmp efectiv*:

$$E_{ef}^2 = \frac{1}{2} \frac{\nu_c^2}{\nu_c^2 + \omega^2} E_{\omega}^2 \quad (3.15)$$

La presiuni mai ridicate și frecvențe mari, mecanismul străpungerii este mai simplu decât în curent continuu deoarece nu este necesară prezența proceselor de emisie secundară. Condiția de străpungere rezultă din ecuația de conservare:

$$\frac{dn_e}{dt} = \left(\frac{dn_e}{dt} \right)_{c\acute{a}\acute{s}\acute{t}\acute{i}g\acute{u}r\acute{i}} - \left(\frac{dn_e}{dt} \right)_{p\acute{i}e\acute{r}d\acute{e}r\acute{i}} = 0 \quad (3.16)$$

Câștigurile se datorează proceselor de ionizare iar pierderile, fenomenelor de difuzie și recombinare. Pentru ca plasma să poată fi întreținută în absența unui agent de ionizare extern, doar în prezența câmpului electric de radiofrecvență, este necesar ca energia dobândită de un electron între două ciocniri succesive ionizante să fie cel puțin egală cu energia de ionizare a atomilor sau moleculelor gazului "materie primă".

Dacă se introduc notațiile:

D - coeficientul de difuzie

ν_r - frecvența de recombinare

ν - frecvența ciocnirilor ionizante

Λ - lungimea caracteristică de difuzie

atunci, condiția de străpungere (3.16) devine:

$$\left[(\nu_i - \nu_r) - \frac{D}{\Lambda^2} \right] \cdot n_e = 0 \quad (3.17)$$

La presiuni mai mici procesele de atașare electronică pot fi neglijate ($\nu_r \ll \nu_i$) și condiția de străpungere devine:

$$v_i - \frac{D}{\Lambda^2} = 0 \quad (3.18)$$

Dacă se ține seama de faptul că frecvența de ionizare și coeficientul de difuzie sunt date de relațiile:

$$v_i = \frac{eE_o^2 v_c}{2m_e V_i (v_c^2 + \omega^2)} \quad (3.19)$$

$$D = \frac{1}{3} \langle v_e \rangle \langle \lambda_e \rangle \quad (3.20)$$

în care V_i este potențialul de ionizare al particulelor neutre, iar $\langle v_e \rangle$ și $\langle \lambda_e \rangle$ sunt viteza medie și drumul liber mediu al electronilor, atunci termenul din dreapta al relației (3.13) devine:

$$\frac{eE_o^2 v_c}{2m_e V_i (v_c^2 + \omega^2)} = \frac{\langle v_e \rangle \langle \lambda_e \rangle}{3\Lambda^2} \quad (3.21)$$

Dacă, în continuare, se ține seama de faptul că frecvența de ciocnire este proporțională cu presiunea ($v_c \sim p$), și că energia medie a electronilor, $W_e = m_e v_e^2 / 2$, trebuie să fie de același ordin de mărime cu energia de ionizare (pentru ca ionizarea prin ciocnire să poată avea loc) atunci, pentru un gaz dat, rezultă:

$$E_o p \Lambda = \text{const} \times \omega \quad (3.22)$$

Aceasta înseamnă că, pentru o frecvență dată, dependența dintre intensitatea câmpului de străpungere și presiune este cea prezentată în Fig.3.1, curba a.

La presiuni mai ridicate se pot neglija pierderile prin difuzie, deoarece ciocnirile devin preponderente, și condiția de străpungere (3.17) devine:

$$v_i = v_r \quad (3.23)$$

și, deoarece v_r este proporțională cu presiunea gazului, condiția de străpungere devine o relație de forma:

$$E/p = \text{const.} \quad (3.24)$$

care este reprezentată grafic prin dreapta b din Fig.3.1.

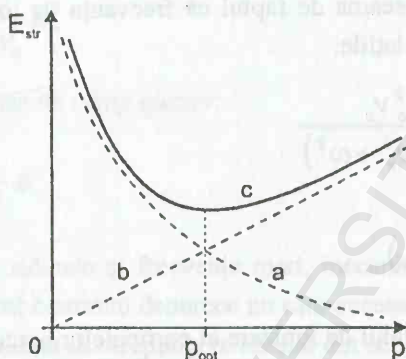


Fig.3.1 - Câmpul de străpungere în funcție de presiunea gazului.

Ținând seama de comportările gazului în cele două situații (la presiuni mai coborâte, respectiv mai ridicate), dependența calitativă a intensității câmpului de străpungere de presiunea gazului este reprezentată de curba c din Fig.3.1. Se poate observa că ea prezintă un minim, presiunea corespunzătoare lui reprezentând presiunea optimă la care amorsarea și întreținerea descărcării într-un câmp de radiofrecvență se poate realiza cu un consum minim de energie. De regulă, în aceste condiții optime, pulsația câmpului de radiofrecvență este egală cu frecvența de ciocnire ($\omega = \nu_c$) și energia absorbită de gaz de la câmpul electric este maximă (vezi relația (3.13)).

3.3 Câmp electric alternativ și câmp magnetic static

În capitolul precedent am subliniat importanța pentru plasmă a prezenței câmpurilor magnetice exterioare. De aceea vom considera acum că peste câmpul electric alternativ se aplică și un câmp magnetic static și omogen pe direcția Oz. Evident, ecuația de mișcare (3.4) trebuie completată cu termenul corespunzător forței Lorentz:

$$m_e \frac{d\vec{v}_e}{dt} = -e\vec{E}_o e^{j\omega t} - e(\vec{v} \times \vec{B}_o) - \nu_c m_e \vec{v}_e \quad (3.25)$$

Admițând pentru viteză o soluție de tip armonic, proiectând ecuația precedentă pe cele trei axe de coordonate și ținând seama de expresia pulsației ciclotronice (1.35), se obține următorul sistem de ecuații:

$$(j\omega + \nu_c)v_x + \omega_c v_y = -\frac{e}{m_e} E_{ox} \quad (3.26)$$

$$(j\omega + \nu_c)v_y - \omega_c v_x = -\frac{e}{m_e} E_{oy} \quad (3.27)$$

$$(j\omega + \nu_c)v_z = -\frac{e}{m_e} E_{oz} \quad (3.28)$$

ale cărui soluții sunt:

$$v_x = -\frac{e}{m_e} \left[\frac{\nu_c + j\omega}{(\nu_c + j\omega)^2 + \omega_c^2} E_{ox} - \frac{\omega_c}{(\nu_c + j\omega)^2 + \omega_c^2} E_{oy} \right] \quad (3.29)$$

$$v_y = -\frac{e}{m_e} \left[\frac{\omega_c}{(\nu_c + j\omega)^2 + \omega_c^2} E_{ox} + \frac{\nu_c + j\omega}{(\nu_c + j\omega)^2 + \omega_c^2} E_{oy} \right] \quad (3.30)$$

$$v_z = -\frac{e}{m_e} \frac{1}{\nu_c + j\omega} E_{oz} \quad (3.31)$$

Din analiza acestor soluții se poate observa că viteza electronului în direcția câmpului magnetic nu este influențată de acesta.

Soluțiile (3.29)-(3.31) se pot scrie și tensorial, într-o formă mai condensată:

$$v_i = \mu_{ij} E_j \quad (i, j = x, y, z) \quad (3.32)$$

μ_{ij} fiind tensorul mobilității complexe, cu următoarele componente:

$$\mu_{xx} = \mu_{yy} = -\frac{e}{m_e} \frac{\nu_c + j\omega}{(\nu_c + j\omega)^2 + \omega_c^2} \quad (3.33)$$

$$\mu_{xy} = -\mu_{yx} = -\frac{e}{m_e} \frac{\omega_c}{(v_c + j\omega)^2 + \omega_c^2} \quad (3.34)$$

$$\mu_{zz} = -\frac{e}{m_e} \frac{1}{v_c + j\omega} \quad (3.35)$$

$$\mu_{xx} = \mu_{yx} = \mu_{yz} = \mu_{zy} = 0 \quad (3.36)$$

Deci, se poate observa că într-un câmp electric alternativ și un câmp magnetic static plasma devine un mediu anizotrop din punct de vedere al proprietăților sale electrice.

Calculând energia medie câștigată de un electron între două ciocniri, se obține expresia:

$$P_m = \frac{n_e v_c e^2}{4m_e} \left[\frac{1}{(\omega + \omega_c)^2 + v_c^2} + \frac{1}{(\omega - \omega_c)^2 + v_c^2} \right] E_o^2 \quad (3.37)$$

din care, prin comparație cu energia absorbită numai de la un câmp continuu ($\omega = 0$, $\omega_c = 0$):

$$P_m = \frac{n_e e^2}{m_e v_c} E_m^2 \quad (3.38)$$

se obține expresia câmpului electric efectiv:

$$E_{ef}^2 = \frac{v_c^2}{4} \left[\frac{1}{(\omega + \omega_c)^2 + v_c^2} + \frac{1}{(\omega - \omega_c)^2 + v_c^2} \right] E_o^2 \quad (3.39)$$

Prezența câmpului magnetic are un efect pronunțat de creștere a câmpului electric efectiv mai ales la presiuni joase, acolo unde frecvența de ciocnire poate deveni mult mai mică decât frecvența câmpului electric și mai ales atunci când se lucrează în condiții apropiate de rezonanță ($\omega \approx \omega_c$). În aceste condiții termenul al doilea din paranteză devine foarte mare, contribuind la mărirea eficienței de transfer energetic de la câmpul electric spre electroni. Fizic, aceasta se explică prin aceea că amplitudinea oscilației electronilor și viteza lor într-un plan perpendicular

pe câmpul magnetic cresc în timp, fiind limitate doar de ciocnirile cu atomii gazului sau cu pereții incintei de descărcare.

Sintetizând ideile mai importante din cele prezentate în paragrafele precedente, se poate concluziona că, în funcție de presiunea gazului "materie primă" și de frecvența câmpului electric care furnizează energia necesară amorsării și menținerii stării de plasmă, străpungerea gazului poate fi controlată de trei mecanisme de bază: difuzie, mobilitate și generarea de electroni secundari la electrozi sau în urma impactului cu pereții incintei de descărcare.

La presiuni și frecvențe foarte joase străpungerea în câmp alternativ este foarte asemănătoare, până la analogie, cu străpungerea în curent continuu și de aceea nu vom insista asupra ei.

La presiuni joase și frecvențe mari, atunci când drumul liber mediu al electronilor este mare în comparație cu dimensiunile incintei de descărcare și probabilitatea de ionizare prin ciocnire electron-atom este mică, străpungerea gazului este controlată de *emisii secundare de electroni* de pe suprafața electrozilor (dacă descărcarea este în contact cu ei) sau a incintei în care se află gazul "materie primă". În acest caz este necesar ca semiperioada oscilațiilor să fie mai mare decât timpul necesar electronilor să parcurgă distanța dintre electrozi sau dintre pereți, astfel încât mișcarea electronilor între cele două suprafețe să fie în fază cu câmpul, iar energia cinetică dobândită de ei să fie suficient de mare pentru a produce emisii electronice secundare la impact electronic. De aceea, intensitatea câmpului de străpungere depinde aproape în exclusivitate de natura materialului electrozilor sau incintei și de geometria constructivă a acestora. Dacă peste câmpul electric se suprapune un câmp magnetic constant, suficient de intens pentru ca electronii să revină în locul unde au fost generați cu energia necesară emisiei secundare, atunci este posibil ca aprinderea descărcării să fie controlată doar de prezența electronilor secundari la un singur electrod sau la un singur perete.

La presiuni mai mari (aprox. 10^{-2} torr), atunci când frecvența de ciocnire devine mult mai mare decât frecvența câmpului și amplitudinea oscilației electronilor devine comparabilă cu dimensiunile incintei de descărcare, apare un nou mecanism de pierdere a electronilor datorită ciocnirii în fiecare semiperioadă a norului de electroni care se formează cu pereții acestora.

În aceste condiții intensitatea câmpului electric necesar amorsării plasmelor trebuie să fie mai mare pentru a compensa acest mecanism de pierdere iar străpungerea va fi în principal controlată de *mobilitatea electronilor*.

La *presiuni mai mari de 10^{-2} torr* și frecvențe din domeniul radio sau microundelor, atunci când drumul liber mediu al electronilor și amplitudinea oscilațiilor sunt mici în comparație cu dimensiunile incintei de descărcare, străpungerea gazului este determinată de fenomenul de *difuzie* a electronilor. Apariția descărcării staționare este condiționată de stabilirea echilibrului dinamic între generarea de electroni prin ionizarea gazului de către electronii accelerați în câmpul electric și scăderea numărului lor datorită difuziei (pierderile prin recombinație sunt semnificative doar în cazul concentrațiilor mari de sarcină). Experimental s-a constatat că mărirea distanței dintre electrozi în anumite limite poate conduce la o micșorare a intensității câmpului electric necesar amorsării descărcării deoarece crește probabilitatea ca un electron să ionizeze un atom înainte ca el să difuzeze la pereții incintei. De asemenea, mai ales la presiuni mai coborâte (limita inferioară a domeniului precizat), suprapunerea unui câmp magnetic static peste câmpul electric alternativ are ca rezultat o micșorare a coeficientului de difuzie cu un factor $v_c^2 / (v_c^2 + \omega_c^2)$, și deci o reducere a câmpului necesar străpunerii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. G. BRĂTESCU, "*Fizica plasmelor*". Ed. Did. Pedag., București 1970.
2. N.A. KRALL și A.V. TRIVELPIECE, "*Principles of Plasma Physics*". Mc Graw - Hill Book Comp., Inc. New York - London 1973.
3. I.I. POPESCU, I. IOVA și E. TOADER, "*Fizica plasmelor și aplicații*". Ed. Științ. Encicl., București 1981.
4. N. GHERBANOVSKI și Gh. PETRESCU, "*Descărcarea inelară*". Ed. Acad., București 1983.
5. P. YANG and R. BARNES, "*A Low-Power Oxygen Inductively Coupled Plasma for Spectrochemical Analysis-III. Excitation Mechanism*". Spectrochim. Acta., 45B, 157-165 (1990).

Capitolul IV

GENERAREA CÂMPURILOR ELECTRICE ALTERNATIVE

4.1 Generatoare de radiofrecvență

Deoarece prezentarea tuturor tipurilor de oscilatoare de radiofrecvență depășește cadrul prezentei lucrări, în paragrafele următoare vom prezenta doar câteva noțiuni de bază necesare înțelegerii funcționării acestora precum și tipurile de oscilatoare care prezintă interes din punctul de vedere al generatoarelor de plasmă.

4.1.1 Principii generale

Un aparat electronic care produce la ieșirea sa un semnal electric armonic este îndeobște cunoscut drept generator de semnale sinusoidale (oscilator). Dacă frecvența semnalului generat se încadrează în domeniul $3 \cdot 10^4 - 3 \cdot 10^8$ Hz atunci este vorba de oscilații de radiofrecvență (unde radio). Oscilatoarele de radiofrecvență conțin ca parte caracteristică un circuit LC cu frecvența de rezonanță în domeniul considerat.

Se știe că dacă un condensator cu capacitatea C , încărcat cu o anumită cantitate de energie electrică, este conectat la bornele unei bobine cu inductanța L și rezistența de pierderi R , în circuitul format (circuit oscilant) vor lua naștere oscilații sinusoidale amortizate, cu frecvența:

$$f_o = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (4.1)$$

Procesul periodic de transformare a energiei acumulate în câmpul electric al condensatorului în energie acumulată în câmpul magnetic al bobinei și invers poate avea loc numai atunci când este îndeplinită condiția:

$$R < 2 \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (4.2)$$

Amortizarea oscilațiilor se datorează pierderilor de energie prin efect Joule în rezistența de pierderi a bobinei și rezistențele conexiunilor electrice, viteza de atenuare a amplitudinii lor fiind cu atât mai mare cu cât aceste rezistențe sunt mai mari. Intuiția ne spune că dacă aceste pierderi de energie vor fi compensate într-un mod oarecare, procesul oscilatoriu poate continua un interval de timp oricât de lung fără ca amplitudinea oscilațiilor să scadă. Practic există două posibilități de realizare a acestui deziderat:

- compensarea rezistenței pozitive de pierderi cu un *efect de rezistență diferențială negativă*;
- *pomparea* în circuit în fiecare perioadă a oscilației a unei cantități de energie egală cu cea disipată în același interval de timp.

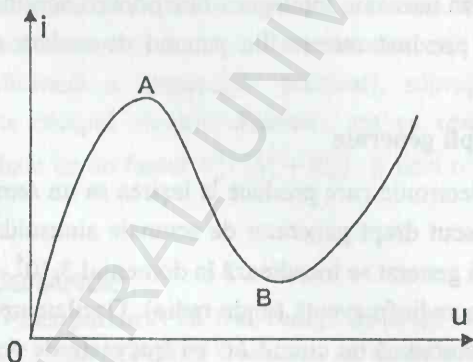


Fig.4.1 - Caracteristică volt-amperică cu o porțiune cu pantă negativă (AB).

Oscilatoarele cu rezistență diferențială negativă au în schema lor un element de circuit (de exemplu dioda tunel) cu o caracteristică volt-amperică care are o porțiune cu pantă negativă (Fig.4.1). Dacă elementul de circuit este polarizat astfel încât punctul său static de funcționare să fie pe porțiunea AB a acestei caracteristici, atunci efectul rezistenței diferențiale:

$$\frac{du}{di} = -\rho \quad (4.3)$$

care este negativă, poate compensa efectul de pierderi al rezistenței pozitive.

În Fig.4.2 este prezentată schema unui circuit cu compensarea pierderilor, care va genera oscilații cu frecvența egală cu frecvența de rezonanță a circuitului oscilant derivație dacă este îndeplinită condiția:

$$\rho = \frac{L}{RC} \quad (4.4)$$

în care L/RC reprezintă chiar rezistența echivalentă de pierderi a circuitului oscilant.

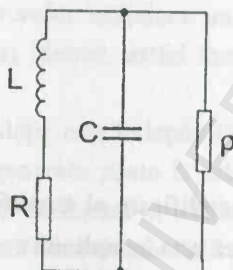


Fig.4.2 – Circuit oscilant cu element de compensare a pierderilor.

Oscilatoarele care se bazează pe introducerea în circuitul oscilant a unei cantități de energie egală cu cea pierdută se numesc *oscilatoare cu reacție*. Un oscilator se poate obține dintr-un amplificator (cu factorul de amplificare \bar{A}) prin aplicarea la intrarea sa a unei părți din semnalul de la ieșire. Acest proces se realizează cu ajutorul unei rețele electrice alcătuită din elemente pasive, numită rețea de reacție (Fig.4.3).

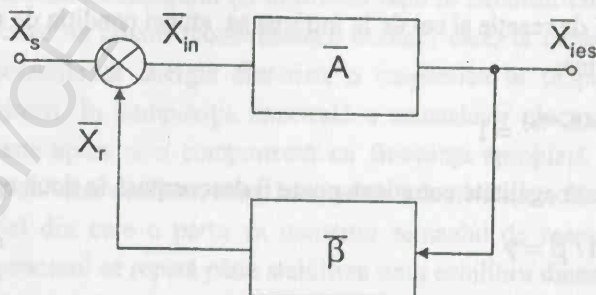


Fig.4.3 - Schema bloc a unui amplificator cu reacție

Semnalul de reacție este aplicat unui sumator care furnizează la ieșirea sa un semnal egal cu suma algebrică a semnalelor care se aplică la intrare. Dacă factorul de transfer al rețelei de reacție este $\bar{\beta}$, atunci între mărimile fazoriale din circuit pot fi scrise relațiile:

$$\bar{X}_{ie\bar{s}} = \bar{A}\bar{X}_{in} \quad (4.5)$$

$$\bar{X}_r = \bar{\beta}\bar{X}_{ie\bar{s}} \quad (4.6)$$

$$\bar{X}_{in} = \bar{X}_s + \bar{X}_r \quad (4.7)$$

$$\bar{A}_r = \frac{\bar{X}_{ie\bar{s}}}{\bar{X}_s} = \frac{\bar{A}}{1 - \bar{\beta}\bar{A}} \quad (4.8)$$

în care \bar{A}_r este factorul de amplificare al amplificatorului cu reacție. Din ultima relație se poate observa că dacă este îndeplinită condiția:

$$\bar{\beta}\bar{A} = 1 \quad (4.9)$$

atunci, cel puțin teoretic, factorul de amplificare cu reacție devine infinit, ceea înseamnă că poate exista un semnal la ieșirea amplificatorului cu reacție chiar și atunci când nu se aplică nici un semnal din exterior. Cu alte cuvinte amplificatorul devine el însuși generator de oscilații. Condiția (4.9) se mai numește *condiția de oscilație a lui Barkhausen*. Dacă φ_a este defazajul dintre semnalul de la ieșirea amplificatorului și cel de la intrarea sa, iar φ_b este defazajul dintre semnalul de la ieșirea rețelei de reacție și cel de la intrarea sa, atunci condiția de oscilație poate fi scrisă sub forma:

$$\beta A e^{j(\varphi_a + \varphi_b)} = 1 \quad (4.10)$$

Această egalitate complexă poate fi descompusă în două egalități reale:

$$A = 1/\beta = \gamma \quad (4.11)$$

și

$$\varphi_a + \varphi_b = 2k\pi \quad (4.12)$$

unde γ este atenuarea rețelei de reacție și $k = 0, 1, 2, \dots$

Condiția (4.11) reprezintă necesitatea ca atenuarea introdusă de rețeaua de reacție să fie compensată de amplificator (*condiția de amplitudine*) iar relația (4.12) arată că suma defazajelor introduse de amplificator și rețeaua de reacție trebuie să fie un multiplu întreg de 2π , adică semnalul de reacție trebuie să fie în fază cu semnalul de intrare (*condiția de fază*). Reacția în care semnalul de reacție este în fază cu semnalul de intrare se numește *reacție pozitivă*.

În cazul oscilatoarelor de radiofrecvență cu reacție sarcina și rețeaua de reacție sunt circuite rezonante LC care determină și frecvența oscilațiilor generate. Elementul activ al amplificatorului introduce un defazaj de 180° iar rețeaua de reacție mai adaugă un defazaj identic, astfel încât să fie îndeplinită condiția de oscilație.

Dacă condiția de oscilație este îndeplinită, relația (4.8) ne lasă să credem că amplitudinea oscilațiilor generate poate fi oricât de mare. Ea a fost obținută considerând că între tensiunea de intrare și tensiunea de ieșire a amplificatorului există o dependență liniară indiferent de nivelul semnalului de intrare. În realitate, caracteristica de transfer a elementului activ din amplificator nu este liniară decât pe un domeniu limitat de amplitudini ale semnalului de intrare, peste care devine neliniară și, oricât de mare ar fi amplitudinea semnalului de intrare, amplitudinea semnalului de ieșire rămâne constantă. Cu alte cuvinte, neliniaritatea caracteristicii de transfer a elementului activ este cea care limitează amplitudinea oscilațiilor generate. Apoi, se mai poate pune întrebarea: dacă la intrarea amplificatorului cu reacție pozitivă care îndeplinește condiția (4.10) nu se aplică nici un semnal din exterior, atunci ce amplifică amplificatorul? Răspunsul poate fi dat gândindu-ne la faptul că în schema oscilatorului (și în primul rând în circuitul său oscilant) există elemente reactive de circuit (condensatori, bobine) care, la cuplarea tensiunii de alimentare, acumulează energie electrică și magnetică în timpul așa-numitelor procese tranzitorii. În compoziția spectrală a semnalelor electrice care însoțesc aceste fenomene apare și o componentă cu frecvența apropiată de frecvența de rezonanță a circuitului oscilant, care, în virtutea selectivității acestuia, va constitui semnalul inițial din care o parte va constitui semnalul de reacție. Acesta va fi amplificat și procesul se repetă până stabilirea unui echilibru dinamic între energia disipată în elementele active din circuit și energia absorbită de la sursa de alimentare în curent continuu.

Deoarece de oscilatoarele de putere medie și mare construite special pentru generarea plasmelor cuplate inductiv și capacitiv ne vom ocupa în

paragrafele 4.1.2 și 4.1.3, vom face referire în continuare la o altă categorie de oscilatoare cu reacție folosite în generatoarele de plasmă de radiofrecvență și anume la oscilatoarele pilotate cu cristal de cuarț, funcționarea cărora se bazează pe efectul piezoelectric. Unui astfel de cristal i se poate asocia o schemă electrică echivalentă ca cea din Fig.4.4.

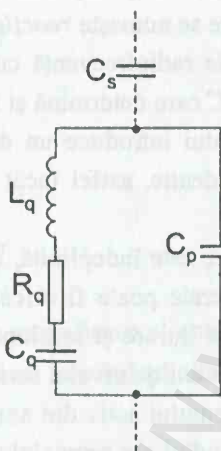


Fig.4.4 - Circuitul echivalent al unui cristal de cuarț.

Este vorba despre un circuit oscilant serie, valorile elementelor de circuit fiind determinate de proprietățile mecanice ale cristalului: inductanța L_q - de masă, capacitatea C_q - de elasticitate și rezistența de pierderi R_q - de frecările mecanice. Capacitatea C_p reprezintă capacitatea dintre electrozii plani între care se află cristalul, prin intermediul cărora cristalul se poate conecta în circuitul electric.

Analizând comportarea acestui circuit în funcție de frecvența semnalului aplicat (Fig.4.5) se poate observa că impedanța sa are două puncte de extrem, corespunzătoare la două frecvențe de rezonanță:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_q C_q}} \quad (4.13)$$

și

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_q \frac{C_p C_q}{C_p + C_q}}} = f_s \sqrt{1 + \frac{C_q}{C_p}} \quad (4.14)$$

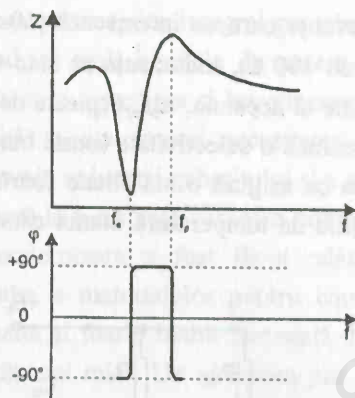


Fig.4.5 - Dependența de fază a impedanței și defazajului circuitului echivalent.

Prima dintre acestea reprezintă frecvența de rezonanță a circuitului serie, iar cea de a doua (frecvența paralel) este frecvența la care reactanța inductanței L_q devine egală cu reactanța capacității echivalente serie formată din C_q și C_p . În deducerea relațiilor (4.13) și (4.14) s-a neglijat contribuția rezistenței de pierderi R_q în expresiile frecvențelor de rezonanță deoarece valoarea ei este mult mai mică decât reactanța inductivă ωL_q . Din dependența de frecvență a defazajului tensiune-curent (Fig.4.5) se vede că pentru frecvențe cuprinse între f_s și f_p comportamentul circuitului este inductiv și în afara acestui domeniu el devine capacitiv.

Deoarece raportul C_q/C_p poate lua valori în domeniul 10^{-3} - 10^{-5} , cele două frecvențe sunt foarte apropiate, diferența dintre ele:

$$f_p - f_s = \frac{1}{2} f_s \frac{C_q}{C_p} \quad (4.15)$$

fiind de cele mai multe ori mai mică decât 1%. Deoarece la frecvența paralel funcționarea cristalului este foarte instabilă, în practică, în serie cu cristalul se conectează o capacitate C_s numită capacitate de sarcină (între linii punctate în Fig.4.4), care deplasează frecvența paralel înspre cea serie, astfel încât diferența dintre ele devine:

$$f'_p - f_s = \frac{1}{2} f_s \frac{C_q}{C_p + C_s} \quad (4.16)$$

Valoarea capacității C_s se alege de 3-4 ori mai mare decât valoarea lui C_p pentru a asigura funcționarea stabilă a cristalului.

În domeniul de frecvențe care ne interesează (10-50 MHz) rezistența de pierderi a cristalului este sub 100Ω , inductanța sa este de ordinul 10^{-2} - 10^{-3} H, astfel încât factorul de calitate al acestuia, $\omega_0 L_q/R_q$, este de ordinul 10^4 - 10^5 . Acest factor de calitate ridicat înseamnă o selectivitate foarte bună a circuitului oscilant echivalent al cuarțului, ceea ce asigură o stabilitate foarte bună a frecvenței de oscilație în raport cu variațiile de temperatură atunci când este folosit ca circuit oscilant în oscilatoare.

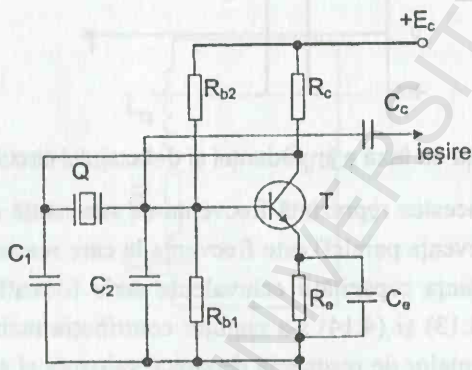


Fig.4.6 - Oscilator cu cuarț de tip Pierce.

Deoarece oscilatoarele pilotate cu cristal de cuarț de multe ori se folosesc ca prim etaj în generatoarele de plasmă de putere medie sau mare (10^2 - 10^3 W) prezentăm în continuare un exemplu de astfel de oscilator (Fig.4.6). Este vorba despre un oscilator Pierce cu tranzistor bipolar care poate lucra fie ca oscilator Colpitts, fie ca oscilator Clapp, cristalul oscilând pe frecvența de rezonanță serie. Pentru a lucra ca oscilator Clapp este necesar ca $C_1, C_2 \geq C_q$, pentru stabilitatea maximă a frecvenței de oscilație alegându-se situația $C_1=C_2$. În această situație condiția de amorsare a oscilațiilor este:

$$\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \leq \frac{1}{4\pi f_s} \sqrt{\frac{g_m}{R_q}} \quad (4.17)$$

în care g_m este panta de semnal mic a tranzistorului.

4.1.2 Generatoare de plasmă cuplată inductiv

Multă vreme drept generatoare pentru obținerea plasmei cuplate inductiv au fost folosite generatoare de mare putere (5 - 10 kW) utilizate în stațiile de

emisie radio. Acestea erau concepute integral pe tuburi electronice, fiind foarte voluminoase și depășind cu mult nivelele de putere necesare pentru generarea plasmei. În momentul în care generarea și întreținerea plasmei cuplate inductiv a început să fie stăpânită și s-a impus necesitatea construcției unor aparate comerciale, s-a simțit nevoia reducerii gabaritului și a găsirii unor soluții pentru ca plasma să poată fi generată la o distanță oarecare față de generator. Un prim pas în această tentativă de modernizare a fost făcut odată cu punerea la punct a tehnologiilor de fabricație a materialelor pentru componentele care trebuie să reziste la tensiuni de înaltă și foarte înaltă frecvență de ordinul kilovolților și, în plus, să aibă pierderi cât mai mici. Un al doilea pas l-a însemnat îmbunătățirea capacității de disipare de putere în înaltă frecvență a componentelor semiconductoare, astfel încât au putut fi realizate generatoare cu puteri de până la 2 kW cu dimensiuni mici și complet lipsite de tuburi electronice. Cu toate acestea și în prezent pentru generarea plasmelor cu puteri consumate mai mari, în etajul final (de putere) al unui generator de plasmă se mai folosesc tuburi electronice. Pentru realizarea unei mobilități mai mari a plasmei și a posibilității de generare a ei la o distanță oarecare de generator, semnalul de radiofrecvență poate fi transmis bobinei de întreținere a plasmei printr-un cablu cu pierderi mici, bobina fiind precedată de o rețea de adaptare ("match box").

Pentru obținerea plasmelor de radiofrecvență se folosesc în general două tipuri de generatoare: generatoare de radiofrecvență autooscilante și amplificatoare de radiofrecvență cu mai multe etaje, semnalul inițial fiind generat de către un oscilator comandat cu cristal de cuarț. În generatoarele autooscilante bobina de sarcină face parte integrantă din circuitul oscilant al oscilatorului și, pentru realizarea transferului maxim de putere de la generator către plasmă, se folosește metoda adaptării impedanței de ieșire a generatorului la impedanța plasmei prin utilizarea unor elemente de circuit reglabile (de obicei condensatori). În acest caz, amorsarea plasmei este însoțită de modificarea frecvenței oscilațiilor generate, fiind necesară încadrarea frecvențelor cu și fără plasmă într-o bandă de frecvențe alocată aplicațiilor industriale. În cazul amplificatoarelor precedate de oscilatoare comandate cu cristal de cuarț frecvența de oscilație este fixă, semnalul este transmis prin cablu către ansamblul rețea de adaptare-plasmă, reglarea maximului de putere transmisă realizându-se printr-o rețea de reacție care acționează asupra unui element reglabil din circuitul de ieșire al amplificatorului final.

Indiferent de tipul de generator folosit, **condiția care trebuie realizată** pentru generarea unei plasmă cuplate inductiv este aceeași: o diferență de potențial de radiofrecvență cât mai înaltă între extremitățile unei bobine și capacitatea de a furniza o putere de regulă mai mare de 500 W plasmă amorată în acea bobină.

Generatorul realizat pentru amorsarea și întreținerea unei plasmă cuplate inductiv a cărui schemă de principiu este prezentată în Fig.4.7, are la bază un oscilator Colpitts care lucrează la frecvența de 27,12 MHz. Elementul activ fiind o triodă de mare putere (de tip 1Y 59B), generatorul poate întreține plasmă cuplate inductiv cu puteri consumate de până la 3 kW, cu tensiuni anodice cuprinse între 2000 și 3600 V. În schemă, între linii punctate au fost reprezentate capacitățile parazite ale triodei.

Acest tip de oscilator intră foarte ușor în regim de oscilații sinusoidale, nu are tendința să oscileze pe frecvențe superioare dictate de capacitățile parazite, poate fi folosit până la 150 MHz și asigură un transfer de 50-60% al puterii către plasmă. Condensatorii C_1 și C_2 ai circuitului oscilant au capacitatea reglabilă și sunt folosiți atât pentru a realiza o diferență de potențial ridicată între extremitățile bobinei circuitului oscilant cât și o adaptare bună între impedanța de ieșire a oscilatorului și impedanța plasmă. De asemenea, cu ajutorul lor poate fi ajustată valoarea frecvenței de oscilație astfel încât să se încadreze în limitele 27,12 MHz $\pm 0,6\%$.

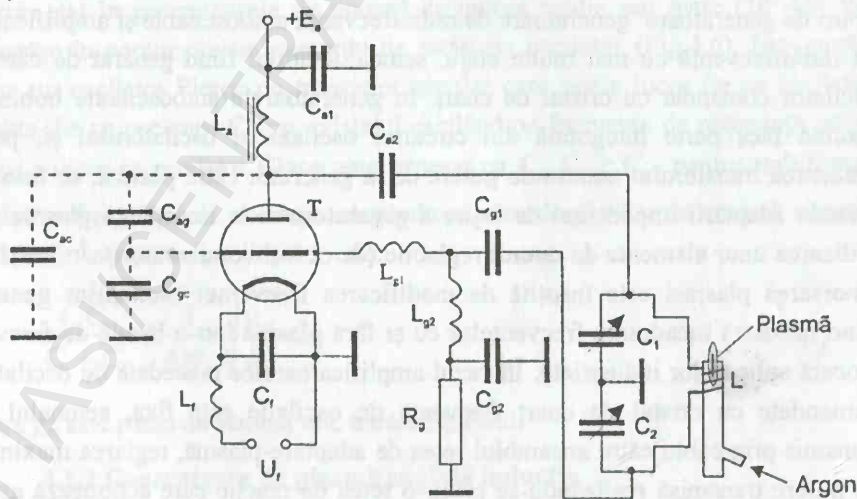


Fig.4.7 - Oscilator Colpitts pentru ICP.

Din analiza pe baza schemelor echivalente la variații ale oscilatorului, se pot determina parametrii funcționali ai acestuia: frecvența oscilațiilor generate, condiția de amorsare a oscilațiilor și efectul de rezistență negativă introdus de elementul activ (trioda). În absența plasmăi acestea sunt date de relațiile:

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}} \sqrt{1 + \frac{r}{R_i} \frac{C_2}{C_1 + C_2}} \quad (4.18)$$

$$\mu \geq \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_1 + C_2}{L} R_i r \quad (4.19)$$

și

$$r_n \cong -\frac{\mu}{\omega_o^2 R_i C_1 C_2} \quad (4.20)$$

În relațiile precedente r este rezistența de pierderi a bobinei circuitului oscilant, R_i și μ_i sunt rezistența internă, respectiv factorul de amplificare ale triodei și ω_o este frecvența unghiulară de rezonanță a circuitului oscilant, $\omega_o = 1/\sqrt{LC_1 C_2/(C_1 + C_2)}$. Inegalitatea (4.19) reprezintă relația care trebuie să existe între valorile elementelor de circuit și parametrii elementului activ, astfel încât la conectarea înaltei tensiuni de alimentare anodică, amplificatorul cu reacție pozitivă să intre în regim de autooscilație. Având în vedere valorile concrete ale elementelor de circuit, în deducerea relațiilor precedente s-a neglijat efectul capacităților parazite ale triodei.

Pentru a se obține plasma cuplată inductiv gazul "materie primă" se introduce tangențial în tubul de descărcare și, după cum se va arăta în capitolul următor, ea poate fi asimilată cu o bobină unispîră cu inductanța L_p și rezistența R_p , cuplată inductiv cu bobina circuitului oscilant. Plasma nu umple interiorul bobinei cu inductanța L pe toată lungimea ei și de aceea, formal, vom considera că ea este alcătuită din două bobine conectate în serie: o bobină cu inductanța L_1 și rezistența de pierderi r_1 , fără plasmă și o bobină cu inductanța L_2 și rezistența de pierderi r_2 cuplată inductiv cu plasma. Schema electrică echivalentă a porțiunii de bobină care conține plasma este prezentată în Fig.4.8. Factorul de cuplaj bobina de cuplaj și plasmă este $k = M/\sqrt{L_2 L_p}$, unde M este inductanța mutuală. Ca urmare a acestui

cuplaj impedanța circuitului oscilant se va modifica, la rezistența și inductanța sa adăugându-se rezistența și inductanța reflectate din circuitul echivalent al plasmei.

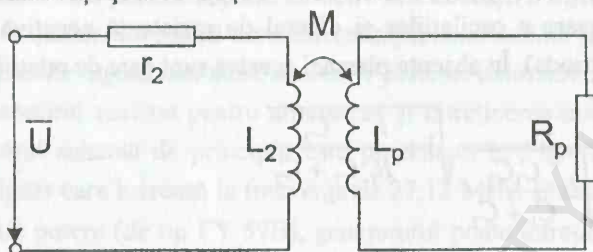


Fig.4.8 - Cuplajul inductiv bobină-plasmă.

Astfel, expresiile rezistenței și inductanței echivalente ale porțiunii de bobină cuplată cu plasma vor fi:

$$R_e = r_2 + k^2 R_p \frac{L}{L_p} \frac{1}{1 + \frac{R_p^2}{\omega^2 L_p^2}} = r_2 + R_{pr} \quad (4.21)$$

$$L_e = L_2 \left[1 - k^2 / \left(1 + \frac{R_p^2}{\omega^2 L_p^2} \right) \right] = L_2 + L_{pr} \quad (4.22)$$

în care R_{pr} și L_{pr} sunt rezistența și inductanța reflectate din circuitul plasmei în circuitul oscilant. Se poate observa că prezența plasmei în bobina circuitului oscilant determină pe de o parte o creștere a rezistenței echivalente de pierderi iar pe de alta, o micșorare a inductanței echivalente ale circuitului oscilant. Creșterea rezistenței este concretizată printr-o mărire a puterii absorbite de oscilator de la sursa de alimentare, în timp ce micșorarea inductanței conduce la o creștere a frecvenței oscilațiilor generate în comparație cu situația în care plasma nu era prezentă în bobină. Expresia acestora poate fi obținută din relația (4.18) în care r se înlocuiește cu $r_2 + R_e$ și L cu $L_2 + L_e$. Se poate observa că atât micșorarea inductanței cât și mărirea rezistenței contribuie la creșterea frecvenței de oscilație.

Această variație a frecvenței de oscilație poate fi un dezavantaj al acestui tip de oscilator, dar el este compensat de avantajul stabilizării automate a puterii absorbite de plasmă, avantaj care va fi demonstrat în continuare. Orice se petrece cu plasma în interiorul unor limite relativ largi, impedanța circuitului oscilant la frecvența de rezonanță rămâne maximă. De aceea, spre deosebire de alte

generatoare, în acesta nu este necesar un circuit suplimentar de adaptare a impedanței de ieșire a oscilatorului la impedanța de sarcină.

Stabilizarea puterii în plasmă se bazează tocmai pe faptul că plasma nu ocupă interiorul bobinei pe toată lungimea ei. Dacă se notează cu λ raportul L_e/L_i și se neglijează rezistența de pierderi în raport cu rezistența reflectată de plasmă, atunci, factorul de calitate a porțiunii de bobină cuplată cu plasma va fi:

$$Q \approx \frac{1}{R_{pr}} \sqrt{\frac{L_1}{C}} \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda}} \quad (4.22)$$

în care $C = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$.

Puterea disipată în plasmă poate fi aproximată cu ajutorul expresiei:

$$P_p \approx \alpha U^2 R_{pr} C / L_1 (1 + \lambda) \quad (4.23)$$

în care α este o constantă pozitivă și subunitară și reprezintă o măsură a eficienței transferului de putere spre plasmă, iar U este tensiunea efectivă de radiofrecvență furnizată de generator și care poate fi considerată constantă. Eliminând R_{pr} din relațiile precedente rezultă:

$$Q \approx \alpha \sqrt{\frac{C}{L_1}} \frac{U^2}{P_p} \frac{\lambda}{(1+\lambda)^{3/2}} \quad (4.24)$$

Presupunând că α este cunoscut și considerând puterea în plasmă ca parametru, funcția $Q = f(\lambda)$ prezintă un maxim pentru $\lambda = 2$.

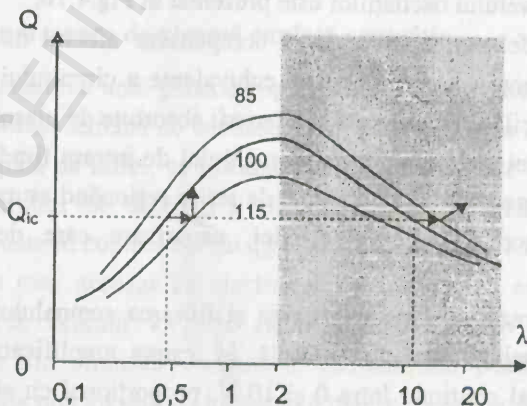


Fig.4.9 - Principiul stabilizării puterii în plasmă.

În Fig.4.9 este prezentată o familie de astfel de caracteristici pentru trei valori ale puterii în plasmă exprimate în unități relative. Atâta timp cât punctul de funcționare rămâne pe aceeași curbă, puterea consumată nu se modifică. Aparent pentru o valoare a lui Q există două valori posibile ale lui λ pentru care funcționarea este posibilă. Se poate însă arăta că numai punctul corespunzător lui $\lambda < 2$ este un punct de funcționare stabil.

Să presupunem că la un moment dat factorul de cuplaj k scade ușor. Aceasta determină o creștere a lui L_e (vezi relația 4.22), deci și a lui λ , și o deplasare pe orizontală a punctului de funcționare spre curba corespunzătoare unei puteri mai mari. Creșterea puterii împiedică scăderea în continuare a factorului de cuplaj și determină deplasarea pe verticală a punctului de funcționare practic pe curba inițială, dar la o valoare mai mare a factorului de calitate. Dacă punctul de funcționare este în partea dreaptă a maximumului, o descreștere a factorului de cuplaj va provoca tot o deplasare tot pe orizontală a punctului de funcționare dar spre o curbă corespunzătoare unei puteri mai mici, determinând descreșterea în continuare a lui k . Astfel, punctul de funcționare nu mai poate reveni pe curba inițială și deci nu se mai poate vorbi despre o stabilizare a puterii în plasmă. Prin analogie se poate arăta că dacă punctul de funcționare din stânga maximumului se deplasează inițial spre valori mai mici ale lui λ el va reveni pe curba corespunzătoare puterii inițiale.

Pentru obținerea unei stabilități și mai mari a puterii absorbite de plasmă se poate realiza și stabilizarea nivelului oscilațiilor de radiofrecvență. Un exemplu de stabilizator al nivelului oscilațiilor este prezentat în Fig.4.10.

El este astfel conceput încât să compenseze efectul micilor variații de impedanță ale plasmei asupra impedanței echivalente a circuitului oscilant și deci asupra nivelului oscilațiilor generate și a puterii absorbite de plasmă. El se bazează pe principiul reacției negative, nivelul semnalului de intrare fiind proporțional cu nivelul oscilațiilor generate, iar semnalul de ieșire acționând asupra grupului $R_g C_g$ de negativare automată a grilei triodei, negativare care determină nivelul oscilațiilor.

Semnalul rezultat după redresarea și filtrarea semnalului de intrare este comparat cu o tensiune fixă de referință, la ieșirea amplificatorului de eroare rezultând un semnal continuu între 0 și 10 V, proporțional cu abaterea nivelului oscilațiilor de radiofrecvență de la valoarea de regim staționar. Un convertor

curent continuu-curent continuu îl transformă tot într-un semnal continuu dar negativ și cu o tensiune multiplicată de aproximativ 10 ori. Prin intermediul unui montaj Darlington al cărui element final este un tranzistor de comutație de putere, acest semnal va comanda variația potențialului grilei astfel încât nivelul oscilațiilor generate să revină la cel inițial.

Deoarece variațiile potențialului grilei triodei determinate de variațiile nivelului oscilațiilor de radiofrecvență se petrec în sens contrar în absența și respectiv prezența plasmăi, funcționarea stabilizatorului este condiționată de prezența plasmăi, prin intermediul unui detector de radiație cu fototranzistor.

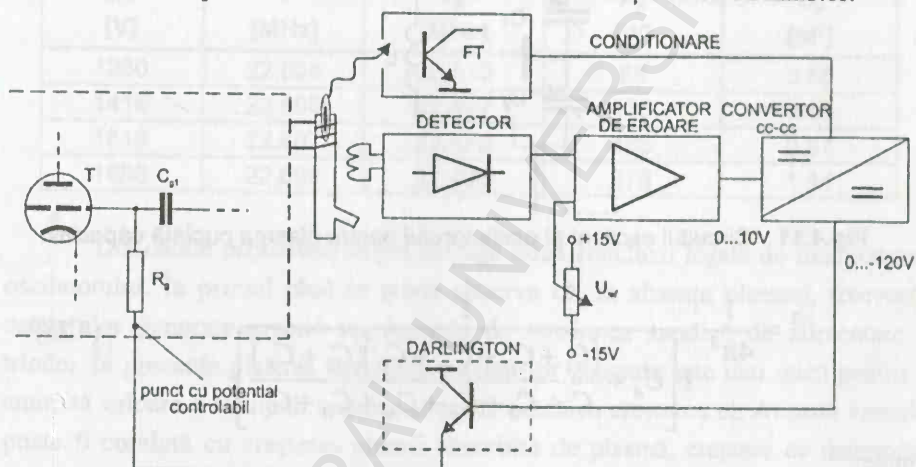


Fig.4.10 - Stabilizarea nivelului oscilațiilor de radiofrecvență la generatorul de plasmă cuplată inductiv.

4.1.3 Generatoare de plasmă cuplată capacitiv

Pentru generarea unei plasmă cuplate capacitiv de putere medie (100-500 W) s-a folosit aceeași schemă de oscilator ca și pentru plasma cuplată inductiv cu deosebirea, esențială de altfel, că plasma este întreținută între un electrod ascuțit aflat în interiorul unui tub de cuarț și un contraelectrod inelar aflat în exteriorul acestuia. Plasma este în contact numai cu electrodul ascuțit. Pentru amorsarea unei astfel de plasmă este necesar ca electrodul de susținere a ei să se afle la un potențial înalt (de ordinul kV) de radiofrecvență. Pentru realizarea acestui deziderat bobina din circuitul oscilant al oscilatorului pentru plasma cuplată inductiv a fost înlocuită cu una cu inductanță mai mare, având un număr sporit de spire, electrodul de susținere a plasmăi fiind conectat la extremitatea cu potențial

mai înalt al ei. În Fig.4.11 este prezentată doar partea modificată a oscilatorului, restul schemei rămânând nemodificată.

Pe baza schemei echivalente la variații a oscilatorului se obține următoarea relație pentru frecvența de oscilație:

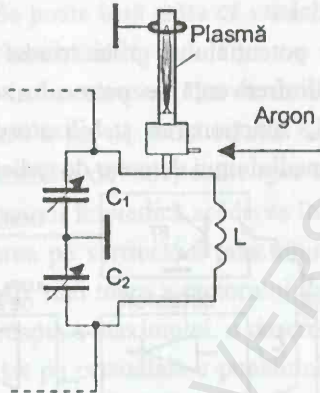


Fig.4.11 - Circuitul oscilant al oscilatorului pentru plasma cuplată capacitiv.

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2} \frac{1}{L \left[C_A + \frac{(C_1 + C_p + C_{ac} + C_c)(C_2 + C_B)}{C_1 + C_2 + C_p + C_{ac} + C_B + C_c} \right]} \quad (4.25)$$

unde:

$$C_A = \frac{C_{g1} C_{ag}}{C_{g1} + C_{ag} + C_{gc}} \quad (4.26)$$

$$C_B = \frac{C_{g1} C_{gc}}{C_{g1} + C_{ag} + C_{gc}} \quad (4.27)$$

$$C_C = \frac{C_{ag} C_{gc}}{C_{g1} + C_{ag} + C_{gc}} \quad (4.28)$$

și C_p este capacitatea plasmei. Această capacitate poate fi calculată din formula (4.25) cu condiția cunoașterii valorilor celorlalte mărimi din ea. Pentru o mai exactă determinare a capacității plasmei, în deducerea relațiilor precedente s-a ținut seama și de capacitățile parazite ale triodei.

Rezultatele măsurărilor și calculelor parametrilor oscilatorului sunt prezentate în Tabelul 4.1, în care f și f_p reprezintă frecvența oscilațiilor generate în absența plasmă și respectiv în prezența ei, P_p reprezintă puterea absorbită de plasmă și C_p capacitatea plasmă. Puterea transferată de la oscilator către plasmă (puterea utilă) poate fi evaluată cu o precizie de $\pm 10\%$ (în care sunt incluse erorile de metodă și de măsurare) prin diferența dintre puterea consumată de la sursa de tensiune continuă anodică în prezența plasmă și puterea consumată în absența ei.

Tabelul 4.1 - Parametri funcționali ai oscilatorului pentru CCP

| E_a [V] | f [MHz] | f_p [MHz] | P_p [W] | C_p [pF] |
|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 1260 | 22.604 | 22.510 | 85 | 0.55 |
| 1416 | 22.606 | 22.497 | 135 | 0.65 |
| 1618 | 22.607 | 22.470 | 185 | 0.87 |
| 1888 | 22.609 | 22.436 | 275 | 1.14 |

Din datele prezentate se pot extrage două concluzii legate de funcționarea oscilatorului. În primul rând se poate observa că, în absența plasmă, frecvența oscilațiilor generate practic nu depinde de tensiunea anodică de alimentare a triodei. În prezența plasmă frecvența oscilațiilor generate este mai mică pentru o anumită valoare a tensiunii anodice și scade odată cu creșterea ei. Această variație poate fi corelată cu creșterea puterii absorbite de plasmă, creștere ce determină mărirea gradului de ionizare a plasmă și deci a capacității ei electrice. În al doilea rând, se vede că dependența puterii absorbite de plasmă de tensiunea anodică este practic lineară (Fig.4.12).

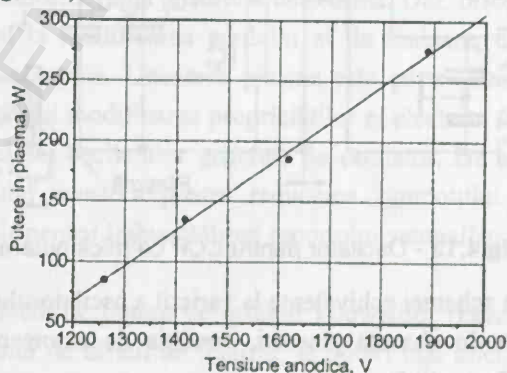


Fig.4.12 - Dependența puterii în plasmă de tensiunea anodică.

Pentru generarea unei plasme de radiofrecvență cuplată capacitiv de mică putere la presiune atmosferică s-a realizat un oscilator cu reacție inductivă și circuit acordat în grilă, a cărui schemă de principiu este arătată în Fig.4.13.

Elementul activ este o pentodă tip 1Y 50. Oscilatorul, deși are la bază o schemă comună, are câteva particularități care derivă din scopul pentru care a fost construit. Astfel, pentru diminuarea efectului zgometelor de joasă frecvență asupra stabilității și zgometului de fond al plasmei, tensiunile anodică, pentru alimentarea grilei ecran și filamentului sunt furnizate de surse stabilizate. De asemenea, în circuitul de alimentare a filamentului și cel de polarizare a grilei ecran au fost prevăzute celule de filtrare ($R_f C_f$, respectiv $R_{g2} C_{g2}$). Pentru realizarea adaptării impedenței de ieșire a generatorului la impedența plasmei se folosesc elemente de circuit reglabile chiar în timpul funcționării. Astfel bobinele cu cuplaj variabil L_1, L_2 și condensatorul variabil C_v fac posibilă reglarea nivelului reacției pozitive și a punctului de funcționare a elementului activ (pentoda) și implicit a impedenței de ieșire a oscilatorului. Impedența plasmei poate fi modificată prin reglarea distanței dintre electrodul de susținere și contraelectrodului inelar (vezi Fig.4.13). Toate aceste elemente de circuit, împreună cu alegerea corespunzătoare a grupului de negativare automată $R_g C_g$, fac posibil lucrul oscilatorului în condiții de adaptare.

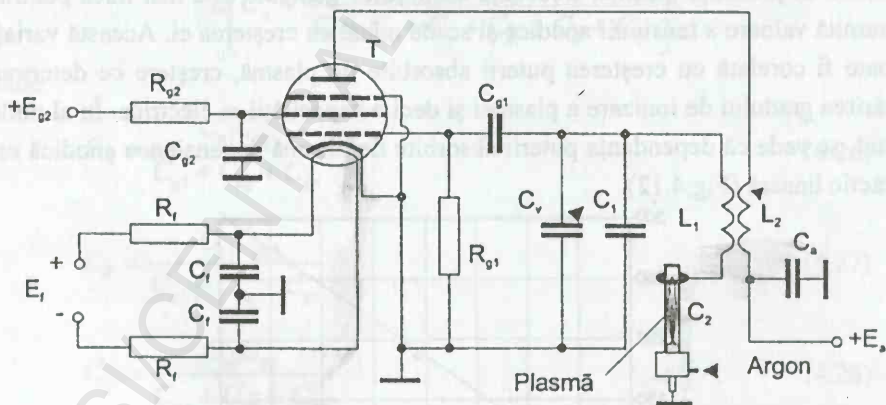


Fig.4.13 - Oscilator pentru CCP de mică putere.

Din analiza schemei echivalente la variații a oscilatorului rezultă frecvența oscilațiilor generate în absența plasmei, condiția de amorsare a oscilațiilor și efectul de rezistență negativă:

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2} \frac{1}{L_2 C \left(1 + \frac{L_1}{L_2} \frac{r_{2e}}{R_i} \right)} \quad (4.29)$$

$$\mu \geq \frac{C_{1v} r_{2e} R_i}{M} + \frac{MC_{1v}}{L_2 C} \quad (4.30)$$

$$r_n = -\frac{R_i}{\mu} \frac{L_2}{M} \quad (4.31)$$

unde: $C = C_{1v} C_2 / (C_{1v} + C_2)$, $r_{2e} = r_2 + 1/\omega_2 C_{1v}^2 R_g$, r_2 este rezistența de pierderi a bobinei L_2 , M este inductanța mutuală dintre bobinele cu cuplaj variabil iar R_i și μ sunt rezistența internă, respectiv factorul de amplificare ale pentodei.

Valoarea frecvenței este de 12,13 MHz înainte de amorsarea plasmă și 12,10 MHz după aceea, în condițiile unei tensiuni anodice $E_a = 1000$ V și unei tensiuni a grilei ecran $E_{g2} = 150$ V. Această scădere a frecvenței se datorează creșterii capacității dintre electrodul ascuțit și contraelectrod (notată cu C_2 în Fig.4.13) în prezența plasmă. Capacitatea plasmă se datorează separării sarcinilor pozitive de cele negative, datorită mobilității mult mai mici a ionilor pozitivi în comparație cu electronii. Puterea absorbită de plasmă de la oscilator poate fi controlată în domeniul 10 - 45 W prin modificarea tensiunii anodice.

Una dintre cerințele importante ale unei surse spectrale este stabilitatea sa din punct de vedere al radiației emise. Aceasta este legată direct de constanța în timp a puterii de radiofrecvență absorbită de plasmă. Dar, orice variație de putere în plasmă conduce la modificarea gradului ei de ionizare, deci la modificarea proprietăților sale electrice. Deoarece plasma este parte intrinsecă a circuitului oscilant al oscilatorului modificarea proprietăților ei electrice va conduce implicit la variații ale nivelului oscilațiilor generate de oscilator. De aceea este necesară stabilizarea nivelului acestora pentru reducerea zgomotului propriu al sursei spectrale și implicit pentru îmbunătățirea raportului semnal/zgomot al semnalului măsurat.

Dacă la nivele de putere de ordinul kilowaților (cazul ICP) o astfel de stabilizare este destul de dificil de realizat, la puteri mai mici ea este realizabilă fără eforturi deosebite. Astfel în Fig.4.14 este prezentat modul de realizare a

stabilizării nivelului oscilațiilor generate de către oscilatorul descris anterior (în schemă sunt indicate doar modificările aduse acestuia).

În fapt este vorba despre o rețea de reacție negativă în curent continuu care, atunci când nivelul oscilațiilor de radiofrecvență tinde să crească va determina o scădere a lui și invers. Semnalul de reacție este o tensiune continuă aplicată pe grila de comandă a pentodei, punctul din care se pot controla cel mai bine fenomenele din circuit. Această tensiune este obținută prin detecția unui semnal proporțional cu nivelul tensiunii de radiofrecvență, semnal cules cu ajutorul bobinei L , cuplată inductiv cu bobina L_1 din circuitul oscilant. La ieșirea detectorului format din dioda D , rezistența R și condensatorul C se obține o tensiune continuă care este aplicată pe borna inversoare a unui amplificator diferențial comparator. Ea este comparată cu o tensiune de referință furnizată de o sursă stabilizată de tensiune continuă iar tensiunea de la ieșirea comparatorului este aplicată pe rezistența R_g din circuitul grilei de comandă, comandând modificarea potențialului acesteia astfel încât nivelul oscilațiilor generate să revină la cel inițial.

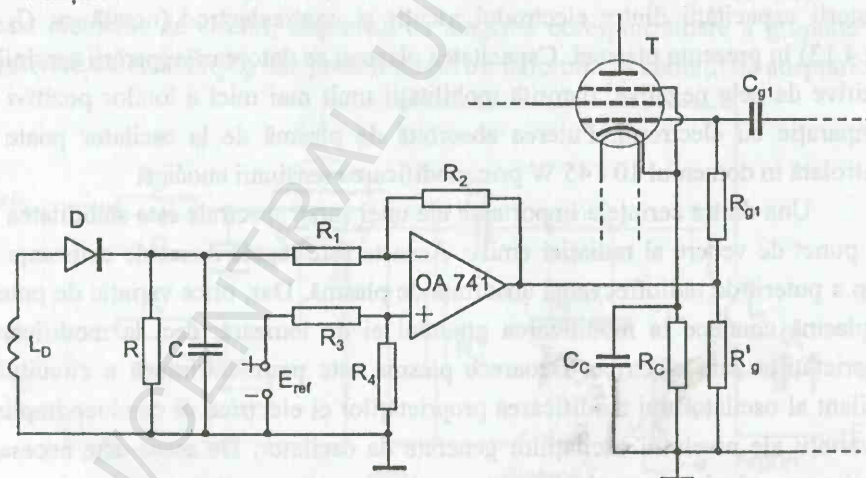


Fig.4.14 - Stabilizarea nivelului oscilațiilor generate.

Eficiența stabilizării poate fi estimată măsurând nivelul zgomotului cu diferite frecvențe suprapus peste oscilațiile armonice. Măsurarea se poate realiza cu ajutorul unui voltmetru cu detecție sincronă la intrarea căruia se aplică semnalul rezultat în urma detecției realizate ca și în cazul stabilizării, iar ca referință se

aplică un semnal cu frecvență variabilă de la un generator de audiofrecvență. Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în graficele din Fig.4.15.

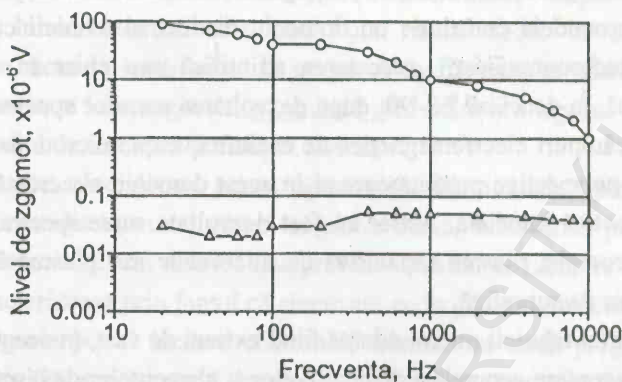


Fig.4.15 - Dependența de frecvență a nivelului de zgomot:

O - fără stabilizator, Δ - cu stabilizator.

Din analiza lor se poate observa că folosirea rețelei de stabilizare determină o reducere cu aproape trei ordine de mărime a zgomotului la limita inferioară a domeniului de frecvențe studiat și cu mai mult de un ordin de mărime la limita lui superioară. Practic, rețeaua de stabilizare face ca nivelul de zgomot să fie aproape constant între 20 și 10000 Hz. Deoarece, după cum se poate observa și din grafic zgomotul "natural" este descrescător cu frecvența, important este efectul stabilizării la frecvențe mici ale semnalului perturbator.

4.2 Generatoare de microunde

Microundele sunt unde electromagnetice cu frecvențe cuprinse între 0,1 și 300GHz ($\lambda = 1\text{mm} - 1\text{m}$). Deoarece aceste lungimi de undă sunt comparabile cu dimensiunile fizice ale componentelor active, pasive și circuitelor "clasice", caracteristicile de funcționare ale acestora se modifică foarte mult în comparație cu domeniile radiofrecvență sau joasă frecvență. De aceea, în domeniul microundelor, circuitele cu elemente discrete (rezistori, bobine, condensatori) ale căror parametri caracteristici (rezistența, inductanța, capacitatea) sunt concentrați în volumul fizic al elementului, se înlocuiesc cu circuite cu parametri distribuiți, cel mai adesea structuri metalice închise sau deschise prin care, sau pe suprafața cărora, se propagă undele electromagnetice cu frecvențe ultraînalte. Datorită particularităților

constructive ale circuitelor cu constante distribuite, a metodelor specifice legate de teoria și practica generării, emisiei, propagării și măsurării semnalelor la aceste frecvențe, microundele constituie un domeniu distinct al tehnicii cu aplicații în radiolocație, radiocomunicații, cercetarea științifică sau chiar în aparatura de utilitate casnică. În deceniul '80-'90, după dezvoltarea surselor spectrale cu plasmă întreținută în câmpuri electromagnetice de radiofrecvență, microundele și-au găsit o aplicație cu perspective promițătoare și în acest domeniu al cercetării științifice cu utilitate practică imediată. Astfel au fost dezvoltate surse spectrale cu plasmă indusă în microunde, plasmă capacitivă de microunde sau plasmă întreținută cu ajutorul undelor de suprafață.

Domeniul tehnicii microundelor fiind extrem de vast, în acest capitol vom face doar o prezentare generală a dispozitivelor și elementelor de circuit folosite în generatoarele de plasmă de microunde, prezentare necesară înțelegerii fenomenelor fizice care stau la baza funcționării lor.

4.2.1 Generarea microundelor

În general, dispozitivele electronice pentru generarea microundelor pot fi clasificate în două mari categorii: *dispozitive cu fascicul electronic în vid* (tuburi electronice) și *dispozitive semiconductoare*.

Funcționarea tuburilor electronice în domeniul microundelor prezintă câteva trăsături specifice. Întâi, timpul de tranzit al electronilor între electrozii tubului este comparabil cu perioada oscilațiilor generate. Apoi, valorile inductanțelor și capacităților circuitelor oscilante cu parametri concentrați devin comparabile cu inductanțele și capacitățile parazite ale electrozilor. În sfârșit, faptul că lungimea de undă devine comparabilă cu dimensiunile geometrice ale circuitului oscilant impune ca acesta să fie realizat sub forma unui circuit cu parametri distribuiți. Dificultățile care apar ca urmare a acestor particularități pot fi depășite fie prin micșorarea dimensiunilor geometrice ale tuburilor electronice clasice și folosirea unor izolatori cu pierderi foarte mici în câmpuri cu frecvențe ultraînalte, fie prin înglobarea tubului într-o cavitate rezonantă (sau într-un sistem cu cavități rezonante) rezultând un dispozitiv complex în care partea de tub electronic nu mai poate fi separată de sistemul rezonant. Tuburile electronice de microunde care provin din cele clasice (diode, triode, tetrode) pot funcționa și la frecvențe inferioare microundelor. Ele se mai numesc și "electrostatice" deoarece procesele de amplificare, generare și detecție sunt realizate prin intermediul

comenzii electrostatice a curentului anodic de către tensiunile aplicate pe electrozi. În cazul dispozitivelor specializate pentru microunde, timpul de tranzit al electronilor între electrozi este mult mai mare decât în cazul tuburilor electrostatice, aceasta contribuind la creșterea randamentului conversiei energiei de curent continuu în energie de microunde prin mărirea timpului de interacțiune dintre fascicolul de electroni și câmpul alternativ.

Tuburile specializate pentru generarea microundelor pot funcționa în prezența sau în absența unui câmp magnetic static, transversal pe fascicolul de electroni. Dispozitivele în care nu este prezent un astfel de câmp se numesc de "tip O" și se caracterizează prin faptul că electronii au în general traiectorii rectilinii. În această categorie pot fi incluse clistronul, tuburile cu undă progresivă și undă inversă de "tip O", acceleratorul liniar. Ele pot avea un câmp magnetic longitudinal pentru focalizarea fascicolului de particule și menținerea deplasării pe o traiectorie rectilie. Dispozitivele care au un câmp magnetic transversal se numesc de "tip M". Datorită ortogonalității câmpurilor electric și magnetic traiectoriile electronilor pot avea cele mai diferite forme. Din această categorie fac parte magnetronul, tuburile cu undă progresivă și undă inversă de "tip M", ciclotronul, sincrotronul.

Dispozitivele semiconductoare de microunde au principii de funcționare și construcție foarte variate: efectul de amplificare în dispozitivele bipolare clasice (tranzistori bipolari de construcție specială), comanda unor capacități neliniare (diode varactor), comanda unor impedențe neliniare (diode PIN), efecte de amplificare în dispozitive unipolare (tranzistorii cu efect de câmp din GaAs cu barieră Schottky), obținerea de rezistențe diferențiale negative prin efect tunel (diode tunel), prin transfer de electroni (diode Gunn, LSA) și prin avalanșă și timp de tranzit (IMPATT, TRAPATT, BARITT).

Dintre toate aceste dispozitive de microunde, cel mai folosit pentru generarea acestora în scopul utilizării lor la amorsarea plasmelor întreținute în câmpuri de microunde la presiune atmosferică este magnetronul. El este folosit ca oscilator de microunde de mare putere și cu randament ridicat ($\eta > 70\%$). În continuare vom încerca să înțelegem funcționarea lui pornind de la analiza mișcării unui electron în spațiul dintre două armături plane (anod-catod) între care se stabilește un câmp electric continuu peste care se suprapune un câmp magnetic static perpendicular pe cel electric (Fig.4.16).

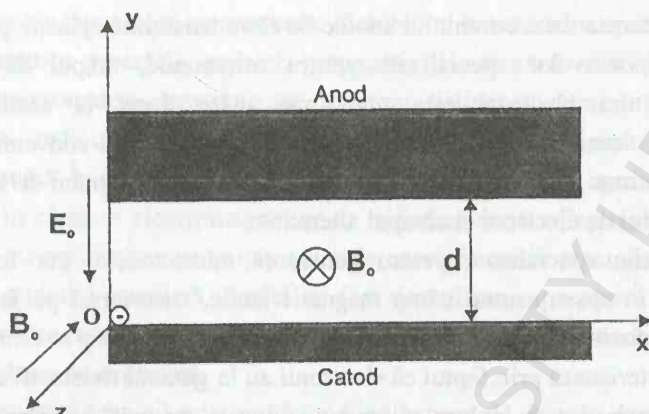


Fig.4.16 - Electron în câmpuri electrice și magnetice încrucișate.

În fapt este vorba de mișcarea unui purtător de sarcină cu masa m și sarcina electrică $-e$ în câmpuri electrice și magnetice statice și încrucișate, câmpuri ale căror componente ortogonale sunt: $\vec{E}(0, -E_0, 0)$ și $\vec{B}(0, 0, -B_0)$. Presupunând că electronul emis la catod are viteza inițială nulă, proiecția ecuației de mișcare:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e [\vec{E} + (\vec{v} \times \vec{B})] \quad (4.32)$$

pe cele trei axe de coordonate, conduce la sistemul de ecuații:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{e}{m} B_0 \frac{dy}{dt} \quad (4.33)$$

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{e}{m} E_0 - \frac{e}{m} B_0 \frac{dx}{dt} \quad (4.34)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = 0 \quad (4.35)$$

Deoarece forța ce acționează asupra electronului datorată câmpului magnetic este îndreptată tot timpul perpendicular pe planul format de vectorii \vec{v} și \vec{B}_0 , traiectoria electronului va avea componente numai în planul xy ($v_z = 0$).

Dacă la $t = 0$ electronul pleacă din originea sistemului de coordonate, rezolvarea sistemului de ecuații (4.33) - (4.35) conduce la soluțiile:

$$x = v_c - \frac{v_c - v_{ox}}{\omega_c} \sin \omega_c t \quad (4.36)$$

$$y = \frac{v_c - v_{ox}}{\omega_c} (1 - \cos \omega_c t) \quad (4.37)$$

unde $\omega_c = qB_o / m$ este frecvența unghiulară ciclotronică și $v_c = E_o / B_o$ are dimensiunile unei viteze.

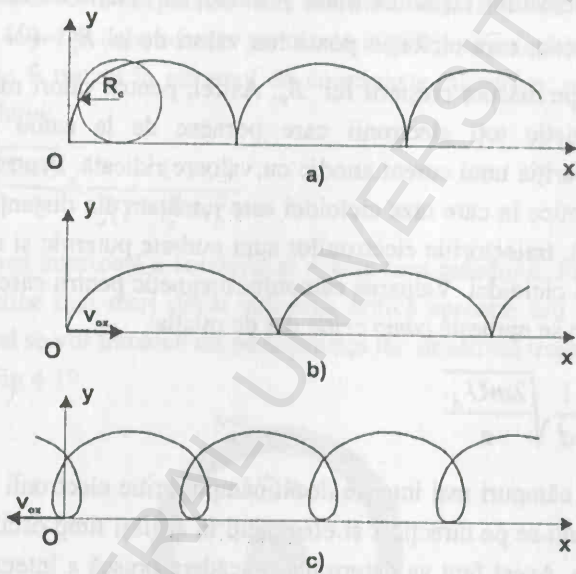


Fig.4.17 - Traiectoriile electronului.

Sistemul (4.36), (4.37) reprezintă ecuațiile unei thoroide. Electronul se mișcă în planul xy după curbe thoroidale a căror formă depinde de componenta pe direcția Ox, v_{ox} a vitezei inițiale Fig.4.17. Dacă $v_{ox}=0$, thoroida ia forma particulară a cicloidei (Fig.4.17a). Traectoria electronului este descrisă de mișcarea unui punct de pe circumferința unui cerc cu raza:

$$R_c = \frac{v_c}{\omega_c} = \frac{mE_o}{eB_o} \quad (4.38)$$

care se rostogolește fără alunecare pe direcția x cu viteza unghiulară ω_c . Rezultă că viteza de deplasare a centrului cercului pe direcția x este v_c , ea fiind și viteza medie de deplasare a electronului pe această direcție. În același timp electronul

efectuează și o mișcare periodică pe direcția y cu viteza unghiulară ω_c . Dacă v_{ox} este pozitivă atunci traiectoria electronului este o thoroidă alungită (Fig.4.17b) iar dacă v_{ox} este negativă atunci traiectoria reprezintă o thoroidă comprimată (Fig.4.17c).

În general, în studiul magnetronului se pot neglija vitezele inițiale ale electronilor emiși de catod, astfel încât în regim static (în absența oscilațiilor de foarte înaltă frecvență) electronii se deplasează pe traiectorii cicloidale. Pentru o valoare fixă a tensiunii U_A dintre anod și catod, în funcție de mărimea inducției câmpului magnetic, raza cicloidei poate lua valori de la $R_c \rightarrow \infty$ pentru $B_o = 0$, micșorându-se pe măsura creșterii lui B_o . Astfel, pentru valori mici ale inducției câmpului magnetic toți electronii care pornesc de la catod ajung la anod determinând apariția unui curent anodic cu valoare ridicată. Pentru acea valoare a inducției magnetice la care raza cicloidei este jumătate din distanța dintre anod și catod ($2R_c = d$), traiectoriile electronilor sunt curbate puternic și ele ating anodul numai în vârful cicloidei. Valoarea câmpului magnetic pentru care este satisfăcută această condiție se numește *câmp critic* dat de relația:

$$B_{cr} = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{2mU_A}{e}} \quad (4.39)$$

Pentru câmpuri mai intense decât câmpul critic electronii nu mai ajung la anod, deplasându-se pe direcția x și efectuând în același timp oscilații ciclotronice după direcția y . Acest fapt va determina o scădere bruscă a intensității curentului anodic, așa cum este arătat în Fig.4.18.

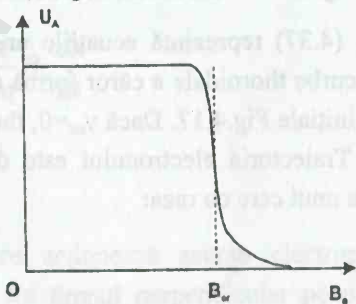


Fig.4.18 - Câmpul magnetic critic.

Aceeași discuție se poate face și dacă se presupune că inducția câmpului magnetic este menținută constantă și se modifică valoarea tensiunii anodice. Va exista o valoare critică a acesteia sub care intensitatea curentului anodic scade brusc.

O configurație de electrozi și o structură a câmpurilor electric și magnetic ca cele discutate anterior stau la baza construcției și funcționării *magnetronului plan*. Dacă cei doi electrozi plani se rulează astfel încât să rezulte doi cilindri concențrici rezultă o configurație de electrozi caracteristică *magnetronului cilindric* (Fig.4.19). De data aceasta problema mișcării electronului în câmpurile încrucișate poate fi tratată în sistemul de coordonate cilindrice, rezultând pentru câmpul critic relația:

$$B_{cr} = \sqrt{\frac{8mU_A}{e}} \frac{1}{r_a(1 - r_c^2/r_a^2)} \quad (4.40)$$

în care r_a este raza interioară a anodului și r_c este raza catodului. Pentru valori ale inducției magnetice mai mari decât valoarea critică aproape toți electronii care pleacă de la catod se vor întoarce tot pe suprafața lui descriind traiectorii de forma celei arătate în Fig.4.19.

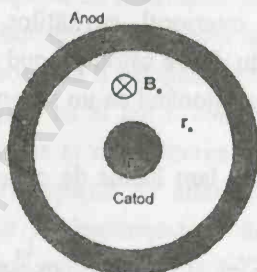


Fig.4.19 - Magnetron cilindric.

Această structură cilindrică a electrozilor stă la baza realizării magnetronului cu cea mai largă răspândire, *magnetronul cu cavități multiple*. El se obține practicând în corpul anodului un număr par de cavități identice (R_1, R_2, \dots Fig.4.20).

obține practicând în corpul anodului un număr par de cavități identice (R_1, R_2, \dots Fig.4.20).

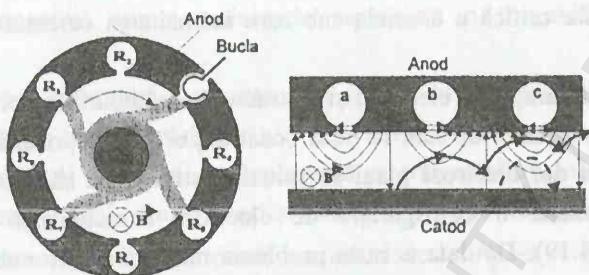


Fig.4.20 - Magnetronul cu cavități multiple, distribuția câmpului electric în spațiul de interacțiune și traiectorii posibile ale electronilor.

Deoarece oricărei incinte metalice închise i se poate asocia o schemă electrică echivalentă sub forma unui circuit rezonant paralel LC , cu frecvența proprie de oscilație dependentă de dimensiunile geometrice ale ei, aceste cavități poartă denumirea de *cavități rezonante*. Cavitățile rezonante comunică cu spațiul dintre catod și anod prin niște fante dreptunghiulare. Deoarece în acest spațiu are loc procesul de interacțiune dintre electronii emiși de catod și câmpul electromagnetic generat în interiorul cavităților, el se numește *spațiu de interacțiune*. Prin același spațiu dintre catod și anod cavitățile rezonante comunică între ele, întregul ansamblu funcționând ca un sistem de circuite oscilante cuplate între ele prin intermediul unor capacități. O porțiune din acest lanț închis de circuite cuplate este prezentată în Fig.4.21.

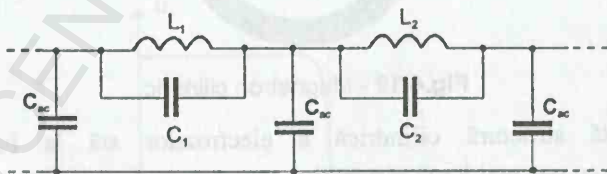


Fig.4.21 - Circuitul echivalent pentru o secțiune de magnetron.

Cuplajul dintre două cavități este atât de natură inductivă, realizat prin intermediul câmpurilor magnetice de foarte înaltă frecvență care se influențează reciproc la capetele cavităților, cât și de natură capacitivă, realizat prin intermediul capacităților elementare C_{ac} dintre segmentele de anod și catod. În unele tipuri de

magnetron cavitățile rezonante pot fi cuplate între ele și prin intermediul unor bucle de cuplaj speciale. Pentru extragerea energiei de ultraînaltă frecvență generată de magnetron este suficient ca sarcina (consumatorul) să fie cuplată prin intermediul unei bucle doar la una dintre cavități (Fig.4.20). Există trei regimuri de funcționare a unui magnetron ca oscilator: *a) cu rezistență negativă; b) cu oscilații ciclotronice; c) cu undă progresivă*. Regimul cu undă progresivă este cel mai des folosit dintre cele trei și de aceea, în continuare vom face referire doar la acesta.

Procese principale care se desfășoară în spațiul de interacțiune sunt sortarea și gruparea electronilor sub influența câmpului de microunde și transferul de energie de la electroni către câmp. Dacă se consideră un magnetron desfășurat, distribuția tipică a câmpului electric de microunde în spațiul de interacțiune este cea prezentată în Fig.4.20. El are intensitatea maximă în regiunea fantei unde sunt concentrate proprietățile capacitive ale cavității rezonante și totodată pătrunde în spațiul de interacțiune pe o anumită adâncime, interacționând cu electronii emiși de catod. Deci electronii vor interacționa simultan cu trei câmpuri: câmpul electric continuu aplicat între anod și catod, câmpul magnetic static și câmpul electric de microunde. În primă aproximație se poate neglija interacțiunea electronilor cu componenta magnetică a câmpului de microunde deoarece aceasta are intensitatea maximă în interiorul cavităților rezonante, acolo unde sunt concentrate proprietățile inductive. Particularitatea deosebită a câmpului electric de microunde din spațiul de interacțiune constă în faptul că el are o configurație de undă staționară care poate fi privită ca suprapunerea și compunerea a două unde progresive care se propagă în sensuri opuse prin spațiul de interacțiune. În orice punct din acest spațiu câmpul electric poate fi descompus în două componente: o componentă tangențială, E_t , și o componentă radială, E_r (Fig.4.22). Termenii tangențial și radial se referă la direcțiile față de un cerc concentric cu catodul. Componenta tangențială are nodurile localizate întotdeauna la mijlocul segmentelor anodice și ventrelor în dreptul fantelor cavităților. Distribuția câmpului de microunde variază în timp, având perioada T egală cu perioada oscilațiilor generate, deci și cele două componente ale câmpului vor avea aceeași variație. În procesul de interacțiune a electronilor cu câmpul de microunde cele două componente ale acestuia joacă roluri diferite: componenta tangențială E_t realizează schimbul energetic dintre electroni și câmp, producând în același timp un proces de "sortare" a electronilor emiși de catod iar componenta radială E_r realizează "focalizarea de fază",

asigurând condiții optime de transfer a energiei acumulate de electroni de la câmpul electric continuu accelerator către câmpul de microunde.

Traectoriile reale ale electronilor sunt destul de complicate dar, pentru a ușura înțelegerea fenomenelor care se produc, vom presupune că ele sunt de formă epicycloidală și că viteza medie de deplasare a electronilor în lungul cavității este v_c . Electronii emiși la catod pe de o parte sunt accelerați către anod de către câmpul electric continuu datorat tensiunii anodice acumulând energia de la acesta, iar pe de alta sunt deviați spre dreapta datorită prezenței câmpului magnetic static. Electronii care pornesc de pe acea porțiune a catodului corespunzătoare unui câmp tangențial de microunde E_t frânant (Fig.4.22) vor ceda acestuia o parte din energia lor cinetică și viteza lor se va micșora. Drept urmare curbura traiectoriei lor va scădea și electronii vor începe o nouă traiectorie epicycloidală intrând din nou într-un câmp tangențial frânant. Astfel, acești electroni se vor deplasa în medie spre dreapta și spre anod pe epicycloide repetate (Fig.4.20 traiectoria continuă) și, după un număr relativ mare de interacțiuni cu câmpul de microunde în decursul cărora îi cedează acestuia energia acumulată de la câmpul continuu, vor cădea pe anod. Această condiție de plecare a electronilor dintr-o zonă "favorabilă" a catodului se numește *condiție de sincronism*. Electronii care pleacă dintr-o zonă a catodului corespunzătoare unui câmp tangențial de microunde accelerator vor absorbi energie de la acesta, viteza și deci curbura traiectoriei lor vor crește și ei vor ieși foarte repede din spațiul de interacțiune căzând pe catod (Fig.4.20 traiectoria întreruptă). În acest mod, componeta tangențială E_t a câmpului de microunde va realiza o sortare a electronilor, reținând electronii "utili" (cei care cedează energie câmpului de microunde) un timp mai îndelungat în spațiul de interacțiune și eliminându-i rapid pe cei care absorb energie de la câmpul de microunde. Astfel, în medie, câmpul de microunde câștigă energie de la electronii accelerați de către câmpul anodic continuu. Totodată se produce o acumulare de electroni în zonele favorabile și o rarefiere a acestora în zonele defavorabile, densitatea norului electronic din spațiul de interacțiune căpătând o periodicitate (sub forma unor "spîțe" electronice) determinată de numărul de cavități rezonante.

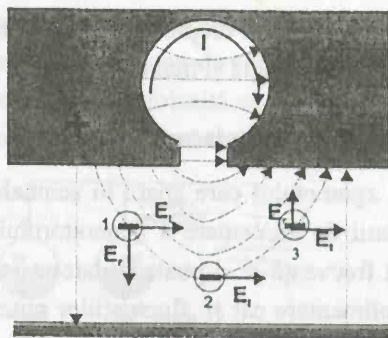


Fig.4.22 - Componentele câmpului electric de microunde.

Pentru a înțelege efectul componentei radiale E_r a câmpului de microunde asupra "spîtelor" electronice, considerăm trei electroni echidistanți din zona de interacțiune cu câmp tangențial frânant, electroni despre care presupunem că au aceeași viteză v_e (Fig.4.22). Se poate observa că electronul 1 va fi accelerat în direcția anodului deoarece câmpul radial are același sens cu câmpul anodic continuu, viteza electronului 2 va rămâne neschimbată ($E_r=0$) iar viteza electronului 3 se va micșora deoarece câmpul radial are sens contrar câmpului anodic continuu. Dacă structura câmpului de microunde ar fi invariabilă în timp, vitezele electronilor și distanțele dintre ei ar rămâne nemodificate deoarece în zona din stînga cavității toți electronii ar fi accelerați iar în zona din dreapta ar fi frânați cu aceeași cantitate.

Dacă însă se ia în considerare variația în timp a câmpului de microunde, se poate observa că electronul 3 a parcurs spațiul din stînga cavității atunci când intensitatea câmpului era mai mică decât valoarea maximă, deci el a fost accelerat de către un câmp mai mic decât cel care îl frînează. Rezultatul acțiunilor cumulate va fi o micșorare a vitezei electronului 3. În schimb, electronul 1 va fi frânat de către un câmp mai mic decât cel care-l accelerează, consecința fiind o creștere a vitezei lui. Evident, viteza electronului 2 va rămâne nemodificată, el fiind în permanență în zona cu câmp radial nul. Ca urmare, va avea loc o grupare a electronilor 1 și 3 în apropierea electronului 2 și deci o mărire a densității "spîtelor" electronice. Tot componenta radială a câmpului de microunde va contribui la anihilarea tendinței de împrăștiere a electronilor datorită forțelor de respingere electrostatică. Aceste "spîțe" se rotesc cu viteza v_e , transferul optim de energie de la fascicolul de electroni către câmpul de microunde realizându-se dacă

în momentul trecerii unei "spițe" prin dreptul unei fante componenta tangențială E_t a câmpului de microunde este frânantă și maximă.

4.2.2 Stabilizarea puterii în plasmă

Una din sursele zgomotului care apare în semnalul de emisie al plasmă este instabilitatea tensiunii de alimentare a generatorului de microunde. Acesta este un zgomot de joasă frecvență și el poate fi datorat atât fluctuațiilor tensiunii furnizate de rețeaua de alimentare cât și fluctuațiilor puterii absorbite de sarcină, în cazul de față plasma. Dat fiind faptul că la puterile destul de mari (sute de wați) la care se lucrează este dificilă realizarea unor surse de tensiune continuă stabilizate prin metodele "clasice", reducerea zgomotului de joasă frecvență al semnalului de emisie datorat acestor cauze se poate realiza prin controlul tensiunii alternative de alimentare a sursei de tensiune continuă a generatorului de microunde (magnetronului). Pentru aceasta se folosește o rețea de reacție care are drept semnal de intrare o mărime proporțională cu fluctuația puterii absorbite de plasmă și la ieșire o bobină conectată în serie cu intrarea generatorului, bobină a cărei inductanță este controlată de semnalul de intrare al rețelei de reacție. Acest sistem de stabilizare se bazează pe principiul amplificării magnetice prin care, modificând intensitatea unui curent continuu prin înfășurarea primară a unui transformator cu miez feromagnetic se modifică impedanța înfășurării secundare. Calitatea importantă a acestui circuit de stabilizare constă în capacitatea lui de a controla un nivel mare de putere de curent alternativ (30 - 500 W) cu ajutorul unei puteri mici de curent continuu (0 - 2,5 W).

Semnalul de intrare al rețelei de reacție este diferența dintre puterea incidentă și puterea reflectată de plasmă, puteri care sunt măsurate folosind schema prezentată în Fig.4.23.

Puterea de microunde furnizată de magnetron este direcționată prin ghidul de undă către ieșirea coaxială. O buclă de cuplaj direcțională, împreună cu un atenuator și o diodă detectoare de microunde, furnizează o tensiune proporțională cu puterea incidentă. Prin ieșirea coaxială și un circulator, unda incidentă este direcționată către plasma conectată la poarta 2 a acestuia. Orice putere reflectată de plasmă spre poarta 2 a circulatorului este direcționată spre poarta 3 a lui și, printr-un cuplor direcțional, este măsurată în același mod ca și puterea incidentă.

O tensiune proporțională cu diferența dintre puterea incidentă și puterea reflectată este comparată cu o tensiune de referință care poate fi reglată cu mare precizie iar tensiunea rezultată este folosită ca semnal de reacție în stabilizatorul a cărui schemă de principiu este prezentată în Fig.4.24.

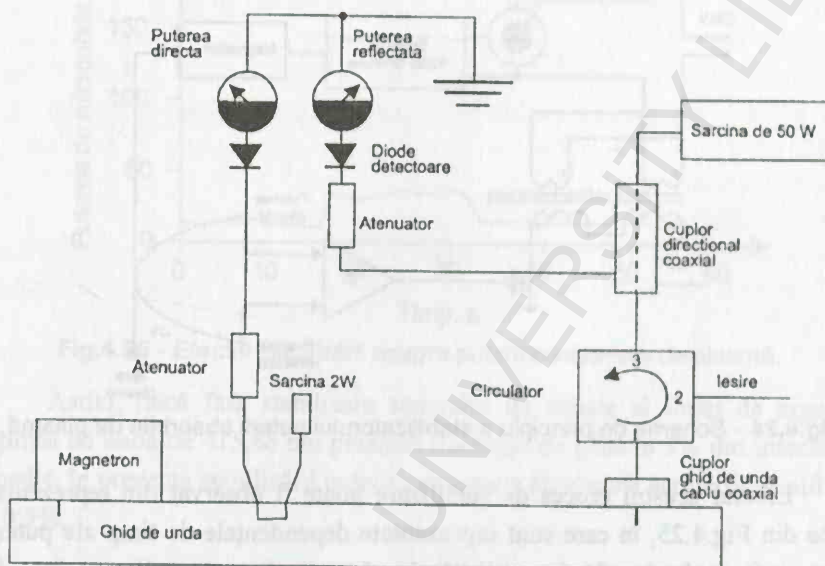


Fig.4.23 - Măsurarea puterii directe și a celei reflectate de plasmă.

Această tensiune este aplicată pe baza unui tranzistor cu efect de câmp care se comportă ca o rezistență variabilă controlată în tensiune și care va determina mărimea curentului continuu prin elementul de comandă al stabilizatorului. Acesta este constituit din două transformatoare coborâtore de tensiune ale căror înfășurări secundare sunt conectate în paralel între ele și în serie cu transformatorul de rețea care alimentează sursa de înaltă tensiune continuă a generatorului de microunde. Înfășurările primare ale celor două transformatoare sunt conectate în serie în opoziție de fază pentru a anula tensiunea alternativă cu frecvența rețelei (50 Hz) care este indusă din circuitele secundare. Această conexiune în antifază este o caracteristică importantă circuitului deoarece elimină modulația în curent alternativ din bucla de control și deci necesitatea folosirii în circuitul primar a unor componente de înaltă tensiune (privite dinspre secundar înspre primar, transformatoarele sunt ridicătoare de tensiune). Când un curent continuu este obligat să parcurgă înfășurările primare ale celor două

transformatoare, miezurile lor devin saturate. Odată cu creșterea saturației impedențele înfășurărilor secundare scad și fracțiunea din tensiunea de alimentare care revine transformatorului sursei de înaltă tensiune crește.

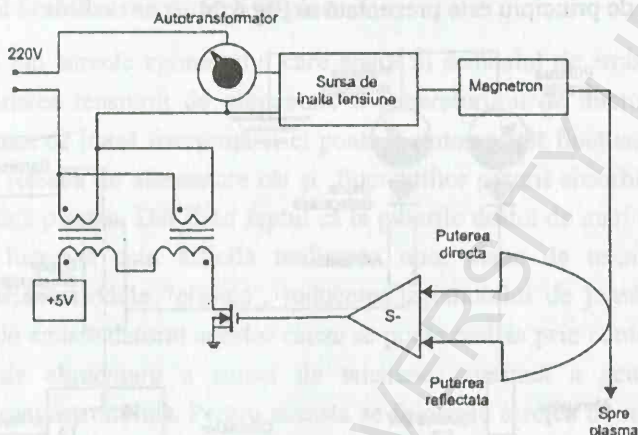


Fig.4.24 - Schema de principiu a stabilizatorului puterii absorbite de plasmă.

Efectul acestui proces de stabilizare poate fi observat din reprezentările grafice din Fig.4.25, în care sunt reprezentate dependențele de timp ale puterilor directă, reflectată și utilă (consumată de plasmă). Pentru realizarea lor, după cincisprezece secunde de la stabilirea regimului staționar de operare, a fost realizată intenționat o dezadaptare între impedența de ieșire a generatorului și sarcina de 50 W. Inițial, puterea directă era de 208 W și cea reflectată de 16 W. Puterea utilă, care este diferența dintre ele (192 W), a fost folosită ca semnal de intrare pentru stabilizator. Dezadaptarea realizată a condus la o mărire a puterii reflectate la 31 W. Dar, prin rețeaua de reacție, această creștere a puterii reflectate a determinat și o creștere corespunzătoare a puterii directe, astfel încât puterea utilă să rămână constantă. Stabilizarea puterii consumate de plasmă are efecte drastice și asupra zgomotului de foarte joasă frecvență (0 - 2 Hz) și asupra stabilității semnalului de emisie al plasmăi.

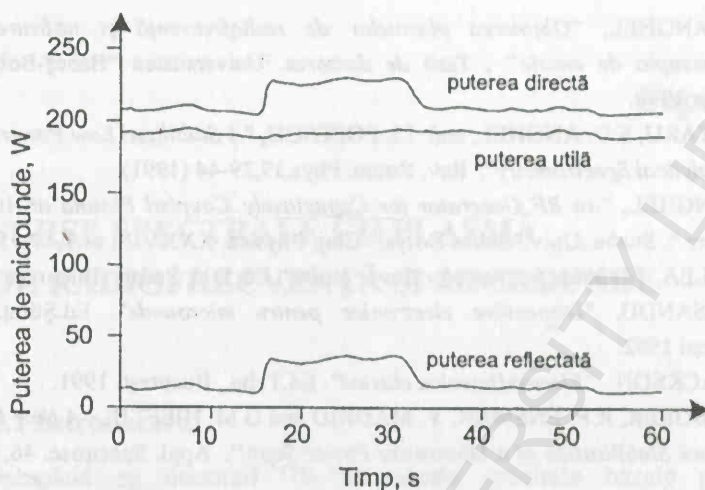


Fig.4.25 - Efectul stabilizării asupra puterii consumate de plasmă.

Astfel, dacă fără stabilizare semnalul de emisie al liniei de argon cu lungimea de undă de 415,86 nm prezintă fluctuații de până la 3% din intensitatea sa medie, în prezența stabilizării puterii consumate de plasmă aceste fluctuații scad sub 0,5%.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. G. BĂJEU și Gh. STANCIU, "Generatoare de radiofrecvență". Ed.Tehn., București 1972.
2. G. BĂJEU și Gh. STANCIU, "Generatoare de semnale sinusoidale". Ed.Tehn., București 1979.
3. D. DASCĂLU și colab., "Dispozitive și circuite electronice". Ed. Did. Pedag., București 1982.
4. P.W.J.M. BOUMANS, F.J. de BOER and J.W. de RUITER, "A Stabilized R.F. Argon-plasma Torch for Emission Spectroscopy". Philips Techn. Rev., 33, 50-59 (1973).
5. A. MONTASER and D.W.GOLIGHTLY, "Inductively Coupled Plasma in Analytical Atomic Spectrometry" (Cap.4). VCH Publishers, New York, Inc. 1987.
6. C.D. ALLEMAND and R.M. BARNES, "Design of a Fixed-Frequency Impedance Matching Network and Measurement of Plasma Impedance in an Inductively Coupled Plasma for Atomic Emission Spectrometry". Spectrochim. Acta 33B, 513-534 (1978).
7. S.D.ANGHEL, A.POPESCU, F.RACZ, E.TĂTARU și E.CORDOS, "Un generator de plasmă cuplată inductiv pentru spectroscopia de emisie". Rev.Chim. 40, 344-349 (1989).

8. S.D. ANGHEL, "Obținerea plasmelor de radiofrecvență și utilizarea lor în spectroscopia de emisie" , Teză de doctorat. Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, 1990.
9. E. TATARU, S.D. ANGHEL, and I.I. POPESCU, "A Stabilized Low Power RF Torch for Analytical Spectrometry". Rev. Roum. Phys.39,29-44 (1991).
10. S.D.ANGHEL, "An RF Generator for Capacitively Coupled Plasma at Atmospheric Pressure". Studia Univ."Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XXXVIII, nr.1,39-51(1993).
11. G. RULEA, "Tehnica frecvențelor foarte înalte". Ed. Did. Pedag., București 1975.
12. D.D. SANDU, "Dispozitive electronice pentru microunde". Ed.Științ.Enciclop., București 1982.
13. J.D. JACKSON - "Electrodinamica clasică". Ed.Tehn., București 1991.
14. M.W. BORER, R.E. ENSMAN, Y. MADRID and G.M. HIEFTJE, "A New Method for Feedback Stabilization of a Microwave Power Supply". Appl. Spectrosc. 46,1162-1167 (1992).

Capitolul V

SURSE SPECTRALE CU PLASMĂ DE RADIOFRECVENȚĂ ȘI MICROUND

5.1 Introducere

Începând cu deceniul '70-'80 sursele spectrale bazate pe plasma descărcărilor în gaze susținute în câmpuri electrice alternative la presiune atmosferică au avut un rol important în dezvoltarea spectrometriei analitice. Astfel, plasma cuplată inductiv (ICP - Inductively Coupled Plasma) și plasma indusă în microunde (MIP - Microwave Induced Plasma) sunt folosite cu foarte mult succes ca surse spectrale în spectroscopia de emisie și de fluorescență atomică și ca surse de ioni în spectrometria de masă. Față de alte surse spectrale (flacără, arc, scânteie etc.) plasma cuplată inductiv are o serie de avantaje: temperatură foarte înaltă (8.000 -10.000 K), efecte interelement minime, gama dinamică largă (4-5 ordine de mărime) și limite de detecție foarte coborâte ($< 1 \text{ ng ml}^{-1}$). O altă formă de descărcare întreținută în câmpuri electromagnetice alternative este plasma cuplată capacitiv, numită CCP (Capacitively Coupled Plasma) atunci când este întreținută în radiofrecvență și CMP (Capacitively Microwave Plasma) atunci când este întreținută în microunde. Pusă în evidență în anul 1928 și studiată mai ales din punct de vedere al fenomenelor fizice în anii '40, plasma cuplată capacitiv a început să fie folosită pe scară largă în scopuri analitice (ca sursă spectrală în spectroscopia de emisie și absorbție atomică, ca detector în cromatografia de gaze) doar în ultimii cincisprezece ani. Deși CCP, CMP și MIP nu au temperatura plamei cuplate inductiv, totuși ele sunt surse spectrale promițătoare, acoperind un domeniu de temperaturi cuprins între cel al surselor clasice (flacără, arc, scânteie) și cel al ICP.

Plasmele menționate mai sus sunt descărcări în gaze întreținute în câmpuri electromagnetice alternative având frecvențele cuprinse în domeniul radio (10 -

lichidă sau solidă, aceasta poate fi atomizată, ionizată și excitată și, la revenirea atomilor și ionilor din stările excitate pe stări energetice inferioare, sunt emise radiații fotonice caracteristice. În Fig.5.1 sunt prezentate schematic speciile majore și procesele de excitare-dezexcitare din plasmă.

5.2 Mecanisme radiative

Mecanismele folosite cel mai des pentru descrierea proceselor de excitare în câmpuri electrice alternative sunt recombinarea-ionizarea radiativă și impactul electronic. Primul pas în procesele de ionizare-recombinație este ionizarea Penning, descrisă de ecuația:



urmată de recombinarea radiativă a ionului generat cu un electron liber:



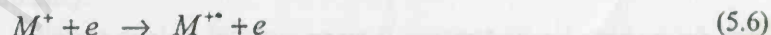
În aceste ecuații M este un atom din proba introdusă în plasmă, Ar este un atom de argon (dacă argonul este gazul "materie primă" pentru plasmă), e este un electron, $h\nu_o$ este o radiație fonică continuă iar asteriscul desemnează o stare excitată. Dacă ionul generat în etapa Penning este excitat, el poate reveni pe starea fundamentală emițând radiația caracteristică de rezonanță:



În mod similar, un atom care este rezultatul unui proces de recombinație electron - ion va fi probabil excitat și va emite o radiație caracteristică:



Excitarea atomilor și ionilor prin ciocniri electronice poate fi și ea descrisă prin procese care au loc în două etape:



urmate de reacțiile de dezexcitare (5.4) și (5.3) și de emisia radiațiilor caracteristice $h\nu_x$, respectiv $h\nu_y$.

Excitarea ionilor prin ciocniri electronice în absența oricărui tip de interacție Penning poate fi descrisă prin procese care au loc în trei etape. Acest mecanism poate fi inițiat prin ionizarea atomilor la impact electronic, ionii rezultați putând fi atât în stare fundamentală cât și în stare excitată în funcție de energia electronului incident:



Revenirea ionilor excitați în starea fundamentală se va desfășura conform ecuației (5.3).

5.3 Introducerea probei în plasmă

Toate aceste mecanisme care au drept consecință radiația plasmelor fac posibilă utilizarea ca surse spectrale a plasmelor întreținute în câmpuri electromagnetice cu frecvențe înalte, la presiune atmosferică. Pentru determinarea elementelor dintr-o probă este necesară introducerea acesteia în plasmă și transformarea ei în faza de atomi liberi care suferă procesul de excitare-dezexcitare sau procesul de ionizare urmat de excitarea ionilor. Metoda de introducere a probei în plasmă trebuie să asigure o eficiență maximă de transport, care depinde de starea de agregare a probei. Fig.5.2 sunt prezentate etapele procesului de transformare a probelor din plasmă până la starea de atomi sau ioni.

Probele solide pot fi introduse în plasmă direct sau prin evaporare cu laser, arc sau scânteie. Se poate folosi și metoda indirectă de dizolvare a probei în mediu acid sau bazic, soluția fiind obținută fiind apoi introdusă în plasmă prin una din metodele de introducere a probelor lichide. Probele lichide pot fi introduse prin evaporare electrotermică, pulverizare pneumatică sau ultrasonică sau depunerea probei într-o cupă de grafit și introducerea directă a acesteia în plasmă. Probele gazoase pot fi introduse direct în plasmă sub formă de atomi sau molecule.

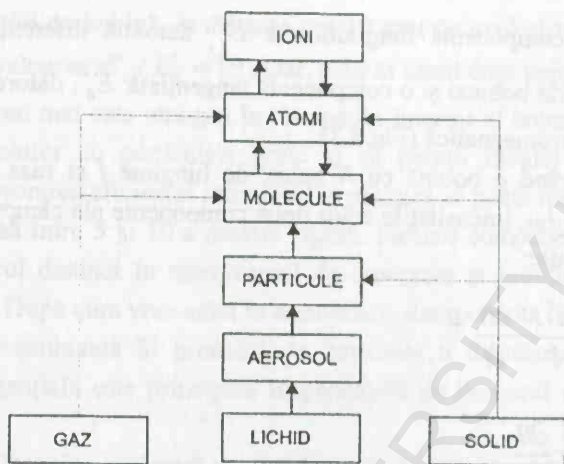


Fig.5.2 - Etapele de transformare a probelor în plasmă.

5.4 Surse spectrale cu plasmă de radiofrecvență

5.4.1 Plasma cuplată inductiv (ICP)

Dacă până în anii '40 plasmăle gazoase în câmpuri de radiofrecvență au putut fi amorsate și întreținute numai la presiuni subatmosferice, după aceea, prin analogie cu metodele de încălzire inductivă în aceleași tipuri de câmpuri, s-a încercat obținerea lor și la presiune atmosferică. Abia în deceniul '60-'70 a fost pusă la punct tehnica de amorsare, întreținere și stabilizare a plasmei cuplate inductiv în curent de argon la presiune atmosferică și au fost începute cercetările de laborator pentru stabilirea posibilităților de utilizare a ei ca sursă spectrală, avându-se în vedere trei caracteristici importante: lipsa electrozilor de contact cu plasma, posibilitatea utilizării drept gaz "materie primă" a argonului și temperatura înaltă. Rezultatul acestor cercetări a fost construirea la începutul anilor '70 a primului spectrometru care folosea ca sursă de excitare plasma cuplată inductiv, în prezent existând mai multe firme specializate în construcția de aparatură spectrală care produc astfel de spectrometre (ARL, Philips, Jobin Yvon, Perkin Elmer, Spectro etc.).

Plasma cuplată inductiv poate fi generată atunci când un tub conținând un gaz este plasat în interiorul unei bobine solenoidale parcursă de un curent intens de radiofrecvență. Câmpul electric în interiorul bobinei este suma vectorială a două

componente: o componentă longitudinală \vec{E}_z , datorată diferenței de potențial dintre extremitățile bobinei și o componentă tangențială \vec{E}_θ , datorată fenomenului de inducție electromagnetică (Fig.5.3).

Considerând o bobină cu N spire, de lungime l și raza R , parcursă de curentul variabil I_{RF} , intensitățile celor două componente ale câmpului electric vor fi date de expresiile:

$$E_z = \frac{\pi R^2 N}{l} \frac{\partial B}{\partial t} \quad (5.9)$$

și

$$E_\theta = \frac{1}{2} r \frac{\partial B}{\partial t} \quad (5.10)$$

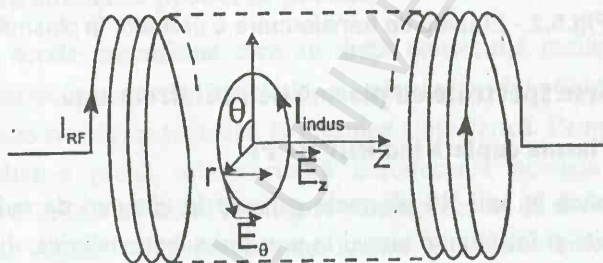


Fig.5.3 - Componentele câmpului electromagnetic într-o bobină solenoidală.

în care s-a ținut seama de ecuația lui Maxwell $\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$, care exprimă legătura dintre câmpul electric și câmpul magnetic, și de simetria cilindrică a configurației date (r - coordonata radială). Făcând raportul celor două intensități se obține o expresie care depinde numai de parametrii geometrici ai bobinei:

$$\frac{E_z}{E_\theta} = \frac{2\pi R^2 N}{rl} \quad (5.11)$$

Ținând seama de relația dintre lungimea bobinei, numărul de spire și distanța dintre ele, se poate observa că, pentru valori date ale razei bobinei R și distanței radiale r până la punctul considerat, mărimea raportului de mai sus nu depinde de numărul de spire. În cele mai multe cazuri pentru generarea plasmei cuplate inductiv se folosesc bobine cu 3-4 spire având diametrul de aproximativ 30

mm. Pentru o astfel de bobină, la distanța $r = 10$ mm de axul ei se obține pentru raportul amintit valoarea $E_z / E_\theta \approx 19$. Dar, cum în cazul unui număr mic de spire câmpul electric nu mai este omogen în tot spațiul interior al bobinei și pentru că ciocnirile electronilor cu particulele grele și cu pereții tubului de descărcare contribuie la micșorarea eficienței câmpului, în practică se poate lua în considerare o valoare cuprinsă între 5 și 10 a acestui raport. Fiecare componentă a câmpului electric are un rol distinct în mecanismul de amorsare și întreținere a plasmei cuplate inductiv. După cum vom arăta în continuare, componenta longitudinală are o contribuție determinantă în procesul de amorsare a descărcării, în timp ce componenta tangențială este principala responsabilă de procesul de menținere a acesteia.

Pentru a întreține o plasmă cuplată inductiv la presiune atmosferică, gazul de lucru (de obicei Ar sau He) este introdus în tubul de descărcare (torță) într-o curgere tangențială cu un debit care depinde dimensiunile acestuia și de puterea absorbită de plasmă. Curgerea elicoidală a gazului asigură atât răcirea tubului de descărcare, cât și stabilizarea turbionară a descărcării. Pentru amorsarea descărcării gazul este inițial ionizat pentru un scurt timp cu ajutorul unei bobine Tesla. Ionii și electronii astfel creați sunt accelerați de către componenta longitudinală a câmpului întreținând ionizarea gazului în direcția curgerii lui și generând un număr de drumuri ionice ("conductori") distincte și deschise încastrate într-un izolator (restul gazului neionizat). Acesta este primul pas al amorsării plasmei, numit "*faza filamentară*". Dacă densitatea acestor filamente conductoare este suficient de mare și curgerea elicoidală a gazului este suficient de intensă pentru ca unele dintre ele să devină drumuri ionice închise, atunci plasma va începe să absoarbă energie suplimentară de la câmpul electromagnetic prin fenomenul de inducție electromagnetică. Acesta este cel de-al doilea pas al amorsării plasmei, numit "*faza continuă*". În această fază, la menținerea descărcării contribuie atât componenta longitudinală cât și cea tangențială ale câmpului electric. Gazul ionizat capătă aproximativ forma unui inel cilindric conductor capabil să absoarbă în continuare energie de la câmp, crescând densitatea de ioni și electroni din plasmă și micșorându-se rezistența ei. Procesul va continua în acest mod și plasma se va dezvolta în volum până când se va stabili un echilibru între energia consumată de aceasta și energia pe care o poate furniza generatorul de radiofrecvență. Din acest moment plasma este "*complet aprinsă*" și

ponderea principală în mecanismul de absorbție a energiei de către plasmă o are fenomenul de inducție electromagnetică (de aceea plasma se numește "cuplată inductiv").

Odată plasma formată se pune problema stabilizării ei deoarece, fiind antrenată de curentul de gaz care traversează tubul în lungul lui, există pericolul stingerii. De aceea plasma trebuie să se propage rapid în câmpul de radiofrecvență împotriva curentului de gaz. Acest deziderat este realizat cu ajutorul stabilizării turbionare bazată pe introducerea tangențială a gazului în tubul de descărcare și deci pe curgerea spiralată a acestuia în lungul peretelui tubului. Această curgere, combinată cu reducerea vitezei gazului la suprafața de contact cu tubul datorită frecării, determină existența unei zone cu presiune mai scăzută de-a lungul axului tubului care face ca plasma să se comprime înspre ax, să se mențină departe de perete și, o parte din ea, să curgă împotriva curentului principal de gaz. În acest mod se elimină atât pericolul stingerii plasmei cât și cel al supraîncălzirii tubului de descărcare, făcând posibilă funcționarea ei la temperaturi înalte.

Datorită structurii ei, plasma cuplată inductiv poate fi considerată ca secundarul unispiră al unui transformator de radiofrecvență cu aer, al cărui primar este chiar bobina inductoare. Din punct de vedere electric, prezența plasmei în bobină va determina pe de o parte o creștere a rezistenței ei de pierderi (concretizată în creșterea consumului de energie de la generatorul de radiofrecvență care alimentează bobina), iar pe de alta o descreștere a inductanței acesteia. Dacă bobina inductoare face parte chiar din circuitul oscilant al oscilatorului, atunci această descreștere a inductanței va determina o creștere a frecvenței oscilațiilor generate.

Generatorul de radiofrecvență care alimentează bobina inductoare trebuie să furnizeze o putere de 1 - 2 kW la frecvențe cuprinse în benzile alocate aplicațiilor industriale din domeniul 12 - 50 MHz. În unele cazuri, oscilatorul și circuitul de ieșire conțin un singur circuit acordat, orice modificare a impedanței plasmei determinând modificări ale parametrilor electrici ai oscilatorului. Alteori, plasma este întreținută în bobina unui circuit oscilant distinct, alimentat de la un oscilator (de obicei controlat cu cuarț) prin intermediul unei rețele de adaptare. Impedanța acestei rețele se reglează automat astfel încât să se asigure o putere utilă maximă și o putere reflectată minimă.

Bobina în care este întreținută plasma are de obicei trei-patru spire din țevă de cupru și este răcită cu apă. Faptul că plasma nu este în contact cu nici un

electrod rezolvă problema contaminării ei cu particule străine, așa cum se întâmplă în cazul arcului sau scânteii electrice.

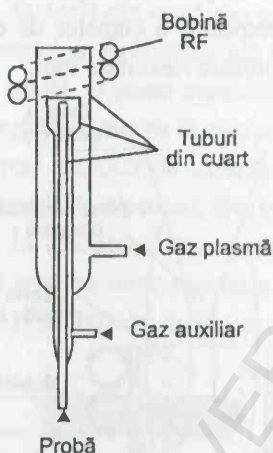


Fig.5.4 - Torță convențională pentru plasma cuplată inductiv.

Pentru utilizarea ICP ca sursă spectrală, ea este amorsată într-o torță alcătuită din trei tuburi concentrice de cuarț (Fig.5.4). Principalul curent de argon ($12 - 18 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$), pe de o parte constituie gazul "materie primă" pentru plasmă, iar pe de alta asigură răcirea tubului exterior al torței. Pentru a ajusta poziția verticală a plasmăi se poate folosi un curent intermediar de argon cu un debit mult mai mic ($0.5 - 1 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$). Proba de analizat, care de regulă trebuie să fie în fază lichidă, este mai întâi pulverizată pneumatic sau ultrasonic și apoi preluată de un al treilea curent de argon ($1 - 2 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$), care o transportă în plasmă.

Trecerea probei prin interiorul plasmăi este facilitată de efectul pelicular (Skin), datorită căruia descărcarea are o formă toroidală și zona axială a ei este mai rece decât zona exterioară (Fig.5.5). Pe acest traseu proba este disociată, atomizată (în zona de preîncălzire) și excitată (în zona de radiație inițială). În acest interval de timp diferitele specii atomice și ionice se relaxează pe stările fundamentale emițând radiațiile lor caracteristice. Pentru scopuri analitice, cele mai importante sunt zona de radiație inițială și zona analitică normală. Aceste zone caracteristice pot fi observate și cu ochiul liber dacă în plasmă se introduce o soluție monoelement de ytriu în concentrație de 1%. Pe axul descărcării, în partea superioară a bobinei și imediat deasupra ei, se observă o zonă având culoarea roz datorată emisiei atomice. Ea se continuă în partea superioară cu o zonă albastră

datorată emisiei ionice, înconjurată înspre coada plasmei de o manta de culoare roșie datorată emisiei oxidului de ytriu. De fapt, această distribuție spațială este și o consecință a succesiunii temporale a etapelor de evoluție a probei: disociere - atomizare - excitare atomi - ionizare - excitare ioni.

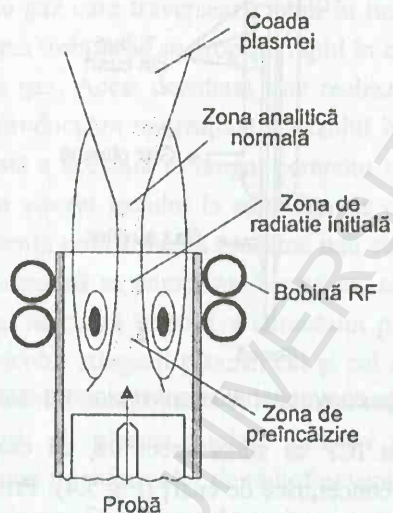


Fig.5.5 - Zonele caracteristice ale plasmei cuplate inductiv.

În ceea ce privește gazul "materie primă", argonul este preferat din două motive: primul, pentru că este un gaz inert și al doilea pentru că dintre gazele inerte este cel mai ieftin din punct de vedere al prețului de fabricație. S-a constatat însă că adăugarea în argon a unei cantități mici de gaz poliatomic (hidrogen, azot, aer sau amestecuri din aceste gaze) poate contribui la îmbunătățirea eficienței descompunerii probei, deoarece aceste gaze absorb energie de la câmpul electric alternativ și pentru a trece în stări energetice vibraționale și rotaționale superioare, contribuind în acest fel la creșterea temperaturii cinetice a plasmei.

5.4.2 Plasma cuplată capacitiv (CCP)

Plasma cuplată capacitiv sau torța capacitivă de radiofrecvență este o formă de descărcare care poate să apară accidental în generatoarele de radiofrecvență de putere relativ mare (peste 100 W), sau care poate fi amorsată deliberat cu scopul studierii mecanismului de amorsare și întreținere, a caracteristicilor electrice sau a parametrilor de plasmă. De asemenea, s-a demonstrat că ea poate fi utilizată în scopuri analitice. Acest tip de descărcare

poate fi întreținut între armăturile unui condensator conectat la o tensiune înaltă de radiofrecvență sau microunde, sau pe vârfuri sau muchii ascuțite având potențiale electrice alternative ridicate. În acest din urmă caz prezența unui al doilea electrod nu este absolut necesară, curentul de radiofrecvență închizându-se prin pământ sau borna de masă. Dacă totuși există, el poate avea diferite forme geometrice (placă, disc, inel etc.), descărcarea putând fi sau nu în contact cu el.

Există mai multe tipuri de CCP la diferite presiuni, frecvențe și puteri consumate, cu diferite combinații de electrozi, fiecare din acești parametri putând fi un criteriu de clasificare. În continuare vom prezenta câteva tipuri de plasma cuplată capacitiv cu aplicații largi ca surse spectrale pentru spectroscopia atomică de emisie și de absorbție, dar și cu utilizări în alte domenii.

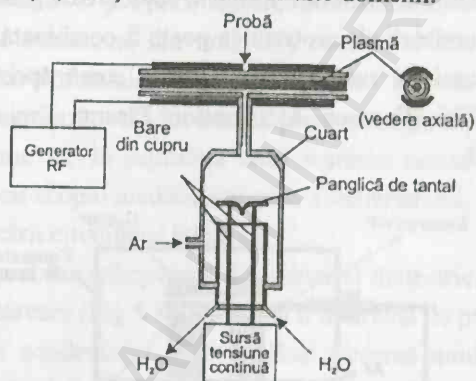


Fig.5.6 - Sursă de plasmă cuplată capacitiv pentru spectrometria de absorbție atomică.

În domeniul frecvențelor radio s-a urmărit construcția unor generatoare capabile să întrețină plasmă cuplate capacitiv la presiune atmosferică în condițiile unui consum total de putere foarte scăzut (sub 100 W) și găsirea unor metode eficiente de introducere în plasmă a probelor de analizat. Astfel, în Fig.5.6 este prezentată o plasmă cuplată capacitiv amorsată într-un tub de cuarț cu lungimea de 20 cm și diametrul interior de 4 mm. Puterea este transmisă plasmei prin intermediul a două armături din oțel inoxidabil (electrozii descărcării), de formă semicilindrică, lungi de 18 cm și late de 0,5 cm, plasate în exteriorul tubului de cuarț în poziții diametral opuse. Electrozii sunt conectați la generatorul de radiofrecvență printr-o bobină cuplată inductiv cu bobina circuitului oscilant al oscilatorului care lucrează la 27,12 MHz. Se obține astfel o plasmă stabilă de argon, heliu sau amestecuri ale acestor gaze cu azot hidrogen sau aer, într-un

domeniu de puteri cuprins între 30 și 600 W și pentru debite de gaz cuprinse între 0,2 și 0,6 l·min⁻¹. Proba de analizat este introdusă în plasmă prin vaporizare electrotermică. Înainte de amorsarea plamei ea este picurată cu ajutorul unei micropipete pe o panglică de tantal încălzită electric, unde este vaporizată și atomizată. Un ciclu de introducere a probei cuprinde trei etape care pot fi controlate și optimizate independent: uscarea, calcinarea și atomizarea. Plasma este amorsată la sfârșitul celei de a doua etape și se înregistrează răspunsul în timp al acesteia prin metodele spectrometriei de absorbție atomică, plasma fiind traversată longitudinal de un fascicol luminos provenit de la o lampă cu catod cavităar ("hallow-cathode"). Sensibilitățile de detecție sunt comparabile cu cele obținute prin măsurători de absorbție folosind cuptoare de grafit.

Eficiența atomizării electrotermice poate fi combinată cu capacitatea mare de excitație a plamei de radiofrecvență într-o sursă spectrală cunoscută sub denumirea de FAPES (Furnace Atomization Plasma Emission Spectroscopy), prezentată în Fig.5.7.

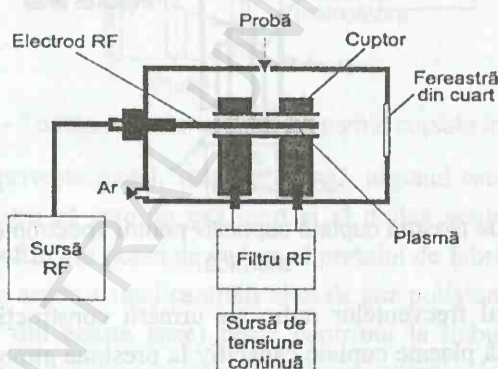


Fig.5.7 - Sursă FAPES.

Ea constă dintr-un atomizor electrotermic (cuptorul) în interiorul căruia se amorsează o plasmă cuplată capacitiv. Cuptorul de grafit este încălzit cu o sursă de curent continuu de putere și este folosit pentru evaporarea și atomizarea probei. Pentru obținerea unei plame în cuptor, în lungul axului acestuia a fost introdusă o bară de tungsten toriat la care este cuplată borna "caldă" a generatorului de radiofrecvență prin intermediul unei rețele de adaptare. Cel de al doilea electrod al descărcării fiind chiar cuptorul, se poate observa că, spre deosebire de sursa pentru spectrometria de absorbție atomică, în acest caz plasma este în contact cu ambii

electrozi. Frecvența de lucru este de 27,12 MHz, puterea în plasmă este în domeniul 10-100 W iar debitul de gaz (Ar) este de 1 l·min⁻¹. În vederea evaporării și atomizării, probele solide pot fi plasate numai pe suprafața interioară a cuptorului, în timp ce probele lichide pot fi plasate atât pe suprafața cuptorului, cât și pe bara de tungsten toriat. Ca metodă de analiză se folosește spectroscopia atomică de emisie, iar sensibilitățile de detecție sunt în domeniul picogramelor.

Una dintre cele mai promițătoare descărcări cu aplicații ca sursă spectrală și în tehnologia materialelor semiconductoare este descărcarea luminiscentă (*Glow Discharge*) în câmp electromagnetic de radiofrecvență la presiuni subatmosferice. Fiind ea însăși sursa de atomizare, excitare și ionizare, descărcarea luminiscentă permite analiza directă a probelor solide neconductive, cum sunt sticla și ceramica. Deși este cunoscută din anii '30, ea este aplicată în tehnologiile de fabricație a dispozitivelor semiconductoare din anii '70 și în chimia analitică din anii '80. În cele ce urmează, vom încerca să prezentăm principiile care stau la baza generării unei plasme RF la suprafața unui material neconductor din care sunt eliberați atomi, fie cu scopul analizei chimice a materialului, fie pentru corodarea lui în vederea fabricării circuitelor integrate.

Dacă pe o probă confecționată din material dielectric, aflată pe electrodul unei incinte de descărcare (Fig.5.8), se aplică o diferență de potențial constantă, ea se comportă ca un condensator, nepermițând trecerea unui curent care să fie capabil să întrețină descărcarea în gaz. Răspunsul potențialului suprafeței izolatorului este asemănător cu descărcarea unui condensator (Fig.5.9).

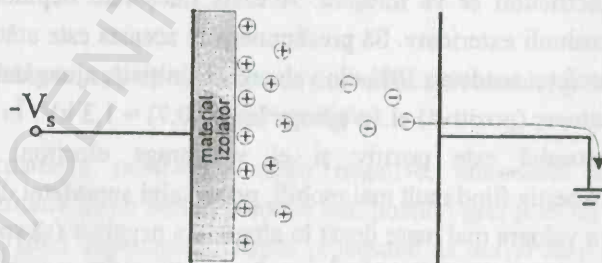


Fig.5.8 – Acumularea de sarcină pe suprafața unei probe izolatoare.

Dielectricul aflat pe electrodul pe care se aplică potențialul negativ $-V_s$ se comportă ca un condensator. Din acest motiv, tensiunea pe el nu poate varia în salt și imediat după aplicarea potențialului exterior, potențialul suprafeței care se află

în contact cu gazul va fi tot $-V_s$. Dacă tensiunea inițială între cei doi electrozi este suficientă pentru amorsarea unei descărcări, atunci ionii pozitivi se vor acumula pe suprafața dielectricului, anulând potențialul negativ al acesteia. Deoarece dielectricul nu permite trecerea curentului continuu prin el, descărcarea se va stinge.

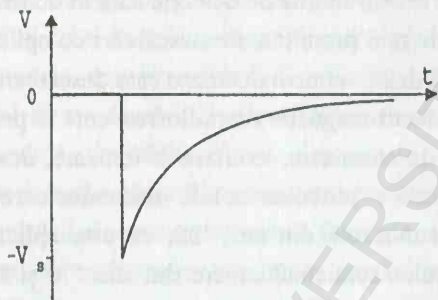


Fig.5.9 - Răspunsul potențialului unei suprafețe izolatoare la o tensiune continuă.

Cu totul altfel se petrec lucrurile dacă între cei doi electrozi se aplică o diferență de potențial alternativ, cu o frecvență care să nu permită ionilor pozitivi (mai puțin mobili decât electronii) să se deplaseze în ritmul variațiilor câmpului exterior. Să presupunem că potențialul alternativ este de forma unor impulsuri dreptunghiulare cu amplitudinea de 2 kV (vârf la vârf, Fig.5.10a).

Evoluția în timp a potențialului suprafeței dielectricului este prezentată în Fig.5.10b. Dacă primul impuls este negativ, în timpul duratei sale potențialul suprafeței dielectricului se va micșora. Această micșorare depinde de perioada impulsurilor tensiunii exterioare. Să presupunem că aceasta este atât de mică încât potențialul suprafeței scade cu 30% din valoarea sa inițială, ajungând la $-0,7$ kV. În alternanța următoare (pozitivă) el va ajunge la $2 + (-0,7) = 1,3$ kV. În timpul acestei alternanțe electrodul este pozitiv și el va atrage electroni pe suprafața dielectricului. Aceștia fiind mult mai mobili, potențialul suprafeței dielectricului se va micșora cu o valoare mai mare decât în alternanța negativă (să spunem cu 55%) ajungând la aproximativ $0,6$ kV. În a doua alternanță negativă potențialul suprafeței izolatoare va ajunge la valoarea de $-1,4$ kV și va scădea la aproximativ -1 kV, după care fenomenele se vor repeta, astfel încât potențialul mediu al suprafeței dielectricului va deveni negativ. Din punct de vedere electric, în regim staționar potențialul suprafeței dielectricului va avea o componentă continuă negativă peste care se suprapune componenta alternativă. De regulă, valoarea

componentei continue negative este egală cu jumătate din tensiunea vârf-vârf a semnalului alternativ aplicat între electrozi (în exemplul de mai sus, -1 kV). Ea depinde de geometria electrozilor și de parametrii de operare a plasmei. Deoarece suprafața liberă a probei dielectrice este la un potențial mediu negativ, electrodul pe care se află ea este asimilat catodului dintr-o descărcare în curent continuu, atribuindu-i-se această denumire, deși operarea se face în curent alternativ.

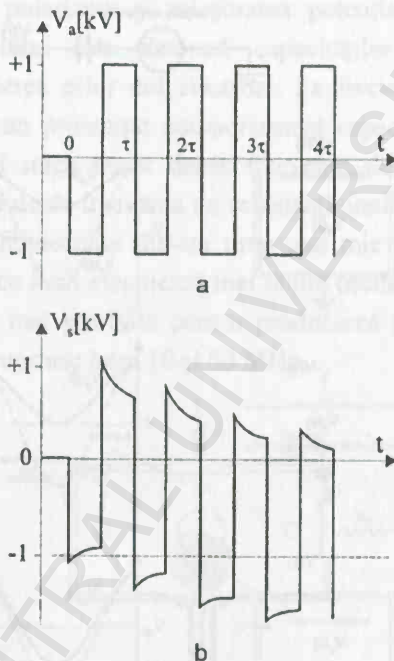


Fig.5.10 - Răspunsul potențialului unei suprafețe izolatoare (V_s) la o tensiune alternativă (V_a).

Ca urmare a polarizării medii negative, *materialul dielectric* este bombardat alternativ de un număr mare de ioni pozitivi grei și de un număr mic de electroni ușori, fiind în consecință supus procesului de *pulverizare catodică*. Este important să subliniem încă odată, că natura capacitivă a proceselor care au loc la suprafața dielectricului este datorată mobilității diferite a celor două tipuri de purtători de sarcină: ionii pozitivi și electronii. Această comportare nu se va regăsi în cazul în care pe electrod nu există materialul dielectric, potențialul mediu al lui fiind nul.

Majoritatea electronilor din descărcare sunt produsul secundar al procesului de pulverizare. Ei sunt accelerați de către căderea normală de tensiune catodică și intră în lumina negativă unde cedează energia atomilor de probă și de gaz, producând excitări și ionizări. Atomii de gaz care au nivele metastabile cu timp de viață ridicat pot influența ionizarea atomilor de probă prin procese de tip Penning.

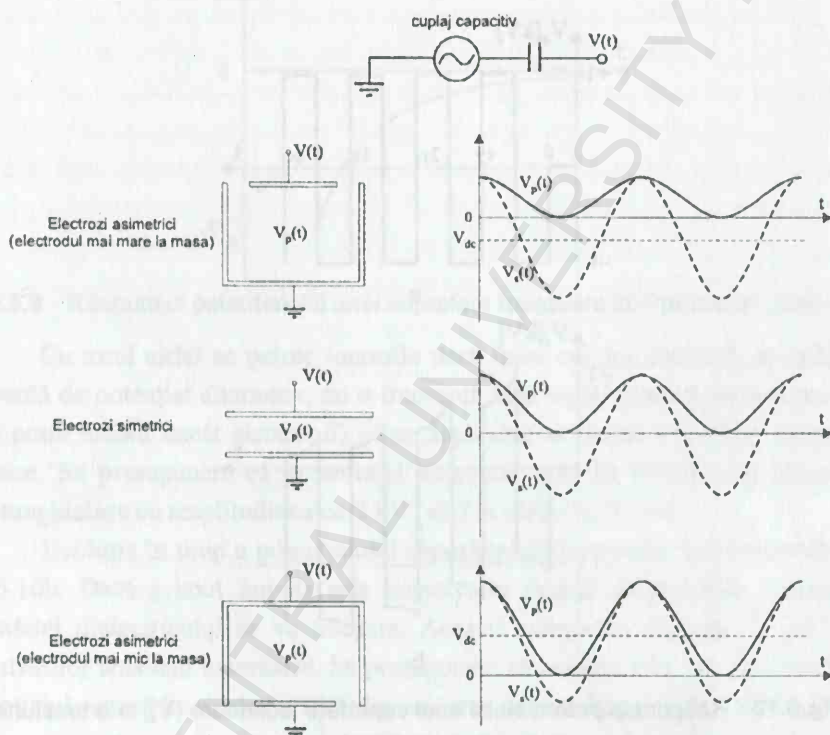


Fig.5.11 - Geometrii posibile pentru electrozi și potențialele electrice corespunzătoare.

Geometria descărcării reprezintă un factor critic de care depinde atât energia ionilor pozitivi care provoacă pulverizarea cât și randamentul pulverizării. Valoarea negativă continuă a potențialului suprafeței libere a probei și randamentul pulverizării sunt determinate de raportul ariilor suprafețelor celor doi electrozi ai descărcării. După cum se vede din Fig.5.11, numai în condițiile unei asimetrii puternice a electrozilor, suprafața dielectricului aflat pe electrodul pe care se aplică potențialul RF va avea o componentă continuă a potențialului.

Această componentă este negativă dacă potențialul RF se aplică pe electrodul mai mic. Capacitatea dintre sursa RF și descărcare din schema de alimentare (Fig.5.11 sus) reprezintă capacitatea electrică a probei dielectrice. Liniile punctate reprezintă potențialele de polarizare (RF și continuu) ale dielectricului iar linia continuă reprezintă potențialul plasmiei. După cum se poate observa, mărirea raportului dintre suprafața anodului și suprafața catodului determină creșterea tensiunii continue negative de polarizare și micșorarea potențialului plasmiei. Această distribuție a potențialului este datorată capacităților diferite ale spațiilor întunecoase din apropierea celor doi electrozi. La frecvențe de ordinul câtorva MHz aceste spații au un pronunțat comportament capacitiv deoarece frecvența câmpului RF este mai mică decât decât frecvența de rezonanță ciclotronică electronică și mai mare decât decât frecvența de rezonanță ionică. Astfel, electronii pot să traverseze spațiile întunecoase într-un timp mai mic decât cel corespunzător unui ciclu RF, în timp ce ionii efectuează mai multe oscilații în același interval de timp. Frecvențele cele mai potrivite pentru producerea pulverizării catodice cu randament optim sunt cuprinse între 10 și 50 MHz.

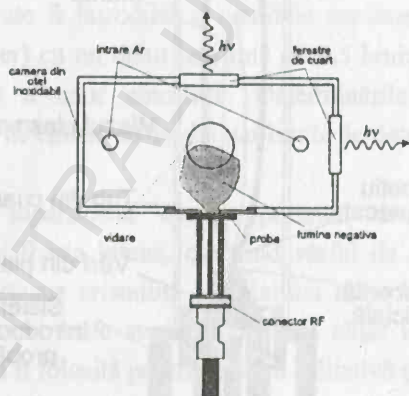


Fig.5.12 - Incintă de pulverizare în descărcarea luminiscentă.

În Fig.5.12 este prezentată o incintă standard pentru producerea pulverizării în câmp de radiofrecvență la presiune subatmosferică. Ea este astfel dimensionată încât densitatea de putere la suprafața probei să fie optimă și randamentul de pulverizare să fie maxim.

O altă geometrie a electrozilor folosită cu succes pentru amorsarea plasmiei cuplate capacitiv de putere mică (30 W, 12 MHz) și medie (100-500 W, 27,12

MHz) este geometria vârf-inel. Plasma, generată la presiune atmosferică, este în contact numai cu unul dintre electrozi, care este vârful ascuțit de platină al unui electrod cilindric de alamă cu diametrul exterior de 8 mm și lungimea de 60 mm. Acest electrod este plasat în interiorul unui tub de cuarț (cu diametrul interior de 15 mm, cel exterior de 18 mm și lungimea de 100 mm) susținut de sistemul de introducere a probei care este confecționat din teflon (PTFE) și care asigură o curgere laminară a aerosolului (proba lichidă pulverizată pneumatic) de-a lungul tubului (Fig.5.13). La o distanță de 45 mm de vârful de platină, tubul de cuarț este înconjurat de al doilea electrod (contraelectrod) care are formă inelară și care asigură simetria liniilor de câmp electromagnetic și deci simetria descărcării. Gazul de întreținere a plasmei este și cel care pulverizează și transportă proba și are un debit de $0,6 - 1,5 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$.

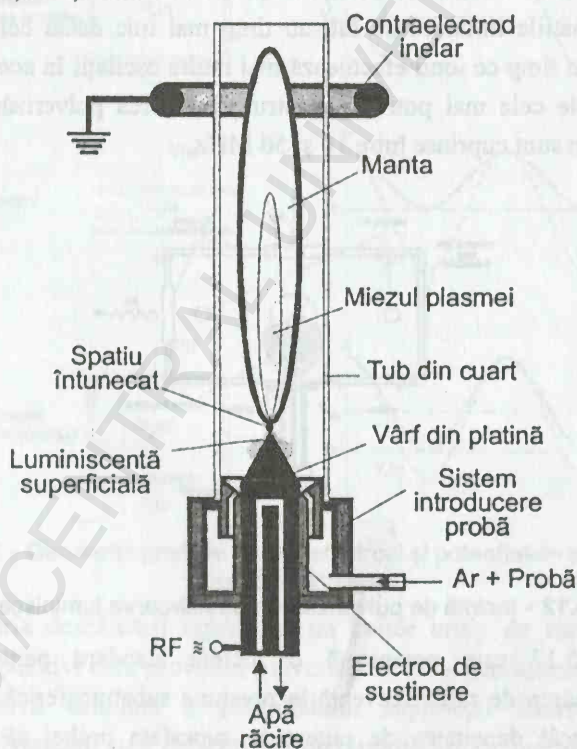


Fig.5.13 - Plasma cuplată capacitiv în geometrie vârf-inel.

În contrast cu plasmăle capacitive descrise anterior care aveau un aspect omogen, plasma generată într-o geometrie asimetrică a electrozilor de tip vârf-inel

are patru zone caracteristice. În imediata vecinătate a vârfului de susținere a plasmă se poate observa un strat subțire (sub 1 mm) foarte luminos numit *luminiscență superficială* și care are toate caracteristicile unei căderi normale de tensiune catodică din descărcarea în curent continuu. Plasma propriu-zisă constă dintr-un miez care în argon este alb-strălucitor și are o temperatură de 3500 - 4000K, și o *manta* mai rece și mai puțin strălucitoare decât miezul și care-l înconjoară pe acesta.

Ultimele două zone sunt separate de luminiscența superficială printr-un spațiu întunecat similar spațiilor întunecate din descărcările în curent continuu. Din punct de vedere analitic sunt importante miezul descărcării și luminiscența superficială.

În miez, elementele introduse prin pulverizare pneumatică din fază lichidă sunt atomizate, excitate și ionizate și, la revenirea pe starea fundamentală emit radiații fotonice caracteristice. Introducerea aerosolului se face printr-un dispozitiv cu douăsprezece canale dispuse concentric cu vârful de susținere a plasmă. Aceasta asigură o curgere laminară a gazului prin tubul de cuarț, fără perturbarea plasmă. În plasmă poate fi introdusă o cantitate suplimentară de gaz (aer sau amestec de argon cu aer) cu un debit mai mic de $0,5 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$ pentru a îmbunătăți condițiile de excitație a unor elemente. Determinările făcute cu metodele spectroscopiei atomice de emisie au evidențiat limite de detecție de la $\text{ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ până la zeci de $\mu\text{g} \cdot \text{ml}^{-1}$.

Luminiscența superficială este importantă deoarece ionii pozitivi, accelerați în câmpul ei foarte intens, ciocnind vârful de susținere, își transferă energia atomilor din rețeaua cristalină a metalului eliberându-i și permițându-le accesul în miezul plasmă unde sunt excitați sau chiar ionizați. În consecință, această geometrie poate fi folosită pentru analiza calitativă și cantitativă a probelor solide dacă vârful de susținere este confecționat chiar din aceste probe, cu limite de detecție de ordinul $10^{-3} - 10^{-2} \%$ pentru unele elemente.

5.4.3 Sursa spectrală tandem

Sursa spectrală tandem ICP-CCP este obținută din sursa "tradițională" de plasmă cuplată inductiv, căreia i se adaugă un electrod metalic ascuțit conectat la potențial nul și care este plasat deasupra plasmă cuplate inductiv, coaxial cu bobina de radiofrecvență (Fig.5.14). El este confecționat din alamă și este răcit cu apă.

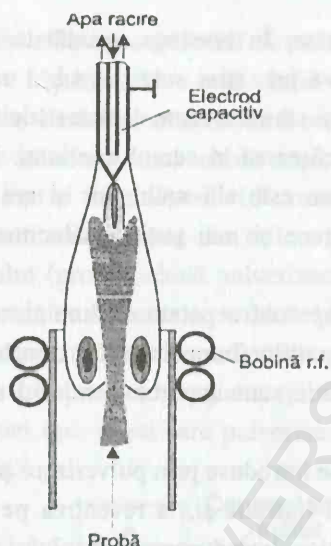


Fig.5.14 - Sursa spectrală tandem.

Această geometrie permite formarea unei descărcări auxiliare datorată câmpului electric care ia naștere între extremitatea superioară a bobinei de radiofrecvență și vârful electrodului ascuțit, mecanismul de transfer a energiei de la câmp la plasmă fiind unul capacitiv. Prezența electrodului suplimentar tinde să localizeze descărcarea pe vârful lui, permițând curentului capacitiv să se scurgă spre masă traversând zona analitică normală și contribuind astfel la îmbunătățirea capacității de atomizare și excitare a plasmei în ansamblul ei. În acest fel se pot obține performanțe analitice comparabile cu cele ale plasmei cuplate inductiv dar cu o putere consumată mai mică. Faptul că transferul energiei de radiofrecvență absorbită de plasmă în energie de excitare și radiativă este mai eficient în cazul sursei tandem este confirmat și de faptul că plasma în sursa tandem de 500 W este mai intensă și mai robustă decât plasma cuplată inductiv cu puterea de 1500 W.

Formarea descărcării capacitive are următoarele efecte asupra plasmei cuplate inductiv peste care este suprapusă: îi elimină coada, produce o mică descărcare globulară albăstruie pe vârful electrodului și determină o creștere ușoară a diametrului porțiunii de plasmă care se află în interiorul tubului de cuarț.

O plasmă de heliu din sursa tandem poate funcționa stabil într-un domeniu de puteri absorbite cuprins între 250 W și 700 W. La puteri mai mici nu mai poate

fi amorsată iar la puteri mai mari apare fenomenul de pulverizare catodică din electrodul capacitiv datorită creșterii căderii normale de tensiune catodică.

Ca sursă spectrală, această plasmă combinată a fost folosită pentru analiza substanțelor gazoase nemetalice conținând F, Cl, Br, I, S și C. Ele au fost introduse într-o plasmă de heliu cu puterea de 500 W, fie prin injectarea directă a probei uscate, fie prin preamestecarea cu vapori de apă obținuți prin pulverizare ultrasonică înainte de injectarea în plasmă. Limitele de detecție obținute sunt comparabile sau mai bune decât cele obținute într-o plasmă de heliu cuplată inductiv cu puterea de 1500 W iar pentru F sunt chiar de șase ori mai mici. Deoarece fluorul, are cea mai mare energie de ionizare dintre elementele amintite mai sus, această limită de detecție foarte bună nu face decât să evidențieze eficiența sursei tandem ICP-CCP. Din punct de vedere al parametrilor fizici, densitatea de electroni este mai mare decât cea din aceeași plasmă cuplată inductiv ($7,4 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ față de $5,6 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$), în timp ce temperaturile de excitare pentru clor și temperaturile rotaționale pentru azot sunt aproape egale (6000 K, respectiv 1800 K).

5.5 Surse spectrale cu plasmă de microunde

Descărcările în microunde au fost observate pentru prima dată în anii '40 de către fizicieni și inginerii electroniști ca fenomene nedorite și perturbatoare apărute în timpul cercetărilor efectuate pentru dezvoltarea sistemelor RADAR. Plasmele de microunde sunt produse prin interacțiunea dintre un câmp electric de ultraînaltă frecvență (uzual 2,45 GHz) și gaze. Ele pot fi clasificate în două categorii: *plasme induse în microunde* (MIP) și *plasme capacitive în microunde* (CMP). Ambele tipuri de plasme de microunde pot fi întreținute la presiuni subatmosferice sau la presiune atmosferică, absorbind puteri scăzute sau medii de la câmp.

5.5.1 Plasma indusă în microunde

O plasmă indusă în microunde este o descărcare fără electrozi, generată într-un tub de sticlă, cuarț sau ceramic, având un diametru interior de la câțiva milimetri până la câțiva centimetri. Energia de microunde poate fi transferată către plasmă folosind o cavitate rezonantă, un ghid de undă coaxial sau o altă structură de microunde cuplată cu un ghid de undă rectangular alimentat de la un magnetron (generatorul de microunde).

În primul caz, rolul cavității rezonante este acela de a permite formarea unei unde electromagnetice staționare care să aibă un maxim de câmp electric în vecinătatea torței de plasmă. Modurile rezonante ale acestor cavități pot fi clasificate în moduri transversal electrice (TE) și transversal magnetice (TM). Deseori aceste moduri nu pot exista în formă pur electrică sau formă pur magnetică și în aceste cazuri se vorbește despre moduri hibride. Cavitatarea care a devenit cea mai utilizată pentru generarea plasmelor induse în microunde care urmează să fie folosite ca surse spectrale sau surse de ioni este cea de tip TM_{010} . Ea s-a dovedit a fi foarte eficientă în generarea plasmelor de heliu sau argon la presiune atmosferică, folosind puteri de intrare foarte mici (40-100 W).

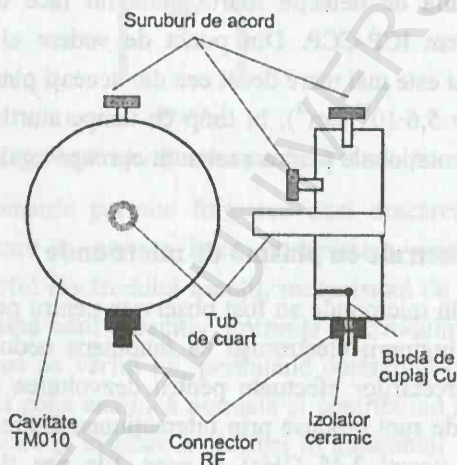


Fig.5.15 - Cavitatarea TM_{010} pentru plasma indusă în microunde.

În Fig.5.15 este prezentată schematic o astfel de cavitatare. Ea este de forma unei cutii de medicamente și este alcătuită dintr-un corp cilindric cu fund fix și capac demontabil. Tubul de descărcare (torța) este montat în centrul cavității, în lungul axului ei. Energia de microunde este transferată spre cavitatare prin intermediul unei antene de cuplaj sub formă de buclă, confecționată din sârmă de cupru cu diametrul de 1 mm. Rezonanța cavității este obținută cu ajutorul unor șuruburi de acord poziționate fie în peretele cilindric, fie în capacul cavității.

În cel de-al doilea caz, microundele generate de un magnetron sunt transferate către o bobină eleicoideală prin intermediul unui cuplor direcțional și unui transformator de mod, și sunt absorbite sub formă de unde circular polarizate

de către plasma aflată în tubul de descărcare plasat în interiorul bobinei elicoidale. Piesa cea mai importantă a acestui ansamblu este *transformatorul de mod*, a cărui schemă este prezentată în Fig.5.16. El este alcătuit din două părți: una este un ghid de undă dreptunghiular cu înălțime redusă pentru realizarea adaptării între impedanța bobinei elicoidale împreună cu plasma și impedanța sursei de microunde; cealaltă este un ghid de undă coaxial cu o impedanță de 50Ω , cuplat cu ghidul de undă dreptunghiular. Un capăt al bobinei elicoidale (cu două spire) este conectat la conductorul interior al ghidului de undă coaxial, iar celălalt la flanșa de capăt a conductorului exterior. Torța constă din două tuburi concentrice de cuarț și este răcită cu aer. Debitul gazului transport-probă (Ar) este de $0,35 - 0,5 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$, iar debitul aerului de răcire este de $60 - 70 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$.

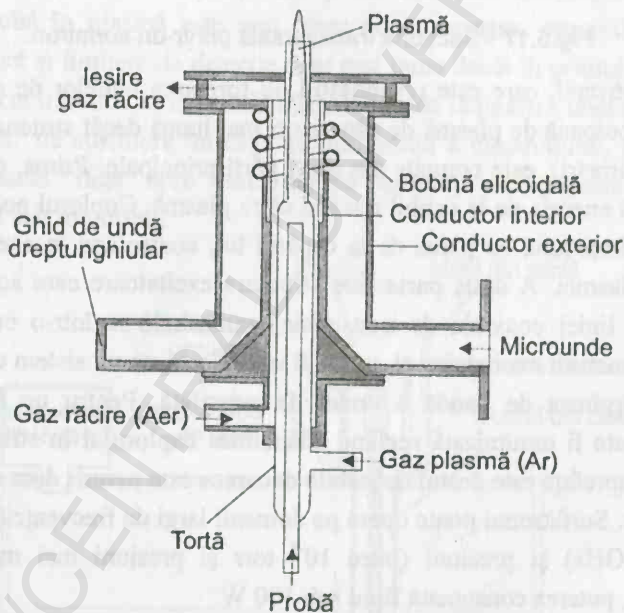


Fig.5.16 - Transformatorul de mod pentru plasma indusă în microunde.

O altă structură de microunde pentru generarea plasmelor induse este *surfatronul* (Fig.5.17). Plasma de microunde de suprafață este legată de propagarea microundelor pe suprafața de separare dintre două medii. Dacă undele de suprafață într-un mediu gazos au energie suficientă, ele pot genera plasma și o pot întreține simultan cu propagarea lor.

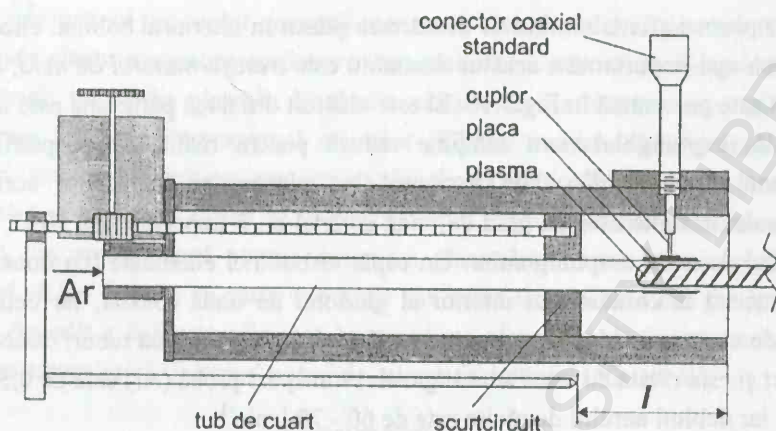


Fig.5.17 - Secțiune transversală printr-un surfatron.

Surfatronul, care este responsabil de formarea undelor de suprafață care generează o coloană de plasmă de câteva ori mai lungă decât structura excitatoare (zeci de centimetri), este compus din două părți principale. Prima, este un cuplor care transferă energia de la cablul coaxial către plasmă. Cuplorul poate fi deplasat pe verticală împreună cu placa de la capătul lui, controlând în acest fel energia transferată plasmei. A doua parte este structura excitatoare care acționează ca o prelungire a liniei coaxiale de transmisie, extinzându-se într-o cușcă Faraday. Lungimea structurii excitatoare, l , poate fi modificată cu un sistem cremalieră. Ea determină lărgimea de bandă a undei de suprafață. Pentru un l dat, puterea reflectată poate fi minimizată reglând adâncimea cuplорului în structură. Plasma undelor de suprafață este destul de stabilă deoarece este permis doar un singur mod de propagare. Surfatronul poate opera pe domenii largi de frecvențe (de la 27 MHz pînă la 10 GHz) și presiuni (între 10^{-4} torr și presiuni mai mari decât cea atmosferică), puterea consumată fiind sub 100 W.

Pentru o plasmă indusă în microunde la presiune atmosferică, cu puterea de 100W, temperaturile de excitație sunt de aproximativ 5000 K pentru Ar și 7200 K pentru He, iar densitățile de electroni sunt în domeniul 10^{14} - 10^{16} cm⁻³. Această plasmă poate fi folosită pentru analiza probelor gazoase, lichide și solide, limitele de detecție fiind cuprinse în domeniul 10^{-3} - 10^3 ng·ml⁻¹.

5.5.2 Plasma cuplată capacitiv în microunde

În cazul generării plasmei cuplate capacitiv în microunde, undele generate de magnetron sunt transmise prin intermediul unui ghid de undă dreptunghiular către un ghid de undă coaxial, al cărui conductor central este chiar electrodul pe care se va forma o plasmă sub formă de flacără. Electrodele centrale pot fi confecționate din platină, wolfram, aluminiu, grafit sau alte materiale conductoare. Au fost concepute două tipuri de configurații geometrice pentru electrod: în una electrodul este o baghetă cilindrică ascuțită la vârf, proba și gazul transport-probă difuzând în plasmă prin partea inferioară a ei imediat deasupra vârfului, iar în cealaltă electrodul este tubular, proba fiind transportată de gaz direct în miezul plasmei. În acest caz interacția plasmă-probă este mai intensă, concentrația de atomi de probă în plasmă este mai mare și, ca urmare, raportul semnal/fond, semnal/zgomot și limitele de detecție sunt mai bune decât în primul. Dezavantajul electrodului central tubular constă în dificultățile de obținere a unei plasme care să aibă ca "bază" de susținere întreaga circumferință a electrodului, cunoscut fiind faptul că plasma "fuge" spre zonele de pe suprafața de susținere care prezintă neregularități sau impurități.

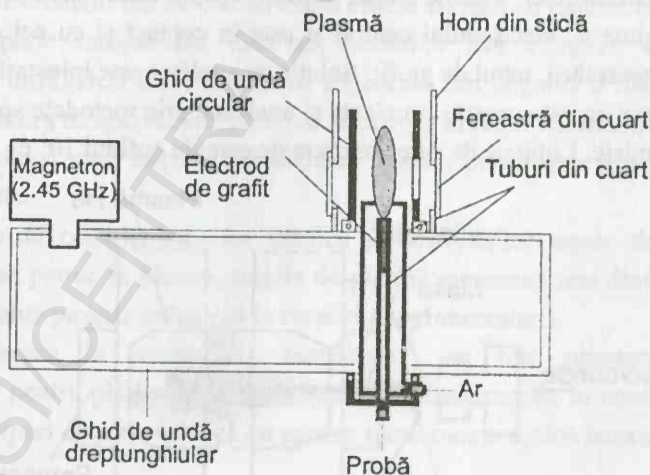


Fig.5.18 - Generator pentru plasma de microunde cuplată capacitiv.

În Fig.5.18 este prezentată schema unui generator de plasmă de microunde cuplată capacitiv cu electrod central tubular. Puterea de operare este de 600 W deoarece s-a constatat că la puteri sub 400 W densitatea de energie din plasmă este

insuficientă pentru a asigura vaporizarea și atomizarea probelor solide și lichide, iar introducerea aerosolului poate cauza dezadaptarea impedanțelor sistemului și stingerea plamei. Torța este asemănătoare cu cea utilizată pentru generarea plamei cuplate inductiv, având însă numai două tuburi de cuarț. Tubul interior se termină cu un vârf de grafit de aproximativ 5 cm lungime prevăzut cu un canal longitudinal cu diametrul de 1mm prin care proba poate intra în plasmă. El reprezintă și electrodul central al ghidului coaxial. Un horn de sticlă prevăzut cu ferestre de cuarț pentru transmisia radiației plamei protejează plasma împotriva curenților de aer care ar putea provoca instabilități ale ei. Gazul pentru întreținerea plamei (Ar, He) are un debit de aproximativ $6 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$ iar cel necesar pulverizării și transportului probei, de $0.4 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$. Zona de observare a semnalului de emisie este localizată chiar deasupra electrodului de grafit.

O altă sursă spectrală cu plasmă cuplată capacitiv în microunde în care proba este vaporizată pe cale electrotermică, este prezentată în Fig.5.19. Ea este similară sistemului FAPES din radiofrecvență, operând însă în banda de frecvențe de microunde de 2,45 GHz. Energia de microunde este furnizată electrodului central de grafit printr-o antenă astfel acordată încât să se lucreze în regim de adaptare a impedanțelor. Plasma umple uniform spațiul dintre cei doi electrozi pe întreaga lungime a electrodului central și este în contact și cu cel de al doilea electrod al descărcării, tubul de grafit. Soluția de analizat este injectată pe peretele cuptorului, apoi ea este uscată, atomizată și analizată prin metodele spectroscopiei atomice de emisie. Limitele de detecție obținute sunt de ordinul 10^1 pg .

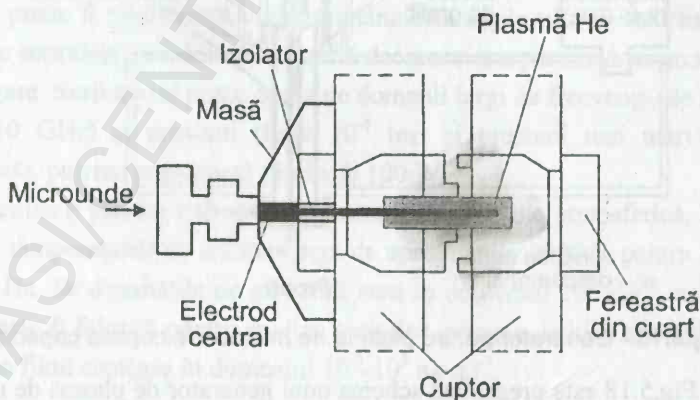


Fig.5.19 - Sistemul FAPES pentru microunde.

Drept gaz suport-plasmă a fost folosit heliul cu un debit cuprins între 50 și 360 ml·min⁻¹. Datorită bunei stabilități în timp a acestui tip de plasmă a fost lansată ideea utilizării ei în procesul de analiză a probelor solide prin pulverizare catodică (sputtering).

5.6 Torțe de plasmă

Performanțele analitice ale surselor spectrale cu plasmă sunt puternic dependente de zona din plasmă în care este introdusă proba care urmează să fie analizată. Pentru obținerea unui raport semnal/zgomot cât mai bun este necesar ca proba să ajungă în acele zone ale plasmelor în care capacitatea de disociere, atomizare și excitare a plasmelor este cea mai mare. Atingerea acestui deziderat depinde de starea în care se află proba (lichidă sau solidă), de sistemul de introducere a ei în plasmă și de configurația geometrică a incintei în care este generată plasma.

După cum am mai arătat, în cazul unei plasmă întreținută la presiune atmosferică nu poate fi vorba despre o incintă închisă în care ea să fie confinată. În majoritatea cazurilor plasma este amorsată și întreținută într-un tub de cuarț sau alt material termorezistent, tub care la un capăt este în contact cu mediul înconjurător. Tubul face parte întotdeauna dintr-un ansamblu mai complex care poartă denumirea de torță. Deși acest termen ne sugerează mai degrabă o flacără, el este folosit în literatura de specialitate pentru a simboliza întregul ansamblu în care este generată plasma și care asigură introducerea gazului plasmogen și a probei care trebuie studiată.

Datorită complexității lor tehnice și necesităților legate de procesele chimice care se petrec în plasmă, torțele de plasmă reprezintă una dintre cele mai delicate probleme pe care trebuie să le rezolve experimentatorii.

Deoarece în paragrafele anterioare au fost prezentate torțele convenționale pentru plasmă de radiofrecvență și microunde, în continuare vom prezenta alte tipuri de torțe folosite cu succes spectrometria optică bazată pe sursele cu plasmă.

5.6.1 Torțe pentru plasma de radiofrecvență (RF)

5.6.1.1 Torțe pentru plasma RF cuplată inductiv

Principial, un tub de cuarț parcurs de un curent laminar de gaz, plasat în interiorul unei bobine parcurse de un curent de radiofrecvență, este suficient pentru a genera o plasmă cuplată inductiv (ICP) dacă în gaz se generează purtători inițiali de sarcină (de exemplu cu o bobină Tesla). Rezultatul va fi o plasmă de forma unei sfere alungite susținută numai în câmpul de radiofrecvență. Comportarea ansamblului plasmă-tub depinde de diametrul acestuia, de debitul de gaz și de puterea absorbită de plasmă. În cazul în care curentul de radiofrecvență este mare, plasma poate ajunge în contact cu tubul de cuarț și, datorită temperaturii ei foarte ridicate, îl poate topi. De aceea este necesară răcirea tubului de cuarț fie cu apă, fie cu aer, fie prin introducerea tangențială a unui curent suplimentar de gaz, similar gazului plasmogen. Atunci când răcirea se face cu apă, tubul de cuarț devine peretele interior al unui condensator. Dacă răcirea se face prin introducerea tangențială a gazului, atunci este necesar un tub de cuarț exterior, concentric cu primul și mai înalt decât el, formându-se astfel un strat de gaz mai rece care învelește plasma și o împiedică să atingă tubul de cuarț. De asemenea, datorită debitului mai ridicat al curentului tangențial de gaz ($12 - 20 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$) plasma se alungește mult în exteriorul sistemului de tuburi, având aspectul cozii unei comete. S-a constatat că plasma poate fi susținută numai în curentul tangențial de gaz deoarece în zona de deasupra tubului mai scurt, datorită depresiunii create pe axul tubului, gazul se va extinde în interior și plasma se va forma deasupra lui. În plus, așa cum am arătat în paragraful 5.4.1, introducerea tangențială a gazului favorizează amorsarea mai ușoară a plasmei și pătrunderea probei prin plasma cuplată inductiv (vezi și Fig.5.4 și 5.5). Proba este introdusă printr-un al treilea tub cu diametrul mai mic decât primele două, aflat chiar pe axul sistemului, cu orificiul de ieșire la nivelul tubului intermediar sau cu 1 mm mai jos.

În literatura de specialitate atunci când se vorbește de curentul exterior de gaz se folosește noțiunea de gaz de răcire, iar atunci când se vorbește de curentul intermediar se folosește noțiunea de gaz plasmogen. Curentul de gaz care pulverizează sau preia proba și o introduce în plasmă este cunoscut sub denumirea de gaz de transport, injector sau nebulizator.

Pentru prevenirea supraîncălzirii torței poate fi folosită și răcirea cu aer, renunțând la curentul exterior de gaz și economisind gazul plasmogen care de obicei este scump. Experimental s-a constatat că pentru menținerea tubului de cuarț la o temperatură mai mică de 1000 K, la un consum de argon de 1 l/min⁻¹, este necesar ca peretele torței să disipe în mediul ambiant o putere de 200 W. Această putere poate fi preluată de un curent de aer cu un debit de 50 l/min⁻¹. În Fig.5.20 este prezentat sistemul de răcire cu aer a unei torțe de plasmă cuplată inductiv.

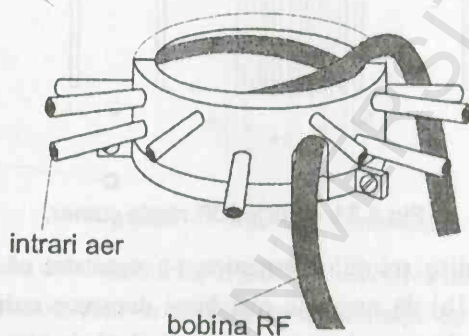


Fig.5.20 – Dispozitivul de răcire cu aer pentru torțe ICP.

El constă din două piese semicilindrice, prinse împreună cu două șuruburi și fixate foarte strâns pe bobina de radiofrecvență. Aerul este introdus în interiorul bobinei de radiofrecvență prin 14 tuburi dispuse echidistant pe întreaga circumferință și înclinate la 10° față de verticală. Întreg dispozitivul este confecționat din teflon.

Cu acest sistem de răcire au fost experimentate diferite tipuri de torțe, prezentate în Fig.5.21 (dimensiunile sunt date în mm). Astfel torța din Fig.5.21a este construită doar din două tuburi de cuarț și poate fi folosită cu succes la analiza soluțiilor apoase.

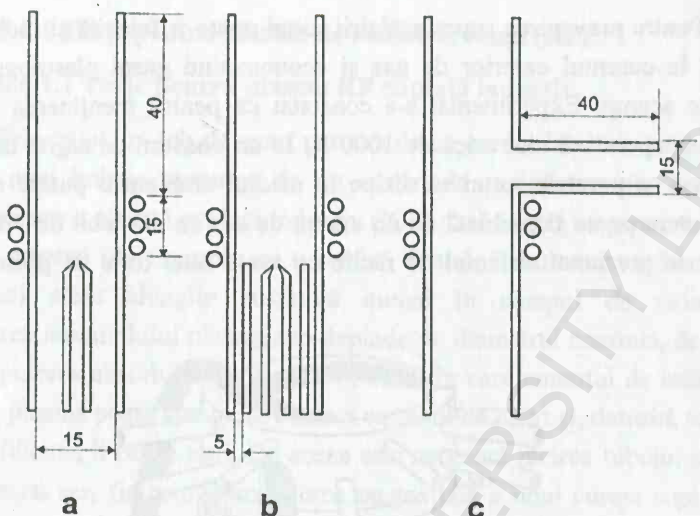


Fig.5.21 – Torțe ICP răcite cu aer.

Pentru analiza soluțiilor organice s-a constatat că torța cu trei tuburi concentrice (Fig.5.21b) dă rezultate mai bune deoarece curentul intermediar de argon asigură o stabilitate mai bună a plasmei. Ambele torțe se extind cu 55-60 mm deasupra bobinei de radiofrecvență pentru a proteja plasma de turbulențele create de aerul de răcire. Efectul acestei extensii este creșterea intensității de emisie a continuumului și descreșterea intensității de emisie a benzilor moleculare. În plus, faptul că plasma se află în totalitate în interiorul tubului de cuarț favorizează depunerile de carbon pe tub și necesitatea curățirii sale destul de des. Acest inconvenient poate fi atenuat prin adăugarea unei extensii laterale, perpendiculară pe tub, prin care să poată fi observată plasma (Fig.5.21c). S-a constatat că tubul lateral nu afectează stabilitatea plasmei.

Pentru evitarea folosirii unor debite mari de argon dar și a unor sisteme destul de complicate de răcire cu aer, s-a studiat posibilitatea folosirii în construcția torței a unor materiale refractare: alumina, carbura de siliciu sau nitrura de bor. În Fig.5.22 este prezentată o astfel de torță în care în zona cea mai afectată de supraîncălzire a tubului exterior de cuarț a fost intercalată o porțiune confecționată din nitrură de bor. Părțile componente sunt prelucrate astfel încât să poată fi asamblate fără a fi necesară folosirea vreunui adeziv.

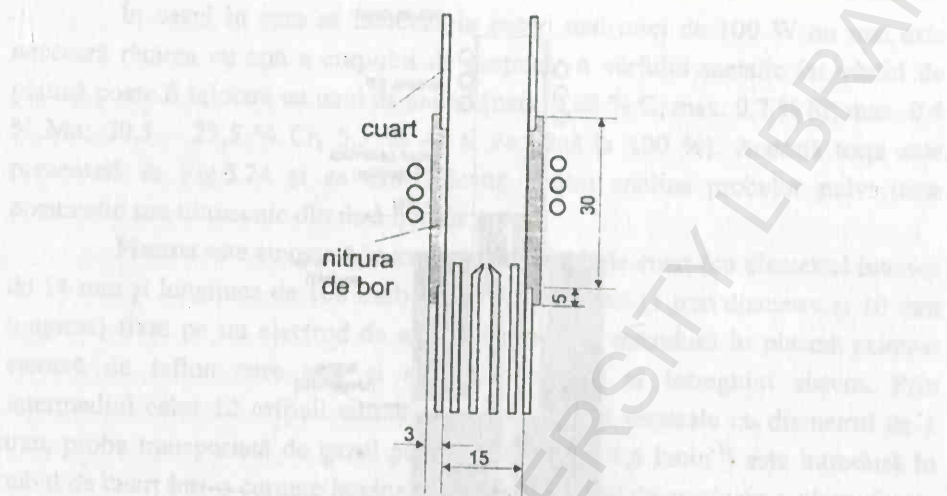


Fig.5.22 – Torță ICP combinată.

Micșorarea consumului de argon fără afectarea randamentului de răcire a tubului exterior și reducerea la maximum a cantității de cuarț consumate sunt deziderate majore ale oricărui proiectant de torțe. În Fig.5.23 este prezentată o torță pentru plasma cuplată inductiv cu consum redus de argon. Ea are în construcție un singur tub de cuarț cu diametrul interior de 14 mm și lungimea de 100 mm iar tuburile interior și intermediar ale torței convenționale au fost înlocuite cu un sistem de introducere a probei format din materiale ieftine: textolit, sticlă de pyrex și alumina sinterizată. Față de torța convențională, debitul de argon de răcire poate fi cu aproximativ 35% mai mic iar plasma poate fi întreținută cu putere cu 38% mai mică. Cu toate că puterea este mai mică, se poate demonstra că densitatea de putere este cu aproximativ 12,5% mai mare decât în cazul torței convenționale. Aceasta asigură limite de detecție comparabile cu cele obținute cu torța convențională.

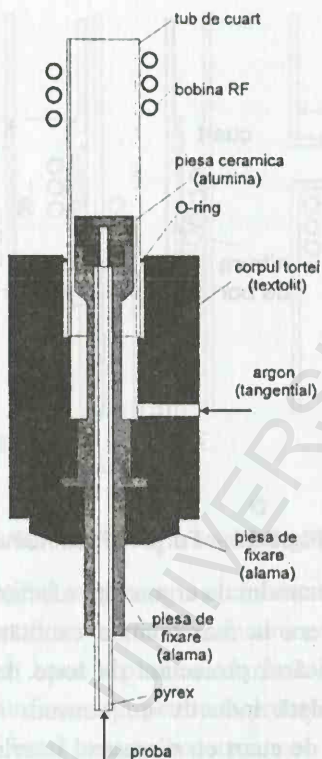


Fig.5.23 – Torță cu consum redus de argon.

5.6.1.2 Torțe pentru plasma RF cuplată capacitiv

Plasma cuplată capacitiv (CCP) poate fi fără contact cu electrozii între care se aplică diferența de potențial de radiofrecvență, în contact cu un ambii electrozi sau în contact doar cu un singur electrod. Datorită faptului că la presiune atmosferică sunt necesare puteri de la câteva zeci de wați în sus, în acest caz plasma trebuie să fie în contact cu cel puțin un electrod iar al doilea electrod poate să existe sau nu.

O torță convențională pentru generarea unei plasmă cuplate capacitiv cu electrod "cald" (electrodul la care este conectată tensiunea de radiofrecvență) cu vârf de platină a fost prezentată în Fig.5.13. Plasma, cu puteri de până la 500 W, este în contact cu electrodul de susținere a ei iar al doilea electrod este un inel care înconjoară în exterior tubul de cuarț.

În cazul în care se lucrează la puteri mai mici de 100 W nu mai este necesară răcirea cu apă a corpului de susținere a vârfului metallic iar vârful de platină poate fi înlocuit cu unul de kantal (max. 0,08 % C; max. 0,7 % Si; max. 0,4 % Mn; 20,5 – 23,5 % Cr, 5,3 % Al și Fe până la 100 %). Această torță este prezentată în Fig.5.24 și ea este folosită pentru analiza probelor pulverizate pneumatic sau ultrasonic din fază lichidă.

Plasma este amorsată în interiorul unui tub de cuarț (cu diametrul interior de 14 mm și lungimea de 100 mm) pe vârful de kantal (1 mm diametru și 10 mm lungime) fixat pe un electrod de alamă. Proba este introdusă în plasmă printr-o cameră de teflon care este și suportul mecanic al întregului sistem. Prin intermediul celor 12 orificii cilindrice concentrice și verticale cu diametrul de 1 mm, proba transportată de gazul plasmogen (argon, $1,6 \text{ l min}^{-1}$) este introdusă în tubul de cuarț într-o curgere laminară. Deoarece vârful de susținere a plasmăi este foarte subțire și ascuțit, câmpul electric în vecinătatea lui este foarte intens și nu mai este necesar un contraelectrod exterior tubului de cuarț pentru menținerea plasmăi.

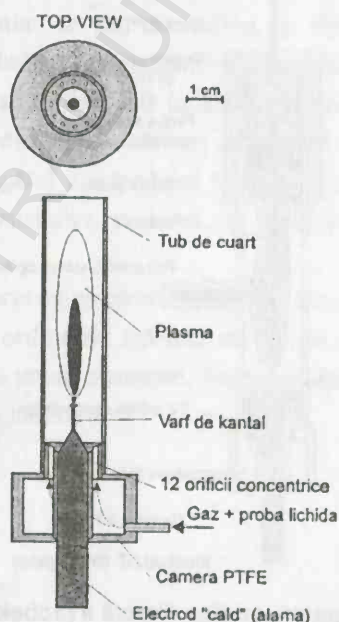


Fig.5.24 – Torță CCP cu vârf de kantal.

Prin modificarea convenabilă a torței precedente s-a realizat o torță pentru analiza directă a probelor solide neconductoare (Fig.5.25). Tubul de cuarț în interiorul căruia este generată plasma este prevăzut cu un tub lateral, perpendicular pe primul, cu diametrul de 5 mm și lungimea de 50 mm prin care se vizează plasma care se extinde și în el. Electrocul de susținere a plasmei este din tungsten cu diametrul de 4 mm și este ascuțit la 45°. Proba neconductoare solidă, de formă cilindrică, este fixată într-un suport din teflon, pe contraelectrodul din alamă. Pentru a obține proba sub această formă ea trebuie prelucrată mecanic sau poate fi presată din stare de pulbere. Producerea particulelor de probă și accesarea lor în spațiul ocupat de plasmă este datorată unui proces asemănător cu pulverizarea catodică a metalelor în curent continuu. Procesul poate avea loc și în cazul corpurilor neconductoare electric dar numai în curent alternativ, datorită asimetriei geometrice a electrozilor și a polarizării suprafeței dielectricului care se comportă ca un condensator.

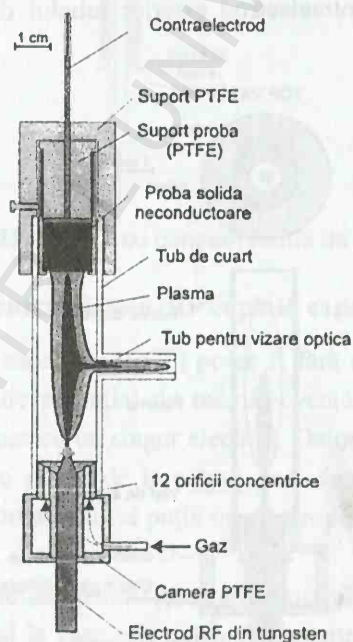


Fig.5.25 – Torță CCP pentru analiza directă a probelor solide neconductoare.

Un alt tip de torță pentru plasma cuplată capacitiv este cel care folosește ca electrod “cald” un tub metalic iar drept contraelectrod un inel conectat la masă.

Ideea folosirii unui astfel de electrod a fost sugerată de forma și structura zonală a unei plasme cuplate inductiv, care permite întregii cantități de aerosol purtător de probă să traverseze plasma prin canalul central, pe întreaga lungime a ei. Electrobul tubular asigură formarea unui astfel de canal și în cazul plasmei cuplate capacitiv. Deoarece proba este transportată în plasmă chiar de către gazul plasmogen, este clar că ea va trece în integralitate prin interiorul acesteia. Dezavantajul acestei torțe este acela că, spre deosebire de cazul în care electrodul “cald” este ascuțit, puterea de radiofrecvență necesară amorsării și întreținerii unei astfel de plasme este mai mare cu aproape un ordin de mărime. Explicația este simplă: spre deosebire de electrodul ascuțit care asigură o suprafață de contact metal-plasmă mică, în cazul electrodului tubular, pentru ca proba să se regăsească în integralitate în plasmă, ea trebuie să se formeze pe întreaga circumferință a tubului-electrod.

În Fig.5.26 este prezentată o torță cu electrod tubular din molibden cu diametrul de 3,5 mm, pentru întreținerea unei plasme de argon cuplată capacitiv la presiune atmosferică. Corpul torței este confecționat din alamă și este răcit cu apă. În interiorul său este montat un tub din teflon cu diametrul de 5 mm care se continuă cu electrodul tubular cu diametrul interior de 2 mm. Ansamblul celor două tuburi se poate deplasa pe verticală în interiorul tubului de cuarț cu diametrul interior de 15 mm. Electrobul inelar exterior, cu diametrul de 25 mm, este plasat la o distanță de 5 mm de capătul electrodului tubular. Plasma formată în interiorul tubului de cuarț are intensitatea maximă de emisie la 10-25 mm deasupra electrodului inelar.

Folosirea unor torțe cu electrod “cald” tubular a condus la obținerea unor limite de detecție cu 1-2 ordine de mărime mai bune decât în cazul torțelor cu electrod ascuțit sau, pentru unele elemente, limite de detecție comparabile cu cele obținute cu plasma cuplată inductiv.

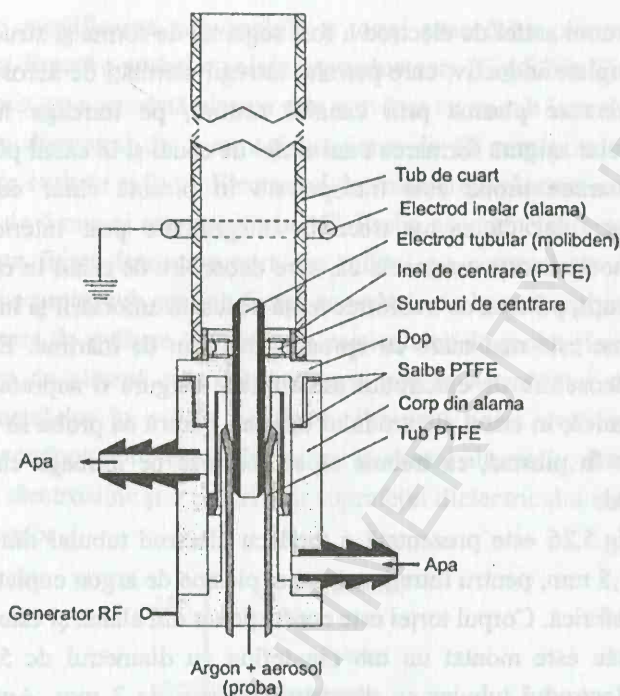


Fig.5.26 – Torță CCP cu electrod tubular.

5.6.2 Torțe pentru plasma de microunde

În paragraful 5.5.2 au fost prezentate modurile de generare a principalelor tipuri de plasmă de microunde împreună cu torțele așa-numite standard. Diferența dintre torța pentru plasma capacitivă de microunde din Fig.5.18 și cea din Fig.5.27 este modul de introducere a probei și faptul că aceasta din urmă este alcătuită din trei tuburi de cuarț. Cuplarea la câmpul de microunde se face prin intermediul unei antene terminată cu un vârf din material refractar. Pentru ca puterea în plasmă să fie maximă este necesar ca antena să fie plasată la o distanță egală cu un sfert din lungimea de undă în ghid față de capătul ghidului dreptunghiular. Microundele sunt direcționate spre vârful antenei printr-un ghid de undă coaxial, montat perpendicular pe ghidul de undă dreptunghiular.

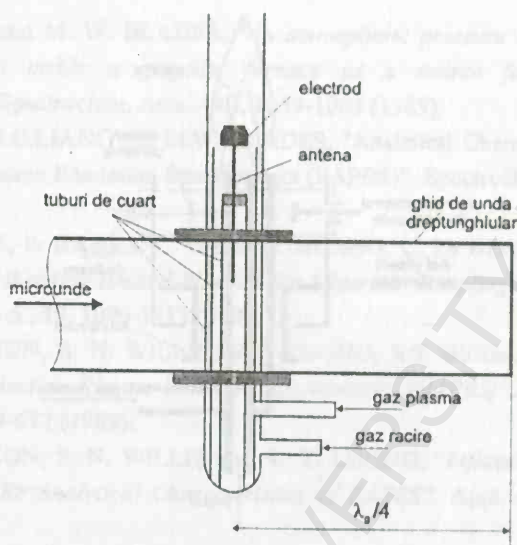


Fig.5.27 – Torță pentru plasma capacitivă de microunde.

O plasmă de microunde care poate fi menținută cu un debit foarte mic de argon ($10 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1}$) și puteri cuprinse între 40 și 500 W este generată cu torța prezentată în Fig.5.28, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea MPT (Microwave Plasma Torch). Spre deosebire de plasma indusă în microunde și de cea generată cu surfatronul, această plasmă poate suporta mult mai ușor introducerea probelor lichide. Torța este similară cu cea standard folosită pentru plasma cuplată inductiv (ICP) dar tuburile concentrice sunt metalice. Prin tubul intermediar se introduce gazul plasmogen iar proba și gazul de transport al ei sunt introduse prin tubul central al torței. Plasma nu este în contact cu vârful electrodului și nu va fi contaminată cu elemente constitutive ale lui. Energia de microunde de la generator este cuplată la torță prin intermediul unei antene cilindrice care înconjoară tubul intermediar și este acordată prin modificarea distanței ei până la vârful torței și prin modificarea poziției scurtcircuitului.

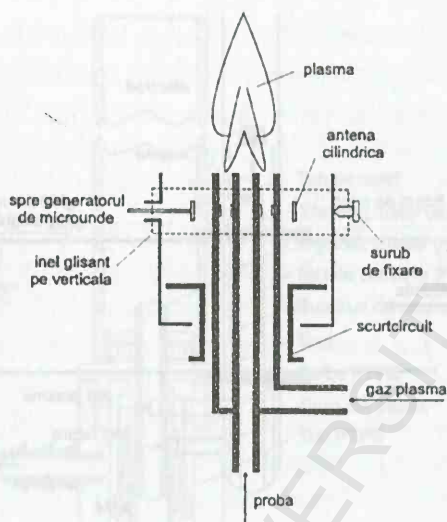


Fig.5.28 – Torța de plasmă pentru microunde (MPT).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. G. CRISTESCU and R. GRIGOROVICI, "Study of high frequency torch. Measurements of voltage, current and power". An. Acad. RPR, vol. 3, pp. 63-78 (1949).
2. P.W.J.M. BOUMANS, F.J. de BOER and J.W. de RUITER, "A Stabilized R.F. Argon-plasma Torch for Emission Spectroscopy". Philips Techn. Rev., 33, 50-59 (1973).
3. N.I. GONCHAR, A. V. ZVYAGINTSEV, R. V. MITIN, and K. K. PRYADKIN, "Electrodeless plasma generator (plasmatron) with capacitive arc discharge". Sov. Phys.-Tech. Phys., vol. 20, pp. 407-408 (1975).
4. P. YANG and R. BARNES, "A Low-Power Oxygen Inductively Coupled Plasma for Spectrochemical Analysis-III. Excitation Mechanism". Spectrochim. Acta., 45B, 157-165 (1990).
5. S.D. ANGHEL, A. POPESCU, A. SIMON and D. STĂNILĂ, "Review on High and Ultrahigh Plasmas Used as Spectral Sources Operated at Atmospheric Pressure". Studia Univ. "Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XLI, nr.1, 89-108 (1996).
6. D.C. LIANG and M.W. BLADES, "Atmospheric Pressure Capacitively Coupled Plasma Spectral Lamp and Source for the Direct Analysis of Conducting Solid Samples". Spectrochim. Acta. 44B, 1049-1057 (1989).

7. D. C. LIANG and M. W. BLADES, "An atmospheric pressure capacitively coupled plasma formed inside a graphite furnace as a source for atomic emission spectrometry". *Spectrochim. Acta.* 44B, 1059-1063 (1989).
8. D.L. SMITH, D.C. LIANG and M.W. BLADES, "Analytical Characteristics of Furnace Atomization Plasma Excitation Spectrometry (FAPES)". *Spectrochim. Acta.* 45B, 493-498 (1990).
9. M.W. BLADES, P. BANKS, C. GILL, D. HUANG, C. Le BLANC and D. LIANG, "Application of Weakly Ionized Plasmas for Materials Sampling and Analysis". *IEEE Trans. Plasma Sci.*, 19, 1090-1113 (1991)
10. R. E. STURGEON, S. N. WILLIE, V.T. LUONG, S.S. BERMAN and J.G. DUNN, "Furnace Atomization Plasma Emission Spectrometry (FAPES)". *Journ. Anal. Atom. Spectrom.* 4, 669-672 (1989).
11. R. E. STURGEON, S. N. WILLIE and V. T. LUONG, "Influence of the Generator Frequency on the Analytical Characteristics of FAPES". *Appl. Spectrosc.* 45, 1418 (1991).
12. R. E. STURGEON, V. T. LUONG, S. N. WILLIE and K. MARCUS, "Impact of Bias Voltage on Furnace Atomization Plasma Emission Spectrometry Performance". *Spectrochim. Acta.* 48B, 893-908 (1993).
13. R. E. STURGEON and S. N. WILLIE, "Furnace Atomization Plasma Emission Spectrometry at Controlled Pressure". *Journ. Anal. Atom. Spectrom.* 9, 759-764 (1994).
14. R.K. MARKUS, "Operation Principles and Design Consideration for Radiofrequency Powered Glow Discharge Devices". *J. Anal. At. Spectrom.* 8, 935-943, (1993).
15. R.K. MARKUS, T.R. HARVILLE, Y. MEI and C.R. SHICK, "RF Powered Glow Discharge". *Anal. Chem.* 66, 902A-911A, (1994).
16. E.A. CORDOS, S.D. ANGHEL, T. FRENTIU and A. POPESCU, "Capacitively Coupled Plasma with Tip-ring Electrode Geometry for Atomic Emission Spectrometry. Analytical Performance and Matrix Effect of Sodium Chloride and Potassium Chloride". *J. Anal. At. Spectrom.* 9, 635-641 (1994).
17. S. MURAYAMA, "Ultrahigh-Frequency Discharge in Atmospheric-Pressure Gas". *Journ. Appl. Phys.*, 39, 5478-5484 (1968).
18. A.T. ZANDER and G.M. HIEFTJE, "Microwave-supported Discharge". *Appl. Spectrosc.*, 4, 357371 (1981).
19. S.K. CHAN, R.L. van HOVEN and A. MONTASER, "Generation of a Helium Inductively Coupled Plasma in a Low-Gas-Flow Torch". *Anal. Chem.*, 58, 2342-2343 (1986).

20. B.M. PATEL, E. HEITHMAR and J.D. WINEFORDNER, "*Tubular Electrode Torch for Capacitively Couple Helium Microwave Plasma as a Spectrochemical Excitation Source*". Anal. Chem., 59, 2374-2377 (1987).
21. J.D. HWANG, W. MASAMBA, B.W. SMITH and J.D. WINWFORDNER, "*Development of High Power, Capacitively Coupled Microwave Helium Plasma for Atomic Emission Spectrometry (CMP-MS)*". Canad. Journ. Phys. 33, 156-160 (1988).
22. S.K. CHAN, H. TAN and A. MONTASER, "*Tandem Helium Plasma Spectrometry with a Capacitively Coupled Discharge Formed Above a Helium ICP*". Appl. Spectrosc., 43, 92-95 (1989).
23. K.A. FORBES, E.E. RESZKE, P.C. UDEN and R.M. BARNES, "*Comparison of Microwave-induced Plasma Sources*". Journ. Anal. Atom. Spectrom. 6, 57-71 (1991).
24. A.H. ALI, K.C. NG and J.D. WINEFORDNER, "*Direct Solid Sampling in Capacitively Coupled Microwave Plasma Atomic Emission Spectrometry*". Journ. Anal. Atom. Spectrom. 6, 211-213 (1991).
25. M.D. ARGENTINE and R.M. BARNES, "*Camparison of Stripline Source and Enhanced Beenakker Microwave Cavity Designs for Atomic Emission Spectrometry*". Journ. Anal. Atom. Spectrom. 7, 1013-1018 (1992).
26. A.E. CROSLYN, B.W. SMITH and J.D. WINEFORDNER, "*A Rewiev of Microwave Plasma Sources in Atomic Emission Spectrometry: Literature from 1985 to the Present*". Critical Reviews in Analytical Chemistry, 27, 199-255 (1997).
27. T.B. REED, "*Induction Coupled Plasma Torch*", Journ. Appl. Phys., 32, 821-824 (1961).
28. A. MONTASER and D.W. GOLIGHTLY, "*Inductively Coupled Plasma in Analytical Atomic Spectrometry*" (Cap.8). VCH Publishers, New Zork, Inc. 1987.
29. P.S.C. van der PLAS, "*Realization of Low Flow Torches for Inductively Coupled Plasma Spectrometry*". Teză de doctorat, Delft University Press, 1987.
30. S.D. ANGHEL, "*Minitorch for Inductively Coupled Plasma Used in Atomic Emission Spectroscopy*". Studia Univ. "Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XXXV, nr.2, 67-71 (1990).
31. H. MATUSIEVICZ, "*Design Considerations and Preliminary Characterization of a Microwave Induced Plasma Atomic Emission Spectrometry System*". Chem. Anal., 40, 667-673 (1995).
32. S.D. ANGHEL, T. FRENTIU, A.M. RUSU, L. BESE and E.A. CORDOS. "*The Analysis of Conductible Solid Samples by RF Capacitively Coupled Plasma at Atmospheric pressure*". Fresenius Journ. Anal. Chem. 355:252-253 (1996).
33. S.D. ANGHEL and M. TODICA, "*Capacitively Coupled plasma as Spectral Source for Direct Analysis of Conductive Samples*". Studia Univ. "Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XLI, nr.2, 67-76 (1996).

34. E.A.CORDOS, T.FRENTIU, A.M.RUSU, S.D.ANGHEL, A.FODOR and M.PONTA, "Analytical Characterization of CCP Torch with central Tube Electrode". Talanta 48, 827-837 (1999).
35. T.FRENTIU, A.M.RUSU, S.D.ANGHEL, A.POPESCU, S.NEGOESCU, A.SIMON and E.A.CORDOS, "Radiforequency CCP Torch with Central Tubular Electrode and Outer Ring Electrode". Acta Chimica Hungarica - ACH Models in Chemistry 136,91 - 129 (1999).
36. S.D.ANGHEL, E.A.CORDOS, T.FRENTIU, A.POPESCU and A.SIMON, "Atmospheric Pressure Capacitively Coupled Plasma Source for Direct Analysis of Non-Conductive Solid Samples". J.Anal.At.Spectrom 14, 541-545, (1999).

Capitolul VI

MODELAREA ÎN FIZICA PLASMEI

6.1 Conceptul de model

Domeniile de aplicație ale plasmei descărcării gazoase sunt într-o continuă dezvoltare, care atrage după sine în mod automat apariția unor noi probleme care necesită soluționări rapide. Dorința de a studia și de a înțelege fenomenele fizice care au loc în plasmă este astfel justificată. Rezultatele științifice obținute în acest sens sunt condiționate de eficiența metodelor de studiu teoretice și experimentale folosite. Dintre metodele “mai” teoretice le amintim pe cele de modelare și simulare (de care ne vom ocupa în acest capitol) iar dintre metodele de studiu experimentale trebuie amintite metodele de diagnosticare care vor fi subiectul unui alt capitol.

Gândirea științifică modernă operează din ce în ce mai puțin cu mărimi (entități) considerate simple și omogene unele față de altele și se impune din ce în ce mai mult folosirea noțiunii de *sistem*, caracterizat prin tipuri specifice de structuri. Astfel, putem numi sistem un ansamblu de elemente în interdependență ce constituie un întreg organizat.

În același timp, evoluția științei și tehnicii în general și a fizicii în mod particular a impus o pătrundere din ce în ce mai adâncă în esența fenomenelor studiate. Aceste fenomene se prezintă sub forme extrem de variate și complexe, rezultând din interacțiunea unui număr foarte mare de factori. O parte din acești factori au un rol deosebit de important în fenomenele observate, pe când alții nu, fiind poate chiar lipsiți de importanță. Fenomenele auxiliare, mai puțin importante, pot umbri fenomenul studiat și de aceea, dacă ele nu pot fi eliminate definitiv vor trebui ca într-o primă aproximație să fie neglijate. Pentru eliminarea informațiilor secundare și punerea în valoare a elementelor principale, sunt necesare cunoștințe profunde, atât din punct de vedere teoretic cât și din punct de vedere experimental.

Să considerăm două sisteme: unul corespunzător situației reale, conținând toți factorii (fie principali, fie secundari) care caracterizează problema respectivă și un al doilea sistem, special, care conține numai factorii principali (cei secundari fiind eliminați complet).

Dacă acest al doilea sistem va permite mai bine studiul fenomenului vizat decât primul, atunci vom putea să ne facem o idee destul de reală despre proprietățile sistemului real, observând modul de comportare al celui special. În acest caz sistemul special, ales pentru studiu poartă denumirea de *model*.

Se spune despre un sistem că este model al unui sistem dat dacă se poate stabili o corespondență bine definită între cele două sisteme. Spre deosebire de sistemul original sistemul model este înzestrat numai cu proprietăți și caracteristici esențiale și de aceea este mai sărac decât originalul. Stabilirea proprietăților și a legăturilor dintre sisteme se face cu ajutorul unor axiome, pe baza cărora se va dezvolta teoria modelului.

Definim modelul ca un sistem material sau abstract care, fiind pus în corespondență cu un alt sistem dat (anterior), va putea servi indirect studiului proprietăților acestui sistem mai complex (original) și cu care modelul prezintă o anumită analogie.

În procesul modelării există un sistem ale cărui proprietăți sau comportament urmează să fie modelat, pe care îl numim *obiect modelat* sau original și un alt sistem care constituie un *model al originalului*. Între original și model sunt corespondențe obiective care ne permit, în anumite situații date, înlocuirea originalului cu modelul și stabilirea de reguli de trecere de la rezultatele obținute pe model la informațiile obținute pe original.

În procesul de modelare apar, în general, trei faze distincte: (a) trecerea de la original la model; (b) studiul pe model și (c) transferul pe original a rezultatelor obținute pe model.

Față de studiul de pe original, studiul efectuat pe model prezintă avantajul că proprietățile sistemului ce constituie modelul sunt mai bine cunoscute și mai ușor de studiat.

În general, modelele folosite în fizică nu sunt izomorfe cu originalul. Trebuie să mai amintim și faptul că din cauza neidentității, modelele au o sferă de valabilitate mai restrânsă iar originalul este mult mai complex decât modelul. Acest lucru se poate compensa prin perfecționarea sau reactualizarea ulterioară a modelului dat.

În esență, limitarea posibilității modelării se datorează: (a) neglijării tuturor fenomenelor considerate într-o primă aproximare ca fiind secundare, dar care în urma trecerii la original sau în condiții experimentale modificate devin la fel de importante ca și fenomenul principal; (b) apariției unor fenomene noi care din punct de vedere al modelării prezintă un caracter parazit; (c) neglijării complete a structurii sau a naturii corpurilor care iau parte la fenomenul studiat (de exemplu la modelarea pe calculator).

Chiar și modelele foarte simplificate pot fi extrem de folositoare în înțelegerea proceselor fundamentale, presupunând că studiul lor se bazează pe înțelegerea temeinică a unui proces fizic important și poate fi reprezentat cu ajutorul unui formalism matematic corespunzător.

Practica arată că, de obicei, modelele se construiesc prin *similitudine*, prin *analogie* sau prin *idealizare*.

Modelarea prin similitudine constă în extinderea asemănării geometrice asupra unor mărimi fizice din domeniul mecanicii, al electromagnetismului etc. Modelul folosit este de obicei o machetă care reproduce originalul la dimensiuni reduse și ale cărei proprietăți se studiază în laborator cu scopul de a fi extinse apoi asupra originalului.

Modelul analogic este un sistem abstract sau concret care se deosebește ca formă geometrică de original, dar care are aceleași proprietăți și “comportament” cu ale lui.

Modelul ideal are un loc intermediar între teorie și experiment. Modelele de acest tip pot fi construite din diferite imagini grafice și/sau formule matematice care sugerează sau prezintă o anumită asemănare cu originalul. Evoluția lor poate fi descrisă matematic datorită idealizării.

Evident această clasificare nu este foarte riguroasă sau exclusivistă, de foarte multe ori un tip de model putând include elemente din celelate două.

6.2 Modelarea în fizica plasmei

Având în vedere cele prezentate mai sus precum și definiția stării de plasmă, putem spune că *plasma* descărcării gazoase este un *sistem cu proprietăți deosebite*:

1. există cel puțin o componentă mobilă (de exemplu electronii – datorită mobilității lor ridicate în raport cu celelalte componente ale plasmei).
2. este neutru din punct de vedere electric la scară macroscopică.

3. particulele interacționează prin intermediul cuplajelor și câmpurilor electromagnetice interne ale plasmiei.

Pentru a studia procesele și fenomenele care au loc în plasmă este necesar să se facă o separare cât mai completă a acestora. Vom putea să ne formăm o imagine cât mai completă despre plasmă dacă vom cunoaște mărimile fizice caracteristice plasmiei: pulsația, densitatea particulelor, conductivitatea sau rezistivitatea electrică, densitatea de putere disipată în plasmă, impedanța complexă a plasmiei, frecvența de ciocnire dintre particule, secțiunile eficace de ciocnire, permitivitatea, temperaturile ce descriu distribuțiile particulelor după energii pe diferitele nivele energetice (de excitare, de vibrație, de rotație). Un rol foarte important este deținut de forțele electromagnetice generate de câmpurile electrice și magnetice ale plasmiei sau de cele aplicate din exterior, forțe care complică foarte mult investigarea plasmelor. Nu în ultimul rând, complexitatea problemei este sporită și de cuplajele care se stabilesc între particule.

Astfel, realizarea unor modele de plasmă este necesară pentru a reduce complexitatea tratării teoretice a fenomenelor și proceselor din ea.

În această ordine de idei se definesc trei mari *submodele de plasmă* care sunt părți componente ale unui model complet. Fiecare submodel poate fi considerat la rândul său un model și este definit de un număr dat de parametri fizici și va presupune un set de date obținute fie pe cale experimentală, fie pe cale teoretică.

1. Un model care prezintă modul în care se desfășoară procesele (reacțiile) care dau naștere la purtătorii de sarcină și ce efecte ulterioare vor avea asupra descărcării. El descrie procesele și interacțiunile chimice din plasmă și de aceea este denumit foarte sugestiv *model plasmă-chimic*. Aceste procese elementare au loc în volumul gazului și, de regulă, reprezintă ciocniri între două particule componente (rareori trei): electroni, ioni, atomi, molecule, fotoni. Se aproximează că între două ciocniri consecutive particula studiată se va mișca numai sub influența câmpurilor externe (dacă ele există), fără să fie perturbată de microcâmpul creat de celelalte particule vecine.

Astfel, pentru ca elementul de bază al submodelului plasmă-chimic, *ciocnirea*, să aibă sens trebuie satisfăcute două criterii: (a) drumul liber mediu să fie mult mai mare decât raza medie de acțiune a particulelor și (b) între două ciocniri particula să se mișcă liber, cu un impuls bine determinat (acest lucru se întâmplă dacă lungimea de undă de Broglie asociată particulei este mult mai mică

decât drumul liber). Nesatisfacerea acestor criterii face ca noțiunea de ciocnire să nu mai aibă sens, interacțiunea simultană a unui număr foarte mare de particule conducând la noțiunea de plasmă colectivă.

În urma analizei detaliate a ciocnirilor binare (elastice și inelastice) care au loc în volumul gazului și care au fost prezentate în Capitolul II, din acest submodel se pot trage următoarele concluzii foarte utile:

- particulele mai ușoare nu pot pierde foarte multă energie în favoarea particulelor mai grele, totuși vor avea loc schimbări substanțiale în impuls (\sim tenis)
- o particulă în mișcare care ciocnește frontal o altă particulă identică, aflată în repaus, își poate transfera energia în totalitate celei de a doua particule (\sim biliard)
- particulele ușoare își pot pierde întreaga energie la ciocnirea inelastică cu o particulă grea (\sim glonț/sac de nisip)
- particulele de mase egale nu pot pierde mai mult de jumătate din energia lor la o ciocnire inelastică (\sim ionizare prin impact ionic)
- ciocnirile binare în care cel puțin o particulă este încărcată electric pot fi dominate de forțe coulombiene având rază mare de acțiune.

2. Plasmele de laborator sunt confinate și au o întindere fizică bine definită. Procesele elementare de volum au loc în interiorul suprafeței confinate, dar este inevitabilă interacțiunea particulelor din plasmă cu factorii fizici care confinează plasma (pereții incintei, electrozii descărcării) sau cu suprafața unui material care vine în contact cu plasma. Astfel ia naștere încă un set de procese elementare, denumite de suprafață. Pentru a putea descrie în mod real procesele de la interfața plasmă – material (nucleație, expulzare de material, emisie secundară, sputtering, etching, etc.) s-a introdus un al doilea submodel numit *model superficial*, care neglijează orice proces care are loc în altă parte decât în imediata vecinătate a suprafeței de contact dintre plasmă și materialul dat.

Principalele reacții la suprafață și efectul lor imediat sunt:

- $AB + C_{solid} \longrightarrow A + BC_{vapori}$ (\sim “etching”, material corodat)
- $AB \longrightarrow A + B_{solid}$ (\sim depunere, film subțire)
- $e^- + A^+ \longrightarrow A$ (\sim recombinare, pierderea particulelor libere)
- $A^* \longrightarrow A + h\nu$ (\sim dezexcitare)
- $A^* \longrightarrow A + e^-_{din\ suprafață}$ (\sim emisie secundară, electroni Auger)
- $A^+_{rapid} \longrightarrow A + e^-_{din\ suprafață}$ (\sim emisie secundară, electroni Auger)

3. Al treilea submodel se numește *model electric*. Purtătorii de sarcină sunt rezultatul unor procese la care sunt supuse moleculele sau atomii din plasmă (vezi cele două submodele de mai sus). Modelul nu este interesat de condițiile sau modul în care decurg aceste procese (acum le vom considera ca având un rol secundar), ci doar de modul în care purtătorii se mișcă ordonat (sub formă de curent electric) în plasmă. Întreaga plasma, sau anumite zone ale sale, vor fi înlocuite cu elemente pasive de circuit (rezistențe, bobine, condensatori), care vor fi alese în așa fel încât comportamentul și proprietățile lor să-l descrie cât mai fidel pe cel al plasmei. Sistemul complex devine astfel un simplu consumator electric (impedanța de sarcină).

Tot în cadrul acestui model, plasma poate fi modelată ca un spațiu cu proprietăți fizice (electrice sau magnetice) speciale și particulare (izotropie, omogenitate, simetrie). Astfel se pot calcula mult mai ușor distribuțiile și configurațiile câmpurilor electrice și magnetice ale plasmei sau potențialul electric într-un punct oarecare din plasmă.

În concluzie, modelarea plasmei poate furniza relații teoretice care permit calculul unor parametri ce nu au fost sau nu pot fi determinați experimental. Pe de altă parte, modelul de plasmă în general și cel electric în particular poate avea contribuții substanțiale la proiectarea și exploatarea generatoarelor cu care se întrețin descărcările, făcând posibilă adaptarea optimă a impedenței de ieșire a generatorului la impedența plasmei.

Există un număr foarte mare de modele matematice cu care se pot descrie plasmă și fiecare în parte îi corespund o serie de scheme numerice capabile să le rezolve. Evident, nu s-au proiectat modele numerice care să țină cont de toate procesele existente în plasmă. În schimb s-a pus accent pe realizarea unor modele simplificate care au menirea să ușureze desfășurarea programelor experimentale și prelucrarea, respectiv interpretarea datelor experimentale. Modelatorului îi revine sarcina să selecteze cea mai potrivită metodă cu care să descrie problemele fizice particulare ale sistemului pe care îl studiază. Dintre aceste metode amintim:

1. *Metoda circuitului analogic*. Este o metodă care folosește o serie de ipoteze despre proprietățile plasmei pentru a putea calcula valori empirice ale impedenței de plasmă, care apoi pot fi incluse într-un model de circuit analogic, conținând un circuit extern real. Această metodă poate furniza informații foarte importante despre densitatea medie a electronilor, impedența plasmei și puterea transmisă în descărcare. Ea este folosită în exclusivitate de modelarea electrică.

2. *Metoda particulelor.* În principiu, cea mai exactă metodă de tratare a plasmelor este urmărirea particulei probă ce se mișcă în câmpul electromagnetic self-consistent al plasmei (metoda PIC, "particle in cell" - a particulei în celulă) și aplicarea unor tehnici statistice pentru a descrie procesele de ciocnire între particulele date și particulele ce alcătuiesc plasma (metoda MCC - a ciocnirilor Monte-Carlo). Această metodă este una teoretică și, în principiu, este mai flexibilă decât celelalte metode deoarece include cu ușurință mișcarea tridimensională a particulelor și împrăștierea lor unghiulară (rezultat al ciocnirilor elastice și plastice), respectiv își poate stabili limita matematică prin fixarea numărului de particule ce trebuie urmărite.

3. *Metoda ecuației Boltzmann.* O funcție de distribuție $f_j(x,v,t)$ poate fi definită pentru fiecare specie de descărcare astfel încât $N_j = \int f_j dx dv$ să reprezinte numărul de particule din seria "j" ce sunt conținute în unitatea de volum, definită de intervalele: $(x-dx, x+dx)$, $(v-dv, v+dv)$ la momentul t , în spațiul vitezelor. Ecuația fundamentală ce descrie comportarea fiecărei specii din plasmă este ecuația Boltzmann care descrie toate ciocnirile (elastice și neelastice) suferite de particulele dintr-o serie dată, împreună cu procesele atomice și moleculare care au loc la crearea unor noi purtători din această serie.

4. *Metodele de fluid.* O soluție completă a ecuației Boltzmann cere pentru plasmă o reprezentare în 7 dimensiuni (o dimensiune pentru timp și câte 3 dimensiuni pentru spațiu, respectiv viteză). Cele 7 dimensiuni pot fi reduse prin introducerea unor cantități "fluide" care sunt mediate în spațiul vitezelor și sunt denumite ca "momente" ale ecuației Boltzmann.

Aceste trei metode, prin complexitatea lor, impun folosirea calculatoarelor pentru rezolvarea ecuațiilor și sistemelor de ecuații care le stau la bază. Astfel, modelatorul pășește în sfera modelării numerice și matematice.

Modelarea numerică și modelele matematice fac posibile "incursiuni" deosebit de interesante în lumea proceselor fundamentale care se petrec în plasmă. Modelele matematice menite descrierii proprietăților și comportamentului descărcărilor în arc sau la joasă presiune au fost concepute la începutul acestui secol. Mai târziu, în anii 40', elemente de modelare numerică au fost folosite pentru a asigura o mai bună înțelegere a descărcărilor. Evoluția performanței computerelor din ultimul deceniu a permis folosirea acestora în procesele de modelare. Mai mult, a devenit posibilă folosirea metodelor numerice mai avansate pentru explicarea discrepanțelor dintre modelele matematice timpurii și rezultatele măsurătorilor

experimentale, modelarea pe computer devenind astfel indispensabilă procesului de modelare a plasmelor.

6.3 Modelarea electrică a plasmelor de radiofrecvență

6.3.1 Plasma cuplată capacitiv

Plasmele cuplate capacitiv utilizează energia de radiofrecvență (RF) furnizată de componenta electrică a câmpului electromagnetic creat de generatorul RF pentru străpungerea gazului și pentru menținerea descărcării. Ele sunt cunoscute și sub denumirea de *descărcări tip E* și folosesc de obicei un element capacitiv de circuit (condensator) pentru transferul puterii de la sursa RF către descărcare (plasmă). Astfel, puterea de va fi transferată descărcării prin intermediul componentei electrice a câmpului electromagnetic.

Datorită multiplelor aplicații în industria semiconductorilor, plasmele cuplate capacitiv întreținute în atmosfere gazoase la joasă presiune au fost investigate și studiate foarte amănunțit. În același timp, acest tip de descărcare a fost aproape complet ignorat de colectivele de cercetare din domeniul spectroscopiei analitice. O posibilă explicație pentru această atitudine sunt avantajele prezentate de plasmele generate la presiuni subatmosferice (sunt mai ușor de generat și întreținut și sunt lipsite de contaminarea cu materialul electrozilor de susținere). La sfârșitul anilor '50 și începutul anilor '60 s-au manifestat anumite tendințe de folosire a plasmelor cuplate capacitiv în spectroscopie care au fost aproape în totalitate umbrite de expansiunea plasmelor cuplate inductiv la mijlocul deceniului șase.

În domeniul plasmelor cuplate capacitiv cu aplicații în spectroscopie, s-au evidențiat două direcții de cercetare: plasma cuplată capacitiv, cu electrozi plan-paraleli (*plate-parallel CCP torch*) și plasma cuplată capacitiv, cu vaporizare electrotermică în cuptor de grafit (*FAPES*). La acestea se adaugă continuarea ideilor lansate de Cristescu și Grigorovici la începutul anilor 40', idei care se referă la o *plasmă RF în contact cu un singur electrod* (de tip vârf sau tub), întreținută în aer sau atmosfere de gaze nobile, cu ajutorul unor contraelectrozi inelari (prezența acestora nefiind obligatorie).

În timpul unei perioade a câmpului RF cei doi electrozi se comportă succesiv ca anod și respectiv catod. Datorită mobilității mult mai mici a ionilor față de electroni, la cele două extremități ale descărcării se formează straturi de sarcină

spațială preponderent pozitivă, cu potențial înalt, având o evoluție dependentă de timp. Aceste straturi au fost denumite *pături* și ele contribuie la confinarea plasmei.

Ideea modelării electrice a plasmelor cuplate capacitiv a apărut în domeniul plasmelor subatmosferice folosite în tehnologia materialelor și provine din dorința de a asigura o cât mai bună adaptare a impedanței de ieșire a generatorului de RF la impedanța sarcinii (plasmei), precum și pentru explicarea și controlul proceselor care au loc la suprafața de contact plasmă-solid în vederea aplicațiilor tehnologice ale plasmei cuplate capacitiv. Ca orice model primar, pentru plasma cuplată capacitiv s-a ales unul simplificat, cu doi electrozi identici plan-paraleli. Plasma generată are trei zone distincte, bine definite: un *miez* fierbinte și două *pături*, mai reci, în vecinătatea electrozilor (Fig.6.1).

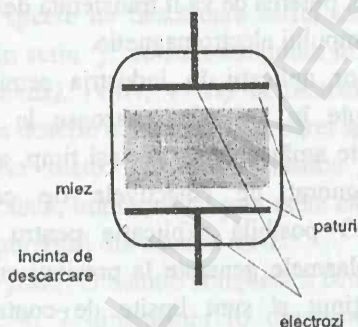


Fig.6.1 - CCP la presiune subatmosferică.

Literatura de specialitate prezintă câte un model electric distinct pentru fiecare din aceste zone.

(i) *Modelarea păturilor*. S-a dovedit că plasma cuplată capacitiv are un regim de funcționare în care electronii urmează câmpul variabil, de potențial înalt din pături. Această urmărire ne duce cu gândul la un fel de separare a sarcinilor, foarte asemănătoare cu încărcarea unui condensator. Notând cu n_j , q_j și m_j concentrația, sarcina și respectiv masa particulelor încărcate din plasmă (dacă $j = e$ atunci este vorba de electroni și dacă $j = i$ este vorba de ioni), frecvența (pulsatia) de plasmă pentru orice componentă purtătoare de sarcină electrică în exces poate fi aciculată din relația:

$$\omega_{pj} = \frac{n_j q_j^2}{m_j \epsilon_0} \quad (6.1)$$

Comparând această frecvență cu cea a câmpului aplicat (ω) vom înțelege mai ușor fenomenele ce au loc în plăci și le vom putea modela. (a) în cazul în care $\omega \ll \omega_{pi}$, ω_{pe} atât mișcarea electronilor cât și mișcarea ionilor va fi modulată de câmpul RF, adică atât ionii cât și electronii vor participa la conducție. Din punct de vedere electric plăta se va comporta ca o *rezistență*. (b) în cazul în care $\omega_{pi} \ll \omega \ll \omega_{pe}$, ionii nu vor mai putea urmări oscilațiile câmpului alternativ RF, distribuția lor spațială va rămâne constantă în timp (are loc o separare de sarcină), iar din punct de vedere electric plăta se comportă ca un *condensator*.

Unii autori consideră că plățile sunt capacități fără pierderi, iar grosimea lor va fi dată de relația: $d = 2\varepsilon_0 A / C$, unde A este aria suprafeței electrodului și C reprezintă capacitatea plății. Alții, pornind de la ipoteza că plățile au o mișcare neliniară (constatată de altfel cu ajutorul unor sonde cilindrice introduse în plasmă), propun ca plăta să fie înlocuită din punct de vedere electric cu un condensator care pe unitatea de arie va avea capacitatea:

$$C_{miez} = \varepsilon / d_{miez}$$

unde d_{miez} reprezintă grosimea plății. Evident, capacitatea plasmei obținută în acest mod va depinde de aria suprafeței electrozilor cu care s-a generat descărcarea.

Toate aceste raționamente sunt valabile doar în cazul geometriilor de electrozi plani-paraleli simetrici (de formă și dimensiuni identice). O modelare mai aproape de realitate este aceea în care se ține cont de ambele ipoteze privind comportarea plăților. În această ipoteză, modelul propus pentru o placă este cel al unui circuit RC paralel, care modelează mai bine comportamentul fizic real al acestei zone a plasmei (Fig.6.2).

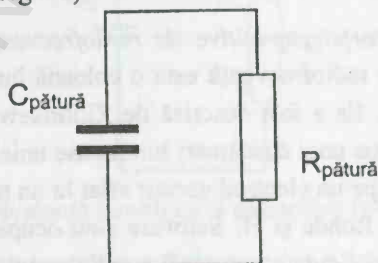


Fig.6.2 - Modelul electric al plății.

(ii) *Modelarea miezului plasmei.* Pentru a modela miezul de plasmă se poate considera descărcarea ca fiind un singur condensator, cu capacitatea pe unitatea de arie:

$$C_{plasma} = \frac{\epsilon_o}{d_{plasma}} \cdot \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) \quad (6.2)$$

unde: d_{plasma} este lungimea miezului (plasmei), iar ω_p reprezintă pulsația plasmei. În viziunea propunătorilor acestui model întreaga descărcare (păturile + miezul) poate fi privită ca un singur condensator, rezultat în urma conectării în serie a doi condensatori, unul reprezentând miezul iar celălalt pătura, cu capacitatea echivalentă:

$$C = \frac{C_{miez} C_{plasma}}{C_{miez} + C_{plasma}} = \frac{\epsilon_o (\omega^2 - \omega_p^2)}{d_{miez} (\omega^2 - \omega_p^2) + d_{plasma} \omega^2} \quad (6.3)$$

Studiind comportamentul electric al miezului, el poate fi privit ca un circuit RL serie prezentat în Fig.6.3. În această schemă echivalentă L_p este inductanța plasmei iar R_p este rezistența sa. Pentru $\omega < \omega_p$ păturile vor avea un caracter *capacitiv* iar miezul va prezenta un caracter *inductiv*.



Fig.6.3 – Modelul electric al miezului.

(iii) *Modelarea torței capacitive de radiofrecvență.* După cum am mai arătat, torța capacitivă de radiofrecvență este o coloană luminoasă de gaz ionizat, având forma unei flăcări. Ea a fost descrisă de Zilitinkewich, Baxter și Heinrich care au obținut-o sub forma unei descărcări luminoase unielectrod generată într-un circuit de radiofrecvență, pe un electrod ascuțit aflat la un potențial electric ridicat. M. Neiman, respectiv L. Rohde și H. Schwarz s-au ocupat de stabilirea schemei echivalente a descărcării obținute pe un vârf metalic ascuțit al unui circuit oscilant RF, vârf în vecinătatea căruia câmpul electric avea o intensitate foarte mare. După părerea lui Neiman, între Pământ și torță se formează un cuplaj capacitiv (cea ce este foarte adevărat, deoarece transferul de putere se face prin intermediul

câmpului electric). El propune ca schemă echivalentă un circuit RC serie în care R este rezistența ohmică a coloanei de gaz ionizat, iar C este capacitatea condensatorului format între torță și Pământ. (Fig.6.4).

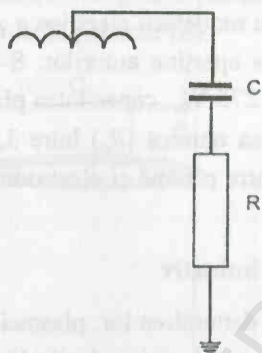


Fig.6.4 - Schema electrică echivalentă pentru torța capacitivă RF cu un singur electrod.

Pe baza acestor considerente, în articolul lor intitulat “*Cercetări privind descărcarea luminoasă (în plasmă) de frecvență înaltă*”, G. D. Cristescu și R. Grigorovici prezintă o schemă echivalentă pentru plasma de radiofrecvență obținută de ei (Fig.6.5). În această schemă echivalentă R reprezintă rezistența ohmică a plasmei, C_2 este capacitatea condensatorului plan între armăturile căruia s-a obținut descărcarea, iar C_1 este capacitatea dintre plasmă și electrodul superior.

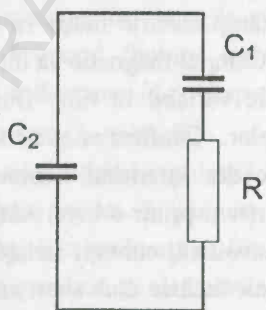


Fig.6.5 - Schema echivalentă pentru torța capacitivă RF cu contraelectrod plan.

După publicarea acestor rezultate a urmat o lungă pauză cauzată atât de apariția plasmei cuplate inductiv, cât și de folosirea plasmei cuplate capacitiv strict în industria și tehnologia materialelor.

Ideea folosirii torței de plasmă de radiofrecvență cuplată capacitiv ca sursă spectrală în spectroscopia atomică de emisie a fost reluată la sfârșitul anilor '80, sub aspectul plasmelor cuplate capacitiv în RF cu geometria electrozilor vârf-inel. Astfel a reapărut și necesitatea modelării electrice a acestor plasmе. Primul articol scris și publicat în acest sens aparține autorilor. S-a constatat că în domeniul de puteri disipate în plasmă 85 - 275 W, capacitatea plasmei (C_p) este cuprinsă între 0,55 - 1,14 pF iar rezistența sa ohmică (R_p) între 3,62 - 6,25 k Ω . S-a estimat și valoarea capacității formate între plasmă și electrodul inelar superior (C) la valori de ordinul 1,35 - 1,97 pF.

6.3.2 Plasma cuplată inductiv

Așa cum reiese și din denumirea lor, plasmеle cuplate inductiv (cunoscute și sub denumirea de *descărcări inelare* sau de *tip H*) folosesc un element inductiv de circuit (bobină) pentru transferul puterii de la sursa RF către descărcare (plasmă). Bobina este elicoidală (solenoidală) sau plană și poate înconjura descărcarea sau poate fi cufundată în ea. Pentru obținerea rezonanței la ă frecvență dată se folosește o reactanță adițională, de regulă capacitivă. Acordat în mod corespunzător, circuitul rezonant dă naștere unor curenți mari de radiofrecvență care se vor scurge prin bobină. Curenții, la rândul lor vor genera un flux magnetic orientat axial, care va penetra regiunea de descărcare imediat adiacentă. Conform legii lui Faraday variația în timp a inducției câmpului electromagnetic va induce un câmp electric de RF. Acest câmp electric indus va accelera electronii liberi din descărcare, susținând plasma. Câmpul magnetic va interacționa cu plasma, cuplajul inductiv al câmpului magnetic variabil în timp fiind similar cu cel realizat la încălzirea inductivă a metalelor. Confinarea plasmei se realizează prin însăși distribuția câmpului magnetic din interiorul bobinei, prin alegerea potrivită a fluxului de gaz suport al plasmei și printr-o bună adaptare la sarcină. Atunci când descărcarea este pe deplin dezvoltată, curenții induși de câmpul electric variabil creat de solenoid vor forma inele închise. Sub acest aspect *plasma cuplată inductiv poate fi privită ca circuitul secundar unispiră al unui transformator de înaltă frecvență* și reprezintă punctul de pornire în modelarea electrică a acestui tip de plasmă (Fig.6.6).

Cuplajul inductiv este folosit atât la producerea și întreținerea plasmelor de interes termionuclear cât și în industria și tehnologia materialelor. În mod firesc s-a pus un mare accent pe modelarea acestor plasmе. Modelele elaborate în acest sens

vizează în primul rând componentele câmpului electromagnetic (H_z , E_r , E_θ), densitatea de curent (J_θ), densitatea de putere disipată în descărcare (W), adâncimea de pătrundere (δ), conductivitatea electrică a plasmei (σ), densitatea de electroni (n_e) și nu în ultimul rând impedanța plasmei (Z).

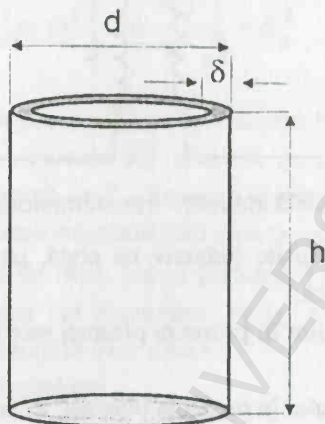


Fig.6.6 - Plasma cuplată inductiv privită ca o spirală scurtcircuitată.

Cel mai simplu model electric pentru o plasmă cuplată inductiv este *modelul transformatorului*. În acest model bobina de lucru, parcursă de curentul de radiofrecvență cu intensitate mare, este considerată drept primarul unui transformator fără miez feromagnetic, iar plasma este considerată ca fiind secundarul unispiră al lui. Primarul (bobina inductoare) este un solenoid de lungime l , având N spire și inductanța (L_o), respectiv rezistența (R_o) cunoscute. Factorul de calitate al bobinei este $Q_o = \omega L_o / R_o$.

Aplicând o tensiune sinusoidală cu pulsația ω (obținută de la un generator RF) la capetele acestei bobine ea va fi parcursă un curent cu intensitatea I_l . Descărcarea (secundarul) poate fi considerată ca fiind alcătuită de o multitudine de descărcări filiforme circulare, paralele ce alcătuiesc o singură spirală scurtcircuitată, cu inductanța L_p și rezistența R_p .

Inductanța L_p a descărcării are două componente: o inductanță inerțială a electronilor $L_e = R_p / v$, care provine din formula conductivității plasmei și o inductanță geometrică (magnetică) L , datorată curentului prin plasmă. Inductanța L este cuplată inductiv cu primarul prin intermediul inductanței mutuale M . Inductanța L_e va fi privită ca partea imaginară a impedanței sarcinii (partea reală

fiind R_p). Ținând cont de aceste amănunte, cele două circuite RL serie cuplate inductiv (transformatorul fără miez) sunt prezentate în Fig.6.7.

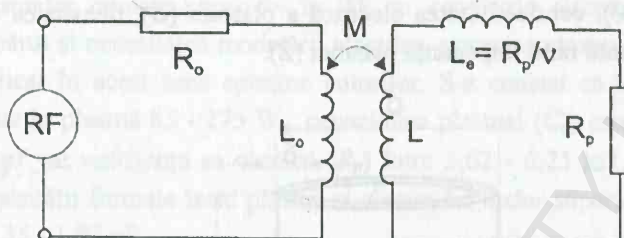


Fig.6.7 - Plasma cuplată inductiv - transformatorul fără miez de fier.

Teoria circuitelor cuplate inductiv ne arată, iar rezultatele măsurărilor experimentale ne confirmă, că:

a) frecvența oscilațiilor în prezența plasmei este mai mare decât în absența ei

b) rezistența primarului în prezența plasmei, R_1 , este mai mare decât R_o

c) inductanța primarului în prezența plasmei, L_1 , este mai mică decât L_o

Astfel, presupunând descărcarea ca fiind pur inductivă și că plasma și solenoidul au lungimi egale (plasma umplând interiorul solenoidului) se pot stabili următoarele relații:

$$L = L_o k / N^2 \quad (6.4)$$

$$k^2 = \frac{\omega^2 (L_o - L_1)^2 + (R_1 - R_o)^2}{\omega L_o \left[\omega (L_o - L_1) - \frac{\omega}{v} (R_1 - R_o) \right]} \quad (6.5)$$

$$R_p = \frac{\omega L (R_1 - R_o)}{\omega (L_o - L_1) - \frac{\omega}{v} (R_1 - R_o)} \quad (6.6)$$

$$I_p = I_1 \frac{\omega L_o \sqrt{k^3}}{N Z_p} \quad (6.7)$$

$$V_p = I_p R_p \quad (6.8)$$

$$P_d = V_p I_p \quad (6.9)$$

$$Z_p^2 = \omega^2 L_p^2 + R_p^2 = \omega^2 \left(L + \frac{R_p}{\nu} \right)^2 + R_p^2 \quad (6.10)$$

unde: I_p este curentul prin plasmă, I_l - curentul prin bobină, V_p - partea ohmică a tensiunii în plasmă, P_d - puterea RF disipată în plasmă, k - coeficientul de cuplaj dintre solenoid și plasmă iar Z_p - impedanța plasmei.

Cunoscând parametrii experimentali care rezultă din construcția bobinei de lucru (L_o și R_o), frecvența de lucru (ω) și parametrii măsurabili (L_l , R_l , V_l , I_l) și folosind setul de relații mai sus prezentate, se pot evalua parametrii electrici ai plasmei care nu pot fi măsurăți în mod direct:

- adâncimea de pătrundere:

$$\delta = \frac{2}{\mu \omega \operatorname{Re}(\sigma_p)} \quad (6.11)$$

- conductivitatea electrică:

$$\sigma_p = \frac{n_e e^2}{m(\nu^2 + \omega^2)} (\nu - j\omega) \quad (6.12)$$

- permitivitatea plasmei:

$$\epsilon_p = 1 - \frac{\omega_p^2}{j\omega\epsilon_o} \quad (6.13)$$

Concluzia studiilor de specialitate a fost că relațiile obținute mai sus pentru parametrii plasmei pot fi folosite și în "sens invers": presupunându-le cunoscute și combinându-le cu ecuațiile de bilanț energetic, respectiv de ionizare și cu cunoașterea prealabilă a factorului de cuplaj k , aceste date pot constitui baza unei teorii consistente pentru plasmă cuplată inductiv.

În continuare vom prezenta o metodă de calcul al unor parametrii (electrici și ne-electrici) pentru o plasmă cuplată inductiv generată folosind oscilatorul RF a cărui schemă este prezentată în Fig.4.7. Măsurând frecvența oscilațiilor generate,

tensiunea continuă a sursei de alimentare a oscilatorului, respectiv intensitatea curentului continuu absorbit de la aceasta și construind un model electric pentru plasma cuplată inductiv, se pot determina: rezistența, inductanța și impedanța plasmei, factorul de calitate al plasmei privită ca o singură spiră și coeficientul de cuplaj dintre bobina de inducție și plasmă. De asemenea, metoda prezentată permite evaluarea unor mărimi fizice importante din punct de vedere al aplicațiilor practice ale plamei cuplate inductiv, mărimi inaccesibile aparatelor de măsură: densitatea de electroni, adâncimea de pătrundere, conductivitatea electrică, frecvența de ciocnire electron-atom în plasmă, pulsația plasmei, densitatea de putere disipată în plasmă.

Dacă se notează cu I_1 intensitatea curentului prin primar (bobină) în prezența plasmei, puterea transferată secundarului poate fi exprimată ca fiind diferența dintre puterea activă totală, primită de bobina de inducție (primarul), $I_1^2 R_1$ și puterea disipată prin efect Joule, $I_1^2 R_o$. Astfel, randamentul de transfer se poate scrie:

$$\eta = P_{\text{secundar}} / P_{\text{primar}} = (R_1 - R_o) / R_1 = (1 + \varepsilon)^{-1} \quad (6.14)$$

unde:

$$\varepsilon = R_o / (R_1 - R_o) \quad (6.15)$$

Puterea RF transferată de la generator spre plasmă, se mai poate scrie:

$$P_{\text{generator}} = P_d + P_{\text{pierdut}} \quad (6.16)$$

în care:

$P_{\text{generator}}$ - puterea de RF transferată de la generator spre plasmă;

P_{pierdut} - puterea pierdută;

$P_d = P_{\text{plasmă}}$ - puterea disipată în plasmă

Randamentul procesului de transfer al puterii către plasmă este:

$$\eta = P_d / P_{\text{generator}} \quad (6.17)$$

În acest moment intervin considerentele privind bilanțul energetic al procesului de transfer al puterii de la generator către plasmă și precizia cu care se evaluează puterea disipată în plasmă din diferența dintre puterile absorbite de generator de la sursa de alimentare de curent continuu în prezența și respectiv absența plasmei.

Astfel:

$$P_{generator} = (E_{ap} I_{ap} - E_{ao} I_{ao}) \eta_{cc-ka} \quad (6.18)$$

unde:

$E_{ap} I_{ap}$ - puterea de alimentare în prezența plasmei

$E_{ao} I_{ao}$ - puterea de alimentare în absența plasmei

η_{cc-ka} - randamentul de transformare al energiei de curent continuu în energie de curent alternativ (oscilații RF)

Deci:

$$P_d = \eta (E_{ap} I_{ap} - E_{ao} I_{ao}) \eta_{cc-ka} \quad (6.19)$$

Având în vedere teoria circuitelor cuplate inductiv și considerând plasma ca fiind secundarul unispiră al unui transformator cu aer, după amorsarea plasmei rezistența și inductanța primarului se exprimă cu formulele:

$$R_l = R_o + \omega^2 M^2 R_p / Z_p^2 \quad (6.20)$$

$$L_l = L_o - \omega^2 M^2 (L + R_p / \nu) / Z_p^2 \quad (6.21)$$

unde:

$$M = k \sqrt{L L_o} \quad (6.22)$$

este inductanța mutuală (k = coeficientul de cuplaj între primar și secundar), iar

$$Z_p^2 = \omega^2 L_p^2 + R_p^2 = \omega^2 (L + R_p / \nu)^2 + R_p^2 \quad (6.22)$$

reprezintă impedanța plasmei.

Inductanța geometrică a plasmei L , poate fi exprimată în funcție de numărul de spire ale bobinei primare și de inductanța ei L_o care este o mărime măsurabilă. Presupunând descărcarea ca fiind pur inductivă și că plasma și bobina inductoare au lungimi egale, legătura dintre inductanța geometrică a plasmei și inductanța bobinei este dată de relația: $L = L_o k / N^2$.

Plasma, fiind de natură pur inductivă, poate fi considerată un circuit RL serie căruia i se poate atribui un factor de calitate, Q_p :

$$Q_p = \omega L_p / R_p \quad (6.23)$$

Folosind relațiile (6.14) – (6.19) se obține următoarea expresie pentru ε :

$$\varepsilon = \frac{R_o R_p (1 + Q_p^2)}{k^2 \omega^2 L L_o} \quad (6.24)$$

sau, în funcție de Q_p :

$$\varepsilon(Q_p) = \left(\frac{Q_p^2 + 1}{Q_p - \frac{\omega}{v}} \right) \frac{R_o}{\omega k^2 L_o} \quad (6.25)$$

Din punctul de vedere al amorsării și susținerii plasmei, sunt de interes condițiile în care randamentul de transfer al puterii dinspre generatorul RF (bobina de lucru) spre plasmă este maxim. Aceasta se va realiza când ε este minim.

Valoarea lui Q_p corespunzătoare minimului funcției $\varepsilon(Q_p)$ este dată de relația:

$$Q_p = \frac{\omega}{v} + \sqrt{\left(\frac{\omega}{v} \right)^2 + 1} \quad (6.26)$$

pentru care valoarea minimă a lui $\varepsilon(Q_p)$ este:

$$\varepsilon(Q_p)_{\min} = \frac{2R_o}{\omega k^2 L_o} Q_p \quad (6.27)$$

Exprimând raportul $(R_l - R_o)/(L_o - L_l) = \Delta R/\Delta L = R_p/L_p$ din (6.20), știind că $L_p = L + R_p/v$ și înlocuindu-l în relația pentru R_p (6.23) vom obține :

$$Q_p = \omega \Delta L \varepsilon(Q_p) / (R_l - R_o) \quad (6.28)$$

Dacă se cunoaște Q_p , atunci folosind relația (6.26), se poate exprima frecvența ciocnirilor dintre electroni și neutri:

$$v = \frac{2Q_p}{Q_p^2 - 1} \omega \quad (6.29)$$

În unele cazuri este mai util și mai sugestiv să folosim raportul ω/v :

$$\frac{\omega}{\nu} = \frac{Q_p^2 - 1}{2Q_p} \quad (6.30)$$

Folosind expresiile deduse pentru Q_p (6.26 și 6.23) se deduce rezistența plasmei:

$$R_p = \frac{2\omega L Q_p}{Q_p^2 + 1} \quad (6.31)$$

Pentru exprimarea coeficientului de cuplaj dintre bobină și plasmă, se înlocuiește relația (6.27) în relația (6.28) și se obține:

$$k = \sqrt{2 \frac{\Delta L}{L_o}} \quad (6.32)$$

Variația inductanței primarului, ΔL se exprimă din condiția de rezonanță în circuitul oscilant al generatorului. Astfel:

$$\Delta L = L_o \left[1 - \left(\frac{f_o}{f_p} \right)^2 \right] \quad (6.33)$$

unde f_o și f_p sunt frecvențele oscilațiilor generate în absența, respectiv în prezența plasmei.

Cunoscând relația dintre adâncimea de pătrundere, frecvență și conductivitatea electrică:

$$\delta^2 = \frac{2}{\mu_o \omega \sigma_{pr}} = \frac{2\rho_p}{\mu_o \omega} \quad (6.34)$$

și folosind relațiile deduse până în prezent, ea poate fi adusă sub forma:

$$\delta = \frac{2R_p h}{\mu_o \omega \pi d} \quad (6.35)$$

Astfel, rezistivitatea electrică a plasmei se scie:

$$\rho_p = \frac{1}{\sigma_{pr}} = \frac{\mu_0 \omega \delta^2}{2} \quad (6.36)$$

Partea sa reală a conductivității electrice presupusă uniformă este:

$$\sigma_{pr} = \frac{n_e e^2}{m_e (v^2 + \omega^2)} = \frac{n_e e^2}{m_e v \left(1 + \frac{\omega^2}{v^2} \right)} \quad (6.37)$$

Din această relație se exprimă densitatea de electroni din plasmă:

$$n_e = \frac{m_e}{e^2} \sigma_{pr} v \left(1 + \frac{\omega^2}{v^2} \right) \quad (6.38)$$

Modelul prezentat anterior a fost aplicat pentru studierea plasmei cuplate inductiv generate cu ajutorul oscilatorului prezentat în Capitolul IV (Fig.4.7). Drept torțe au fost folosite torța convențională, prezentată în Fig.5.4 și torța cu consum redus de argon prezentată în Fig.5.23. Bobinele de lucru, prin intermediul cărora se transmite energie plasmei au fost confecționate din țeavă de cupru, având parametrii electrice și geometrice prezentați în Tabelul 6.1. Inductanțele și rezistențele de pierderi ale lor au fost măsurate printr-o metodă Q-metrică la frecvența de 27,12 MHz.

Mărimile măsurabile (Tabelul 6.2) sunt pur electrice: tensiunea continuă de alimentare a oscilatorului RF, intensitatea curentului continuu consumat de la sursa de alimentare și frecvența oscilațiilor generate. Ele au fost măsurate odată în absența plasmei și odată în prezența ei.

Tabelul 6.1 - Parametrii electrici și geometrici ai bobinelor de lucru.

| Parametru | Torța convențională (Ar 20 l / min) | Torța cu consum redus de argon (Ar 13.2 l / min) |
|--|--|---|
| Diametrul țevii de Cu | 5 mm | 3 mm |
| Diametrul exterior al bobinei de lucru | 34 mm | 27 mm |
| Distanța dintre spire | 5 mm | 3 mm |
| Numărul de spire | 2 | 3 |
| Rezistența bobinei de lucru (R_0) | 0.12 Ω | 0.24 Ω |
| Inductanța bobinei de lucru (L_0) | 0.18 μH | 0.24 μH |

Tabelul 6.2 - Condițiile de lucru pentru modelarea ICP.

| Parametru | Torța convențională | Torța cu consum redus |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| E_{ao} | 3200 V | 3300 V |
| I_{ao} | 130 mA | 80 mA |
| f_{ao} | 26.64 MHz | 26.77 MHz |
| E_{ap} | 2800 V | 3000 V |
| I_{ap} | 830 mA | 420 mA |
| f_{ap} | 27.24 MHz | 27.13 MHz |

Frecvențele de oscilație în prezența și absența plasmei au fost măsurate cu un frecvențmetru prin intermediul unei bobine cuplate inductiv cu bobina de lucru iar tensiunea și intensitatea curentului continuu de alimentare a oscilatorului au fost măsurate cu multimetre electronice.

Plasma cuplată inductiv a fost aproximată cu un cilindru (Fig.6.6) cu următoarele dimensiuni: $h = 24$ mm și $d = 20$ mm pentru torța convențională, respectiv $h = 18$ mm și $d = 15$ mm pentru torța cu consum redus de argon.

Rezultatele obținute pe baza modelului electric considerat sunt sintetizate în Tabelul 6.3.

Pe baza informațiilor din literatura de specialitate se poate aprecia că aceste rezultate sunt în concordanță cu cele obținute prin alte metode de măsurare, ceea ce ne face să credem că metoda aplicată este bună.

Tabelul 6.3 - Parametrii calculați ai plasmei.

| Parametru | Torța convențională | Torța cu consum redus de argon |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| P_d | 716 W | 374 W |
| R_p | 1,13 Ω | 2,14 Ω |
| L_p | 0,024 μH | 0,02 μH |
| k | 0,3 | 0,23 |
| Z_p | 4,33 Ω | 3,94 Ω |
| ρ_p | 118 W/cm ³ | 121 W/cm ³ |
| ν | 100 MHz | 379 MHz |
| ω/ν | 1,71 | 0,45 |
| δ | 4,03 mm | 3,64 mm |
| ρ_p | 1,74 Ωmm | 1,42 Ωmm |
| n_e | $8,02 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$ | $3,35 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$ |

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. C.RUSESCU și C.TUDOSE, "Modele și modelare în fizică". Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987
2. G. CRISTESCU and R. GRIGOROVICI, "Study of high frequency torch. Measurements of voltage, current and power". An. Acad. RPR, vol. 3, pp. 63-78 (1949).
3. S.D. ANGHEL, "Obținerea plasmelor de RF la presiune atmosferică și utilizarea lor în spectroscopia atomică". Teză de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Fizică, 1990
4. S.D. ANGHEL and A.SIMON, "Evaluating ICP Parameters by Electrical Modelling". BPL, 5, 118-128, 1997.
5. C.G.LISTER, "Plasma Modelling for surface processing". Vacuum, 45, 525-534, 1994.
6. R.B.PIEJAK, V.A.Godyak and B.M.ALEXANDROVICH, "A simple analysis of an inductive RF discharge". Plasma Sources Sc. Technol, 1, 179-186, 1992.
7. P.W.J.M. BOUMANS, F.J. de BOER and J.W. de RUITER, "A Stabilized R.F. Argon-plasma Torch for Emission Spectroscopy". Philips Techn. Rev., 33, 50-59 (1973).
8. N.I. GONCHAR, A. V. ZVYAGINTSEV, R. V. MITIN, and K. K. PRYADKIN, "Electrodeless plasma generator (plasmatron) with capacitive arc discharge". Sov. Phys.-Tech. Phys., vol. 20, pp. 407-408 (1975).
9. R.K.MARKUS, "Operation Principles and Design Consideration for Radiofrequency

- Powered Glow Discharge Devices*". J.Anal.At.Spectrom 8, 935-943, (1993).
10. S. MURAYAMA, "Ultrahigh-Frequency Discharge in Atmospheric-Pressure Gas". Journ. Appl. Phys., 39, 5478-5484 (1968).
 11. A.T. ZANDER and G.M. HIEFTJE, "Microwave-supported Discharge". Appl. Spectrosc., 4, 357371 (1981).
 12. T.B.REED, "Induction Coupled Plasma Torch", Journ. Appl. Phys., 32, 821-824 (1961).

Capitolul VII

TEMPERATURI ȘI DENSITĂȚI DE ELECTRONI

7.1 Introducere

Măsurarea sau determinarea unor parametri interni care caracterizează starea fizică a plasmăi (concentrația particulelor, gradul de ionizare, temperatura particulelor, etc.) poartă denumirea de *diagnosticare*.

Variatatea mare sub care se prezintă plasmăle a necesitat apariția și dezvoltarea unor metode de măsură și investigare foarte diferite. Determinările experimentale sau teoretice se referă în special la densitatea și temperatura purtătorilor de sarcină din plasmă (n_e , T_e , n_i , T_i), intensitatea câmpului electric și/sau a câmpului magnetic din plasmă (E și/sau B), potențialul plasmăi (V_p), intensitatea curentului prin plasmă (I_p), frecvența de ciocnire (ν_c), coeficientul de difuzie (D).

În general, metodele experimentale de diagnosticare sunt clasificate în patru mari categorii:

(a) *Metodele optico-spectrale* au la bază fenomene și efecte fundamentale din spectroscopie sau optică, cum ar fi: emisia spontană a luminii, împrăștierea Thomson-Rayleigh, efectul Doppler-Fizeau, efectul Stark, absorbția luminii, radiația Bremsstrahlung etc. Ele se folosesc în mod curent pentru determinarea concentrației și temperaturii purtătorilor de sarcină.

(b) *Metodele electrice* se bazează pe răspunsul plasmăi la semnalele de joasă frecvență sau de curent continuu aplicate din exterior. Dintre tehnicile de investigare ce aparțin acestui grup de metode amintim traductoarele, spectrometria de masă, sondele magnetice, sondele electrice (Langmuir) sau sondarea cu fascicule de electroni. Mărimile fizice care pot fi determinate astfel sunt: concentrația, temperatura și distribuția energetică a purtătorilor de sarcină;

intensitatea câmpului electric; intensitatea câmpului magnetic; intensitatea curentului prin plasmă; potențialul plasmei.

(c) *Metodele de înaltă frecvență* sunt metode de diagnosticare care implică în general, folosirea semnalelor electromagnetice din banda de microunde și studierea răspunsului plasmei la aceste semnale. Principalele tehnici din această categorie sunt: interferometria de microunde, rotația Faraday, metoda perturbării cavității și metoda sondei rezonante. Aplicarea acestor metode permite determinarea experimentală, pe lângă mărimile deja consacrate, a unor mărimi fizice mai greu accesibile celorlalte metode: coeficientul de difuzie, coeficientul de recombinare și coeficientul de atașare.

(d) *Metoda semnalelor netermice* este metoda prin care se analizează semnalele electromagnetice emise de plasmă.

Metodele teoretice de investigare se pot clasifica în două mari categorii: microscopice și macroscopice. *Metode microscopice* sunt cele statistice sau cinetice. Ecuațiile care stau la baza lor sunt ecuația Liouville, setul de ecuații BBGKY, ecuația Boltzmann (Vlasov) și ecuația Fokker-Planck. Pentru *analiză macroscopică* a plasmelor există două posibilități. Prima aparține așa numitei teorii a continuumului și a fost adoptată din hidrodinamica gazelor și fluidelor. Teoria este mai mult fenomenologică și nu prezintă o imagine de ansamblu a plasmei. A doua posibilitate, mai riguroasă, se bazează pe folosirea ecuației Boltzmann pentru obținerea ecuațiilor hidrodinamice ale plasmei și ne dă posibilitatea obținerii expresiilor coeficienților de transport care apar în aceste ecuații.

Din punct de vedere istoric, cea mai veche metodă de diagnosticare este cea a sondelor, care face parte din categoria metodelor electrice (Langmuir, 1924). Ea a fost folosită pentru determinarea temperaturilor și densităților de particule, chiar în primele lucrări publicate pe această tematică de Langmuir și Tonks. Metoda sondelor este o metodă de contact. Deși una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o sondă este aceea ca ea să nu perturbe plasma, uneori acest deziderat nu poate fi realizat și exactitatea informațiilor locale obținute va avea un anumit grad de eroare. Din aceste motive metoda sondelor poate fi considerată utilă doar în cazul în care plasma este rece, concentrația electronilor și temperatura nu sunt foarte mari, iar câmpurile magnetice sunt slabe. În cazul plasmelor

fierbinți, nu pot fi folosite decât metode fără contact (radiospectroscopie, metode optico-spectrale).

În continuare ne vom concentra asupra metodele de diagnosticare optico-spectrale și a rezultatelor obținute de autori în urma aplicării lor la studiul plasmei cuplate capacitiv la presiune atmosferică.

7.2 Temperaturi și densități de particule într-o sursă spectrală

Metodele de analiză (calitativă sau cantitativă) din domeniul spectroscopiei atomice își propun ca prim scop determinarea elementelor dintr-o probă dată, prin convertirea lor în formă atomică și satisfacerea condițiilor impuse de procesele de excitare-dezexcitare. Dispozitivul care realizează și asigură în mod uzual aceste condiții se numește *sursă spectrală* care, în particular, poate fi *plasma descărcării gazoase*.

Așa cum s-a arătat în capitolele precedente, din punct de vedere electric plasma descărcării gazoase este neutră la scară macroscopică și conține electroni, ioni (în stare fundamentală și/sau excitată), atomi (în stare fundamentală și/sau excitată) și fotoni (rezultați în urma proceselor de dezexcitare). Distribuția după energii a acestor particule este determinată de un parametru numit *temperatură absolută*. Din moment ce plasma conține mai multe tipuri de particule, este foarte posibil și firesc să existe mai multe distribuții, respectiv temperaturi necesare pentru descrierea acestor distribuții.

Astfel, în cazul unei plasme susținute într-o atmosferă de gaz monoatomic pot exista 4 tipuri de temperaturi: *temperatura electronilor* (T_e) și *temperatura gazului* (Doppler sau cinetică, T_{cin}), temperaturi care descriu distribuția electronilor, respectiv ionilor după energia cinetică; *temperatura de excitare* (T_{exc}) care descrie distribuției particulelor pe nivelele energetice excitate și *temperatura de ionizare* (T_{ion}) care descrie echilibrului de ionizare (ea rezultă din ecuația lui Saha). Dacă gazul de susținere este bi- sau poliatomic, atunci este necesară introducerea a încă două temperaturi: *temperatura de rotație* (T_{rot}) care descrie distribuția particulelor pe nivelele energetice de rotație și *temperatura de vibrație* (T_{vibr}) care va descrie distribuția particulelor pe nivelele energetice de vibrație.

Densitatea de electroni (n_e) este o măsură a numărului de electroni liberi într-un cm^3 de plasmă, indicând gradul de ionizare al plasmei și este considerată a

fi un parametru fundamental, independent de temperaturi sau de existența echilibrului termodinamic. Dacă acest echilibru există, atunci n_e va defini temperatura unică a plasmăi.

Scopul principal al diagnosticării plasmăi este determinarea temperaturilor și densității de electroni. În literatura de specialitate sunt amintite următoarele procedee optico-spectrale:

- pentru temperatura de excitare: *metoda dreptei Boltzmann*
- pentru temperatura de ionizare:
 - *metoda ecuației lui Saha*
 - *metoda raportului liniilor ionice și atomice*
 - *metoda raportului linie-continuum*
- pentru temperatura cinetică a gazului:
 - *metoda lărgirii Doppler*
 - *metoda împrăstierii Rayleigh*
 - *metoda absorbției radiației laser*
- pentru temperatura cinetică a electronilor:
 - *metoda radianței spectrale a continuumului*
 - *metoda împrăstierii (Thomson; Rayleigh; Raman)*
- pentru temperatura de rotație: *metoda dreptei Boltzmann*
- pentru temperatura de vibrație: *metoda dreptei Boltzmann*
- pentru densitatea de electroni:
 - *metoda lărgirii Stark a liniilor spectrale ($H\beta$ sau $H\alpha$)*
 - *metoda raportului linie-continuum*
 - *metoda ecuației Kramers-Unsöld*

Metodele de diagnosticare optico-spectrală care investighează plasma prin intermediul studiului radiației electromagnetice de excitare-dezexcitare spontană și profilului liniilor spectrale se numesc *metode de diagnosticare pasive* (de exemplu metoda dreptei Boltzmann, metoda ecuației lui Saha, metoda raportului dintre o linie ionică și una atomică ale aceluiași element, metoda raportului linie-continuum, metoda lărgirii Doppler, metoda radianței spectrale a continuumului, metoda lărgirii Stark).

Metodele de diagnosticare care au la bază interacțiunea dintre radiația laser și plasmă, unde informațiile despre caracteristicile plasmăi se obțin din studiul modificărilor aduse de plasmă în proprietățile radiației laser, se numesc *metode de*

diagnosticare active (metoda împrăștiilor Rayleigh-Thomson-Raman, metoda absorbției radiației laser).

Rezultatele obținute prin diagnosticarea spectrală își găsesc aplicațiile în optimizarea surselor spectrale cu plasmă, stabilirea zonelor analitice optime, realizarea unor hărți ale plasmei (de temperatură sau densitate de electroni) sau prevederea comportamentului unor specii analitice introduse în plasmă.

Metoda de diagnosticare aplicată se alege în funcție de temperatura care se dorește a fi determinată și de constantele spectrale pe care le avem la dispoziție.

7.3 Echilibrul termodinamic într-o sursă spectrală

Atunci când temperaturile din plasmă au valori identice spunem că ea se găsește în *starea de echilibru termodinamic* (această stare este o idealizare, ea nu poate fi observată în realitate).

Echilibrul termodinamic este starea în care principiul echilibrului detaliat se aplică perfect, adică fiecare proces este perfect echilibrat de procesul său invers (de exemplu: excitarea de dezexcitare sau ionizarea de recombinare). Acest principiu se aplică tuturor formelor de energie și formelor de transfer de energie. Echilibrul termodinamic total sau global (ETG) este caracterizat de coexistența următoarelor 4 legi:

1) *distribuția vitezei* pentru toate particulele din plasmă este o *distribuție Maxwell*:

$$f(v) = 4 \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot v^2 \cdot \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) \quad (7.1)$$

2) *distribuția densității de radiație* emisă de plasmă în funcție de lungimea de undă și temperatură este descrisă de *ecuația lui Planck*:

$$\rho_\lambda(T) = 2 \cdot \frac{hc^2}{\lambda^5} \cdot \exp\left(-\frac{hc}{\lambda k_B T} \right) \quad (7.2)$$

3) pentru fiecare specie chimică (element), *distribuția populației de particule pe diferitele nivele energetice* este o *distribuție tip Boltzmann*:

$$\frac{N_m}{N_n} = \frac{g_m}{g_n} \cdot \exp\left[-\frac{E_m - E_n}{k_B T}\right] \quad (7.3)$$

4) *gradul de ionizare* al plasmei este descrisă de *ecuația lui Saha*:

$$\frac{N_i N_e}{N_a} = \frac{g_i g_e}{g_a} \cdot \frac{(2\pi m_e k_B T)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \exp\left(-\frac{E_{ioniz}}{k_B T}\right) \quad (7.4)$$

Astfel, putem spune că *echilibrul termodinamic global* este acea stare în care distribuția după energiile particulelor și distribuția după densitatea de radiație sunt descrise de aceste 4 legi (Maxwell, Boltzmann, Saha, respectiv Planck). În starea de echilibru termodinamic plasma este caracterizată printr-o singură temperatură, iar toate procesele din plasmă decurg cu aceeași probabilitate. Pe lângă ciocniri, procesele de schimb energetic includ și fenomenele radiative iar fotonii emiși vor fi absorbiți în totalitate.

Sistemele în care distribuția după energii este descrisă de legile amintite, dar cea după densitatea de radiație nu (deoarece absorbția completă necesită densități optice ridicate pentru toate tranzițiile radiative), se consideră a fi în *echilibru termodinamic local* (ETL). Această condiție este realizată atunci când modul dominant de transfer al energiei se face prin ciocniri între particule și nu prin absorbția sau emisia radiațiilor. Conform literaturii de specialitate, matematic vorbind, condiția de ETL se poate scrie:

$$n_e \gg 1,6 \cdot 10^{12} \cdot T_e^{\frac{1}{2}} \cdot (\Delta E)^3 \quad (7.5)$$

unde T_e este temperatura electronilor (în K) iar ΔE reprezintă diferența de energie (în eV) dintre nivelele energetice în discuție.

În acest caz starea plasmei nu mai poate fi descrisă cu ajutorul unei singure temperaturi. În starea de echilibru termodinamic local, plasma poate fi împărțită în volume infinitezimale, în care cele patru legi mai sus amintite sunt satisfăcute în același timp. În interiorul fiecărui volum infinitezimal starea plasmei este caracterizată de o singură temperatură.

Cu toate că o sursă spectrală cu plasmă, aflată la echilibru termodinamic este considerată a fi nepotrivită pentru analiza spectrochimică, starea ideală de echilibru termodinamic este dorită din patru motive:

- 1) efectul instabilității sursei asupra semnalului emis va fi minim;
- 2) interferențele spectrale lipsesc aproape în totalitate;
- 3) comportamentul unui element introdus în plasmă va fi previzibil;
- 4) în anumite condiții date unele relații deduse pentru o plasmă aflată la echilibru termodinamic vor putea fi aplicate și pentru plasmă care nu se găsește în această stare.

7.4 Intensitatea și profilul unei linii spectrale

Metodele spectroscopice de analiză au ca prim scop *identificarea elementelor* prezente în proba originală (*analiză calitativă*) și/sau *determinarea concentrației* unuia sau mai multor elemente aflate în proba originală (*analiză cantitativă*).

Procese suferite de moleculele, atomii și ionii probei dau naștere la "semnătura" atomilor și moleculelor. În cazul spectroscopiei de emisie această "semnătură", ce face posibilă analiza, este rezultatul emisiei de radiație electromagnetică, rezultat concretizat într-un spectru format din linii pentru atomi și ioni și din benzi pentru moleculele neutre și pentru radicali. Liniile spectrale sunt rezultatul tranzițiilor electronice la nivel de atom sau ion, între nivele energetice cuantificate.

În condiții ideale radiația emisă este perfect monocromatică, iar linia de emisie apare sub forma unei linii verticale - impuls Dirac (Fig.7.1). În realitate, radiația nu este monocromatică, ci una rezultată din suprapunerea a mai multor radiații monocromatice. Drept urmare va exista o distribuție a intensității în funcție de lungimea de undă, iar linia spectrală va fi reprezentarea grafică a acestei distribuții (Fig.7.2).

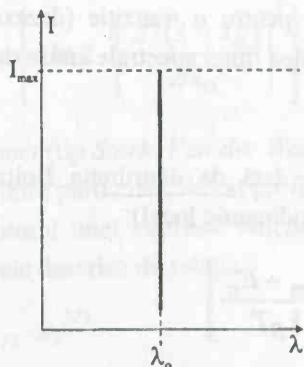


Fig.7.1 - Linia spectrală ideală.

După cum se vede și din figură, linia spectrală reală va prezenta o lărgire. Lărgirea liniilor spectrale depinde de valoarea intensității ei. Pentru caracterizarea unitară a lărgirilor, s-a introdus noțiunea de *semilărgime* a liniei spectrale (notată de obicei cu $\Delta\lambda_{1/2}$). Ea reprezintă lărgimea liniei spectrale ($\lambda_2 - \lambda_1$) la o intensitate egală cu jumătate din intensitatea maximă a liniei spectrale (I_{max}). λ_0 reprezintă lungimea de undă la care intensitatea de emisie este maximă, lungime de undă față de care se va măsura lărgirea.

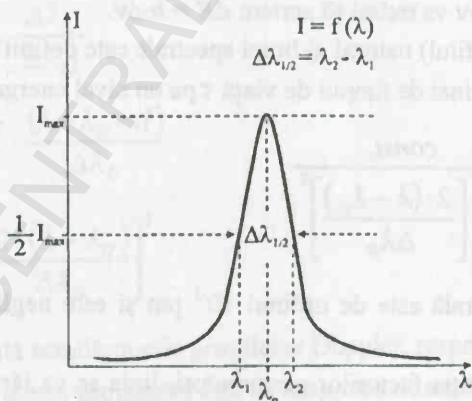


Fig.7.2 - Linia spectrală reală.

Prin intensitatea unei linii spectrale vom înțelege puterea radiantă emisă pe unitatea de volum, unitatea de timp și unghi solid. Dacă se neglijează

autoabsorbția plasmei atunci, pentru o tranziție (dezexcitare) între două nivele energetice "m" și "n", intensitatea liniei spectrale emise de un atom excitat va fi:

$$I_{mn} = N_m A_{mn} h \nu_{mn} \quad (7.6)$$

iar populația nivelelor va fi dată de distribuția Boltzmann (se presupune că sistemul este la echilibru termodinamic local):

$$\frac{N_m}{N_n} = \frac{g_m}{g_n} \cdot \exp \left[-\frac{E_m - E_n}{k_B T} \right] \quad (7.7)$$

unde: N_m și N_n reprezintă populația nivelelor m și n ; A_{mn} este probabilitatea de emisie spontană; g_m și g_n sunt ponderile statistice ale nivelelor m și n ; E_m și E_n reprezintă energia nivelelor m și n ; ν_{mn} este frecvența radiației emise ($\nu_{mn} = c/\lambda_{mn}$), iar T reprezintă temperatura de excitare.

Atunci când nu există nici un factor perturbator, lărgirea care apare se numește *lărgire naturală* ($\Delta\lambda_N$). Cauza acestei lărgiri se regăsește în faptul că, ținând cont de relația de nedeterminare a lui Heisenberg, energia unui nivel nu poate fi determinată cu o precizie oricât de mare (timpul de viață $\tau \approx 1/A$, unde A este probabilitatea de tranziție spontană, are o valoare finită și bine determinată). Astfel în loc de $E = h \cdot \nu$ va trebui să scriem $\Delta E = h \cdot \Delta \nu$.

Conturul (profilul) natural al liniei spectrale este definit de o distribuție tip Lorentz și este determinat de timpul de viață τ pe un nivel energetic excitat:

$$P_N(\lambda) = \frac{const.}{1 + \left[\frac{2 \cdot (\lambda - \lambda_0)}{\Delta\lambda_N} \right]^2} \quad (7.8)$$

Lărgirea naturală este de ordinul 10^{-3} pm și este neglijabilă față de alte tipuri de lărgiri.

Odată cu apariția factorilor perturbatori, linia se va lărgi față de conturul său natural. Astfel mai apar două lărgiri:

a) *lărgirea Doppler*, cauzată de vibrația termică și/sau de deplasarea particulelor emitente față de receptorul de radiație care va determina un profil descris de relația:

$$P_D(\lambda) = \text{const} \cdot \exp \left\{ -\ln 2 \cdot \left[\frac{2 \cdot (\lambda - \lambda_0)}{\Delta\lambda_D} \right]^2 \right\} \quad (7.9)$$

b) *lărgirea prin impact* (tip *Stark, Van der Waals, Holmsmark* - cauzate de interacțiile care iau naștere între particule). Acest profil lărgit din cauza impactului se descrie mai greu cu ajutorul unei expresii funcționale simple. Semilărgimea profilului Lorentz rezultat este descrisă de relația:

$$\Delta\lambda_s = 2,5 \cdot 10^{-9} \cdot \alpha_{1/2} \cdot n_e^{2/3} \quad (7.10)$$

unde $\alpha_{1/2}$ este o constantă tabulată, iar n_e reprezintă densitatea de electroni din plasmă.

Profilul real al unei linii spectrale, care include lărgirile de linie prezentate anterior, se numește *contur Lorentz-Doppler sau Voight*, și este descris de funcția:

$$P(\lambda) = \frac{a}{\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(-t^2)}{a^2 + (b-t)^2} dt \quad (7.11)$$

unde:

$$a = \sqrt{\ln 2} \cdot \frac{\Delta\lambda_L}{\Delta\lambda_D} \quad (7.12)$$

$$b = 2\sqrt{\ln 2} \cdot \frac{(\lambda - \lambda_0 - d)}{\Delta\lambda_D} \quad (7.13)$$

$$t = \ln 2 \left[\frac{2 \cdot (\lambda - \lambda_0)}{\Delta\lambda_D} \right]^2 \quad (7.14)$$

$\Delta\lambda_D$ și $\Delta\lambda_L$ reprezintă semilărgimile progielilor Doppler, respectiv Lorentz (*Stark și van der Waals*), iar d este deplasarea față de lungimea de undă nominală λ_0 .

Trebuie amintit că, profilul unei linii spectrale observate cu ajutorul unui instrument optic (de exemplu monocromator) va fi un profil efectiv, rezultat al profilului fizic și profilului instrumental. Relația dintre semilărgimi va fi una cvadratică:

$$\Delta\lambda_{eff}^2 = \Delta\lambda_{instr}^2 + \Delta\lambda_{phys}^2 \quad (7.15)$$

Lărgirea instrumentală ($\Delta\lambda_{inst}$), care se mai cunoaște și sub denumirea de *rezoluție*, este determinată de lărgimea fanteide intrare a monocromatorului, parametrii rețelei de difracție și de aberațiile optice după o relație de tipul:

$$\Delta\lambda_{instr}^2 = \Delta\lambda_{geom}^2 + \Delta\lambda_{difr}^2 + \Delta\lambda_{aber}^2 \quad (7.16)$$

unde:

$$\Delta\lambda_{difr} = \frac{\lambda d}{mD} \quad (7.17)$$

$$\Delta\lambda_{geom} = DLR \cdot f \quad (7.18)$$

iar d este constanta rețelei de difracție, m ordinul de difracție, D lăimea rețelei de difracție, DLR dispersia liniară reciprocă (intervalul de lungime de undă, în nm, corespunzător lungimii efective ocupate, în mm) și f lăimea fantei monocromatorului.

Lărgimea fizică a liniei spectrale va conține toate contribuțiile pe care le-am discutat până acum (naturală, Doppler, Stark, Van der Waals și Holmsmark).

7.5 Metode optico-spectrale de determinare a temperaturilor

7.5.1 Determinarea temperaturii de excitare atomice

Temperatura de excitare atomică (T_{exc}) este temperatura care poate fi asociată energiei de excitare a atomilor, adică energiei primite de ansamblul de atomi pentru a trece pe nivele excitate. Ea este asociată stării electronilor dintr-un atom și va caracteriza distribuția lor după energia de excitare, respectiv va descrie populația relativă a nivelelor energetice pentru o specie atomică dată, prezentă în plasmă.

Deoarece la dezexcitare se emite o radiație luminoasă, intensitatea liniilor spectrale emise poate fi folosită pentru determinarea acestor temperaturi. Pentru a realiza aceste determinări se folosesc așa numitele *specii termometrice*, elemente ale căror linii și caracteristici spectrale sunt bine cunoscute. Pentru a determina temperatura de excitare se folosesc cel mai des următoarele elemente: Fe, Ar sau He (în funcție de tipul gazului de susținere al descărcării), Cu sau Pb.

Combinând ecuațiile (7.6) și (7.7) rezultă:

$$I_{mn} = N_n A_{mn} \frac{g_m}{g_n} \frac{hc}{\lambda_{mn}} \exp\left(-\frac{E_m - E_n}{k_B T}\right) \quad (7.19)$$

sau

$$\frac{I_{mn} \lambda_{mn}}{A_{mn} g_m} = N_n \frac{hc}{g_n} \exp\left(-\frac{E_m - E_n}{k_B T}\right) \quad (7.20)$$

Logaritmând expresia precedentă, rezultă:

$$\ln\left(\frac{I_{mn} \lambda_{mn}}{A_{mn} g_m}\right) = \text{const}_1 - \left(\frac{E_{exc}}{k_B T_{exc}}\right) \quad (7.21)$$

Făcând trecerea de la produsul $g_m A_{mn}$ la $g_n f_{nm}$ (unde f_{nm} este tăria cuantică a oscilatorului) ecuația (7.19) se mai poate scrie:

$$\log\left(\frac{I_{mn} \lambda_{mn}^3}{g_n f_{nm}}\right) = \text{const}_2 - \left(\frac{E_{exc}}{k_B T_{exc}}\right) \quad (7.22)$$

Relațiile (7.21) și (7.22) reprezintă niște drepte cu pantă negativă ($\text{tg}\alpha < 0$) numite *drepte Boltzmann*. Reprezentând grafic membrul stâng în funcție de E_{exc} , din panta dreptei se determină temperatura de excitare:

$$\text{tg}\alpha = -\frac{1}{k_B \cdot T_{exc}} \Rightarrow T_{exc} = -\frac{1}{k_B \cdot \text{tg}\alpha} \quad (7.23)$$

Folosind formule mai practice, temperatura de excitare se poate calcula cu una din relațiile:

$$T_{exc} = -\frac{5040}{\text{tg}\alpha}, \text{ dacă folosim logaritmul zecimal} \quad (7.24)$$

$$T_{exc} = -\frac{11592}{\text{tg}\alpha}, \text{ dacă folosim logaritmul natural} \quad (7.25)$$

Din relația (7.19) rezultă că temperatura de excitare s-ar putea determina, în cazul în care se cunoaște intensitatea absolută a liniei spectrale pentru elementul dat, în mod direct și anume după formula:

$$T_{exc} = - \frac{E_{exc}}{k_B \cdot \ln \left(\frac{l}{4\pi} \cdot \frac{I_{mn}}{N \cdot A_{mn}} \cdot \frac{B(T)}{g_m} \cdot \frac{\lambda_{mn}}{hc} \right)} \quad (7.26)$$

unde: N reprezintă concentrația totală a particulelor, $B(T)$ este funcția de partiție pentru atomi neutri sau ioni, E_{exc} reprezintă energia de excitare, l reprezintă grosimea sursei spectrale considerată a fi "subțire" din punct de vedere optic, iar I_{mn} este intensitatea absolută a radiației emise la o dezexcitare de pe nivelul superior m pe un nivel inferior n (exprimată în $\text{erg/sr} \cdot \text{s} \cdot \text{cm}^2$).

Evident măsurătorile de intensități absolute sunt extrem de greu de realizat. Din acest motiv este mult mai comod să folosim metoda dreptei Boltzmann, unde avem nevoie de intensitățile relative a cel puțin două linii spectrale.

În situația în care se lucrează doar cu două linii spectrale, erorile de determinare pot fi considerabile dacă nu se respectă următorul criteriu: cele două linii spectrale folosite la determinarea temperaturii să fie apropiate în lungimi de undă ($\Delta\lambda < 10 \text{ nm}$) și îndepărtate în energii de excitare ($\Delta E \geq 1 \text{ eV}$). Astfel temperatura de excitare se va calcula după formula:

$$T_{exc} = \frac{1}{k_B} \cdot \frac{E_{exc_1} - E_{exc_2}}{\ln \frac{g_1 A_1 \lambda_2}{g_2 A_2 \lambda_1} - \ln \frac{I_1}{I_2}} \quad (7.27)$$

Pentru a obține rezultate cât mai corecte este preferată folosirea a cât mai multor perechi de linii spectrale și medierea rezultatelor obținute.

7.5.2 Determinarea temperaturii de ionizare - disociere

Temperatura de ionizare (T_{ion}) caracterizează echilibrul de ionizare în plasmă. Ea este asociată energiei cedată plasmei pentru disocierea, atomizarea și ionizarea particulelor ei. Pentru determinarea temperaturii de ionizare se pot folosi mai multe metode, dintre care amintim: *metoda ecuației lui Saha* (dacă se cunosc densitățile de particule din plasmă); *metoda raportului dintre o linie ionică și o linie atomică ale aceluiași element* (Boumans - De Boer) și *metoda raportului linie-continuum*.

Ecuația lui Saha (1922) caracterizează echilibrul de atomizare-ionizare în plasmă și exprimă gradul de ionizare:

$$\frac{n_i n_e}{n_a} = \frac{g_i g_e}{g_a} \cdot \frac{(2\pi m_e k_B T)^{3/2}}{h^3} \cdot \exp\left(-\frac{E_{ioniz}}{k_B T_{ion}}\right) \quad (7.28)$$

Din această ecuație se poate exprima temperatura de ionizare dacă se cunosc densitățile de particule din plasmă (n_e, n_i, n_a). Deoarece aceste densități se determină foarte greu, metoda este foarte rar folosită.

Trebuie menționat faptul că ecuația lui Saha prevede existența echilibrului termodinamic local, ionizarea simplă a atomilor și atomii simplu ionizați să fie singură sursă de electroni (adică introducerea unui element în plasmă nu va afecta cvasineutralitatea plasmei sau altfel spus nu va conduce la "însămânțarea" acestuia).

Metoda raportului dintre o linie ionică și o linie atomică folosește raportul intensităților liniilor aceluiași element (de obicei Ca) pentru a determina temperatura de ionizare. Liniile din spectrul de emisie pot proveni atât din dezexcitarea atomilor excitați cât și din dezexcitarea ionilor excitați, în conformitate cu relațiile (7.6) și (7.7).

Făcând raportul celor două intensități, eliminând funcțiile de partiție cu ajutorul ecuației lui Saha, ținând cont de cvasineutralitatea plasmei ($n_e \approx n_i$), respectiv de echilibrul termodinamic local ($T = T_{exc} = T_{ion}$) și știind că funcția de partiție pentru electroni este $B_e(T) = 2$, rezultă:

$$\left(\frac{I_i}{I_a}\right)_{ETL} = 2 \cdot \left(\frac{2\pi m_e k_B}{h^2}\right)^{3/2} T^{3/2} \left(\frac{gA}{\lambda}\right)_i \left(\frac{\lambda}{gA}\right)_a \cdot \frac{1}{n_e} \cdot \exp\left(-\frac{E_{ioniz} + \Delta E_i - \Delta E_a}{k_B T_{ion}}\right) \quad (7.29)$$

Înlocuind constantele universale și logaritmand ecuația de mai sus, ea se transformă în:

$$\ln\left(\frac{I_i}{I_a}\right)_{ETL} = 49,93 + \ln\left[\left(\frac{gA}{\lambda}\right)_i \left(\frac{\lambda}{gA}\right)_a\right] + \frac{3}{2} \ln(T_{ion}) - \ln(n_e) - \frac{E_{ioniz} + \Delta E_i - \Delta E_a}{k_B T_{ion}} \quad (7.30)$$

Relația precedentă este ecuația unei drepte cu pantă negativă ($\text{tg}\alpha < 0$). Reprezentând grafic membrul stâng în funcție de $(E_{ioniz} + \Delta E_i - \Delta E_e)$, din panta drepte se determină temperatura de ionizare-disociere:

$$\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{k_B \cdot T_{ion}} \Rightarrow T_{ion} = -\frac{1}{k_B \cdot \operatorname{tg} \alpha} \quad (7.31)$$

Metoda descrisă mai sus presupune, ca o condiție de pornire, existența echilibrului termodinamic local în plasmă. Pentru cazul real, se definește *abaterea de la echilibrul termodinamic local* b_r , ca fiind raportul dintre $(I_i/I_a)_{\text{experimental}}$ (măsurat din spectru) și $(I_i/I_a)_{\text{la ETL}}$ (calculat din ecuația 7.30, luând $T = T_{exc}$):

$$b_r = \frac{\left(\frac{I_i}{I_a} \right)_{\text{experimental}}}{\left(\frac{I_i}{I_a} \right)_{\text{la ETL}}} \quad (7.32)$$

În funcție de valoarea acestui parametru se pot face aprecieri cu privire la starea în care se află plasma. Astfel, dacă acest coeficient este 1 se spune că plasma se află la echilibru termodinamic local. Dacă coeficientul este cuprins în intervalul $0,1 < b_r < 10$ se poate spune că plasma, sau zona investigată unde această valoare a fost determinată, se găsește într-o stare apropiată de starea de echilibru termodinamic local (valorile subunitare sunt caracteristice plasmelor recombinative, iar cele supraunitare celor ionizante). În afara intervalului amintit (valori mai mari decât 10) avem de a face cu o abatere de la starea de echilibru termodinamic, abaterea fiind cu atât mai mare cu cât valoarea lui b_r este mai mare.

Metoda raportului linie-continuum urmărește determinarea temperaturii de ionizare din raportul dintre intensitatea totală a unei linii spectrale la o lungime de undă dată λ și intensitatea din continuum, integrată pentru intervalul de lungimi de undă $\Delta\lambda$, din jurul liniei spectrale. Această metodă se limitează la temperaturi de ionizare mai mici de $6 \cdot 10^4$ K.

Folosind ecuația lui Saha și incluzând intensitatea cuantică de oscilație în absorbție, se obține o expresie generală pentru intensitatea liniei spectrale la o lungime de undă dată. Ea se împarte la suma dintre intensitatea radiației corespunzătoare tranzițiilor de tipul "liber-liber" sau de frânare a electronilor ("bremsstrahlung") și intensitatea radiației de recombinare.

Fiind necesare măsurători de intensități absolute, acestea se realizează cu ajutorul unei lămpi etalon, de exemplu cu filament de W, folosită pe post de "corp

gri". Astfel se măsoară intensitatea continuumului emis de un bec etalonat și se raportează la intensitatea relativă a unei linii de emisie. În cazul plasmelor de Ar, se folosește linia de la 430,01 nm, iar continuumul se măsoară la 428,6 nm.

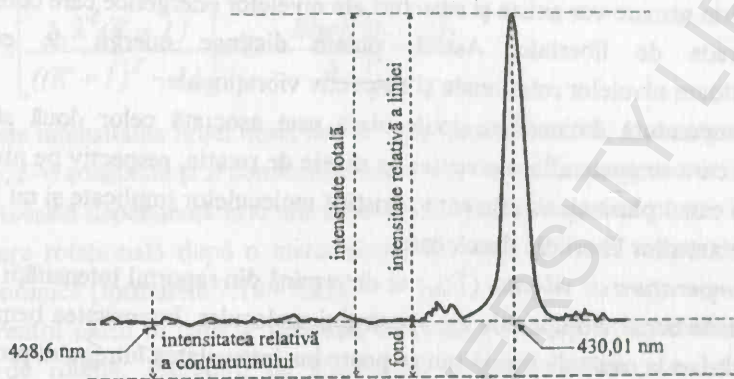


Fig.7.3 - Metoda raportului "linie la continuum".

S-a demonstrat că pentru determinarea temperaturii de ionizare se pot utiliza și intensități relative pentru linia spectrală, respectiv pentru continuum (Fig.7.3). În acest caz formula de lucru este:

$$\frac{I_{\lambda}}{I_c} = \frac{3,139}{T_{ion}} \cdot \exp\left[\frac{14565,2}{T_{ion}}\right] \cdot \frac{\lambda}{D_{\lambda}} \quad (7.33)$$

unde: I_{λ} este intensitatea relativă a liniei spectrale, I_c este intensitatea relativă a continuumului, D_{λ} reprezintă banda spectrală de trecere a aparatului spectral utilizat

Astfel se poate determina temperatura de ionizare-disociere, fără a presupune că plasma se găsește în echilibru termodinamic local.

7.5.3 Determinarea temperaturii de excitare moleculară

În continuare ne vom referi doar la moleculele biatomice deoarece acestea sunt suficient de bine studiate și destul de reprezentative pentru speciile moleculare care se pot întâlni în plasma descărcării gazoase, folosită ca sursă spectrală.

Aceste molecule pot fi excitate într-o varietate de stări electronice (asemănător atomilor), stări în care electronii se vor găsi pe orbite cu energii mari în jurul nucleului. Tranzițiile dintre nivelele energetice se realizează folosind fotoni din domeniul vizibil și(sau) ultraviolet al spectrului de radiație

electromagnetică și care au importante cantități de energie. Față de un atom, molecula biatomică are două grade suplimentare de libertate de rotație pe cele două direcții perpendiculare pe axa sa și un grad de libertate de vibrație în lungul axei sale. Prin urmare vor exista și structuri ale nivelelor energetice care corespund acestor grade de libertate. Astfel, putem distinge energii de excitație corespunzătoare nivelelor rotaționale și respectiv vibraționale.

Temperatura de excitație moleculară este asociată celor două stări de excitație în care se poate afla molecula: pe nivele de rotație, respectiv pe nivele de vibrație. În cazul plasmăi, ea este caracteristică moleculelor implicate și nu în mod necesar electronilor liberi din descărcare.

Temperatura de vibrație (T_{vibr}) se determină din raportul intensității a două sau mai multe benzi vibraționale ale spectrului molecular. Intensitatea benzii date se poate măsura la capăt de bandă sau se poate lua intensitatea întregului profil.

Dificultățile apar în cazul suprapunerii benzilor. În acest caz investigatorul trebuie să se asigure că s-au folosit aceleași fracțiuni sau capete de bandă din sistemul de benzi dat (la rezoluții slabe, liniile de rotație sunt suprapuse spre capetele de bandă). Acest tip de temperatură nu prezintă interes din punctul de vedere al surselor spectrale care folosesc plasma descărcării gazoase și în concluzie nu vom insista mai mult asupra sa.

Temperatura de rotație (T_{rot}) este o temperatură de excitație moleculară și va descrie distribuția particulelor pe nivele energetice de rotație. Ea este asociată energiei de rotație a moleculei și se determină din raportul intensităților liniilor spectrale aparținând unei benzi dintr-un spectru de emisie molecular. Aceste linii spectrale sunt foarte apropiate între ele atât din punct de vedere al lungimii de undă, cât și din punct de vedere energetic (aprox. 10^{-3} eV; în cazul benzii OH distanța dintre nivelele cele mai joase este de numai $5 \cdot 10^{-4}$ eV), deci populațiile acestor nivele rotaționale nu vor diferi semnificativ. Totuși, numărul mare de nivele care se pot folosi oferă determinării o bună acuratețe (~ 30 K). Cel mai des se studiază spectrul moleculelor OH (0 - 0) $A^2\Sigma^+ \rightarrow X^2\Pi_1$ (306 - 312 nm) și N_2^+ (0 - 0) $B^2\Sigma_u^+ \rightarrow X^2\Sigma_g^+$ (387 - 392 nm).

Temperatura de rotație se determină prin metoda dreptei Boltzmann și furnizează informații prețioase cu privire la starea speciilor moleculare din plasmă.

Intensitățile de rotație ale liniilor de vibrație-rotație sunt invers proporționale cu puterea a 4-a a lungimii de undă și direct proporționale cu gradul

de populare a nivelului superior de rotație. Folosind metoda logaritmării pentru liniarizare, intensitățile de emisie ale liniilor rotaționale emise de o moleculă biatomică vor fi date de relația:

$$\ln \left[\frac{I \lambda^4 (K+1)}{((K+1)^2 - 1)} \right] = D - \frac{BhcK(K+1)}{k_B T_{rot}} \quad (7.34)$$

unde: I este intensitatea liniei observate la lungimea de undă λ , K numărul cuantic de rotație, D o constantă și B constanta rotațională a nivelului superior de vibrație.

Această dependență este una liniară. Din panta dreptei se poate determina temperatura rotațională după o metodologie descrisă în cazul temperaturilor de excitare atomică (formulele 7.19 - 7.23).

Pentru cazul în care se cunoaște tăria (S) și energiile de excitare pentru nivelele de rotație, literatura de specialitate prevede și alte posibilități. De exemplu, intensitatea liniilor din bandă se poate și scrie sub forma:

$$I_{rot} = CS\sigma^4 \exp \left(-\frac{E_{rot}}{k_B T_{rot}} \right) \quad (7.35)$$

unde: C este un factor identic pentru toate liniile dintr-o bandă dată, iar σ este numărul de undă al tranziției.

Se poate reprezenta dependența $\ln(I/S\sigma^4)$ în funcție de energia nivelului superior E_{rot} , obținându-se o dreaptă de tip Boltzmann cu panta egală cu $-1/k_B T_{rot}$. Din panta dreptei se va determina temperatura de rotație:

$$T_{rot} = -\frac{1}{k_B \cdot \text{tg}\alpha} \quad (7.36)$$

7.5.4 Determinarea temperaturii cinetice

Temperatura cinetică descrie distribuția particulelor după energia lor cinetică. În cazul în care este vorba de particule grele (atomi sau ioni) ea se mai numește și *temperatură Doppler* sau *temperatura gazului*.

Determinarea acestei temperaturi se bazează pe ideea că particula emitentă de radiație electromagnetică (lumină) se află în mișcare în raport cu receptorul (aparatura optică de detecție). Astfel, acest receptor va sesiza lumina la o altă lungime de undă decât la care a fost ea emisă. Acest fenomen este binecunoscut în

fizică și sub denumirea de efect Doppler-Fizeau. El se va materializa prin lărgirea liniei spectrale în jurul lungimii de undă de emisie a particulei presupuse în repaus. Semilărgimea unei linii spectrale rezultată în urma existenței efectului Doppler-Fizeau este dată de formula:

$$\Delta\lambda_D = 2\lambda_o \sqrt{\frac{2(\ln 2)RT_{\text{gaz}}}{A}} = 7,16 \cdot 10^{-7} \lambda_o \sqrt{\frac{T_{\text{gaz}}}{A}} \quad (7.37)$$

unde: λ_o este lungimea de undă a radiației emise de specia termometrică folosită (de obicei se lucrează cu Be I, $\lambda_o = 234,861$ nm), iar A este masa atomică a ei. ($A_{\text{Be}} = 9,012$ u.a.m).

Astfel, formula generală pentru temperatura Doppler va fi:

$$T_D = A \left(\frac{\Delta\lambda_D}{7,16 \cdot 10^{-7} \lambda_o} \right)^2 = 1,95 \cdot 10^{12} \cdot A \cdot \left(\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_o} \right)^2 \quad (7.38)$$

sau, în particular pentru Be I: $T_{\text{gaz}} = 319 \Delta\lambda_D^2$, cu $\Delta\lambda_D$ exprimat în pm.

Împrăștierea radiației electromagnetice (de exemplu cea a unui laser) pe particulele din plasmă (atomi sau molecule) ce au dimensiuni mult mai mici decât lungimea de undă a radiației incidente, se numește *împrăștiere Rayleigh*. Aceste particule împrăștiitoare, având o masă mult mai mare decât electronii, vor avea viteze termice reduse, motiv pentru care efectul Doppler se poate neglija.

Diagrama schematică a procesului de împrăștiere este prezentată în Fig.7.4.

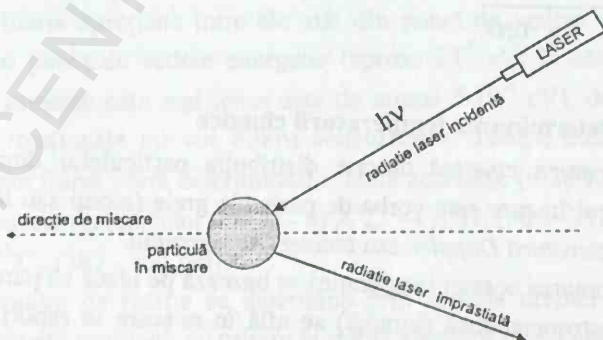


Fig.7.4 - Procesul de împrăștiere a radiației laser pe o particulă aflată în mișcare.

Deoarece împrăștierea Rayleigh depinde liniar de concentrația particulelor pe care se realizează împrăștierea și de secțiunea de împrăștiere a acestora, legea gazului ideal $p = nk_B T_{\text{gaz}}$ (unde n , p și k_B sunt numărul atomilor de gaz din unitatea de volum, presiunea și respectiv constanta lui Boltzmann) poate fi folosită la determinarea temperaturii particulelor grele din plasmă, *temperatura cinetică a gazului*.

Dacă spectrometrul este calibrat în mod corespunzător, se poate determina densitatea locală a atomilor și astfel se poate afla temperatura locală a gazului. Pentru calibrare sunt necesare doar două puncte, deoarece împrăștierea Rayleigh este un fenomen liniar. De exemplu, este suficient să se măsoare semnalul împrăștiat la temperatura camerei pentru Ar și He și astfel se poate obține o dreaptă de calibrare valabilă în intervalul de temperaturi: temperatura camerei (~ 293 K) – 18.000 K.

Măsurătorile care au la bază împrăștierea Rayleigh nu sunt influențate sau condiționate de existența sau lipsa echilibrului termodinamic în plasmă. Singura cerință impusă este distribuția maxwelliană a vitezelor particulelor, iar acuratețea determinărilor este de aproximativ 8 %.

O altă metodă care nu se bazează pe existența echilibrului termodinamic și servește la determinarea temperaturii cinetice a gazului este *metoda absorbției radiației laser*. Pentru aceasta se folosește un laser cu semiconductor pentru a determina profilul de absorbție al unei linii spectrale caracteristice gazului plasmiei.

Se alege o diodă laser având lungimea de undă corespunzătoare unei tranziții (de exemplu 811,53 nm pentru Ar $4s^3P_2 - 4p^3D_3$). Lungimea de undă a radiației laser (cu o lărgime de $\sim 0,05$ pm) poate fi baleată în jurul lungimii de undă corespunzătoare liniei spectrale corespunzătoare tranziției prin modificarea treptată a curentului prin diodă. Făcând ca radiația laser să treacă prin plasmă și detectând intensitatea acesteia se poate determina coeficientul de absorbție în funcție de lungimea de undă. Este de reținut că coeficienții de absorbție locali se pot obține doar după efectuarea inversiei Abel.

Profilul de absorbție obținut poate fi fitat cu o funcție de tip Voigt și conține lărgirile datorate presiunii (profil lorentzian), prezenței câmpurilor electrice (profil Stark) respectiv efectului Doppler (profil gaussian). Din

semilărgimea profilului gaussian se poate determina *temperatura gazului* cu o precizie de 10 % (formulele 7.33, 7.34).

Împrăștierea radiației laser pe electronii liberi din plasmă se numește *împrăștiere Thomson*. Ei se vor afla în mișcare atât față de fasciculul laser incident cât și față de detector. Astfel, radiația împrăștiată va prezenta o lărgire Doppler dublă. Dacă distribuția după viteze a electronilor este de tip maxwellian, atunci lărgirea liniilor din spectru se poate atribui temperaturii electronilor. Diagrama schematică a procesului de împrăștiere este identică cu cea prezentată în Fig.7.5, folosită pentru împrăștierea Rayleigh.

Într-o plasmă de argon cuplată inductiv viteza electronilor este foarte mare (100 - 1000 km/s), astfel încât lărgirea sesizată va fi de până la 5 nm.

Măsurând spectrul împrăștiat pentru diferite lungimi de undă lărgite Doppler, se poate determina distribuția energiei electronilor, iar din profilul gaussian al liniei obținute după împrăștiere se poate determina temperatura electronilor.

Deoarece interacțiunea dintre fasciculul laser și plasmă are loc într-o zonă aproape punctiformă (oricum de dimensiuni foarte mici față de dimensiunile plasmei), se poate realiza o investigare punct cu punct a plasmei. Totodată, pentru a asigura o rezoluție temporală pentru măsurători, se poate folosi un laser în impulsuri.

În comparație cu alte metode, împrăștierea Thomson are avantajul că nu perturbă fizic plasma și nu necesită prezența sau presupunerea existenței echilibrului termodinamic local. Neajunsurile metodei constau în semnalul relativ slab cauzat de faptul că într-o plasmă de Ar concentrația particulelor grele este de circa 1000 de ori mai mare decât cea a electronilor și acești atomi sunt "ținte" mai mari decât electronii (secțiunea eficace de "ciocnire" este mult mult mai mare).

O altă metodă de determinare a temperaturii electronilor este *metoda radianței spectrale a continuumului*. Radianța continuumului este datorată unor tranziții ce implică electroni liberi. Ea poate fi constituită din radiația de recombinare (un electron liber se combină cu un ion pozitiv) și radiația bremsstrahlung (de frânare - un electron liber rămâne liber, dar pierde energie). Deoarece energia electronilor liberi nu este cuantificată, radiația va fi distribuită într-un spectru continuu, intensitatea la orice frecvență depinzând de temperatura și concentrația electronilor după o relație de tipul:

$$I(\nu) \approx \frac{n_e^2}{T_e} \quad (7.39)$$

unde: n_e este densitatea de electroni iar T_e temperatura electronilor.

Expresia intensității continuumului I_c la o lungime de undă dată este:

$$I_c(\lambda) = C \cdot \frac{n_i n_e}{T_e^{1/2}} \cdot \left\{ \xi \cdot \left[1 - \exp\left(\frac{-hc}{\lambda \cdot k_B T_e}\right) \right] + G \cdot \exp\left(\frac{-hc}{\lambda \cdot k_B T_e}\right) \right\} \quad (7.40)$$

unde C este o constantă, ξ - factorul de corecție Biberman (datorat interacțiunilor de tipul liber-legat; pentru Ar $\xi = 1,8$), G - factorul Gaunt (datorat interacțiunilor de tipul liber-liber; pentru Ar $G = 1,1$).

Folosind expresia intensității unei linii spectrale (7.17) și ecuația lui Saha (7.26) se poate da o expresie mai complexă unei linii spectrale emise, funcție de temperaturile de excitație și ionizare. Raportând această expresie la relația (7.40), în final se va obține relația:

$$\frac{I}{I_c}(\lambda) = C \cdot \frac{gA}{B_i} \cdot \frac{I}{\lambda T_e} \cdot \frac{\exp\left(\frac{E_i - \Delta E_i}{k_B T_{ion}}\right) \cdot \exp\left(\frac{E_{exc}}{k_B T_{exc}}\right)}{\left\{ \xi \cdot \left[1 - \exp\left(\frac{-hc}{\lambda \cdot k_B T_e}\right) \right] + G \cdot \exp\left(\frac{-hc}{\lambda \cdot k_B T_e}\right) \right\}} \quad (7.41)$$

Calculul direct al temperaturii electronilor dintr-o astfel de relație este foarte dificil (presupune cunoașterea T_{ion} și T_{exc}). Dacă se presupune că plasma este în echilibru termodinamic local, atunci $T_{ion} = T_{exc} = T_e$ și relația (7.41) devine mai simplă.

7.6 Determinarea densității de electroni

Densitatea de electroni (n_e) este o măsură a numărului de electroni liberi într-un cm^{-3} de plasmă. Ea indică gradul de ionizare a plasmei și este considerată a fi un parametru fundamental, independent de temperaturi sau existența echilibrului termodinamic. Dacă acest echilibru există, atunci n_e va defini temperatura unică a plasmei. Pentru determinarea ei se pot folosi mai multe metode, cum ar fi: *metoda lărgirii Stark*; *metoda raportului linie-continuum*; *metoda ecuației Kramers-Unsöld*.

Metoda lărgirii Stark a liniei $H\beta$ (linia β din seria Balmer a hidrogenului, $\lambda_{H\beta} = 486,13$ nm) are la bază efectul Stark (lărgirea liniei spectrale în urma interacțiunii cu un câmp electric). Ea se datorează prezenței unui câmp electric extern constant și a unor microcâmpuri electrice interne, variabile în timp, cauzate de prezența particulelor încărcate electric. Totuși, pe timpul interacțiunii unui atom care emite radiație electromagnetică cu un ion lent, câmpul intern se poate considera constant. Efectul Stark este direct proporțional cu concentrația ionilor (sau electronilor - plasma fiind cvasineutră). Formula de lucru pentru această metodă este:

$$n_e = 7,966 \cdot 10^{12} (\Delta\lambda / \alpha_{1/2})^{\frac{3}{2}} \quad (7.42)$$

unde $\Delta\lambda$ este semilărgimea liniei $H\beta$, iar $\alpha_{1/2}$ este o constantă tabulată.

Această formulă este valabilă pentru temperaturi ale electronilor cuprinse în intervalul 5000 - 40 000 K.

În funcție de tipul de plasmă, de natura gazului de susținere sau de aparatura disponibilă se pot folosi și alte linii spectrale în vederea determinării densității de electroni cu ajutorul lărgirii Stark (linia α din seria Balmer a hidrogenului, $\lambda_{H\alpha} = 656,28$ nm, sau liniile din seria Lyman, respectiv linia de la 696,5 nm din spectrul Ar I).

Metoda raportului linie-continuum, pentru calculul densității de electroni, presupune valabilitatea ecuației lui Saha pentru sistemul în cauză. Pe lângă această condiție este nevoie și de măsurători spațiale pentru radianța continuumului și pentru temperatura de ionizare. Formula de lucru este:

$$n_e = 5,84 \cdot 10^{13} \cdot \lambda_c \cdot \left(\frac{I_c}{D_{\lambda_c}} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot T_{ion}^{\frac{1}{4}} \quad (7.43)$$

unde: I_c este intensitatea absolută a continuumului la lungimea de undă $\lambda_c = 428,6$ nm a continuumului și D_{λ_c} reprezintă lărgimea spectrală (vezi Fig.7.3).

Metoda ecuației Kramers-Unsöld urmărește, de asemenea, evoluția intensității continuumului în jurul lungimii de undă $\lambda = 450$ nm din spectrul plasmiei. Astfel, ecuația de lucru devine:

$$n_e = (1,241 \cdot 10^{30} \cdot \varepsilon_\lambda \cdot \sqrt{T_e})^{1/2} \quad (7.44)$$

unde: ε_λ este intensitatea absolută a continuumului (în W/sr·μm·cm²), iar T_e reprezintă temperatura electronilor (în K). Constantele prezente în această ecuație provin din literatura de specialitate.

M. W. Blades și colab. prezintă o relație de legătură între n_e (în cm⁻³) și T_{ion} (în K) aparent mai complicată, care poate fi folosită la calcularea densității de electroni dacă se cunoaște T_{ion} :

$$n_e = 5,95 \cdot 10^{18} \cdot \sqrt{\sqrt{T_{ion}} \left[4 + 2 \exp\left(\frac{-2061}{T_{ion}}\right) \right] \exp\left(\frac{-182900}{T_{ion}}\right)} \quad (7.45)$$

Relația de mai sus a rezultat în urma presupunerii că expresia funcției de distribuție după energii a atomilor de Ar este foarte apropiată de cea din cazul echilibrului termodinamic local.

Densitatea de electroni se poate calcula și cu ajutorul raportului dintre o linie ionică și o linie atomică ale aceluiași element, valabil la echilibru termodinamic:

$$\ln\left(\frac{I_i}{I_a}\right)_{EN} = 49,93 + \ln\left[\left(\frac{gA}{\lambda}\right)_i \left(\frac{\lambda}{gA}\right)_a\right] + \frac{3}{2} \ln(T_{ion}) - \ln(n_e) - \frac{E_{ioniz} + \Delta E_i - \Delta E_a}{k_B T_{ion}} \quad (7.46)$$

Reprezentând grafic membrul stâng în funcție de $(E_{ioniz} + \Delta E_i - \Delta E_a)$, din panta drepte se determină temperatura de ionizare-disociere, iar din intersecția cu axa $(E_{ioniz} + \Delta E_i - \Delta E_a = 0)$ se poate determina densitatea de electroni, după formula:

$$\ln(n_e) = 49,93 + \ln\left[\left(\frac{gA}{\lambda}\right)_i \left(\frac{\lambda}{gA}\right)_a\right] + \frac{3}{2} \ln(T_{ion}) - \ln\left(\frac{I_i}{I_a}\right) \quad (7.47)$$

7.7 Diagnosticarea plasmelor și inversia Abel

Majoritatea surselor spectrale nu sunt complet omogene pe direcție verticală sau orizontală și astfel informațiile optico-spectrale prezintă o structură spațială oarecum neomogenă.

În cazul în care plasma prezintă o oarecare simetrie cilindrică, informațiile optico-spectrale (intensități de emisie sau absorbție, densități de particule, temperaturi etc.) sunt obținute din radiația luminoasă provenită de la întreaga grosime laterală a sursei spectrale (Fig.7.5).

Procedura de transformare a datelor laterale (plan $x - y$; profil lateral) în date radiale (plan $r - \theta$; plan radial) se numește *inversie Abel*.

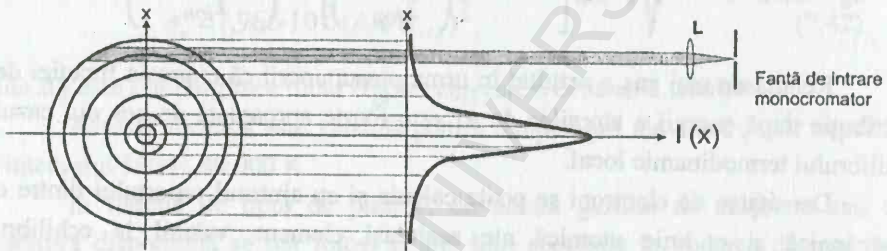


Fig.7.5 - Diagrama de observare optică a plasmelor cu simetrie cilindrică.

Dacă sursa poate fi considerată ca având o simetrie cilindrică, intensitatea laterală $I(x)$ în direcția axei de observare Ox este dată de relația:

$$I(x) = 2 \cdot \int_x^R \frac{I(r) \cdot r}{\sqrt{x^2 - r^2}} dr \quad (7.48)$$

unde R este raza sursei spectrale, iar $I(r)$ este intensitatea radială la o distanță r de axa de simetrie a sursei.

În aceste condiții $I(r)$ va fi dată de ecuația Abel (Fig.7.6):

$$I(r) = -\frac{1}{\pi} \cdot \int_r^R \frac{dI(x)/dx}{\sqrt{x^2 - r^2}} dx \quad (7.49)$$

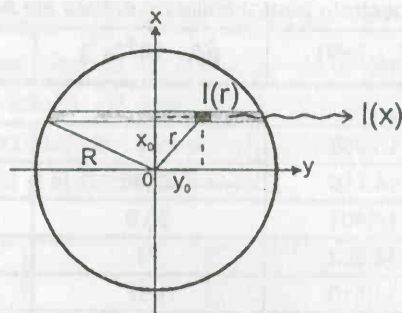


Fig.7.6 - Intensitățile radiale și laterale.

Rezolvarea numerică a ecuației (7.48) se face în modul următor. Având în vedere că intensitatea laterală înregistrată va prezenta o oarecare asimetrie față de axa centrală a sursei spectrale, se va calcula prima dată intensitatea "simetrică" (media aritmetică a celor două intensități laterale situate la aceeași distanță față de axa centrală a plasmăi). Profilul lateral astfel obținut se va aproxima cu o expresie polinomială de gradul n . Profilul radial se va obține în urma integrării, conform ecuației (7.47), al derivatei de ordinul întâi a expresiei polinomiale.

Inversia Abel își găsește aplicația în realizarea hărților de temperatură sau densități de particule ale plasmăi sau în studiul variației profilului liniilor spectrale.

7.8 Temperaturi și densități de electroni într-o plasmă de argon

O parte dintre metodele optico-spectrale de diagnosticare prezentate anterior au fost aplicate pentru studiul plasmăi de Ar cuplată capacitiv la presiune atmosferică. Plasma a fost generată cu oscilatorul RF prezentat în Fig.4.7, cu modificările din Fig.4.11, la o putere de 185 W și cu un consum de argon de 1 l/min.

Pentru determinarea temperaturilor de excitație au fost folosite ca specii termometrice argonul și fierul iar pentru determinarea temperaturii de ionizare, argonul și calciul. Fierul și calciul au fost introduse în plasmă prin pulverizarea pneumatică a unor soluții etalon monoelement cu concentrația de $1000 \mu\text{g ml}^{-1}$.

Temperaturile de excitație au fost determinate prin metoda dreptei Boltzmann folosind relațiile (7.21) sau (7.22), în funcție de datele spectrale avute la dispoziție din literatură, date care sunt prezentate în Tabelul 7.1. Spre exemplificare, în Fig.7.7 este prezentată o astfel de dreaptă pentru argon.

Tabelul 7.1 - Date spectrale pentru liniile de emisie ale Ar, Fe, Ca și OH.

| λ [nm] | E_{exc} [eV] | $gA \cdot 10^{-8} [\text{s}^{-1}]$ | $(\lambda^3/gf) \times 10^{-13}$ |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ARGON | | | |
| 383,50 | 15,088 | 80 | - |
| 404,44 | 14,716 | 32,55 | - |
| 425,12 | 14,491 | 33,9 | - |
| 427,22 | 14,552 | 71 | - |
| 430,01 | 14,510 | 1,97 | - |
| 434,50 | 14,708 | 93,9 | - |
| 451,07 | 16,603 | 1,02 | - |
| FIER | | | |
| 371,994 | 3,34 | - | 1.3855 |
| 372,256 | 3,42 | - | 9.8294 |
| 373,484 | 4,19 | - | 0.2552 |
| 373,713 | 3,37 | - | 1.9392 |
| 375,873 | 4,26 | - | 0.5308 |
| 376,379 | 4,29 | - | 0.8258 |
| 376,719 | 4,31 | - | 1.1696 |
| CALCIU | | | |
| 430,253 | 2,882 | 7,1 | linie atomică |
| 445,673 | 2,784 | 7,5 | linie atomică |
| 393,367 | 3,152 | 0,91 | linie ionică |
| 422,67 | 2,932 | 1 | linie atomică |

| λ [nm] | E_J [cm^{-1}] | $S_{JJ'}$ | notație |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|
| OH | | | |
| 307,114 | 35913,21 | 53,2 | $R_2(14)$ |
| 307,303 | 36394,95 | 57,2 | $R_2(15)$ |
| 307,437 | 32778,99 | 12,8 | $R_2(4)$ |
| 307,703 | 32643,83 | 9,1 | $R_2(3)$ |

A fost studiată dependența temperaturii de excitație pentru atomii de argon și fier în funcție de înălțimea de vizare a plasmelor (măsurată de la vârful de susținere a plasmelor). În Fig.7.8 sunt prezentate două astfel de dependențe pentru

două valori ale distanței (H) dintre electrodul de susținere a plasmelor și contraelectrod. Se poate observa că cele două curbe prezintă câte două maxime, unul în apropierea vârfului de susținere a plasmelor și celălalt în apropierea contraelectrodului. Maximele pot fi explicate prin efectul cumulativ al distribuției liniilor de câmp electric și al fluxului de argon.

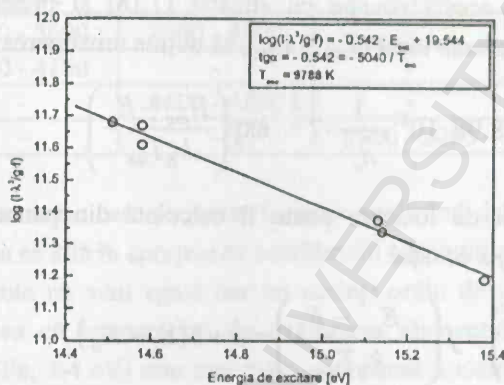


Fig.7.7 - Dreapta Boltzmann pentru determinarea temperaturii de excitare a Ar.

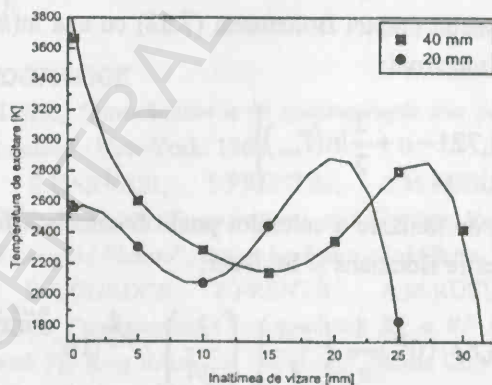


Fig.7.8 – Temperatura de excitare a Ar în funcție de înălțimea de vizare, pentru două poziții diferite ale contraelectrodului.

Temperaturile de ionizare ale argonului au fost determinate pornind de la ecuația lui Saha (7.26) scrisă în ipoteza ionizării simple și a cuasineutralității

plasmei ($n_i \equiv n_e$). Ținând seama de faptul că $g_e = 2$ și $g_i = 6$ pentru argon și înlocuind valorile numerice ale celorlalte constante, rezultă ecuația:

$$\frac{n_e^2}{n_a} = 28,98 \cdot 10^{21} \frac{1}{g_a} \cdot \exp\left(-\frac{E_i}{k_B T_{ion}}\right) \quad (7.50)$$

Combinând această ecuație cu ecuația (7.18) și presupunând prezența echilibrului termodinamic local ($T_{exc} \equiv T_{ion}$), se obține următoarea ecuație:

$$\frac{hc \cdot gA}{I \cdot \lambda} = 28,98 \cdot 10^{21} \cdot \frac{1}{n_e^2} \cdot T^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(\frac{E_{exc} - E_i}{k_B T_{ion}}\right) \quad (7.51)$$

Temperatura de ionizare poate fi calculată din panta regresiei liniare (dreaptă Boltzmann) a ecuației:

$$\ln\left(\frac{hc \cdot gA}{I \cdot \lambda}\right) = f\left(-\frac{E_{exc} - E_i}{k_B T_{ion}}\right) = a + b(E_i - E_a) \quad (7.52)$$

unde: $a = 51,721 - 2 \cdot \ln(n_e) + 3/2 \cdot \ln(T_{ion})$ și $b = -1/(k_B T_{ion})$.

După determinarea temperaturii de ionizare, din valoarea parametrului a , care reprezintă intersecția dreptei Boltzmann (7.52) cu axa $\ln(hc \cdot gA/I\lambda)$, se poate calcula densitatea de electroni:

$$n_e = \exp\left\{51,721 - a + \frac{3}{2} \ln(T_{ion})\right\} \quad (7.53)$$

Temperatura de ionizare a calciului poate fi calculată folosind o expresie dată în literatură de către Boumans și De Boer:

$$\left(\frac{I_i}{I_a}\right)_{LTE} = 4,83 \cdot 10^{21} \cdot \frac{1}{n_e} \cdot \left(\frac{gA}{\lambda}\right)_i \cdot \left(\frac{\lambda}{gA}\right)_a \cdot T^{\frac{3}{2}} \cdot 10^{-\frac{E_i + \Delta E_i - \Delta E_a}{k_B T}} \quad (7.54)$$

unde: I/I_a reprezintă raportul dintre intensitatea unei linii ionice și a uneia atomice iar ΔE_i și ΔE_a – energiile corespunzătoare tranziției ionice, respectiv atomice. Pentru calcularea temperaturii de ionizare au fost folosite trei linii atomice și una ionică ale calciului, linii ale căror date spectrale sunt prezentate în Tabelul 7.1.

O sinteză a rezultatelor obținute este prezentată în Tabelul 7.2, cu precizarea că au fost investigate diferite zone din plasmă, așa cum s-a prezentat și în Fig.7.8.

Tabelul 7.2 - Temperaturi caracteristice și densități de electroni.

| Specie | T_{exc} [K] | T_{ion} [K] | T_{rot} [K] | n_e [10^{14}cm^{-3}] |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Ar | 2000 - 3500 | 2500 - 4500 | - | 2 - 6 |
| Fe | 3700 - 4700 | - | - | - |
| Ca | - | 4600 - 4700 | - | 2 - 6 |
| OH | - | - | 1900 - 2900 | - |

O primă concluzie care se poate formula analizând datele experimentale este aceea că plasma se află în apropierea echilibrului termodinamic local deoarece temperaturile obținute nu sunt egale dar au același ordin de mărime. O a doua concluzie este aceea că temperatura de excitație a elementului cu energie de excitație mai mică (Fe, 3-4 eV) este mai mare decât aceea a elementului cu energie de excitație mai mare (Ar, 14-16eV). Același lucru se poate afirma și despre temperatura de ionizare, care este mai mare pentru Ca ($E_{ion} = 6,11$ eV) decât pentru Ar ($E_{ion} = 15,75$ eV).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. C. PECKEL-WIMEL, "Introduction a la spectroscopie des plasmas". Gordon and Breach, Paris - Londres - New-York 1967.
2. S.D.ANGHEL, E.DARVASI, T.FRENTIU, A.M.RUSU A.SIMON and E.A.CORDOS. "Characteristic Temperatures and Electron Number Densities in an RF Capacitively Coupled Plasma". Fresenius Journ.Anal.Chem. 355:250-251 (1996).
3. S.D.ANGHEL, E.A.CORDOS, T.FRENTIU, A.M.RUSU, A.SIMON and E.DARVASI, "Some Fundamental Characteristics for a RF Capacitively Coupled Argon Plasma with Tip-Ring Electrode Geometry". Studia Univ."Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XLI, nr.1, 109-123 (1997).
4. A.MONSTASER and W.GOLIGHTLY, "Inductively Coupled Plasma in Analytical Atomic Spectrometry", VCH Publishers Inc., 1992.
5. L.IOVA, I.I.POPESCU și E.I.TOADER, "Bazele Spectroscopiei Plasmei". Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987.
6. J.RICHTER, "Radiation of Hot Gases. Plasma Diagnostics". Ed. W.Lochte-Holtgreven, Amsterdam, 1968.

CAPITOLUL VIII

APLICAȚII ALE PLASMELOR DE RADIOFRECVENȚĂ

8.1 Plasma cuplată capacitiv ca sursă spectrală

8.1.1 Principii generale

Substanțele din care se formează corpurile din natură sunt o combinație a celor 92 de elemente din Sistemul Periodic al Elementelor. Proprietățile fizico-chimice ale fiecărei substanțe sunt determinate de combinația particulară a elementelor care le alcătuiesc. Dorința de a înțelege comportarea acestor substanțe în anumite situații date sau interacțiunea dintre diferitele forme ale materiei, au impus necesitatea cunoașterii compoziției pe elemente a substanțelor în cauză. În ultimii 150 de ani s-au elaborat și s-au aplicat o serie de metode de determinare a compoziției pe elemente a substanțelor de interes, incluzând metode spectroscopice, electrochimice, nucleare sau de raze X.

În acest subcapitol vom încerca să elucidăm legăturile dintre metodele spectroscopice de analiză și plasma descărcării gazoase.

Metodele spectroscopice de analiză își propun ca prim scop determinarea compoziției unei probe date sau să elucideze detalii despre structura, mișcarea sau caracteristicile intrinseci (temperatură, presiune, intensitatea câmpului magnetic) ale probei în cauză. În sensul cel mai restrâns al noțiunii, *spectroscopia* este ramura fizicii care studiază interacțiunea dintre lumină și materie. Atunci când lumina întâlnește materia pot avea loc o serie de fenomene: lumina poate fi emisă, reflectată, transmisă, împrăștiată sau absorbită. Aceste fenomene conțin informații caracteristice pentru proba dată.

Aplicațiile moderne ale spectroscopiei au generalizat noțiunea de "lumină" pentru a cuprinde atât spectrul electromagnetic (γ , raze X, ultraviolet, vizibil, infraroșu, microunde și unde radio) cât și alte tipuri de energie decât cea

electromagnetică (de natură mecanică, nucleară, etc.). Toate aceste forme diverse de radiație electromagnetică (sau lungimi de undă) își au propriile metode de măsură, impunând astfel o gamă largă și variată de aparatură experimentală.

Astfel, în sensul cel mai larg al noțiunii, spectroscopia este știința care studiază modul în care o cantitate energie este distribuită în funcție de o mărime fizică caracteristică. Izvorul acestei energii studiate se numește *sursă spectrală*. Proba analizată vine în contact cu această sursă spectrală, analiza putând avea ca prim scop fie *identificarea elementelor* prezente în probă (*analiză calitativă*), fie *determinarea concentrației* unuia sau mai multor elemente aflate în aceeași probă (*analiză cantitativă*). Evident, cele două procedee de investigare nu se exclud reciproc, împreună putând oferi o fișă completă a probei (elemente constitutive și concentrațiile lor).

Pentru ca investigarea să poată avea loc este necesară de "cuplarea" sursei spectrale cu o metodă de lucru bine determinată. Atunci când se realizează această asociere, apare un nou set de cerințe care sunt legate de "compatibilitatea" combinației respective. Rezultatul este dependent atât de caracteristicile sursei spectrale cu plasmă, cât și de cele ale metodei spectroscopice alese. De foarte multe ori aceste caracteristici sunt cele care impun slăbiciunile sau punctele "tari" ale unei metode spectrochimice.

În particular sursa spectrală poate fi *plasma descărcării gazoase*. În funcție de cantitatea de energie transferată plasmelor ea va avea un anumit grad de ionizare și o anumită temperatură. Plasmele folosite ca surse spectrale fac parte din categoria celor slab ionizate (cu un grad de ionizare de aproximativ 2 – 3 %), cu temperaturi medii (mii de K).

O proprietate importantă a plasmelor folosite ca surse spectrale este aceea că energia câmpului electromagnetic generator este transmisă mai întâi electronilor din plasmă, după care ea este transferată prin ciocniri celorlalte particule (atomi, molecule, radicali și ioni). În cazul plasmelor întreținute în medii gazoase la presiune atmosferică, drumul liber mediu al electronilor este mic față de cel din plasmă de joasă presiune. Din acest motiv numărul ciocnirilor per atom per secundă este suficient de mare pentru ca energia cinetică să fie uniform distribuită între electroni, atomi și ioni. O astfel de plasmă care conține atomi excitați, atomi ionizați și ioni excitați, având energii cinetice considerabile, va fi o plasmă caldă. Este foarte important ca plasma folosită ca sursă spectrală să aibă o zonă foarte caldă (canal), care să asigure disocierea completă în atomi a probei analizate și o

zonă mai rece pentru emisie, unde fondul spectral este mai scăzut (miez, coadă și manta). Pentru ca o sursă de plasmă să fie considerată sursă spectrală ideală, ea trebuie să satisfacă o serie de cerințe:

- Conversia cantitativă completă a probei în atomi, ioni, radicali sau molecule și controlul separat al acestor procese
- Lipsa interferențelor și fond spectral scăzut
- Capacitatea de a tolera probe indiferent de starea de agregare
- Condiții de plasmă reproductibile de la o probă la alta
- Stabilitate pe termen lung și scurt
- Preț de cost, operare și întreținere cât mai mic
- Mod de operare ușor, cu perspective pentru automatizare
- Cunoașterea fizicii și chimiei respectivului tip de plasmă

Principalul motiv pentru care se folosesc mai multe tipuri de plasmă ca surse spectrale este acela că nici un tip de plasmă nu întrunește toate caracteristicile enumerate mai sus. Prin urmare, fiecare tip de plasmă are anumite calități și avantaje, dar în același timp și lipsuri.

Pentru înțelegerea rolului în spectroscopie a acestor plasmă, este importantă prezentarea pe scurt a principalelor etape ale procesului de extragere a elementelor din matricea probei. Dacă proba este lichidă, în clipa în care proba ajunge în plasmă, datorită temperaturilor relativ înalte, începe *procesul de desolvatare* (lichidul se evaporă, rămânând în urmă doar particule). Particulele rezultate în urma desolvatării sunt *vaporizate* și apoi *disociate* sub formă de atomi liberi. La o temperatură dată se va stabili un echilibru între forma disociată (atomi, ioni și radicali), respectiv nedisociată (moleculară) a elementelor prezente în plasmă. Rolul plasmă este de a asigura o energie suficientă proceselor de desolvatare, vaporizare și disociere, respectiv de a menține aceste condiții un timp suficient de lung pentru ca analiza să se desfășoare în condiții optime (fondul spectral pe care se efectuează măsurătorile din timpul analizei este dat tocmai de plasmă). Evident, în cazul în care această energie nu este suficientă, procesele dorite nu mai pot avea loc, existând chiar pericolul stingerii plasmă.

În cazul în care se folosește o metodă care permite eliberarea directă a elementelor din matricea probei, acestea vor fi antrenate de un flux de gaz (de obicei identic cu cel de susținere a descărcării) și transportate spre plasmă, unde vor fi supuse proceselor mai sus amintite (cu excepția desolvatării).

Proba trebuie să ajungă la sursa spectrală sub o formă bine determinată, astfel încât să fie îndeplinite toate cerințele pentru obținerea unor informații cât mai reale și exacte despre ea.

O prezentare schematică a diferitelor modalități de introducere a probelor într-o sursă spectrală cu plasmă este prezentată în Fig.8.1.

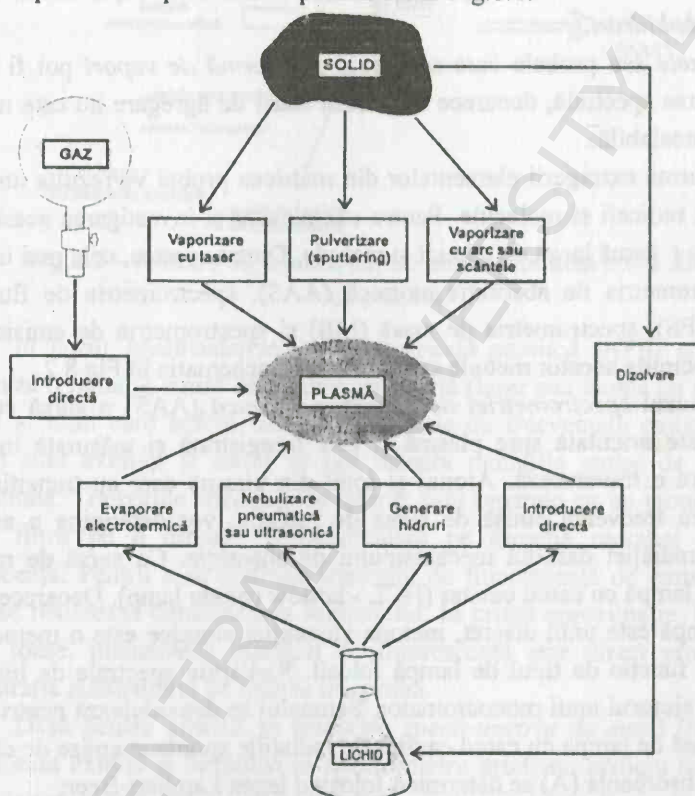


Fig.8.1 – Modalități de introducere a probelor în sursa spectrală cu plasmă.

Pentru probele aflate în stare solidă există două modalități de introducere în plasmă: dizolvarea într-un solvent potrivit (apă sau acid) și aducerea lor în stare lichidă sau, în cazul în care geometria și modul de operare a sursei spectrale o permit, eliberarea atomilor sau ionilor de interes direct din matricea probei. Acest proces se poate realiza prin *evaporare termică*, ca urmare a acțiunii unei plasmei (arc, scântee, descărcare globulară, plasmă cuplată capacitiv) sau prin *vaporizarea locală* cu ajutorul unui fascicul laser. Materialul vaporizat prin aceste procedee este antrenat într-un flux de gaz și transportat în sursa spectrală.

Lichidele trebuie introduse în sursa spectrală sub forma și cu debitul care să nu influențeze buna funcționare a plasmei. De cele mai multe ori se alege varianta picăturilor extrem de fine, obținute cu pulverizatoare pneumatice sau ultrasonice. Alte alternative pentru introducerea probelor aflate în stare lichidă sunt *vaporizarea electrotermică, introducerea directă* prin intermediul unor suporturi de grafit sau *generarea de hidruri*.

Gazele sau probele care se găsesc *sub formă de vapori* pot fi introduse direct în sursa spectrală, deoarece din cauza stării de agregare nu este necesară o atomizare prealabilă.

În urma extragerii elementelor din matricea probei va rezulta un "nor" de atomi, ioni, radicali și molecule. Pentru examinarea și investigarea acestui nor se poate utiliza o gamă largă de tehnici și metode. Dintre acestea, cele mai importante sunt: spectrometria de absorbție atomică (AAS), spectrometria de fluorescență atomică (AFS), spectrometria de masă (MS) și spectrometria de emisie atomică (AES). Principiile acestor metode sunt prezentate schematic în Fig.8.2.

În cazul *spectrometriei de absorbție atomică* (AAS) o sursă cu radiație modulată este orientată spre plasmă și este înregistrată și măsurată intensitatea radiației care o traversează. Atomii și ionii din plasmă care au tranziții atomice rezonante cu frecvența emisă de sursa de radiație, vor determina o atenuare a intensității radiației datorită mecanismului de absorbție. Ca sursă de radiație se utilizează o lampă cu catod cavitărilor (HCL - hollow catode lamp). Deoarece spectrul emis de lampă este unul discret, metoda absorbției atomice este o metodă mono-element, în funcție de tipul de lampă folosit. Radiațiile spectrale de interes sunt separate cu ajutorul unui monocromator. Semnalul se demodulează pentru a separa radiația emisă de lampă cu catod cavitărilor de radiațiile spontane emise de către sursa spectrală. Absorbanța (A) se determină folosind legea Lambert-Beer:

$$\ln\left(\frac{I_0}{I}\right) = A = ab \cdot c \quad (8.1)$$

unde: I_0 și I reprezintă intensitatea radiațiilor incidentă respectiv transmisă; A - absorbanța; c - concentrația absorbantului; a - un coeficient de absorbție; b - lungimea drumului străbătut prin absorbant.

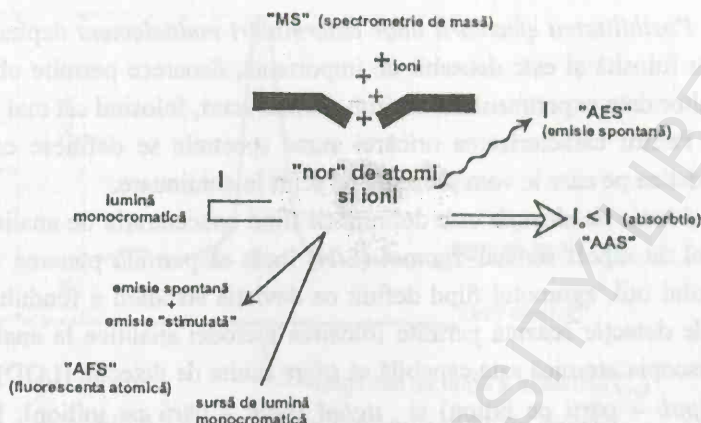


Fig.8.2 – Metode de analiză pentru atomii introduși într-o sursă spectrală cu plasmă.

În cazul *spectrometriei de fluorescență atomică* (AFS) spre plasmă se orientează o radiație emisă de o sursă modulată (laser sau lampă cu catod cavitat). Atomii și ionii care suferă tranziții rezonante cu frecvențele emise de sursa de radiație sunt excitați și astfel se pot măsura radiațiile emise de către speciile fotoexcitate. Tranzițiile spectrale de interes sunt separate cu un monocromator sau cu un filtru pe o direcție perpendiculară pe direcția radiației care produce fluorescența. Pentru a se distinge semnalul de fluorescență de emisia spontană a sursei se realizează demodularea semnalului. În primă aproximație, la concentrații relativ joase, intensitatea radiației de fluorescență este direct proporțională cu concentrația elementului de interes din probă.

Dacă pentru analiză se folosește *spectrometria de masă* (MS), ionii din plasmă sunt extrași și introduși în spectrometru printr-un orificiu special destinat acestui scop numit *skimmer*, urmând ca analiza probei, respectiv identificarea elementelor să se facă în funcție de raportul masă sarcină.

Spectrometria de emisie atomică (AES) este cea mai folosită metodă în efectuarea analizelor spectrochimice. Această metodă are la bază principiul conform căruia atomii și ionii unui element dat, atunci când sunt excitați prin mijloace termice sau nontermice, vor emite în urma proceselor de relaxare un spectru de linii, caracteristic elementului excitat în plasmă. De obicei pentru analiză sunt alese liniile de emisie cele mai intense și cu cel mai mare raport semnal-zgomot sau cele care prezintă cele mai puține interferențe spectrale.

Posibilitatea efectuării unor determinări multielement depinde de tehnica de lucru folosită și este deosebit de importantă, deoarece permite obținerea a cât mai multor date experimentale, în timp cât mai scurt, folosind cât mai puțină probă.

Pentru caracterizarea oricărei surse spectrale se definesc câteva mărimi caracteristice pe care le vom prezenta pe scurt în continuare.

Limita de detecție este definită ca fiind concentrația de analit care asigură un astfel de raport semnal-zgomot (S/N) încât să permită punerea în evidență a semnalului util, zgomotul fiind definit ca deviația standard a fondului spectral. O limită de detecție scăzută permite folosirea metodei analitice la analiza de urme. Spectroscopia atomică este capabilă să ofere limite de detecție (LOD) în domeniul ng/ml (ppb – părți pe bilion) și $\mu\text{g/ml}$ (ppm – părți pe milion), în funcție de element și/sau metodă.

Selectivitatea depinde de calitatea sistemului de analiză și este o măsură a abilității metodei de a detecta prezența unui element dat dintr-un amestec de elemente. Ea este vavorizată de lipsa interferențelor spectrale

Acuratețea și precizia sunt determinate de stabilitatea sursei și sunt o măsură a încrederii pe care o poate avea analistul în metoda analitică de măsură.

Gama dinamică, definită ca intervalul de concentrații ale unui element pentru care se poate stabili o relație liniară între intensitatea de emisie și concentrație, oferă posibilitatea determinării elementelor pentru un interval mare de concentrații, fără a avea nevoie de diluări. Ea este determinată de proprietățile fizice ale sursei spectrale și de gama dinamică intrinsecă a sistemului de detecție.

Posibilitatea adaptării sistemului de analiză la probe aflate în diferite stări de agregare este o consecință a principiilor de operare și a geometriei sursei.

Pentru a putea înțelege mai bine aceste proprietăți să analizăm cu atenție caracteristicile semnalului de emisie prezentat în Fig.8.3, unde: λ_a este lungimea de undă analitică (caracteristică elementului dat); x_{a+b} – intensitatea semnalului brut (total); x_b – intensitatea semnalului "blank" (fără elementul emițător – background sau fond spectral). Astfel, intensitatea semnalului net ($x_a = x_{a+b} - x_b$) reprezintă intensitatea relativă I a radiației emise de un element cu concentrația c_a , la lungimea de undă λ_a . "Zeroul electric" reprezintă intensitatea semnalului înregistrat în absența radiației emise de plasmă. El se mai numește și semnal de întuneric.

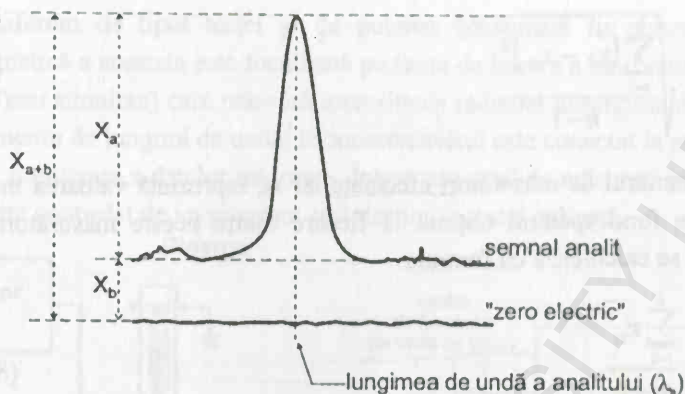


Fig.8.3 – Caracteristicile semnalului de emisie.

Raportul semnal fond ($SBR = \text{signal to background ratio}$) se definește ca fiind raportul dintre intensitatea semnalului net (x_a) și intensitatea semnalului de fond (x_b):

$$SBR = \frac{x_a}{x_b} \quad (8.2)$$

Deviația relativă standard a fondului ($RSDB = \text{relative standard deviation of the background}$), care este rezultatul cumulării unor zgomote, se exprimă cu ajutorul relației:

$$RSDB = \sqrt{\alpha_b^2 + \frac{\beta}{x_b} + \frac{\gamma}{x_b^2}} \quad (8.3)$$

unde: α_b , β și γ reprezintă zgomotul datorat fluctuațiilor, zgomotul de alicie și respectiv zgomotul detectorului.

Limita de detecție în semnal se definește ca fiind semnalul net care este de k ori mai mare decât deviația standard a fondului (σ_B), k fiind un număr întreg. Această definiție justifică afirmația conform căreia performanțele analitice ale unei surse spectrale sunt limitate de zgomotele de fond.

Deviația standard a fondului σ_B este:

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x}_b - x_{bi})^2}{n-1}} \quad (8.4)$$

unde n este numărul de măsurători efectuate iar x_{bi} reprezintă valoarea intensității semnalului de fond spectral obținut la fiecare dintre aceste măsurători. Media acestor valori se calculează cu formula:

$$\bar{x}_b = \frac{\sum_{i=1}^n x_{bi}}{n-1} \quad (8.5)$$

Astfel, deviația relativă standard a fondului se poate calcula cu formula:

$$RSDB = \frac{\sigma_B}{\bar{x}_b} \quad (8.6)$$

Conversia limitei de detecție în semnal la *limită de detecție în concentrație* (LOD - limit of detection) necesită o calibrare.

$$LOD = k \cdot \sigma_B \cdot \frac{c_a}{x_a} = 0,01 \cdot k \cdot RSDB \cdot \frac{c_a}{SBR} \quad (8.7)$$

Constanta k poate lua valorile 2; 3; $2\sqrt{2}$ sau $3\sqrt{2}$. Cel mai des se folosește valoarea $k = 3$, iar metoda de lucru se numește *criteriul 3σ* (Boumans).

Curba de calibrare este reprezentarea grafică a intensității semnalului net în funcție de concentrație, $x_a = f(c_a)$.

8.1.2 Instrumentația folosită în evaluarea surselor spectrale cu plasmă

Cea mai mare parte a surselor spectrale cu plasmă sunt folosite pentru analiza elementară calitativă și cantitativă prin metodele spectrometriei de emisie atomică. Pentru studiul unor tipuri de plasmă cuplată capacitiv la presiune atmosferică folosite ca surse spectrale, în cele mai dese situații se recurge la o instrumentație complexă, prezentată schematic în Fig.8.4.

Plasma este generată cu diferite tipuri de torțe (prezentate în Capitolul V), având geometrii variate ale electrozilor între care este aplicată tensiunea de radiofrecvență. Aceasta este furnizată de generatoare de diverse puteri, generatoare prezentate în Capitolul IV.

Indiferent de tipul torței și de puterea consumată în plasmă, radiația electromagnetică a acesteia este focalizată pe fanta de intrare a unui monocromator (secvențial sau simultan) care măsoară intensitatea radiației luminoase emise pe un anumit domeniu de lungimi de undă. Monocromatorul este conectat la un sistem de achiziție și prelucrare a datelor măsurate. Întreg procesul de măsurare și prelucrare a datelor este controlat de un program soft destinat acestei aplicații.

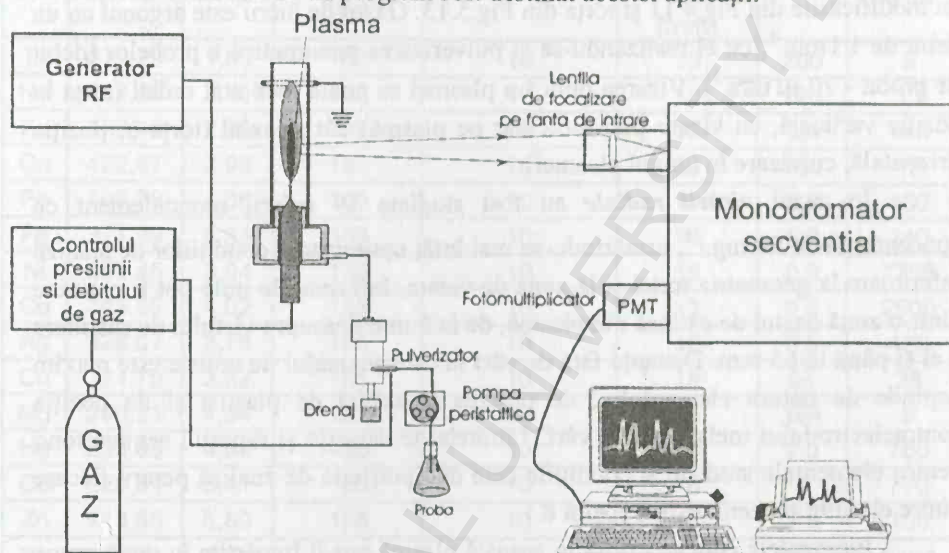


Fig.8.4 – Instrumentația folosită pentru studiul plasmei prin metodele spectrometriei de emisie atomică.

Gazul “materie primă” pentru generarea plasmei este introdus în torță printr-un sistem de regatoare de presiune și debit, care asigură valori precise și reproductibile pentru aceste mărimi.

Dacă probele care urmează să fie analizate sunt sub formă lichidă, atunci ele sunt introduse în plasmă prin pulverizare pneumatică sau ultrasonică. După pulverizare, proba trece printr-o cameră de separare a picăturilor, astfel încât în plasmă vor ajunge doar micropicături de lichid, cu dimensiuni aproximativ uniforme. Pentru ca debitul de probă care intră în plasmă să fie constant și reproductibil, lichidul este preluat din recipientul în care se află de o pompă peristaltică cu role. Prezența ei face ca debitul de gaz necesar pulverizării pneumatice să fie mai mic decât fără ea.

8.1.3 Analiza probelor lichide

Ca surse spectrale pentru analiza calitativă și cantitativă a probelor lichide au fost testate plasmă de medie și de mică putere (135 - 275 W și respectiv 40 - 80 W).

Plasma de medie putere poate fi generată cu oscilatorul prezentat în Fig.4.7 cu modificările din Fig.4.11 și torța din Fig.5.13. Gazul de lucru este argonul cu un debit de 1 l·min⁻¹, cu el realizându-se și pulverizarea pneumatică a probelor (debit de probă - 70 μl·min⁻¹). Vizarea optică a plasmă se poate face atât radial (torța în poziție verticală, cu vizare perpendicular pe plasmă) cât și axial (torța în poziție orizontală, cu vizare în lungul plasmă).

În cazul *vizării radiale* au fost studiate 19 soluții monoelement cu concentrația de 50 mg·l⁻¹, urmărindu-se mai întâi optimizarea condițiilor de analiză referitoare la geometria torței și la zona de vizare. Informațiile utile pot fi obținute dintr-o zonă destul de extinsă din plasmă, de la 5 mm deasupra vârfului de susținere a ei și până la 65 mm. Distanța față de vârf la care semnalul de emisie este maxim depinde de natura elementului, de puterea absorbită de plasmă și de poziția contraelectrodului inelar față de vârf. Limitele de detecție și raportul semnal/fond pentru elementele studiate și condițiile cele mai potrivite de analiză pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în Tabelul 8.1.

Elementele care se excită în această plasmă pot fi împărțite în două grupe în funcție de înălțimea de vizare optimă (h) și de poziția contraelectrodului inelar (H). În prima grupă sunt 14 elemente pentru care limitele de detecție cele mai bune se obțin pentru o poziție coborâtă a contraelectrodului (H = 10 mm) și vizarea optică deasupra lui. Zona de vizare este în apropierea contraelectrodului (h = 13 - 15 mm) pentru elementele cu energia de excitare mai mică de 4,4 eV și mai departe de el (h = 18 - 20 mm) pentru elementele cu energia de excitare mai mare de 4,4 eV (Zn, Cd, Hg și Pb). Pentru următoarea grupă de 5 elemente cel mai bun raport semnal/fond se obține pentru o poziție mai ridicată a contraelectrodului (H între 20 și 40 mm) și vizarea optică sub el (h = 9 - 13 mm). Cele mai bune limite de detecție le au elementele alcaline și alcalino-pământoase (Na, Li, Ca, Mg).

Tabelul 8.1 - Limite de detecție și raport semnal/fond pentru elementele excitate în plasma de Ar cuplată capacitiv de medie putere.

| | λ [nm] | E_{exc} [eV] | Parametrii torței | | | SBR | LOD [$\mu\text{g/ml}^{-1}$] |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| | | | Puterea în plasmă [W] | Distanța inel- electrod [mm] | Înălțimea de vizare [mm] | | |
| Li | 670,79 | 1,85 | 185 | 10 | 13 | 200 | 9 |
| Na | 588,99 | 2,11 | 185 | 10 | 13 | 120 | 13 |
| Eu | 459,40 | 2,70 | 185 | 10 | 13 | 3,4 | 440 |
| Ca | 422,67 | 2,93 | 185 | 10 | 20 | 100 | 15 |
| Pb | 405,78 | 4,38 | 185 | 10 | 18 | 2,2 | 450 |
| Fe | 371,99 | 3,33 | 135 | 10 | 15 | 5,2 | 240 |
| Ni | 352,45 | 3,54 | 135 | 10 | 15 | 0,9 | 1700 |
| Co | 345,35 | 4,02 | 135 | 10 | 13 | 0,6 | 2500 |
| Ag | 328,07 | 3,78 | 185 | 10 | 15 | 3,5 | 430 |
| Cu | 324,75 | 3,82 | 185 | 10 | 18 | 54 | 28 |
| Mg | 285,21 | 4,34 | 185 | 10 | 15 | 164 | 9 |
| Hg | 253,65 | 4,88 | 185 | 10 | 18 | 2,0 | 750 |
| Cd | 228,81 | 5,41 | 185 | 10 | 18 | 2 | 770 |
| Zn | 213,85 | 5,80 | 185 | 10 | 18 | 1,5 | 700 |
| Ba | 493,41 | 2,51 | 135 | 40 | 11 | 0,26 | 5700 |
| V | 437,92 | 3,13 | 185 | 20 | 9 | 2,4 | 620 |
| Cr | 425,43 | 2,91 | 185 | 25 | 13 | 12,5 | 120 |
| Mn | 403,08 | 3,08 | 185 | 25 | 17 | 2,0 | 750 |
| Mo | 386,41 | 3,20 | 185 | 25 | 13 | 2,9 | 520 |

În cazul *vizării axiale* trebuie să se țină seama de două procese care o deosebesc de vizarea radială: (a) radiația focalizată pe fanta de intrare a monocromatorului este colectată de la un număr mai mare de atomi excitați decât în cazul vizării radiale; (b) în drumul său prin plasmă, o parte din radiația emisă poate fi absorbită de atomii elementului emitent aflați în stare fundamentală (autoabsorbția). Numărul atomilor aflați în stare fundamentală crește pe măsură ce ne apropiem de coada plasmei. Cele două procese au efecte complementare asupra raportului semnal/fond și deci asupra limitelor de detecție

Limitele de detecție care se pot obține prin vizarea axială a plasmelor cu puterea de 135 W sunt prezentate în Tabelul 8.2, comparativ cu limitele de detecție în cazul vizării radiale la o putere în plasmă de 185 W.

Tabelul 8.2 - Comparație între limitele de detecție în CCP (135 W) cu vizarea axială și CCP (185 W) cu vizare radială.

| | CCP cu vizare axială 135W | | CCP cu vizare radială 185W |
|----|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | SBR | LOD [ng·ml ⁻¹] | LOD [ng·ml ⁻¹] |
| Na | 172 | 9 | 13 |
| Ca | 200 | 8 | 15 |
| Hg | 5,4 | 280 | 750 |
| Cd | 6,6 | 230 | 770 |
| Zn | 6,7 | 240 | 700 |
| Ba | 0,6 | 2500 | 5700 |
| Ni | 1,1 | 1400 | 1700 |
| Co | 1,6 | 940 | 2500 |
| Ag | 9 | 170 | 430 |
| Eu | 0,5 | 600 | 440 |
| Pb | 2,2 | 680 | 450 |
| Mn | 1,5 | 1000 | 750 |
| Li | 20 | 75 | 9 |
| Fe | 2,1 | 720 | 240 |
| Mg | 26 | 58 | 9 |
| V | 0,9 | 1700 | 620 |
| Cr | 2,2 | 680 | 120 |

Elementele studiate pot fi împărțite în trei grupe: (1) elemente cu limite de detecție mai mici decât în cazul vizării radiale, pentru care zona optimă de excitare este mai apropiată de coada plasmelor și procesul (a) este dominant; (2) elemente cu limite de detecție mai mari decât în cazul vizării radiale, pentru care zona optimă de excitare este mai apropiată de vârful de susținere a plasmelor și pentru care autoabsorbția joacă un rol important; (3) elemente cu limite de detecție

comparabile în cazul celor două vizări, pentru care efectele contrare ale proceselor (a) și (b) se compensează reciproc.

Concluzionând acest studiu comparativ, se poate afirma că cel puțin pentru 9 dintre elementele care se excită în plasma de argon cuplată capacitiv de putere medie, pentru analize calitative și cantitative se recomandă colectarea radiației luminoase prin vizarea axială a plasmăi.

O îmbunătățire a performanțelor analitice ale plasmăi de argon de putere medie poate fi obținută prin folosirea torței cu electrod tubular (Fig.5.26), cu unul sau doi contraelectrozi inelari care au roluri diferite. Electrocul inferior influențează uniformitatea și densitatea liniilor de câmp electric în partea inferioară a plasmăi. Electrocul superior concentrează liniile de câmp electric în centrul plasmăi și îmbunătățește randamentul de transfer a puterii de la câmpul RF către plasmă, mărind probabilitatea de excitaie a atomilor și ionilor. În prezența contraelectrodului superior miezul mai cald al plasmăi devine mai scurt și mai strălucitor (Fig.8.5), ceea ce poate fi semnul unei densități mai mare de putere în această zonă a plasmăi, zonă în care au loc principalele procese de excitaie atomică și ionică.

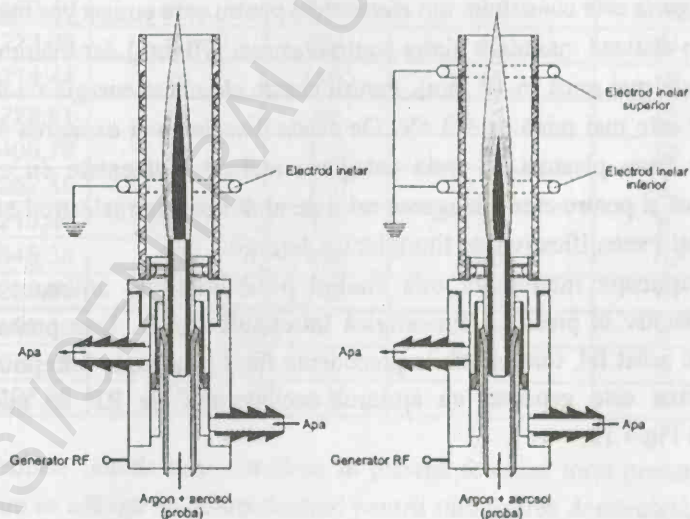


Fig.8.5 - Aspectul plasmăi în torța cu electrod tubular și contraelectrozi inelari: a) un contraelectrod; b) doi contraelectrozi.

Condițiile optime de lucru stabilite experimental sunt: putere RF – 275 W, debit de argon – $0,4 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$, distanța dintre electrodul inferior și electrodul tubular – 5 mm.

Pe lângă îmbunătățirea considerabilă a limitelor de detecție și creșterea numărului de elemente detectabile, această torță are și avantajul excitării ionilor unor elemente. Astfel, în Tabelul 8.3 sunt prezentate comparativ limitele de detecție obținute cu cele două configurații de contraelectrozi și condițiile în care au fost obținute (înălțimea de vizare măsurată de la baza plasmei și distanța dintre contraelectrozi). Cu (I) au fost marcați atomii iar cu (II) ionii ale căror emisii pot fi puse în evidență.

Ca o primă constatare se poate afirma că se adeverește previziunea conform căreia adăugarea unui al doilea electrod are drept consecință îmbunătățirea limitelor de detecție.

Elementele studiate pot fi grupate în trei categorii. O primă categorie include elementele pentru care electrodul superior este relativ apropiat de cel inferior (60 mm) și înălțimea optimă de vizare este relativ mare (12-20 mm). Toate elementele ale căror linii ionice au fost detectate fac parte din această categorie. O a doua categorie este constituită din elementele pentru care emisia cea mai bună are loc pentru o distanță mai mare dintre contraelectrozi (70 mm) dar înălțimea optimă de vizare este mai mică (6-12 mm). Pentru aceste elemente energia de disociere a oxizilor lor este mai mică de 4,3 eV. De aceea disocierea și excitarea au loc mai aproape de baza plasmei. A treia categorie include elementele cu energie de excitare mică și pentru care adăugarea celui de al doilea contraelectrod nu conduce la îmbunătățiri semnificative ale limitelor de detecție.

O aplicație interesantă este studiul posibilității de utilizare a plasmei cuplate capacitiv la presiune atmosferică întreținută în aer. Este probabil prima încercare de acest fel, toate testările precedente fiind pe plasmă întreținute în gaze inerte. Plasma este generată cu ajutorul oscilatorului de RF de mică putere prezentat în Fig.4.13.

Tabelul 8.3 – Limitele de detecție și condițiile de obținere a lor în CCP de argon de putere medie folosind torța cu electrod tubular.

| | λ [nm] | Torța cu | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Un contraelectrod | | Doi contraelectrozi | | |
| | | Înălțime de vizare [mm] | LOD [ng·ml ⁻¹] | Distanța între contaelectrozi | Înălțime de vizare | LOD [ng·ml ⁻¹] |
| Ca(I) | 422,67 | 24 | 9 | 60 | 14 | 3 |
| Ca(II) | 393,36 | 25 | 32 | 60 | 16 | 5 |
| Mg(I) | 285,21 | 20 | 6 | 60 | 12 | 3 |
| Mg(II) | 279,55 | 22 | 35 | 60 | 14 | 9 |
| Cu(I) | 324,74 | 18 | 25 | 60 | 14 | 16 |
| Ba(I) | 493,41 | 28 | 1900 | 60 | 20 | 40 |
| Cr(I) | 425,43 | 24 | 100 | 60 | 18 | 50 |
| Al(I) | 396,15 | 26 | 290 | 60 | 16 | 70 |
| Mn(I) | 403,08 | 18 | 125 | 60 | 12 | 75 |
| Mn(II) | 257,61 | 20 | 155 | 60 | 16 | 90 |
| Yb(I) | 346,44 | 26 | 1000 | 60 | 20 | 100 |
| Fe(I) | 371,99 | 14 | 200 | 60 | 10 | 105 |
| Eu(I) | 459,40 | 28 | 300 | 60 | 16 | 60 |
| Bi(I) | 223,06 | 18 | 800 | 60 | 14 | 400 |
| Cd(II) | 214,44 | 24 | 1100 | 60 | 18 | 400 |
| Cd(I) | 228,81 | 16 | 65 | 70 | 12 | 40 |
| Pb(I) | 405,78 | 14 | 110 | 70 | 10 | 80 |
| Ni(I) | 352,45 | 18 | 170 | 70 | 8 | 120 |
| Zn(I) | 213,85 | 12 | 60 | 70 | 6 | 40 |
| Co(I) | 345,35 | 16 | 390 | 70 | 10 | 210 |
| Hg(I) | 253,65 | 12 | 750 | 70 | 6 | 500 |
| Na(I) | 588,99 | 10 | 4 | 80 | 6 | 3 |
| Li(I) | 670,79 | 10 | 5 | 80 | 6 | 4 |
| Ag(I) | 328,07 | 18 | 13 | 80 | 12 | 50 |

Probele lichide sunt introduse în plasmă folosind torța prezentată în Fig. 5.24 la care se adăugă un contraelectrod pentru stabilizarea descărcării, astfel încât geometria finală a electrozilor este cea prezentată în Fig.8.6.

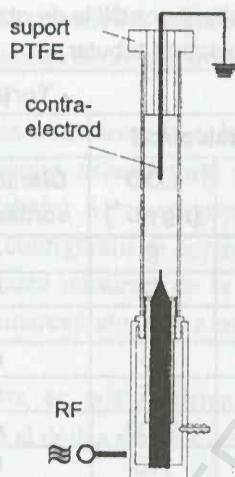


Fig.8.6 – Torța pentru CCP cu aer.

Într-o fază preliminară a fost măsurată temperatura rotațională folosind ca specie termometrică radicalul OH (ramura R2, tranziția (0,0)). Plasma a fost generată la o putere de 40 W și un debit de aer de 0.7 l/min, în două condiții diferite: în absența apei distilate (vapori de apă existând în aerul cu care este generată plasma) și în prezența ei, introdusă fiind prin pulverizare pneumatică. Spectrele de rotație corespunzătoare celor două situații sunt prezentate în Fig.8.7 și Fig.8.8.

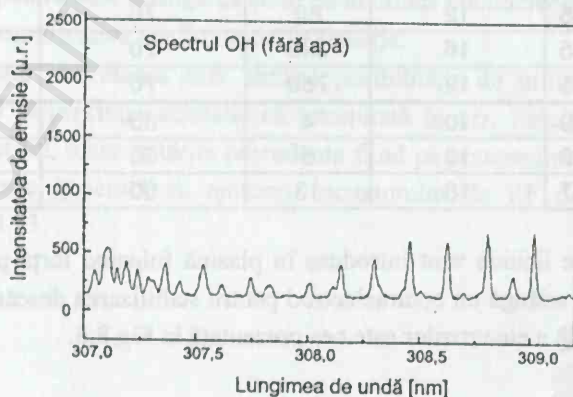


Fig.8.7 – Spectrul de rotație al radicalului OH al plasmiei de aer fără apă distilată.

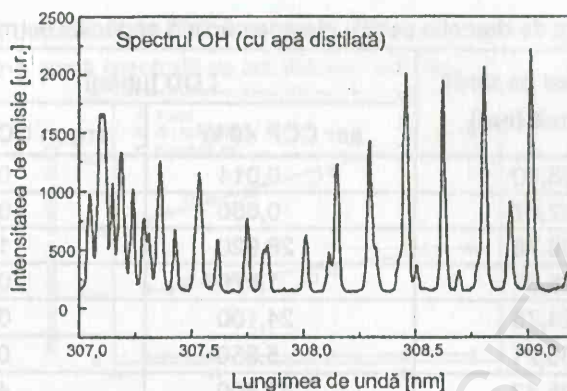


Fig.8.8 – Spectrul de rotație al radicalului OH al plasmiei de aer cu apă distilată pulverizată pneumatic.

Temperaturile rotaționale obținute în cele două situații sunt de 2240 K, respectiv 2210 K. Aceasta confirmă faptul că apa acționează ca un agent de răcire al plasmiei, dar acest lucru nu poate fi evitat pentru că ea face parte din soluția care conține elementele care trebuie analizate.

Folosind soluții etalon monoelement cu concentrația de 50 $\mu\text{g/ml}$, s-a constatat că în această plasmă se excită, astfel încât să poată fi detectate, un număr de 11 elemente. Vizarea optică trebuie făcută la o înălțime de 10 mm deasupra vârfului de susținere a plasmiei. Limitele de detecție care se pot obține sunt prezentate în Tabelul 8.4 comparativ cu cele obținute într-o plasmă de argon cu aceeași putere.

Pentru unele elemente (Na, Li) limitele de detecție sunt comparabile sau chiar mai mici decât cele obținute cu plasma de argon, iar pentru Ba limita de detecție este aproximativ două ori mai bună, ceea ce confirmă teoria conform căreia elementele refractare pot fi analizate mai bine în plasma obținută din gaze moleculare.

Gama dinamică a acestei surse spectrale este de aproximativ trei ordine de mărime, după cum se poate observa și din graficul din Fig.8.9 în care este reprezentată dependența de concentrație a intensității relative a liniei de emisie a argintului la lungimea de undă de 328,07 nm.

Tabelul 8.4 - Limite de detecție pentru plasma cuplată capacitiv de mică putere.

| | Lungimea de undă analitică [nm] | LOD [$\mu\text{g/ml}$] | |
|----|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | aer CCP 40 W | argon CCP 40 W |
| Na | 588,90 | 0,014 | 0,107 |
| Ca | 422,67 | 0,650 | 0,170 |
| Pb | 405,78 | 28,920 | 1,400 |
| Ag | 328,07 | 1,670 | 0,114 |
| Cu | 324,75 | 24,100 | 0,166 |
| Mg | 285,21 | 5,850 | 0,100 |
| Cr | 425,43 | 42,400 | 4,200 |
| Mn | 403,08 | 1,310 | 0,520 |
| Ba | 493,41 | 66,100 | 142,000 |
| Sr | 460,70 | 1,310 | 0,078 |
| Li | 670,79 | 0,063 | 0,130 |

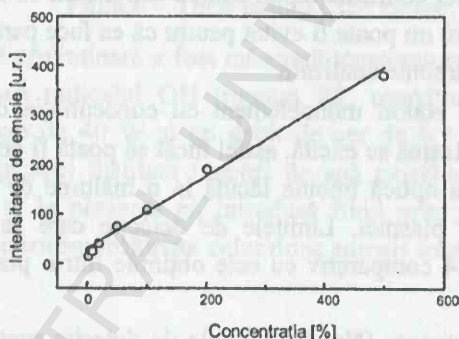


Fig.8.9 – Gama dinamică pentru Ag în CCP de aer.

Una dintre problemele delicate ale surselor spectrale o reprezintă fenomenul de autoabsorbție, adică de absorbție chiar de către plasmă a radiației emise de ea. În practică acest fenomen este apreciat cantitativ măsurându-se raportul intensităților liniilor dubletului sodiului (DI/DII). Se acceptă că dacă valoarea acestui raport este 2, atunci fenomenul de autoabsorbție este absent și cu cât el este mai mic decât 2, cu atât fenomenul de autoabsorbție este mai pronunțat. În Fig.8.10 sunt prezentate dependențele de putere ale intensităților relative ale liniilor dubletului sodiului, precum și a fondului spectral. Deoarece raportul DI/DII este cuprins între 1,9 și 2, se poate afirma că autoabsorbția este mică în această

plasmă pe întreg domeniul de puteri acoperit. Pentru comparație, coeficientul de autoabsorbție într-o sursă spectrală cu arc electric este de 1,7.

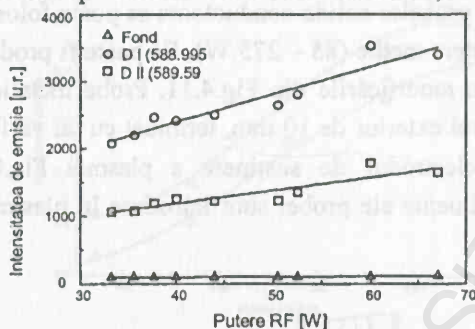


Fig.8.10 – Dependența de puterea RF a fondului de emisie și a intensităților relative ale dubletului sodiului.

Plasma de aer cuplată capacitiv poate fi o sursă spectrală credibilă și pentru probele lichide reale. Pentru susținerea acestei afirmații, în Fig.8.11 și 8.12 sunt prezentate liniile de emisie ale sodiului și calciului din apa potabilă.

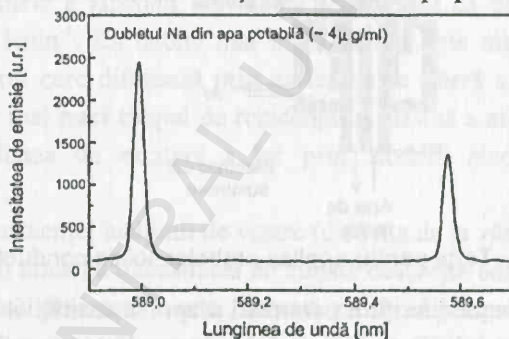


Fig.8.11 - Liniile dubletului sodiului din apa potabilă.

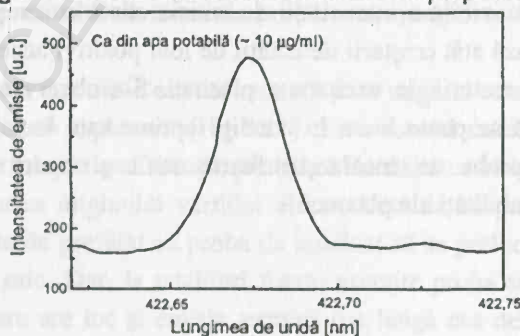


Fig.8.12 – Linia calciului din apa potabilă.

8.1.4 Analiza probelor solide

Pentru analiza probelor solide conductoare se poate folosi plasma de argon cuplată capacitiv de putere medie (85 – 275 W). Ea poate fi produsă cu generatorul prezentat în Fig.4.7 cu modificările din Fig.4.11. Proba metalică, de forma unui cilindru gol cu diametrul exterior de 10 mm, terminat cu un vârf conic (cu unghiul θ), este plasată pe electrodul de susținere a plasmei Fig.8.13. Atomii sau microparticulele constitutive ale probei sunt introduse în plasmă prin procesul de pulverizare catodică.

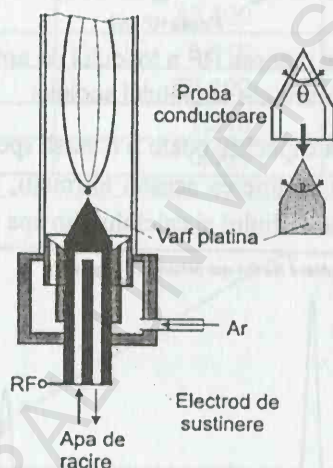


Fig.8.13 – Torța pentru analiza probelor solide conductoare.

Studiul influenței diferiților parametri asupra intensităților de emisie a unor elemente în vederea stabilirii condițiilor optime de analiză, a fost făcut pe probe din alamă. Creșterea previzibilă a intensității de emisie odată cu creșterea puterii RF (Fig.8.14) se datorează atât creșterii densității de ioni pozitivi accelerați spre probă cât și creșterii temperaturii de excitare a plasmei. S-a observat însă că puterea maximă la care încă se poate lucra în condiții optime este în jur de 140 W. La puteri mai mari, proba se încălzește foarte mult și apare emisia termică provocatoare de instabilități ale plasmei.

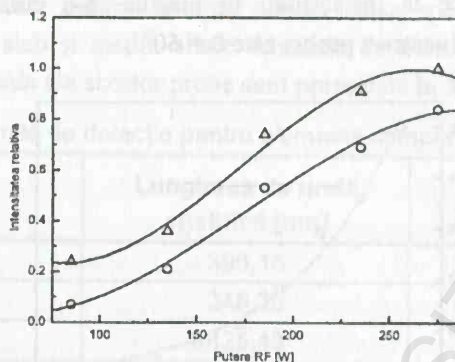


Fig.8.14 – Dependența de puterea RF a intensității de emisie pentru Zn - o, la 213,861 nm și Pb - Δ, la 405,783 nm. Debit Ar – 0,62 l·min⁻¹, $\theta = 90^\circ$.

Debitul de argon influențează atât energia absorbită de plasmă cât și timpul de rezidență a atomilor de probă în aceasta. Studiind efectul acestuia asupra intensității de emisie a zincului din alamă s-a stabilit că debitul optim este de aproximativ 0,6 l·min⁻¹. La debite mai mici plasma este mică în volum și este afectată și de aerul care difuzează prin extremitatea liberă a tubului de cuarț, în timp ce la debite mai mari timpul de rezidență în plasmă a atomilor de probă este mic și probabilitatea de excitare a lor prin ciocniri electron-atom descrește considerabil.

Studiul influenței înălțimii de vizare (distanța de la vârful conic la zona din plasmă observată) arată că intensitatea de emisie descrește odată creșterea acesteia (Fig.8.15). Această descreștere este datorată pe de o parte scăderii temperaturii miezului plasmelor pe măsură ce ne îndepărtăm de vârful de susținere a ei și, pe de alta, micșorării numărului de atomi de probă care ajung în zonele mai îndepărtate ale plasmelor.

Intensitatea de emisie este influențată și de unghiul conului probei care este și vârful de susținere a plasmelor (Fig.8.16). Este normal ca ea să fie cu atât mai intensă cu cât vârful este mai ascuțit, pentru că intensitatea câmpului electric crește odată cu micșorarea unghiului vârfului electrodului de susținere a plasmelor. S-ar părea deci că este de preferat ca proba de analizat să se prelucreze cu un unghi al conului cât mai mic. Dar, la unghiuri foarte ascuțite proba se încălzește până la temperaturi la care are loc și emisia termică (pe lângă cea de câmp), emisie care

este haotică și conduce la instabilități în plasmă. S-a constatat că cel mai convenabil unghi de prelucrare a probei este $\theta = 60^\circ$.

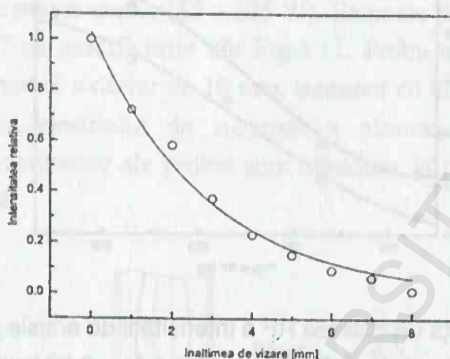


Fig.8.15 - Intensitatea de emisie a Zn la 213,861 nm în funcție de înălțimea de vizare. Puterea în plasmă – 135 W, debit Ar – 0.62 l/min⁻¹, $\theta = 90^\circ$.

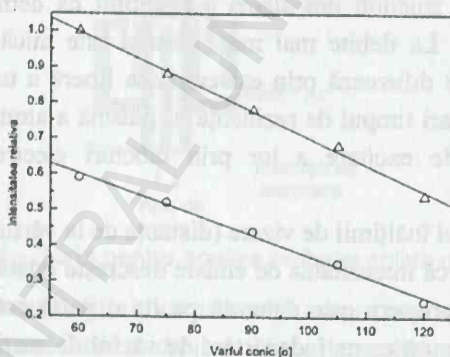


Fig.8.16 – Dependența de unghiul de prelucrare a probei a intensității de emisie pentru Pb - ○ din alamă, la 213,861 nm și Mn - Δ din oțel, la 405,783 nm. Debit Ar – 0,62 l/min⁻¹, putere – 135 W.

Având în vedere rezultatele studiilor amintite mai sus, s-au stabilit condițiile optime de lucru pentru analize pe probe reale: debit Ar - 0,62 l/min⁻¹, putere RF - 135 W, unghiul vârfului conului probei, $\theta = 90^\circ$, vizare - în apropierea vârfului probei.

Ca probe reale pentru testarea acestei surse spectrale au fost folosite etaloane de oțeluri slab și mediu aliate. Limitele de detecție pentru o parte din elementele constitutive ale acestor probe sunt prezentate în Tabelul 8.5.

Tabelul 8.5 - Limite de detecție pentru elemente componente ale oțelurilor.

| | Lungimea de undă analitică [nm] | LOD [%] |
|----|------------------------------------|------------|
| Al | 396,15 | 0,003 |
| Co | 345,35 | 0,001 |
| Cr | 425,43 | 0,008 |
| Cu | 324,75 | 0,006 |
| Mn | 403,07 | 0,048 |
| Mo | 386,41 | 0,012 |
| Ni | 352,45 | 0,031 |
| V | 437,92 | 0,001 |

Analizele cantitative efectuate pe etaloane au furnizat rezultate concordante cu valorile de concentrații elementare certificate.

Pentru analiza directă a probelor solide neconductive plasma poate generată cu ajutorul oscilatorului de RF de mică putere prezentat în Fig.4.14 și se folosește torța prezentată în Fig. 5.25, gazul de lucru fiind argonul. Particule din probele solide neconductive pot ajunge în plasmă printr-un proces asemănător pulverizării catodice în plasmă de curent continuu, proces care este favorizat de faptul că plasma este parte intrinsecă a circuitului rezonant al oscilatorului din Fig.4.14, după cum se vede și în detaliul din Fig.8.17.

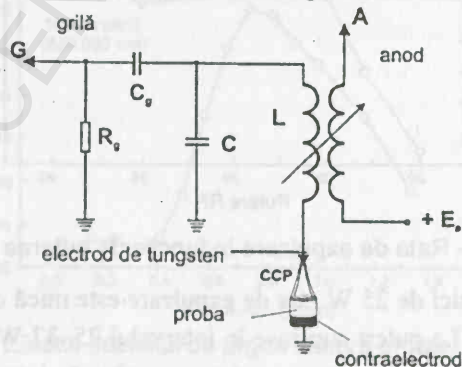


Fig.8.17 - Plasma este parte intrinsecă a circuitului rezonant al oscilatorului RF.

După cuplarea tensiunii continue de alimentare, circuitul de polarizare automată a grilei de comandă ($R_g C_g$) produce pe aceasta un potențial negativ de aproximativ 150-200 V, în funcție de tensiunea anodică. Peste acest potențial negativ constant se suprapune potențialul sinusoidal de radiofrecvență cu o amplitudine cu 15-20% mai mare decât potențialul continuu. Deoarece circuitul oscilant al oscilatorului lucrează în condiții de rezonanță, amplitudinea oscilațiilor RF pe vârful de susținere a plasmei este cuprinsă între 2000 și 3000 V. Datorită componentei continue negative, dintr-un interval de timp egal cu o perioadă a oscilației RF potențialul vârfului va fi negativ mai mult de o jumătate de perioadă. Acest fapt, combinat cu mobilitatea mai mică a ionilor pozitivi, face ca în apropierea vârfului de susținere a plasmei să se formeze o sarcină spațială pozitivă permanentă. Acumularea de sarcină are două consecințe: (a) apariția unui exces de sarcină negativă la extremitatea plasmei la care este plasată proba și (b) ecranarea electrostatică a electrodului de susținere a plasmei. Astfel, în plasmă apare un câmp electric intern care, suprapus peste câmpul extern în semialternanța în care electrodul joacă rol de anod va accelera ionii pozitivi către proba neconductoare provocând eliberarea de microparticule sau chiar de atomi din ea. Pentru ca procesul să se producă, este necesar ca distanța dintre electrod și probă să fie de 2 – 4 mm. Particulele expulzate pătrund în plasmă unde sunt atomizate și excitate. Rata de expulzare depinde de puterea RF așa cum este arătat în Fig.8.13 pentru o probă de cretă (CaCO_3).

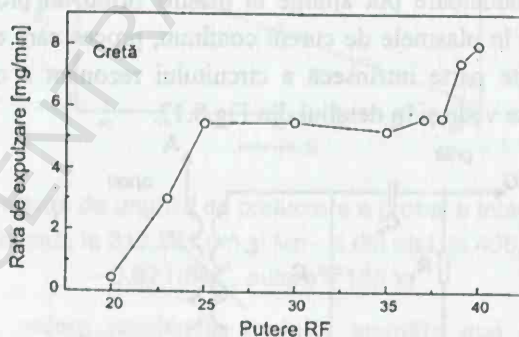


Fig.8.18 – Rata de expulzare în funcție de puterea RF.

La puteri mai mici de 25 W rata de expulzare este mică datorită intensității mici a câmpului intern. La puteri cuprinse în intervalul 25–37 W rata de expulzare este aproximativ constantă ceea ce ne sugerează că intensitatea câmpului

accelerator este constantă deși potențialul RF crește. Creșterea lui este însă ecranată de sarcina spațială pozitivă generată în vecinătatea electrodului. La puteri mai mari de 40 W energia ionilor incidenti pe probă este suficientă pentru a provoca încălzirea ei și pentru apariția evaporării termice. Aceasta determină creșterea ratei de expulzare dar și apariția instabilităților în plasmă. De aceea, puterea maximă la care se poate lucra este de 40 W.

Aceste afirmații sunt susținute și de reprezentarea grafică din Fig.8.19. Curba, care reprezintă dependența de puterea RF a intensității liniei sodiului din cretă, poate fi considerată ca suprapunerea a două drepte: una care este datorată mecanismului de expulzare prin ciocniri ionice și una datorată evaporării termice. Cele două drepte se intersectează la o putere de aproximativ 42 W, care este aceeași cu puterea la care apare creșterea pronunțată ratei de expulzare.

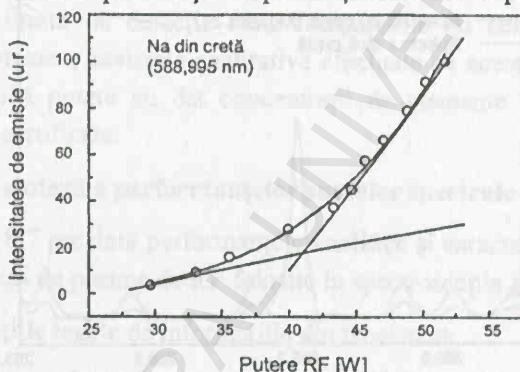


Fig.8.19 – Efectul puterii RF asupra emisieii sodiului la un debit de argon de 0.5 l/min.

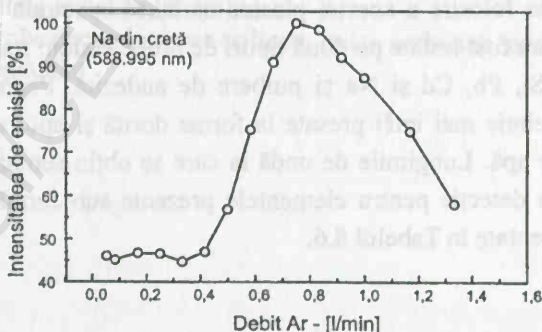


Fig.8.20 - Efectul debitului de argon asupra emisieii sodiului la o putere RF de 40 W.

Dacă se lucrează la puterea maximă la care nu apare evaporarea termică (40 W), și se urmărește dependența de debitul de argon a intensității de emisie, aceasta prezintă un maxim la aproximativ 0.5 l/min (Fig.8.20). La acest debit numărul de atomi de probă care intră în plasmă și care sunt și excitați este maxim. La debite mai mici numărul de atomi de probă preluați și transportați de curentul de argon este și el mai mic, iar la debite mai mari, deși numărul atomilor de probă crește, timpul de rezidență a lor în plasmă este mic și probabilitatea de excitație scade.

Posibilitatea folosirii plasmei cuplate capacitiv de mică putere ca sursă spectrală pentru analiza unor probe reale este demonstrată și de punerea în evidență a urmelor de magneziu dintr-o probă de cretă (Fig.8.21)

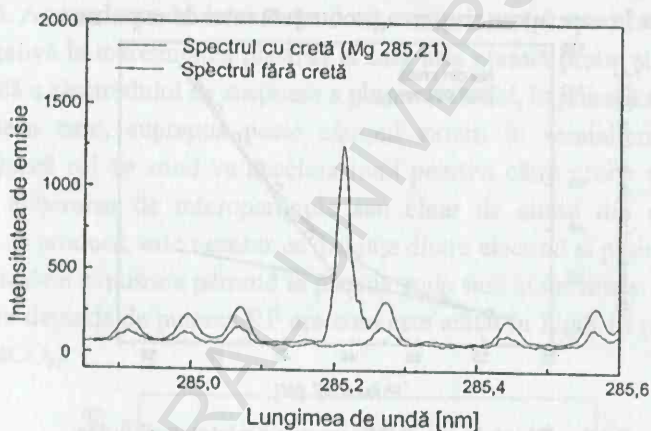


Fig.8.21 – Linia de emisie a magneziului din cretă.

Capacitățile de folosire a acestei plasme ca sursă spectrală pentru probe solide neconductoare au fost testate pe două tipuri de probe etalon: matrice de oxid de zinc cu urme de Si, Pb, Cd și Na și pulbere de andezită. Pentru a putea fi analizate, pulberile trebuie mai întâi presate la forma dorită și apoi uscate pentru eliminarea urmelor de apă. Lungimile de undă la care se obțin semnale de emisie maxime și limitele de detecție pentru elementele prezente sub formă de urme în aceste probe sunt prezentate în Tabelul 8.6.

Table 8.6 - Limitele de detecție pentru urmele de elemente din matrice de ZnO și din andezită.

| | λ [nm] | LOD [$\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$] | Matrice |
|----|-------------------|--|----------|
| Na | 588,99 | 0,3 | ZnO |
| Pb | 405,78 | 0,7 | ZnO |
| Si | 251,61 | 1,0 | ZnO |
| Cd | 228,81 | 0,9 | ZnO |
| Pb | 405,78 | 0,8 | Andezită |
| Cr | 425,43 | 1,0 | Andezită |
| Cu | 324,75 | 0,5 | Andezită |

Aceste limite de detecție sunt comparabile cu cele obținute prin alte metode. De asemenea, analizele cantitative efectuate pe aceste etaloane în plasma de argon de mică putere au dat concentrații de elemente foarte apropiate sau identice cu cele certificate.

8.1.5 O sinteză a performanțelor surselor spectrale cu plasmă RF

Tabelul 8.7 prezintă performanțele analitice și caracteristicile specifice ale principalelor tipuri de plasmă de RF folosite în spectroscopia atomică.

Observațiile legate de informațiile din tabel sunt:

- (1) – consum de Ar foarte mare (> 20 litri/min)
- (2) – Furnace Atomization Plasma Excitation Spectrometry
- (3) – consum de Ar mic (< 20 litri/min)
- (4) – probe metalice (aliaje)
- (5) – probe neconductive (silicați, oxizi, carbonați, andezit)
- ??? – nestudiat

Tabelul 8.7 - Performanțe analitice și caracteristici specifice surselor spectrale cu plasmă de RF

| Sursa | Metoda | LOD [ppb] | Tip probe | Efecte matrice | Cost [mii USD] | | Domenii de aplicație |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | vânzare | operare | |
| PLASMA CUPLATĂ INDUCTIV (ICP) | AES | $10^{-1} - 10^5$ | lichide: ✓ solide: ✓ gaze: ✓ | mici | ~ 150 | ridicat ⁽¹⁾ | larg răspândit |
| | AFS | $10^{-1} - 10$ | lichide: ✓ solide: ✓ gaze: ✓ | mici | ~ 350 | ridicat ⁽¹⁾ | nu foarte răspândit |
| | MS | $10^{-3} - 1$ | lichide: ✓ solide: ✓ gaze: ✓ | mici | ~ 150 | ridicat ⁽¹⁾ | mediu, geologie, agricultură, petrol |
| PLASMA CUPLATĂ CAPACITIV (CCP) | AES cu FAPES ⁽²⁾ | $10^{-2} - 1$ | lichide: ✓ solide: X gaze: ? | ??? | ~ 30 | scăzut ⁽³⁾ | laboratoare de cercetare academică |
| | AES în geometrie tub – inel | $3 - 2 \cdot 10^3$ | lichide: ✓ solide: X gaze: ? | mici | nu este un sistem comercial | scăzut ⁽³⁾ | laboratoare de cercetare academică |
| | AES în geometrie vârf – inel | $9 - 2,5 \cdot 10^3$ | lichide: ✓ solide: ✓ ⁽⁴⁾ gaze: ? | mici | nu este un sistem comercial | scăzut ⁽³⁾ | laboratoare de cercetare academică |
| | AES de mică putere (< 75 W) | $78 - 10^5$ | lichide: ✓ solide: ✓ ⁽⁵⁾ gaze: ? | ??? | nu este un sistem comercial | scăzut ⁽³⁾ | laboratoare de cercetare academică |
| | AAS | $10^{-1} - 10$ | lichide: ✓ solide: X gaze: ? | ??? | nu este un sistem comercial | scăzut ⁽³⁾ | laboratoare de cercetare academică |

8.2 Alte aplicații

Numărul mare de tipuri de descărcări ce pot avea aplicații tehnice sau tehnologică este determinat de forma fizică a descărcării, de comportamentul temporal al plamei, de frecvențele din banda industrială în care pot funcționa generatoarele de radiofrecvență, respectiv de microunde, sau de limitările impuse

de proiectarea, respectiv realizarea generatoarelor folosite. Acești factori depind unul de celălalt și reprezintă principalul criteriu de selecție al metodei de generare a descărcării atunci când se cunoaște aplicația sau rezultatul tehnic dorit.

Principalele direcții de aplicare ale descărcărilor în gaze sunt sintetizate și prezentate în Tabelul 8.8.

Tabelul 8.8 – Aplicații ale plasmei descărcării gazoase

-
- **pentru modificări la suprafață**
 - prin *corodare* (etching)
 - pentru organizare structurală → în microelectronică și micromecanică
 - pentru curățire → etapă premergătoare depunerii
 - prin *schimbarea proprietăților funcționale* (de aderență, de îmbinare, hidrofile, hidrofobe, etc.)
 - prin *modificări interstițiale*
 - difuzie → lipiri, îmbinări, aderări
 - implantări → creșterea gradului de duritate
 - prin *depuneri*
 - pentru schimbarea proprietăților
 - mecanice → tribologie
 - chimice → protecție anticorozivă
 - electrice → circuite integrate
 - optice → filtre, oglinzi
 - pentru "arhitectură" ...
 - cristalografică → diamante artificiale
 - morfologică → încastrări, implantări
 - **pentru modificări în volum**
 - conversia energiei electrice/magnetice sau electromagnetice în:
 - radiație electromagnetică → spectroscopie, surse de iluminat, laseri
 - energie nucleară → fuziune
 - chimie
 - transformări în compuși bine determinați → polimerizare
 - purificare de gaze
 - cataliză
 - producere de precursori
 - **pentru generarea de particule libere**
 - electroni, ioni, particule neutre
 - **prin exploatarea conductivității**
 - electrice → întrerupătoare, comutatoare (*plasma switch*)
 - termice → topiri, tăieri, suduri, spraying, distrugere de deșeuri toxice
-

Așa cum reiese și din tabelul de mai sus, plasma descărcărilor gazoase își găsește aplicabilitatea în cele mai diverse domenii ale științei și tehnicii. Practic, vom întâlni plasma atât în procesul de tratare a lânii de oaie (cu scopul de a o face mai hidrofilă) sau în analiza spectrochimică, cât și în fuziunea termonucleară, iluminatul public sau tratarea, respectiv distrugerea deșeurilor toxice într-un mod mai ecologic și mai eficient.

8.2.1 Prelucrarea materialelor cu ajutorul plasmelor termice

Plasmele care se află în apropierea stării de echilibru termodinamic sunt denumite și *plasme termice*. Ele se produc fie cu ajutorul unor descărcări în arc de mare intensitate (> 100 A), fie cu ajutorul unor descărcări de radiofrecvență (RF), la densități de putere mari și la presiuni ale gazului de suținere mai mari decât 10 kPa (0,1 atm). În aceste plasme, temperaturile electronilor și a particulelor grele sunt identice, iar densitatea de particule este funcție numai de temperatură.

Prelucrarea materialelor cu ajutorul plasmelor termice este un procedeu tehnic și tehnologic foarte complex. Reprezentând unul dintre cele mai importante aspecte tehnice al începutului de mileniu III, ea este privită cu foarte mare interes pentru implementări în industrie. Interesul industrial nu se reduce doar la dezvoltarea și sintetizarea unor noi materiale, ci și la conservarea celor existente. Nu în ultimul rând, se urmărește adaptarea unor tehnologii clasice la specificul plasmelor termice în vederea obținerii unor noi metode mai eficiente din punct de vedere al bilanțului energetic, al productivității sau al poluării mediului înconjurător. Dintre cele mai importante aplicații industriale ale plasmelor termice amintim *mărirea densității pulberilor, realizarea de straturi protectoare, sintetizarea pulberilor și depunerile de starturi subțiri*.

8.2.1.1 Mărirea densității pulberilor cu plasme termice

Mărirea densității pulberilor cu ajutorul plasmelor termice reprezintă unadintre aplicațiile industriale cele mai simple ale acestor plasme. Simplitatea și eficiența metodei fac ca acest procedeu să fie unul dintre mai reușite aplicații. Folosind fie o descărcare în curent continuu, fie una în radiofrecvență, metoda a fost folosită cu succes în densificarea și aducerea sub formă sferică a diferitelor materiale, începând cu metale având temperatură de topire joasă (Cu, Ni), până la oxizi ceramici (Al_2O_3) sau metale refractare (Mo, W). Metoda implică topirea "în zbor" a materialului adus în prealabil în forma de pulbere fină. Topirea este urmată

(tot în "zbor") de o răcire treptată, apoi de una bruscă chiar înainte de colectare. Schema de principiu a metodei este prezentată în Fig.8.22.

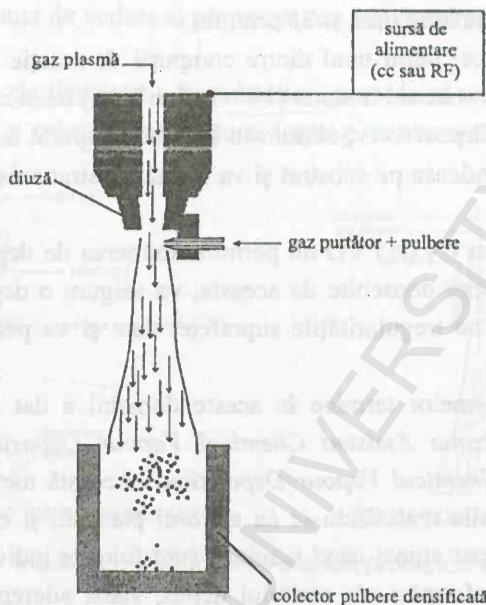


Fig.8.22 – Densificarea pulberilor cu ajutorul plasmelor termice.

8.2.1.2 Realizarea de straturi subțiri cu plasmе termice

Tehnologiile care folosesc plasma descărcării gazoase au revoluționat ingineria straturilor subțiri (protectoare sau de sine stătătoare). Până la începerea folosirii plasmelor în acest domeniu au existat două mari categorii de tehnici de depunere: *CVD* – *chemical vapour deposition* și *PVD* – *physical vapour deposition* (depunere de vapori prin metode chimice, respectiv fizice).

Termenul *Chemical Vapour Deposition* înglobează tehnicile care au ca scop obținerea de straturi subțiri prin decompunerea atomilor și/sau moleculelor unui gaz în imediata vecinătate a unei suprafețe și înglobarea lor în aceasta printr-o reacție chimică la suprafață. Aceste procese chimice necesită temperaturi ridicate (800 – 1000 °C) pentru inițierea reacțiilor. Din acest motiv substratul trebuie ales cu multă atenție. Straturile depuse au o bună aderență, dar prezintă un risc de deformare destul de mare. De aceea sunt necesare tratamente termice atât înainte cât și după depunere. Depunerile obținute (straturile subțiri sau protectoare) nu sunt selective (mono-element sau mono-tip): înainte de a începe un nou proces de

depunere, în vederea obținerii unui nou tip de strat, materialul depus anterior trebuie îndepărtat de pe substrat. Rata de depunere caracteristică straturilor obținute prin CVD este cuprinsă între 0,01 și 25 $\mu\text{m}/\text{min}$.

Atunci când cel puțin unul dintre compușii de reacție nu se află în fază gazoasă și este evaporat în vid înaintat (10^{-6} – 10^{-9} mTorri) tehnica poartă denumirea de *Physical Vapour Deposition*. Solidul sau lichidul evaporat la temperaturi medii (400 – 600 $^{\circ}\text{C}$) va condensa pe substrat și va forma un strat subțire (1 – 5 $\mu\text{m}/\text{oră}$) foarte rezistent.

Comparativ cu CVD, PVD nu permite obținerea de depuneri în interiorul găurilor adânci, dar spre deosebire de aceasta, va asigura o depunere uniformă a materialului chiar și pe iregularitățile suprafeței date și va permite obținerea de straturi selectate.

Folosirea plasmelor termice în aceste domenii a dat naștere la o nouă tehnică *PACVD* (*Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition*) sau *PECVD* (*Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition*). Această metodă combină cele două tehnici, depunerile realizându-se cu ajutorul plamei, și elimină majoritatea dezavantajelor care apar atunci când tehnicile sunt folosite individual (temperaturi relativ ridicate, cu deformări ale stratului depus, slabă aderență, etc). Astfel se combină aderență bună asigurată de CVD cu temperaturile mai scăzute și cu selectivitatea oferită de PVD.

În cazul PACVD (sau PECVD) se obține plasma prin intermediul unui câmp electric. Energia necesară inițierii și realizării reacțiilor chimice de obținere a stratului depus provine din ciocnirile cu ionii și electronii plamei.

Depunerea de straturi protectoare prin procedeul denumit *plasma-spraying* este un procedeu tehnic consacrat pe scară industrială. Astfel, cu un dispozitiv foarte asemănător cu cel folosit la densificarea pulberilor se pot depune atât metale, cât și materiale ceramice sau compozite. În majoritatea situațiilor se folosește o plasmă de curent continuu ca sursă de căldură pentru topirea "în zbor" a materialului din care se va realiza stratul protector, înainte ca acest material să ajungă pe substrat. În funcție de materialul folosit se alege gazul descărcării (Ar, Ar/H₂, Ar/He, etc.) și se lucrează la presiune atmosferică.

Pentru a depune diferite materiale sub formă de strat protector se poate folosi și plasma cuplată inductiv. Avantajul folosirii ei constă în lipsa electrozilor, evitându-se astfel contaminarea cu materiale străine. Depunerile se pot realiza atât în atmosfere neutre cât și în atmosfere oxidante sau reducătoare. În funcție de

compoziția chimică a gazului folosit se poate realiza și o depunere reactivă. În această situație se obține un strat protector care va diferi de materialul depus sau de substrat atât din punct de vedere al proprietăților fizico-chimice, cât și din punct de vedere structural.

Principiile de depuneri a straturilor protectoare cu ajutorul plasmă de curent continuu și a celei cuplate inductiv sunt prezentate în Fig.8.23a, respectiv Fig.8.23b.

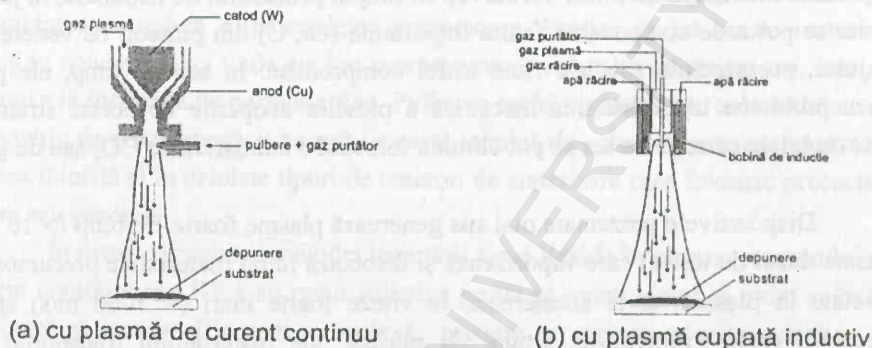


Fig.8.23 – Depuneri de starturi protectoare.

Din punct de vedere economic și energetic, una dintre cele mai eficiente și răspândite metode de depunere a straturilor protectoare este cea a spraying-ului cu ajutorul descărcării în arc. Căldura generată de un arc electric obținut între doi electrozi va determina topirea lor. Picăturile de topitură vor fi preluate de un jet rapid de gaz (de obicei aer) și transportate spre substrat pentru a forma stratul protector (Fig.8.24).

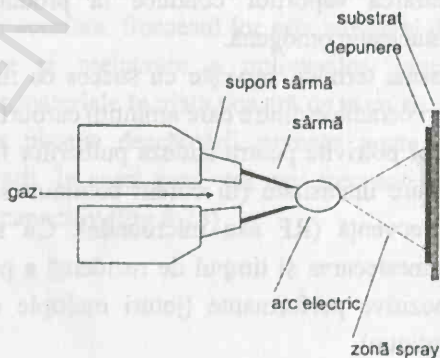


Fig.8.24 – Depunere de start protector cu arc electric.

Conținutul ridicat de oxizi pe care-l va dobândi stratul protector în urma oxidării metalului în jetul de aer transportor poate mări duritatea stratului. În același timp, prezența oxizilor poate afecta într-un mod negativ stratul protector deoarece în anumite situații diminuează gradul de aderare al protectorului la substrat. Aceste straturi slab legate de substrat sunt nedorite deoarece se pot distruge într-un timp foarte scurt (stratul va avea o porozitate relativ ridicată, care va permite infiltrarea de fluide corozive). În timpul procesului de depunere, în jetul de aer se pot arde componente foarte importante (Cr, C) din punctul de vedere al aliajului, proprietățile speciale fiind astfel compromise. În același timp, ele pot cauza probleme în prelucrarea mecanică a pieselor acoperite de aceste straturi. Dezavantajele cauzate de aer se pot elimina folosind o atmosferă de CO_2 sau de gaz inert.

Dispozitivele prezentate mai sus generează plasmă foarte fierbinte ($> 10^4$ K în zona duzei de ieșire) care vaporizează și disociază rapid materialele precursorare injectate în plasmă, și le accelerează la viteze foarte mari (~ 1000 m/s) spre substratul răcit. Proprietățile jetului de plasmă, ale materialului transportat și temperatura substratului determină proprietățile stratului protector obținut, inclusiv grosimea sa.

8.2.1.3 Sintetizarea pulberilor cu plasmă termică

Prin temperaturile înalte și încălzirea diferențiată, plasmă termică oferă o modalitate de sintetizare atractivă și nespecifică din punct de vedere chimic, mai ales pentru materialele refractare. Speciile de vapori asigură condensarea particulelor. Suprasaturarea vaporilor conduce la producerea unor particule ultrafine obținute prin nucleație omogenă.

În prezent, plasma termică servește cu succes ca mediu de procesare în sintetizarea unor pulberi ceramici dintre care amintim carburile, nitrurile și oxizii.

Plasmă termică potrivite pentru sinteza pulberilor fine pot fi generate de descărcări în arc de mare intensitate (în curent continuu sau alternativ) sau de descărcări de înaltă frecvență (RF sau microunde). Cu scopul de a mări la maximum încălzirea, amestecarea și timpul de rezidență a particulelor în plasmă, s-au realizat noi dispozitive performante (jeturi multiple de plasmă, reactoare hibride RF – curent continuu).

În cazul sintetizării pulberilor cu ajutorul plasmelor termice, materialele precursorare se pot găsi în orice stare de agregare, cu mențiunea că în cazul

precursorilor metalici, aceștia sunt foarte rar disponibili în fază gazoasă. Cel mai des, precursorii se găsesc în stare solidă și sunt introduși în plasmă sub formă de pulbere, de către un curent de gaz purtător. Recent s-a dezvoltat o metodă prin care precursorii se pot injecta în plasmă și din fază lichidă. Injectarea se face în sens contrar sensului curgerii jetului de plasmă. În urma interacțiunii lichidului cu plasma apar niște vortexuri care recirculă materialele și asigură un timp de rezidență suficient de lung în zonele fierbinți. Astfel se asigură disocierea și vaporizarea completă a materialelor precursore. Purtate de jet aceste materiale ajung în zone mai reci unde are loc suprasaturarea vaporilor de precursori, ceea ce conduce la formarea de particule fine. Pulberea astfel obținută este colectată într-un dispozitiv de colectare răcit cu apă (această tehnică de colectare este asemănătoare cu cea folosită și în celelate tipuri de reactori de sintetizare care folosesc precursori solizi sau gazoși).

În urma dezvoltării metodei injectării fazei lichide în plasma reactorului de curent continuu sau RF s-au putut sintetiza pe lângă oxizii binari și oxizi având o structură și compoziție mai complexă, precum și supraconductori oxidici cu temperatură critică ridicată. De asemenea, se fac eforturi considerabile pentru sintetizarea pulberilor ceramice neoxidice: nitruri, carburi și boruri.

8.2.2 Modificarea suprafețelor polimerice cu ajutorul plasmelor

Polimerizarea reprezintă procesul de obținere a unor molecule foarte mari (macromolecule) prin unirea unor molecule mai mici numite monomeri. Molecula rezultată în urma procesului de polimerizare poartă numele de polimer.

Interes larg acordat polimerilor este datorat proprietăților fizice, chimice și mecanice deosebite ale acestora. Succesul lor este atestat și de marea dezvoltare a industriei de fabricare și prelucrare a polimerilor, precum și de prezența indispensabilă a acestor materiale în viața noastră de zi cu zi.

Tratamentul în plasma descărcării gazoase poate oferi polimerilor noi proprietăți și noi aplicații. În acest sens, cel mai frecvent se folosește plasma de radiofrecvență cuplată capacitiv (Fig.8.25)

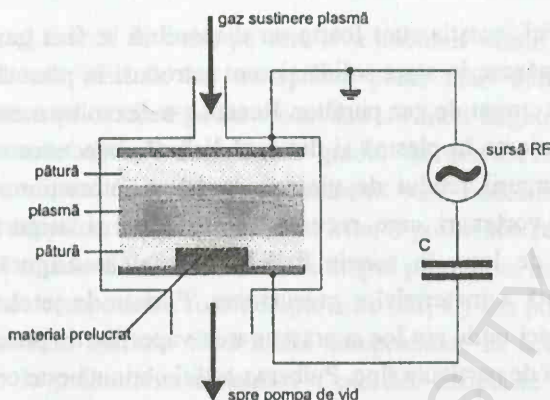


Fig.8.25 – Plasma de radiofrecvență cuplată capacitiv în geometrie plan paralelă.

În prezent există patru mari direcții de tratament al polimerilor: (1) prelucrarea suprafețelor polimerice prin eliberarea și eliminarea elementelor contaminatoare; (2) etching (gravare); (3) activarea suprafeței prin grefare sau crearea pe suprafață de elemente noi, cu grad înalt de reactivitate; (4) depunerea de starturi aderente prin polimerizarea unor monomeri (alții decât monomerul polimerului în cauză) pe suprafața polimerului.

8.2.2.1 Prepararea și prelucrarea suprafețelor

În procesele industriale suprafețele curate sunt foarte importante. Noțiunea de "curat" înseamnă că materialul bulk este de fapt materialul care formează suprafața și nu materiale sau elemente străine de materialul de bază. În cazul metalelor tratamentul cu plasmă poate curăța suprafața metalică de grăsimi sau impurități superficiale. Acest lucru este posibil deoarece metalele sunt destul de rezistente la atacul componentelor din plasmă.

În cazul polimerilor, noțiunea de "curat" se folosește într-un context puțin diferit, deoarece polimerul este foarte ușor atacat în plasmă. Astfel suprafața polimerică nu va fi îndepărtată ca și în cazul metalelor până la starturile lipsite de impurități, ci ea va fi modificată chimic și topografic. Prin tratamentul în plasmă moleculele incomplet polimerizate și monomerii de pe suprafață pot fi transformate în compuși volatili mai ușor și mai rapid decât structura de bază, polimerică, care va rămâne intactă.

De exemplu, un tratament tipic de curățire pentru polietilenă implică o plasmă de argon cuplată capacitiv, obținută la o frecvență de 13,56 MHz și presiuni

de 0,01 – 0,04 Torr, având densități de putere de $\sim 0,5 \text{ W/cm}^2$. De obicei tratamentul este scurt pentru a nu afecta structura polimerică. Evident, după eliminarea impurităților, suprafața polimerică poate fi expusă la acțiunea controlată a plasmelor, obținându-se astfel o suprafață cu proprietăți deosebite.

Gazele nobile efectuează curățirea fără ca ele să se implanteze în suprafață. Agresivitatea metodei se poate mări prin folosirea unor gaze reactive (CF_4 , SF_6 , O_2) sau prin mărirea energiei ionilor care bombardează suprafața.

8.2.2.2 Corodarea suprafeței polimerice

Pentru a obține suprafețe polimerice cu o aderență ridicată este nevoie și de altceva decât curățire. Plasma poate crea pe o suprafață polimerică microasperități care nu pot fi obținute prin metodele abrazive clasice.

Polimerii prezintă o mai bună aderență după un tratament în plasmă deoarece se mărește suprafața de contact. Aderența se poate mări prin ridicarea gradului de porozitate, decontaminarea suprafeței, eliminarea microparticulelor care blochează micropori și prin microasperități obținute în urma procesului de corodare.

Corodarea polimerilor se poate realiza într-un dispozitiv asemănător cu cel prezentat în Fig.8.4. Gradul de corodare depinde de tipul de gaz folosit (CF_4 , SF_6 , O_2 , Ar sau amestecuri ale lor), de compoziția și microstructura polimerului, de densitatea de putere de RF și de timpul de reacție dintre plasmă și polimer.

8.2.2.3 Activarea suprafețelor și grefarea cu plasmă

Activarea și grefarea cu plasmă înseamnă modificarea caracteristicilor suprafeței prin substituirea sau adăugarea la grupările specifice polimerului de noi grupări chimice obținute cu ajutorul speciilor active create în plasmă.

În tratamentele de activare se pot folosi plasmă obținute în atmosfere pure de O_2 , N_2 , He, Ar, NH_3 , N_2O , CO_2 , CF_4 , aer sau plasmă susținute în amestecul unora dintre aceste gaze. Studiind mecanismul de activare, s-a ajuns la concluzia că el constă în obținerea pe suprafața polimerică a unor radicali liberi care se pot cupla cu speciile active din plasmă (ionii și radicalii liberi din descărcare).

De exemplu, polietilena își găsește mai ușor o aplicație practică dacă suprafața sa este transformată în urma unui tratament în plasmă. Reacțiile polietilenei atunci când ea este expusă la acțiunea plasmelor obținute în diferite medii gazoase sunt prezentate în Fig.8.16.

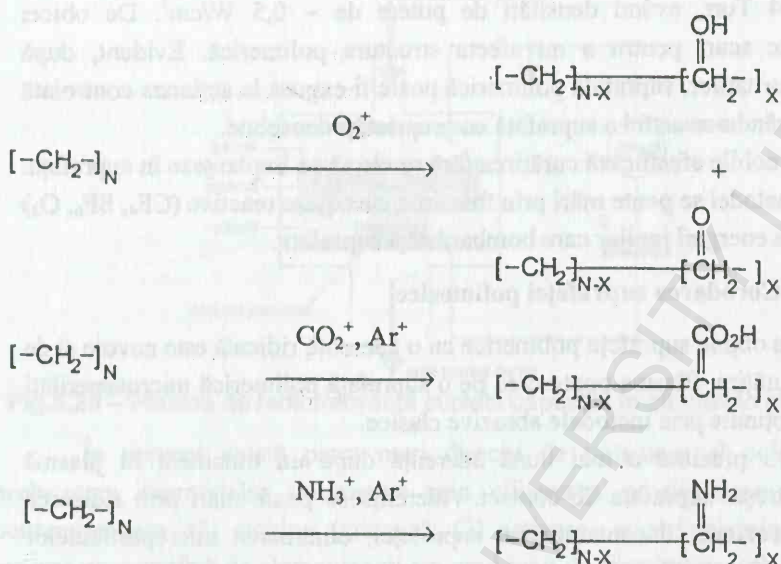


Fig.8.26 – Reacțiile polietilenei în plasmale de RF obținute în diferite atmosfere gazoase.

Polimerii astfel obținuți vor avea proprietăți deosebite. Astfel, radicalii $-\text{OH}$, respectiv $-\text{CO}_2\text{H}$ implantați într-un polimer, transformă suprafața hidrofobă a acestuia într-o suprafață hidrofilă, iar radicalul $-\text{NH}_2$, implantat în anumite poziții ale lanțului polimeric, face suprafața mai receptivă la coloranți.

Urmărind cu atenție cazul activării unui polimer oarecare (RH) într-o plasmă de oxigen, se poate observa că activarea în plasmă este un proces complex și se face în mai multe trepte. Într-o primă fază se extrage un atom de hidrogen din lanțul polimeric, rămânând în urmă o vacanță pentru un radical liber:



În a doua fază, oxigenul molecular se poate cupla cu suprafața polimerică prin intermediul vacanței formând un radical peroxidic:



Acest radical peroxidic poate atrage un atom de hidrogen dintr-un lanț polimeric vecin sau chiar într-un alt lanț cu vacanță, formând un acid carboxilic, respectiv un ester.





În reacțiile de mai sus semnul "•" indică existența unei vacanțe (posibilități de cuplare). Desigur aceste reacții nu au pretenția de a fi singurele posibile. În funcție de gazul plasmă și de condițiile de lucru se pot forma alcoolii, eterii, peroxizi sau hidroperoxizi. Producții secundari (CO_2 , H_2O și speciile de hidrocarburi cu mase moleculare mici) sunt evacuate de pompele de vid.

Experimentele arată că procesul de activare este mult încetinit de ruperea legăturilor carbon-carbon și carbon-hidrogen. Adăugarea de CF_4 în plasma de oxigen va conduce la apariția unor specii cu conținut de fluor (CF_3 , OF , F) care sunt foarte eficiente în ruperea legăturilor mai sus amintite și astfel accelerează rata reacțiilor care au loc în plasmă. În această situație nu se pune problema evacuării produșilor secundari. Odată cu oprirea plasmă sau cu ieșirea speciilor active din zona de RF, ele se recombina formând compuși stabili originali.

8.2.2.4 Polimerizarea și depunerea straturilor polimerice

Monomerii folosiți la obținerea polimerilor au o structură reactivă dată de legăturile duble carbon-carbon (Fig.8.27).

Aceste legături permit cuplarea cu un alt monomer și formarea de lanțuri polimerice.

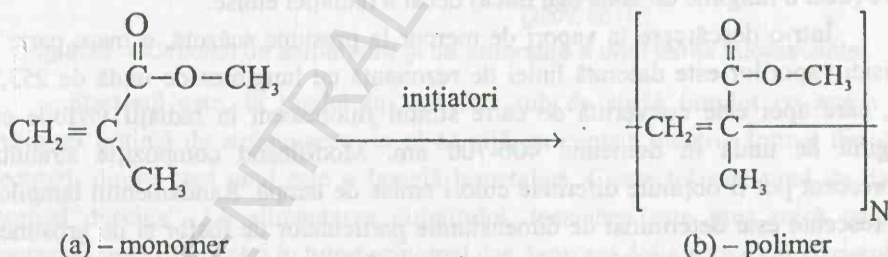


Fig.8.27 – Reacție de polimerizare în plasmă.

În figura de mai sus se prezintă polimerizarea metacrilatului de metil prin intermediul legăturilor duble carbon-carbon. Astfel, legăturile duble de carbon din metacrilatul de metil reprezintă punctele de legătură în formarea polimerului denumit polimetacrilat de metil (folosit la fabricarea sticlei plexi).

Monomerul se introduce în plasmă (cuplaj capacitiv; aprox. 60 W; 0,2 Torr) împreună cu gazul de susținere a descărcării. Inițiatorii procesului de polimerizare vor fi radicalii liberi sau de ioni energetici proveniți din plasmă.

Odată ajuns în plasmă, monomerul se va cupla în mod repetat cu alți monomeri, mărindu-și masa moleculară de sute de mii de ori și va forma polimerul dorit.

Procesul de polimerizare poate fi inițiat și de radiația ultravioletă.

Fenomenele fizico-chimice care au loc într-o plasmă pot asigura condițiile necesare obținerii unor straturi subțiri polimerice chiar și din materiale care nu se polimerizează în condiții și prin metode clasice.

8.2.3 Surse de lumină

8.2.3.1 Lămpi fluorescente

Folosirea pe scară largă a iluminării fluorescente poate fi explicată prin avantajele acestui sistem: (a) eficiență mare; (b) varietate mare a temperaturii de culoare (2700-6500 K); (c) întreținere ușoară și timp de viață lung. Principiul de funcționare a acestor tipuri de lămpi se bazează pe proprietatea radiației ultraviolete, care se găsește din abundență într-o descărcare în vapori de mercur la temperatura mediului ambiant, de a produce radiația de fluorescență a unor materiale. Reamintim aici că fluorescența este proprietatea unor materiale (numite și fosforoase) de a emite aproape instantaneu o radiație electromagnetică cu o anumită lungime de undă atunci când sunt iradiate cu cuante având o energie mai mare (deci o lungime de undă mai mică) decât a radiației emise.

Într-o descărcare în vapori de mercur la presiune scăzută, o mare parte a emisiei vaporilor este datorată liniei de rezonanță cu lungimea de undă de 253,7 nm, care apoi este convertită de către stratul fluorescent în radiații vizibile cu lungimi de undă în domeniul 400-700 nm. Modificând compoziția stratului fluorescent pot fi obținute diferitele culori emise de lampă. Randamentul lampilor fluorescente este determinat de dimensiunile particulelor de fosfor și de grosimea stratului depus pe perții tubului de descărcare. Folosirea unor particule prea mici determină o micșorare a eficienței cuantice (numărul de cuante luminoase emise de către 100 de cuante incidente). Stratul fluorescent trebuie să fie suficient de gros pentru a nu permite radiației ultraviolete să ajungă la peretele de sticlă și să fie absorbită de către acesta.

De regulă, tuburile fluorescente au formă de tuburi cilindrice drepte, cu lungimi variabile (până la câțiva metri). Standardul european actual prevede ca dimensiune tipică pentru aceste lămpi un diametru de 26 mm. Folosirea gazelor

rare drept gaze materie primă pentru plasmă a determinat obținerea unor randamente mai mari de conversie a energiei electrice în energie luminoasă.

În unele aplicații folosirea tuburilor drepte și lungi este un dezavantaj. De aceea s-au produs lămpi mai mici, cu un diametru redus la 10-12 mm, tubul fiind îndoit astfel încât să se obțină o construcție compactă. De asemenea, s-au produs lămpi cu diametre și mai mici (3-4 mm) pentru aplicații în electronică.

Datorită faptului că lungimea tubului de descărcare trebuie să fie mare pentru a avea o eficiență luminoasă acceptabilă, și tensiunea de străpungere este mare, astfel încât aprinderea descărcării devine imposibilă la tensiunea de alimentare a rețelei casnice sau industriale. Pentru a depăși acest obstacol, multe lămpi au un circuit separat de amorsare a descărcării (Fig.8.28).

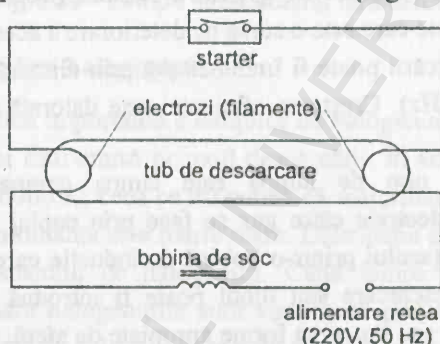


Fig.8.28 – Circuitul de alimentare și de amorsare a unei lămpi fluorescente.

Starterul este, la rândul lui, un mic tub de sticlă umplut cu argon la presiunea optimă de străpungere. În el se află un contact electric format din doi electrozi, dintre care unul este o lamelă bimetalică. Contactul este unul de tipul “normal deschis”. La alimentarea circuitului, tensiunea este prea mică pentru amorsarea unei descărcări în tubul principal dar, între cei doi electrozi ai starterului se poate amorsa o descărcare luminiscentă. În prezența acesteia lamela bimetalică se încălzește și contactul electric se închide. Curentul care va parcurge filamentele le încălzește și în tub vor fi generați electroni prin emisie termoelectronică (electroni primari). Simultan, lamela bimetalică se răcește și contactul din starter se întrerupe. La întreruperea circuitului, tensiunea de autoinducție generată de către bobina de șoc va determina multiplicarea în avalanșă a electronilor primari și amorsarea descărcării luminiscente. După amorsarea descărcării, tensiunea de la rețea va fi suficientă pentru menținerea ei. De asemenea, circuitul de alimentare a filamentelor va rămâne deschis deoarece descărcarea din tub (cu rezistență electrică

foarte mică) șuntează starterul și în el nu se mai poate amorsa o nouă descărcare. De aceea, pe tot parcursul funcționării, filamentele vor fi reci (în fapt ele vor avea temperatura cinetică a particulelor grele din descărcarea luminiscentă). Dacă descărcarea în tub nu se amorsează la prima tentativă, ciclul pe care l-am descris se va repeta până la aprinderea lămpii.

Există lămpi fluorescente cu electrozi acoperiți cu un strat de oxizi care nu au nevoie de preîncălzire, precum și cu catodi reci neacoperiți. Ambele tipuri de lămpi au lungimi mari, fiind necesare tensiuni de străpungere mari, tensiuni care sunt obținute cu ajutorul unor transformatoare. Primul tip de lămpi are avantajul unor căderi mici de tensiune la electrozi și de aceea au o eficiență mare, iar al doilea, are un timp de viață foarte lung pentru că funcționarea lor nu depinde de emisia electrozilor, emisie care este o sursă de deteriorare a acestora.

Eficiența descărcării poate fi îmbunătățită prin alimentarea cu tensiune de înaltă frecvență (>20 KHz). Creșterea eficienței este datorată micșorării căderilor de tensiune la electrozi.

Un timp mai nou de lampă este lampa compactă fără electrozi. Transmiterea energiei electrice către gaz se face prin cuplaj inductiv (Fig.8.29). Puterea este transmisă gazului printr-o bobină de inducție care poate fi plasată în interiorul tubului de descărcare sau tubul poate fi introdus în ea. Tuburile de descărcare pot fi sferice sau pot avea forme apropiate de sferă, cu diametre până la 100 mm. Frecvența câmpului electromagnetic este în domeniul MHz-ilor, ceea ce creează unele probleme legate de protecția la perturbațiile radio.

Lămpile fluorescente fără electrozi au un timp de viață foarte lung (aprox. 60.000 de ore), tocmai pentru că nu există pericolul dezintegrării acestora. Eficiența luminoasă a lor este comparabilă sau chiar mai bună decât aceea a lămpilor fluorescente clasice. De asemenea, ele pot fi comandate de la distanță.

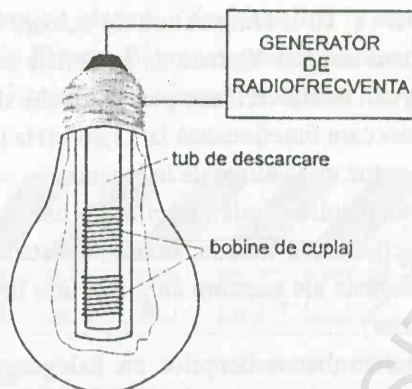


Fig.8.29 - Lampă fluorescentă fără electrozi

8.2.3.2 Lămpi cu halogenuri

O caracteristică importantă a lămpilor cu halogenuri este faptul că cea mai mare parte a radiației este emisă pe axul descărcării. În această zonă temperatura este de aproximativ 6000 K, ceea ce înseamnă că majoritatea liniilor emise sunt în domeniul vizibil și luminanța este foarte mare. Distribuția puterii spectrale depinde de compoziția amestecului de halogenuri. Când lampa ajunge la temperatura normală de funcționare halogenurile sunt vaporizate parțial sau total. Vaporii de halogenuri se disociază în halogeni și metale în zona centrală a arcului, zonă care este mai fierbinte iar metalele emit spectrul lor caracteristic.

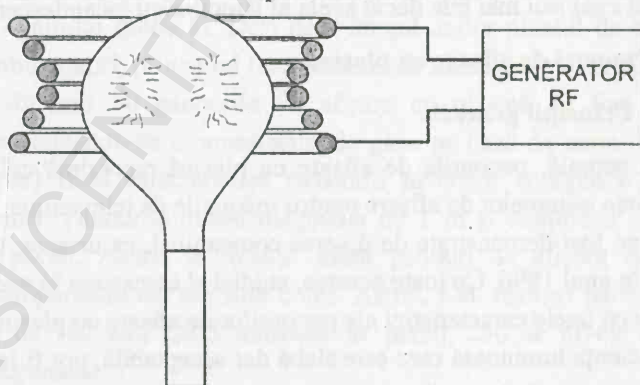


Fig.8.30 - Lampă fără electrozi cu halogenuri.

Lămpile convenționale de descărcare (cu electrozi) cu halogenuri de metale sunt foarte potrivite pentru obținerea fasciculelor luminoase de bună

calitate, cu intensitate mare și cu o temperatură de culoare cuprinsă între 3000 și 6500 K. Folosirea halogenurilor este limitată de posibilele reacții chimice care pot avea loc între ele și electrozii descărcării sau pereții tubului de descărcare. Lămpile cu halogenuri fără electrozi care funcționează la 13,56 MHz (Fig.8.30) au avantajul posibilității alegerii unei game mai variate de halogenuri.

Cele mai importante aplicații ale lămpilor cu halogenuri sunt: proiectarea dispozitivelor de afișare cu cristale lichide; iluminarea stadioanelor; lămpi pentru automobile. Puterile consumate ale acestora sunt cuprinse între 35 W (automobile) și 1800 W (iluminat exterior).

Interesul pentru dezvoltarea lămpilor cu halogenuri este determinat de faptul că iluminarea lor este mai mare de câteva ori decât aceea a lămpilor cu filament de wolfram, deoarece radiația este generată de către atomii care se află în zona centrală a arcului electric (miezul descărcării). Această iluminare sporită poate fi folosită la farurile ale automobilelor, fie pentru îmbunătățirea calității fascicolului luminos, fie pentru faptul că au dimensiuni mai mici față de lămpile clasice.

Una dintre cerințele lămpilor pentru automobile este aceea ca timpul de aprindere și atingere a funcționării normale să fie foarte scurt. Sistemele convenționale cu element de balast (rezistență, bobină) nu pot fi folosite în acest caz. De aceea se recurge la adăugarea în lampa cu halogenuri a unei cantități mici de xenon la o presiune de câteva atmosfere, obținându-se astfel un timp de intrare în regim normal egal sau mai mic decât acela al lămpilor cu incandescență.

8.2.4 Panouri de afișare cu plasmă

8.2.4.1 Principii generale

La ora actuală, panourile de afișare cu plasmă reprezintă cel mai serios concurent pe piața sistemelor de afișare pentru imaginile de televiziune. Fiabilitatea și calitatea lor au fost demonstrate de diverse companii și, ca urmare, producția în serie a început în anul 1996. Cu toate acestea, studiul și cercetarea în acest domeniu continuă pentru că unele caracteristici ale panourilor de afișare cu plasmă, cum ar fi de exemplu eficiența luminoasă care este slabă dar acceptabilă, pot fi îmbunătățite. O modalitate importantă de studiu și înțelegere a mecanismelor care guvernează emisia luminoasă a unui element de imagine este modelarea teoretică a fenomenelor. De aceea studiul panourilor de afișare cu plasmă continuă atât din punct de vedere teoretic cât și experimental.

Panoul de afișare cu plasmă a fost inventat de către Bitzer și Slottow în 1966 la Universitatea din Illinois. Ei au demonstrat posibilitatea afișării informației sub forma unor pixeli luminoși cu plasmă, realizând un panou de afișare foarte simplu (Fig.8.31).

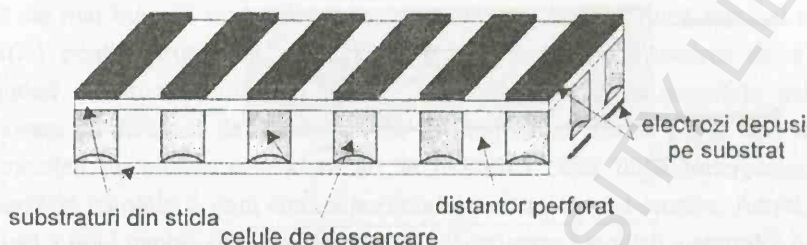


Fig.8.31 – Structura pixelilor unui display monocrom cu plasmă.

Panoul este compus din două seturi de straturi subțiri conductoare paralele, reciproc perpendiculare, depuse pe două substraturi din sticlă. Cele două substraturi sunt separate de o lamelă de sticlă cu grosimea de $100\ \mu\text{m}$. Lamela este perforată, având aspectul unei site. Distanța dintre șirurile de găuri din lamelă este egală cu distanța dintre straturile conductoare depuse pe substraturi. Cavitățile astfel obținute sunt umplute cu un gaz inert la o presiune de aproximativ 300 torr. Se formează astfel o matrice de celule de descărcare (pixeli), fiecare având la capete câte doi electrozi reciproc perpendiculari. Pixelii devin luminoși prin aplicarea între cei doi electrozi a unei tensiuni alternative, suficiente pentru a produce străpungerea spațiului dintre ei. Deși de-a lungul anilor pixelul de bază a suferit numeroase îmbunătățiri, principiul fundamental de funcționare a rămas același.

Până în anii 80 panourile de afișare cu plasmă au fost monocrome, descărcarea producându-se în amestecuri de gaze pe bază de neon, lumina emisă (roșu-portocalie) fiind caracteristică structurii nivelelor energetice ale neonului (585 – 640 nm). Panourile aveau diagonala de 1 m și conțineau aproximativ 2 milioane de pixeli. Astăzi fabricanții oferă panouri de afișare cu dimensiuni geometrice comparabile dar ele sunt color. Astfel, s-au realizat panouri de afișare cu diagonala de 102 cm, 1,075 milioane de pixeli, 256 de nivele de gri, 8 cm grosime și 8 kg masa.

Panourile de afișare cu plasmă pot să fie operate atât în curent continuu cât și în curent alternativ. În Fig.8.32 sunt prezentate sub o formă simplificată structurile celor două tipuri de panouri. Ele au aceeași structură ca și cea prezentată anterior cu deosebirea că în cazul panourilor de afișare care sunt operate în curent

alternativ, electrozii între care se aplică tensiunea necesară amorsării și întreținerii descărcării nu sunt în contact direct cu plasma. În Fig.8.33 este prezentată schema electrică de alimentare a unei matrici de pixeli.

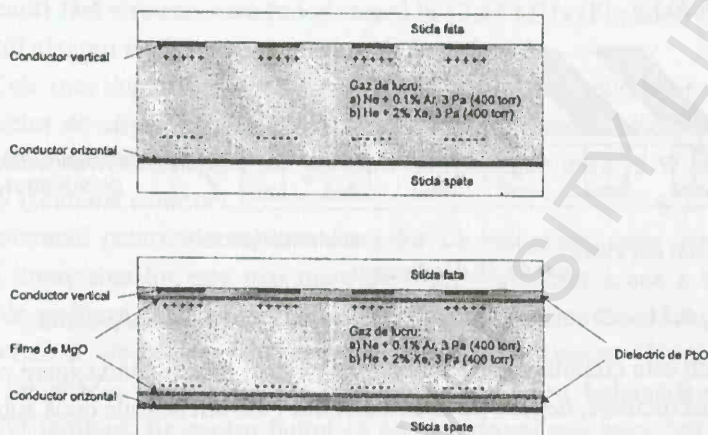


Fig.8.32 – Structura panourilor monocrome operate în curent continuu și curent alternativ.

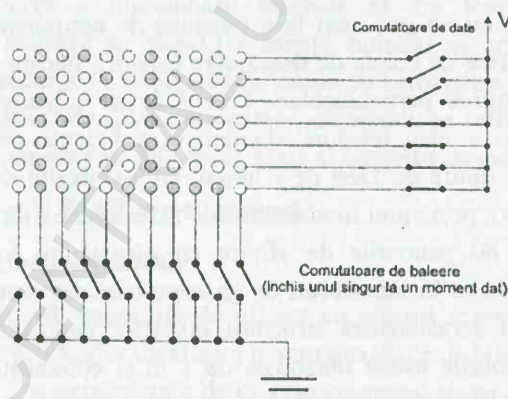


Fig.8.33 – Alimentarea unei matrici de pixeli.

Diferențele constructive dintre pixelii care sunt operați în curent continuu și cei care sunt operați în curent alternativ poate fi observată foarte ușor comparând desenele din Fig.8.32. Se poate observa că în cazul pixelilor operați în curent alternativ straturile conductoare sunt acoperite cu un strat de dielectric, de regulă oxid de plumb, cu o grosime de 25 μm . Peste acesta se depune un alt strat dielectric, de oxid de magneziu, cu grosimea de 50 – 200 nm. Aceste două straturi

dielectrice asigură pe de o parte stocarea de sarcină electrică superficială și, pe de alta, emisia electronică secundară. Oxidul de magneziu a fost ales în urma unor cercetări intense de identificare a unor materiale care să fie rezistente la procesul de pulverizare catodică și să aibă un coeficient de emisie secundară la bombardament ionic cât mai bun. El este utilizat de peste treizeci de ani și încă este cel mai bun material pentru protejarea stratului dielectric și pentru generarea de electroni secundari. Straturile uniforme de MgO pot fi depuse pe suprafețe mari prin evaporare cu fascicul de electroni. Un avantaj important al MgO este acela că proprietatea de emisie secundară nu se modifică chiar după înderpărtarea prin pulverizare catodică a unui strat superficial de sutimi de nanometru. Astfel, timpul de viață a unui panou, deși este limitat de pulverizarea catodică a stratului de MgO, poate fi mai mare de 10.000 de ore.

Se poate ușor constata că în cazul pixelilor operați în curent alternativ plasma nu poate ajunge în contact cu electrozii. Valoarea exactă a tensiunii de străpungere depinde de natura și presiunea gazului din celulele de descărcare, de înălțimea acestora și este condiționată de stratul de MgO. Ea variază de obicei între 120 V și 180 V. După amorsarea descărcării, electronii și ionii se deplasează către anod și respectiv catod, dar ei nu mai pot fi colectați de către electrozi și se vor acumula pe suprafața dielectricului ca sarcini spațiale. Astfel, câmpul electric total în interiorul unei celule va fi în orice moment de timp suma algebrică dintre câmpul datorat tensiunii externe aplicate și câmpul intern datorat acumulării de sarcină spațială pe suprafețele dielectrice. În regim staționar este evident că sensul câmpului datorat acumulării de sarcină este opus sensului câmpului exterior, sarcina superficială acționând în sensul ecranării câmpului electric exterior. De aceea, dacă după amorsarea descărcării câmpul electric extern este menținut constant numai câteva microsecunde, câmpul electric total va scădea foarte rapid (100 – 200 ns). Această scădere poate fi atât de mare încât tensiunea pe descărcare să fie mai mică decât tensiunea minimă de menținere a ei, și descărcarea se stinge. De aceea, în curent alternativ descărcarea acționează în sensul autolimitării curentului electric prin ea, nefiind nevoie de o rezistență exterioară de limitare.

8.2.4.2 Caracteristici ale dispozitivelor de afișare cu plasmă

Panourile de afișare cu plasmă prezintă câteva avantaje în competiția care are loc în domeniul tehnologiei dispozitivelor de afișare. Astfel, comportarea puternic neliniară a fiecărui pixel, cu inerentele proprietăți de memorie, poate constitui un avantaj în proiectarea electronicii de comandă necesare pentru ștergerea și înscrierea informației. Simplitatea construcției pixelilor este un ajutor în procesul de fabricație, reducând problemele legate de alinierea lor sau de uniformitatea straturilor depuse. Comparativ cu matricile de afișare color cu cristale lichide care folosesc tranzistori cu filme subțiri pentru controlul electronic al fiecărui pixel, dispozitivele de afișare cu plasmă necesită un proces de fabricație mult mai simplu și o electronică de comandă mai puțin complicată. Pe de altă parte însă, date fiind tensiunile mari la care se lucrează (100 – 275 V), electronica de comandă este mult mai robustă, voluminoasă și cu un consum energetic mare. De aceea, panourile de afișare cu plasmă nu sunt recomandate pentru aparatura portabilă dar sunt extrem de utile pentru utilizări interioare sau fixe (piețe, stadioane etc). Dacă sunt operate la puteri mari ($10^2 - 10^3$ W) strălucirea lor este suficient de mare pentru a avea o imagine vizibilă chiar și la lumina Soarelui. Suprafața mare, rezoluția înaltă, faptul că sunt foarte plate, fac ca dispozitivele de afișare cu plasmă să fie foarte căutate pentru videoconferințe, ecrane pentru conferințe în interior sau în exterior precum și pentru stații de lucru fixe sau calculatoare personale care necesită o grafică de înaltă rezoluție. Datorită construcției lor, panourile de afișare cu plasmă, monocrome sau color, au un unghi de vedere foarte mare (peste 160°). În vecinătatea normalei la suprafață există un unghi mort foarte mic datorat electrozilor metalici care obturează emisia luminoasă a plamei (în cazul monocrom) sau a straturilor fotoluminiscente (în cazul color). Pentru a elimina acest inconvenient se studiază posibilitatea înlocuirii electrozilor metalici opaci cu electrozi transparenți pe bază de oxid de indiu. Inconvenientul acestei înlocuirii îl constituie conductanța mai slabă a electrozilor transparenți, ceea ce evident conduce la un consum de putere mai mare. O altă soluție, este realizarea unor electrozi metalici semitransenți sub formă de straturi subțiri (aprox. 20 μm).

Pentru pixelii color compoziția gazului este modificată astfel încât să predominie emisia radiațiilor ultraviolete. Din celelalte puncte de vedere principiile de operare sunt identice cu cele ale pixelilor monocromi. Ideal este ca radiația luminoasă emisă de plasmă să fie exclusiv în domeniul ultraviolet, radiație capabilă

să producă emisia culorilor fundamentale (roșu – R, verde – G, albastru – B) de către straturile fotoluminescente de fosfați (lantan, ytriu, gadoliniu) depuse pe electrozii de adresare și pe perții celulelor de descărcare. Structura schematică a unui panou color cu plasmă este arătată în Fig.8.34.

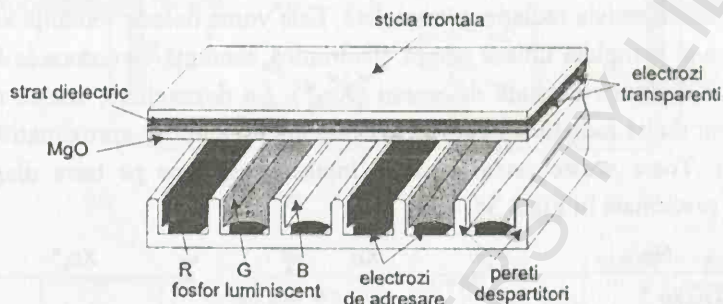


Fig.8.34 – Structura panoului color cu plasmă

Pereții despărțitori sunt orientați în plan vertical și au o înălțime de aproximativ 100 μm . Un pixel se formează la intersecția unui electrod transparent orizontal cu trei straturi fotoluminescente succesive, corespunzătoare celor trei culori fundamentale.

Pentru generarea radiației ultraviolete necesare producerii fotoluminescenței fosforului sunt folosite amestecuri de gaze conținând ca specie minoritară xenonul. Deși xenonul este un emițător eficient de radiații ultraviolete, tensiunea sa de străpungere este prea mare și atunci s-a recurs la folosirea amestecurilor de xenon cu neon sau heliu. Adăugând unul din aceste gaze, tensiunea de străpungere se micșorează din două motive: (1) ionii de neon și heliu sunt mult mai eficienți în producerea emisiei secundare de electroni din stratul de MgO și (2) coeficientul de ionizare într-un amestec de xenon-neon de exemplu, poate fi mult mai mare decât în xenon pur sau neon pur. Aceasta, datorită faptului că secțiunea de ciocnire electron-neutru este mult mai mare în xenon decât în neon, astfel încât într-un amestec conținând o mare concentrație de neon, electronii pot câștiga energie mult mai ușor, producând excitarea și ionizarea xenonului pentru valori mai mici ale câmpului electric. Pe de altă parte, energia de ionizare a xenonului este mai mică decât energia de excitare a neonului (sau a heliului) și electronii accelerați în câmpul electric din celula de descărcare își vor transfera energia lor cu prioritate spre atomii de xenon iar atomii de neon (sau heliu) vor ceda energia de excitare atomilor de xenon producând ionizarea lor prin efect

Penning. Astfel, emisia radiației de dezexcitare roșu-portocalie a neonului va fi suprimată odată cu creșterea concentrației de xenon din amestec. Din cercetările experimentale s-a stabilit că o concentrație a xenonului de aproximativ 10% este cea mai potrivită pentru scopul propus. În afară de aceste procese, mai există unul care favorizează emisia radiației ultraviolete. Este vorba despre tendința xenonului ionizat de a-și completa ultima pătură electronică, tendință care duce la formarea moleculelor dimerice excitate de xenon (Xe_2^*). La dezexcitare, aceste molecule dimerice vor emite radiații ultraviolete cu lungimi de undă de aproximativ 173 nm și 150 nm. Toate aceste procese pot fi înțelese mai bine pe baza diagramelor energetice prezentate în Fig.8.35.

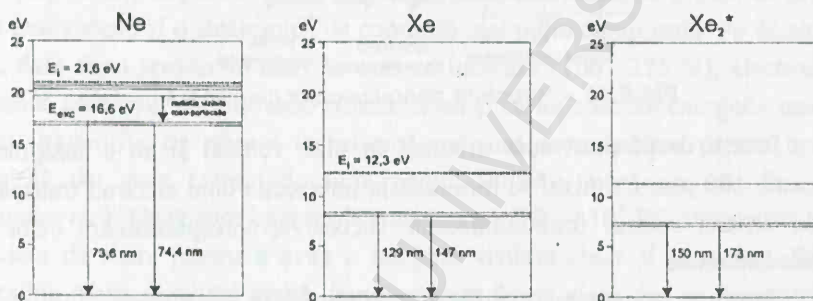


Fig.8.35 – Structura nivelurilor energetice pentru Ne și He.

În panourile de afișare cu plasmă procesele care au loc la suprafața catodului joacă un rol deosebit în asigurarea funcționării lor și în limitarea timpului de funcționare.

O prezentare sintetică a proceselor elementare care au loc în interiorul celulei de descărcare este prezentată în Fig.8.36. Nu vom mai insista asupra lor deoarece au fost prezentate mai detaliat în capitolele precedente. După aprinderea descărcării, ionii pozitivi din vecinătatea electrodului care joacă rol de catod în una din semialternanțele câmpului alternativ sunt accelerați în câmpul căderii normale de tensiune catodică (aprox. 200 V). Ciocnind suprafața electrodului ei capturează foarte repede electroni, cedând acestuia o energie egală cu energia de recombinare electron-ion. Această energie este consumată în două procese: *emisia de electroni secundari* și *pulverizarea catodică*. Primul proces determină creșterea semnificativă a eficienței luminoase a pixelului iar cel de al doilea reduce timpul de viață a celulei de descărcare.

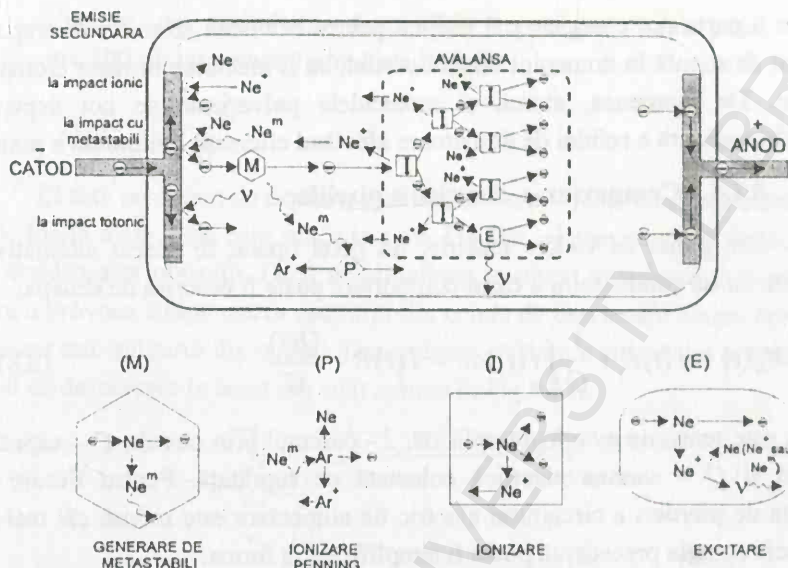


Fig.8.36 – Procesele elementare în interiorul celulei de descărcare.

Electronii secundari sunt foarte eficienți, pe de o parte pentru că ei câștigă o energie mare fiind accelerați în spațiul căderii normale de tensiune catodică și pe de alta, pentru că în drumul lor spre electrodul care joacă rol de anod ei străbat întregul spațiu plin cu gaz ionizat. Coeficientul de emisie secundară la impact ionic (γ) este definit ca numărul de electroni emiși de catod la impactul cu un ion pozitiv. El depinde atât de natura ionului incident cât și de natura materialului depus pe suprafața catodului. Oxidul de magneziu are un coeficient de emisie secundară de aproximativ 0,45 atunci când este ciocnit de ioni de heliu cu energia de 200 eV. Pentru comparație, amintim că dacă MgO este ciocnit de ioni de Ar, $\gamma = 0,05$. În afară de emisia electronică secundară la impact ionic, o contribuție importantă la creșterea numărului de electroni din plasmă îl mai au fotonii și atomii metastabili care ciocnesc suprafețele electrozilor și care sunt capabili să genereze electroni secundari. Deoarece nici fotonii și nici metastabilii nu sunt purtători de sarcină electrică netă, mișcarea lor nu este influențată de câmpurile electrice din plasmă și ei se propagă izotrop prin spațiul de descărcare.

Procesul de pulverizare catodică erodează stratul depus pe suprafața catodului și reduce performanțele pixelului. Contaminarea plasmei cu impuritățile generate de pulverizarea catodică poate conduce la reducerea eficienței luminoase,

deoarece o parte din energie va fi risipită pentru excitarea atomilor de impuritate care emit de regulă în domeniul vizibil. Astfel, va fi afectată puritatea cromatică a pixelului. De asemenea, atomii și moleculele pulverizate se pot depune pe suprafața interioară a celei de descărcare afectând eficiența luminoasă a pixelului.

8.2.4.3 Comportarea electrică a pixelilor

Din punct de vedere electric, un pixel operat în curent alternativ este echivalent cu un condensator a cărui comportare poate fi descrisă de ecuația:

$$V_a(t) = I(t)R + \frac{1}{C} \int_0^t I(t') dt' = I(t)R + \frac{Q(t)}{C} \quad (8.8)$$

unde V_a este tensiune exterioară aplicată, I - curentul prin circuit, C - capacitatea pixelului și Q - sarcina electrică colectată pe suprafață. Pentru fiecare pixel rezistența de pierderi a circuitului electric de alimentare este redusă cât mai mult, astfel încât ecuația precedentă poate fi simplificată la forma:

$$V_a(t) = \frac{1}{C} \int_0^t I(t') dt' = \frac{Q(t)}{C} \quad (8.9)$$

Capacitatea fiecărui pixel este determinată de capacitatea fiecărui strat de dielectric și capacitatea gazului din celula de descărcare, capacități conectate în serie:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{PbO}} + \frac{1}{C_{MgO}} + \frac{1}{C_{gaz}} \quad (8.10)$$

În fiecare caz:

$$C_i = \frac{\epsilon_i A}{d_i} \quad (8.11)$$

unde i este indicele materialului și A - aria suprafeței care este aproximativ egală cu cea a suprafeței stratului conductor. Pentru un pixel prezentat anterior grosimea stratului de PbO este aproximativ 25 μm iar cea a stratului de MgO este cuprinsă între 50 și 200 nm iar constantele dielectrice sunt $\epsilon_{PbO} = 15\epsilon_0$ și $\epsilon_{MgO} = 6\epsilon_0$, depinzând de puritatea filmului subțire și de microstructura sa. Pe baza acestor date se poate observa contribuția mică a stratului de MgO la capacitatea totală a pixelului, în primă aproximație ea putând fi neglijată.

Înainte de aprinderea descărcării capacitatea unui pixel este de aproximativ 500 pF iar curentul prin circuit va fi:

$$I(t) = C \frac{dV(t)}{dt} \quad (8.12)$$

El este un curent de deplasare care apare la aplicarea tensiunii exterioare ca un pic foarte mare după care scade la zero. De fapt, el este curentul de încărcare a unui condensator obișnuit. Dacă amplitudinea tensiunii exterioare este prea mică pentru a provoca străpungerea spațiului din celula de descărcare atunci curentul de deplasare este singurul din circuit. Dependența de timp a curentului și tensiunii pe spațiul de descărcare în acest caz sunt arătate în Fig.8.37a.

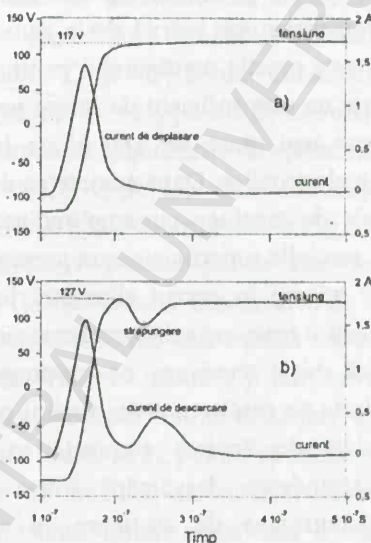


Fig.8.37 – Dependența de timp a curentului pixelic.

Dacă însă tensiunea exterioară este mai mare decât tensiunea de străpungere, după impulsul de curent de deplasare mai apare încă un impuls mai mic, datorat curentului prin descărcare (Fig.8.37b). Impulsul de curent prin plasmă este însoțit de fenomene luminoase puternice datorate proceselor de excitare-dezexcitare care apar imediat după momentul străpunerii spațiului de descărcare.

Impulsul de curent prin descărcare depinde de amplitudinea impulsului de tensiune aplicat din exterior. În Fig.8.38 este arătată dependența de tensiunea exterioară a sarcinii electrice deplasate prin descărcare în cazul unui amestec Penning de heliu-xenon (2%) la presiune de 400 torr.

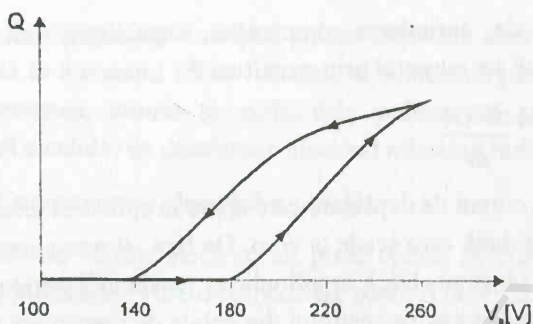


Fig.8.38 – Sarcina electrică deplasată prin pixel

Se poate observa efectul de histerază atunci când tensiunea evoluează în sens descrescător. Dacă tensiunea este mărită de la zero până la 180 V, curentul prin celula de descărcare este practic nemăsurabil pentru că în absența sarcinilor superficiale câmpul electric nu este suficient de intens pentru a produce ionizarea gazului. Pentru o tensiune mai mare de 180 V se inițiază descărcarea prin multiplicarea în avalanșă a electronilor. După amorsarea descărcării, dacă pe celulă se aplică un sigur impuls de tensiune cu amplitudinea mai mică de 135 V, descărcarea se stinge deși sarcinile superficiale sunt prezente.

În cazul pixelilor operați în curent alternativ între cele două rețele de electrozi se aplică permanent o tensiune sub forma unor impulsuri dreptunghiulare cu amplitudinea mai mică decât tensiunea de străpunere (Fig.8.39a). Această tensiune se numește *tensiune de susținere* a descărcării pentru că, după cum vom vedea în continuare, odată descărcarea amorsată ea este suficientă pentru menținerea ei. Pentru aprinderea descărcării într-o celulă, între electrozi corespunzători ei, peste tensiunea de susținere se aplică un scurt impuls dreptunghiular cu amplitudinea mai mare decât tensiunea de străpunere (Fig.8.39b). Această tensiune se numește *tensiune de adresare* sau de *înscrisiere*. Din grafic se poate observa că impulsul de adresare este pozitiv și el se aplică într-un interval de timp în care tensiunea de susținere este zero, înaintea unui impuls negativ al ei.

Descărcarea, amorsată în urma aplicării impulsului de adresare, se stinge foarte repede după dispariția lui datorită câmpului determinat de sarcinile spațiale superficiale acumulate pe suprafețele dielectricilor. În următoarea semiperioadă a tensiunii de susținere, când aceasta este negativă, câmpul datorat sarcinilor superficiale se adună cu câmpul de susținere, suma lor depășind tensiunea de

străpungere și descărcarea se aprinde din nou fără a mai fi necesar un alt impuls de adresare. În timpul acestei noi descărcări are loc o separare și acumulare de sarcini superficiale al căror câmp este opus celui exterior, descărcarea se va stinge și lucrurile se vor repeta în acest mod în timpul ciclurilor următoare ale tensiunii de susținere. Ca o consecință a aprinderilor și stingerilor repetate ale plasmei într-o celulă de descărcare, curentul pixelic va fi de forma unor scurte impulsuri periodice, pozitive și negative (Fig.8.39c). Pentru anularea informației pixelice, adică pentru stingerea descărcării, este suficientă aplicarea unui scurt impuls de ștergere negativ imediat după un impuls pozitiv al tensiunii de susținere.

Amplitudinea lui trebuie să fie suficient de mare pentru a neutraliza sarcinile superficiale create în semiperioada anterioară de către câmpul de susținere. Dacă sarcinile superficiale create la sfârșitul unei semiperioade a câmpului de susținere sunt $+Q$ și $-Q$, atunci următoarea descărcare trebuie să transfere sarcinile $-2Q$ și respectiv $+2Q$ pe aceste suprafețe pentru menținerea unei stări staționare. Asta înseamnă că impulsurile de aprindere și de stingere trebuie să genereze exact sarcinile $+Q$ și $-Q$ pe cele două suprafețe dielectrice. Evoluția în timp a potențialului superficial poate fi observată în Fig.8.39d.

Tensiunea de susținere trebuie să fie mai mică decât tensiunea de străpungere a descărcării (în caz contrar descărcarea ar fi în permanență aprinsă) dar suficient de mare pentru a menține descărcarea după ce ea a fost amorată de către impulsul de adresare. Valorile maximă și minimă ale tensiunii de susținere definesc limitele de tensiune ale dipozitivului de afișare. Este important ca operarea să se facă în condițiile unor limite largi, pentru că tensiunea de susținere trebuie să fie în interiorul limitelor de tensiune ale tuturor celulelor, limite care nu sunt identice. După cum am văzut, limita superioară a tensiunii de susținere este determinată de tensiunea de străpungere. Limita inferioară este legată de tensiunea minimă necesară menținerii unei decărcări luminiscente. Aceste limite se îndepărtează una de alta odată cu creșterea produsului pd (presiune \times distanța dintre electrozi). Acest produs trebuie să fie suficient de mare pentru a avea niște limite largi de tensiune, dar suficient de mic pentru a nu avea o tensiune de străpungere prea mare.

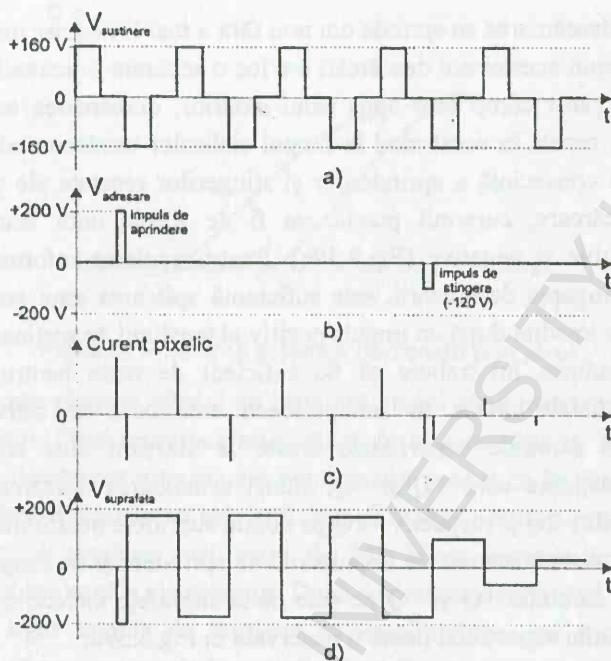


Fig.8.39 – Comanda aprinderii și variația în timp a curentului pixelic.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. S.D.ANGHEL, "Minitorch for Inductively Coupled Plasma Used in Atomic Emission Spectroscopy". Studia Univ."Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XXXV, nr.2,67-71 (1990).
2. E.TĂTARU and S.D.ANGHEL, "Evaluation of low Power Capacitively Coupled Plasma RF Torch as Spectral Source". Rom.Journ.Phys. 37,821-826(1992).
3. E.A.CORDOS, S.D.ANGHEL, T.FRENTIU and A.POPESCU, "Capacitively Coupled Plasma with Tip-ring Electrode Geometry for Atomic Emission Spectrometry. Analytical Performance and Matrix Effect of Sodium Chloride and Potassium Chloride". J.Anal.At.Spectrom. 9, 635-641 (1994).
4. S.D.ANGHEL, T.FRENTIU, A.M.RUSU, L.BESE and E.A.CORDOS. "The Analysis of Conductible Solid Samples by RF Capacitively Coupled Plasma at Atmospheric pressure". Fresenius Journ.Anal.Chem. 355:252-253 (1996).
5. S.D.ANGHEL and M.TODICA, "Capacitively Coupled plasma as Spectral Source for Direct Analysis of Conductive Samples". Studia Univ."Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XLI, nr.2, 67-76 (1996).

6. T.FRENTIU, A..M.RUSU, M.PONTA, S.D.ANGHEL and E.A.CORDOS, "*Analytical Performance of an RF Capacitively Coupled Plasma for Atomic Emission, with Tip-Ring Electrode Geometry*". Fresenius Journ.Anal.Chem. 355:254-255 (1996).
7. S.D.ANGHEL, E.A.CORDOS, T.FRENTIU, A.M.RUSU, A.SIMON and E.DARVASI, "*Some Fundamental Characteristics for a RF Capacitively Coupled Argon Plasma with Tip-Ring Electrode Geometry*", Studia Univ."Babes-Bolyai" Cluj, Physica, XLI, nr.1, 109-123 (1997).
8. S.D.ANGHEL, "*Physical Characteristics and Spectroscopical Applications of RF CCP in Tip-Ring Geometry at Atmospheric Pressure*". Rom. Repts. Phy., 50, 401-415 (1998).
9. E.A.CORDOS, T.FRENTIU, A.M.RUSU, S.D.ANGHEL, A.FODOR and M.PONTA, "*Analytical Characterization of CCP Torch with central Tube Electrode*". Talanta 48, 827-837 (1999).
10. T.FRENTIU, A.M.RUSU, S.D.ANGHEL, A.POPESCU, S.NEGOESCU, A.SIMON and E.A.CORDOS, "*Radiforequency CCP Torch with Central Tubular Electrode and Outer Ring Electrode*". Acta Chimica Hungarica - ACH Models in Chemistry 136, 119-129 (1999).
11. S.D.ANGHEL, E.A.CORDOS, T.FRENTIU, A.POPESCU and A.SIMON, "*Atmospheric Pressure Capacitively Coupled Plasma Source for Direct Analysis of Non-Conductive Solid Samples*". J.Anal.At.Spectrom 14, 541-545, (1999).
12. S.D.ANGHEL, T.FRENTIU, A.M.RUSU, A.POPESCU, A.SIMON and E.A.CORDOS, "*Figures of Merit and Physical Characteristics of a Capacitively Coupled Radiofrequency Argon Plasma Sustained at Atmospheric Pressure in Tip-Ring Electrode Geometry*". Acta Chimica Hungarica - ACH Models in Chemistry 136, 131-148 (1999).
13. T.FRENTIU, S.D.ANGHEL, M.NICOLA, E.DARVASI, A.SIMON and E.A.CORDOS, "*Figures of Merit and Fundamental Processes in Analysis of Ca from Liquid Samples Using an r.f. CCP Torch with Tubular and Ring Electrodes*". Croatica Chemica Acta 72, 763-778 (1999).
14. T.FRENTIU, M.PONTA A.RUSU, S.D.ANGHEL, A.SIMON and E.A.CORDOS, "*Cadmium Determination in Sedimented Dusty by Atomic Emission Spectrometry with a New Radiofrequency Capacitively Coupled Plasma Source*". Analytical Letters 33(2), 323-335 (2000).
15. T.FRENTIU, S.D.ANGHEL, A.SIMON and E.A.CORDOS, "*Study of some matrix effects in low power radiofrequency capacitively coupled plasma with a central tubular molybdenum electrode and a single ring electrode*". Acta Chimica Hungarica - ACH Models in Chemistry 137, 677-690 (2000).
16. G.COLLINS and D.J.REJ, "*Plasma Processing of Advanced Materials*". MRS Bulletin 21, 26-27 (1996).

17. D.M.COATES and L.KAPLAN, "*Modification of Polymeric Surfaces with Plasmas*". MRS Bulletin 21, 43-45 (1996).
18. K.T.RIE, E.MENTHE, A.MATTHEWS, K.LEGG and J.CHIN, "*Plasma Surface Engineering of Metals*". MRS Bulletin 21, 46-51 (1996).
19. J.V.MANTESE, I.G.BROWN, N.W.CHEUNG and G.A.COLLINS, "*Plasma-Immersion Ion Implantation*". MRS Bulletin 21, 52-56 (1996).
20. M.TOMA și GH.POPA, "*Aplicații ale fizicii plasmei*". Ed. Tehn., București 1982.
21. L.DĂSCĂLESCU, "*An Introduction to Ionized Gases. Theory and Applications*". Toyohashi University of Technology, 1993.
22. GH.POPA și M.GHEORGHIU, "*Aplicații tehnologice ale plasmei*". Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iași, 1998.
23. R.A.GOTTSCHO, M.E.BARONE and J.M.COOK, "*Use of Plasma Processing in Making Integrated Circuits and Flat-Panel Displays*". MRS Bulletin 21, 38-42 (1996).
24. J.G.WEBSTER, "*Mesurement, Instrumentation and Sensors*". CRC Press-Springer-IEEE Press, Boca Raton (USA) 1999.

BCU IASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

ISBN 973-647-060-1

272502